香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED
華虹半導體有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：01347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「**本公司**」)於上海證券交易所網站刊發的《華虹半導體有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(修訂稿)》，僅供參閱。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事會主席兼執行董事
白鵬先生

中國上海，二零二六年三月三十日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：
白鵬*(董事會主席兼總裁)*

非執行董事：
葉峻
孫國棟
陳博
熊承艷

獨立非執行董事：
張祖同
王桂壎太平紳士
封松林

股票代码：688347　　股票简称：华虹公司　　上市地点：上海证券交易所

股票代码：1347　　股票简称：华虹半导体　　上市地点：香港联合交易所

华虹半导体有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）

（修订稿）

交易类型	交易对方名称
发行股份购买资产	上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）
募集配套资金	不超过 35 名符合条件的特定对象

独立财务顾问

国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇二六年三月

上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华虹半导体届时拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华虹半导体董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易时，除本报告书及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询其股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

本次交易的交易对方承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

证券服务机构及人员声明

本次交易的证券服务机构及人员承诺：本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。**如其**为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，**且**证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担**相应的法律责任**。

目 录

上市公司声明 1

交易对方声明 2

证券服务机构及人员声明 3

目 录 4

释 义 9

重大事项提示 14

一、本次交易方案概况 14

二、募集配套资金情况 16

三、本次交易的性质 17

四、本次交易对上市公司的影响 18

五、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序 21

六、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 22

七、上市公司控股股东、董事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 22

八、本次交易对中小投资者权益保护的安排 24

九、其他需要提醒投资者重点关注的事项 26

重大风险提示 27

一、本次交易相关风险 27

二、与标的公司相关的风险 28

三、其他风险 29

第一节 本次交易概况 31

一、本次交易的背景、目的及协同效应 31

二、本次交易的方案概要 33

三、本次交易的性质 35

四、标的资产的评估情况 36

五、本次交易的具体方案 36

六、本次交易对上市公司的影响 41

七、本次交易的决策过程和审批情况.....44
八、本次交易相关方所作出的重要承诺.....45
第二节 上市公司基本情况.....75
一、上市公司基本情况.....75
二、公司设立及股本变动情况.....75
三、上市公司最近三十六个月控制权变动情况.....80
四、上市公司最近三年重大资产重组的基本情况.....80
五、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预期变化情况.....80
六、上市公司控股股东及实际控制人情况.....80
七、上市公司最近三年主营业务发展情况.....81
八、上市公司主要财务数据.....81
九、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形.....82
十、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况.....82
十一、上市公司遵纪守法情况.....83
第三节 交易对方基本情况.....84
一、发行股份购买资产的交易对方.....84
二、募集配套资金的交易对方.....114
第四节 标的公司基本情况.....115
一、标的公司基本情况.....115
二、标的公司历史沿革.....115
三、标的公司产权结构及控制关系.....124
四、标的公司下属企业情况.....125
五、标的公司主要资产权属状况、主要负债及对外担保情况.....125
六、标的公司主营业务情况.....129
七、标的公司主要财务数据.....151
八、本次交易已取得标的公司其他股东的同意，符合公司章程规定的股权转让前置条件.....151

九、标的公司报告期会计政策及相关会计处理.....152
第五节 本次交易发行股份情况.....155
一、发行股份及购买资产.....155
二、本次募集配套资金安排.....157
第六节 标的资产评估作价基本情况.....161
一、本次交易标的评估情况.....161
二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析.....213
三、上市公司独立董事对本次交易评估事项的意见.....218
第七节 本次交易合同的主要内容.....220
一、发行股份购买资产协议及其补充协议.....220
二、减值补偿协议.....222
第八节 本次交易的合规性分析.....225
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定.....225
二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形.228
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定.....228
四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定.....229
五、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条及其适用意见的规定.....231
六、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定.....231
七、本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定.....232
八、本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《科创板股票上市规则》第 11.2 条和《重组审核规则》第八条的规定.....232
九、中介机构关于本次交易符合《重组管理办法》规定发表的明确意见.233
十、本次募集配套资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定.233
第九节 管理层讨论与分析.....236
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析.....236
二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析.....241
三、标的公司的财务状况和盈利能力分析.....254
四、上市公司对拟购买资产的整合计划及管控安排.....285
五、本次交易对上市公司持续经营能力影响.....288

六、本次交易对上市公司盈利能力影响的分析.....291

第十节 财务会计信息.....293

一、标的公司的财务会计信息.....293

二、上市公司备考合并财务报表.....296

第十一节 同业竞争和关联交易.....301

一、同业竞争情况.....301

二、关联交易情况.....301

第十二节 风险因素.....313

一、本次交易相关风险.....313

二、与标的公司相关的风险.....314

三、其他风险.....316

第十三节 其他重要事项.....318

一、拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方是否存在对拟购买资产的非经营性资金占用.....318

二、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形.....318

三、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况.....318

四、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况.....319

五、本次交易对上市公司治理机制的影响.....319

六、重大事项披露前股票价格波动情况的说明.....319

七、本次重组对中小投资者权益保护的安排.....320

八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....320

九、本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明.....321

十、本次交易完成后利润分配政策及相应安排.....321

十一、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况.....321

十二、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所

有信息.....331
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见.....332
一、独立董事意见.....332
二、独立财务顾问对本次交易的结论性意见.....335
三、法律顾问对本次交易的结论性意见.....336
第十五节 本次交易有关中介机构情况.....338
一、独立财务顾问.....338
二、律师事务所.....338
三、标的资产审计机构.....338
四、上市公司备考审阅机构.....339
五、资产评估机构.....339
第十六节 声明与承诺.....340
一、上市公司全体董事声明.....340
二、上市公司审核委员会声明.....341
三、上市公司全体高级管理人员声明.....342
四、独立财务顾问声明.....343
五、法律顾问声明.....344
六、审计机构声明.....345
七、备考审阅机构声明.....346
八、资产评估机构声明.....347
第十七节 备查文件.....349
一、备查文件.....349
二、备查地点.....349
附件一：标的公司拥有的主要专利权.....350
表 1：标的公司拥有的主要境内已授权专利.....350
表 2：标的公司拥有的主要境外已授权专利.....468
表 3：标的公司拥有的主要集成电路布图设计专有权.....484

释 义

本报告书中，除非文义载明，下列词语具有如下含义：

一、一般名词释义		
预案、重组预案	指	《华虹半导体有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书/草案/本报告书	指	《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（**修订稿**）》
华虹半导体、华虹公司、本公司、公司、上市公司	指	华虹半导体有限公司
本次交易、本次重组、本次收购、本次发行	指	上市公司拟通过发行股份的方式购买上海华虹（集团）有限公司等 4 名交易对方持有的上海华力微电子有限公司 97.4988%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次发行股份购买资产	指	上市公司拟通过发行股份的方式购买上海华虹（集团）有限公司等 4 名交易对方持有的上海华力微电子有限公司 97.4988%股权
标的公司、华力微	指	上海华力微电子有限公司
标的资产、交易标的	指	上海华力微电子有限公司 97.4988%股权
发行股份购买资产协议	指	公司与交易对方就本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
发行股份购买资产协议之补充协议	指	公司与交易对方就本次交易签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》
减值补偿协议	指	华虹半导体有限公司与上海华虹（集团）有限公司之减值补偿协议
资产评估报告	指	华虹半导体有限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海华力微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告
华虹集团	指	上海华虹（集团）有限公司
华虹国际	指	Shanghai Hua Hong International, Inc.（上海华虹国际公司）
大基金二期	指	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
上海集成电路基金	指	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
国投先导基金	指	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）
交易对方	指	华虹集团、大基金二期、上海集成电路基金、国投先导基金
华虹宏力	指	上海华虹宏力半导体制造有限公司
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
华虹 NEC	指	上海华虹 NEC 电子有限公司

中国日电	指	日电（中国）有限公司
张江集团	指	上海张江（集团）有限公司
上海贝岭	指	上海贝岭股份有限公司
NEC	指	NEC Corporation（日本电气株式会社）
Newport	指	Newport Fab LLC
张江国际	指	Shanghai Zhangjiang International Corporation（上海张江国际有限公司）
鑫芯香港	指	Xinxin （Hongkong） Capital Co., Limited（鑫芯（香港）投资有限公司）
华力集	指	上海华力集成电路制造有限公司
独立财务顾问/国泰海通	指	国泰海通证券股份有限公司
法律顾问/律师/通力律师	指	上海通力律师事务所
审计机构/大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
备考审阅机构/安永会计师	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/东洲评估	指	上海东洲资产评估有限公司
士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
华润微	指	华润微电子有限公司
晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司
芯联集成	指	芯联集成电路制造股份有限公司
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司
联华电子	指	联华电子股份有限公司
格芯	指	格芯股份有限公司（原：Global Foundries Inc.）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
定价基准日	指	上市公司 2025 年第六次董事会决议公告日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《公司条例》	指	中国香港《公司条例》（香港法例第 622 章）（自 2014 年 3 月 3 日起）及其不时修订
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	《华虹半导体有限公司之组织章程细则》
股东大会	指	华虹半导体有限公司股东大会
董事会	指	华虹半导体有限公司董事会
科创板	指	上海证券交易所科创板
A 股	指	在中国境内证券交易所上市的以人民币认购和进行交易的普通股股票
交割日	指	交易对方向上市公司转让标的资产的工商变更登记手续完成，标的资产登记至上市公司名下之日；自交割日起，标的资产的所有权利、义务和风险转移至上市公司
发行日	指	上市公司向交易对方发行的新增股份登记在交易对方名下之日
过渡期	指	自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割日当日）止的期间
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
二、专业名词释义		
晶圆	指	晶圆指制造半导体芯片的衬底（也叫基片）。由于是圆形晶体材料，所以称为晶圆。按照直径进行分类，主要包括 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，一种微型电子器件或部件。采用半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等组件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体芯片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
制程	指	制程亦称为节点或特征线宽，用来衡量半导体芯片制造的工艺水准，线宽越低，则制程水平越高
嵌入式	指	将 IP 模块或工艺模块集成至芯片或基础工艺的简称
嵌入式非易失性存储器	指	Embedded Non-Volatile Memory，缩写为 eNVM，用于满足各种嵌入式系统应用程序的小型芯片，eNVM 被广泛应用于需要存储代码程序、客户数据或其他重要信息的芯片，如智能卡芯片、MCU 等
独立式非易失性存储器	指	Standalone Non-Volatile Memory，缩写为 sNVM，是一种独立于数据处理芯片单独封装的存储器件，其核心特征是断电后数据不丢失，并通过标准化接口（如 USB、PCIe、NVMe）与主机系统通信

高压	指	高压显示驱动
功率器件	指	分立器件板块的一个分支，主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件，如 MOSFET、SJ 和 IGBT
电源管理芯片	指	电源管理芯片（Power Management Integrated Circuits，PMIC），是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片
SONOS	指	硅基-二氧化硅-氮化硅-二氧化硅-多晶硅，一种存储结构
Flash/闪存	指	是一种非易失性存储器的形式，允许在操作中被多次擦或写的存储器
ISP	指	Image Signal Processor，图像信号处理器，主要用来对前端图像传感器输出信号处理的单元
MCU	指	Micro controller Unit，微控制单元，又称单片微型计算机或者单片机，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
AIoT	指	AI+IoT，即人工智能+物联网
SRAM	指	Static Random Access Memory，静态随机存取存储器，是一种半导体存储器，主要用于芯片内的缓存
IP	指	半导体 IP（Intellectual Property），一般指在集成电路设计中，经过验证的、可重复使用且具备特定功能的集成电路模块
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，垂直整合制造工厂，是集芯片设计、芯片制造、封装测试及产品销售于一体的整合元件制造商，属于半导体行业的一种业务模式
Foundry	指	泛指晶圆代工模式，专门负责芯片制造，不负责芯片设计，可同时为多家芯片设计公司或 IDM 公司提供代工服务
逻辑电路	指	传递和处理离散信号，以二进制为原理，实现数字信号逻辑运算和操作的电路
射频	指	高频交流变化电磁波的信号处理电路
CIS	指	CMOS Image Sensor，CMOS 图像传感器
PDK	指	Process Design Kit，工艺设计套件，是集成电路设计流程中的重要工具包
NB-IOT	指	Narrow Band Internet of Things，窄带物联网，是一种由 3GPP 标准化的低功耗广域网（LPWAN）技术，基于蜂窝网络，专为物联网应用设计
FPGA	指	Field Programmable Gate Array，现场可编程逻辑门阵列，是在 PAL、GAL 等可编程器件的基础上进一步发展的产物，在硬件层面可重复进行编程、以满足多种应用需要
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管显示器

CMOS	指	CMOS（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor），互补金属氧化物半导体。CMOS 的制造技术原理主要是利用共存着带 N（带-电）和 P（带+电）级的半导体
nm	指	纳米，10^{-9} 米

正文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因四舍五入造成。

重大事项提示

特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项（本部分引用的简称见本报告书“释义”）：

一、本次交易方案概况

（一）本次交易方案

交易形式		发行股份购买资产并募集配套资金	
交易方案简介		上市公司拟通过发行股份方式向华虹集团等 4 名交易对方购买其合计持有的华力微 97.4988%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。	
交易价格（不含募集配套资金金额）		826,790.22 万元	
交易标的	**名称**	上海华力微电子有限公司	
	主营业务	主要从事 12 英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。	
	所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	
	其他	**符合板块定位**	√是 □否 □不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	√是 □否
		与上市公司主营业务具有协同效应	√是 □否
交易性质		**构成关联交易**	√是 □否
		构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组	□是 √否
		构成重组上市	□是 √否
本次交易有无业绩补偿承诺			□是 √否
本次交易有无减值补偿承诺			√是 □否
其他需特别说明的事项			无

（二）标的资产评估作价情况

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 2446 号），本次交易对华力微采用了资产基础法、市场法进行评估，最终选用市场法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日，华力微报表归属于母公司所有者权益账面价值为 200,191.38 万元，评估值为 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。

交易标的名称	基准日	评估或估值方法	评估或估值结果（万元）	增值率/溢价率	本次拟交易的权益比例	交易价格（万元）	其他说明
华力微	2025 年 8 月 31 日	市场法	848,000.00	323.59%	97.4988%	826,790.22	-

（三）本次交易支付方式

本次交易中，上市公司向各交易对方支付的交易对价及支付方式具体如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易股权比例	支付方式				向该交易对方支付总对价
			现金对价	股份对价	可转债	其他	
1	华虹集团	63.5443%	0.00	538,855.12	无	无	538,855.12
2	上海集成电路基金	15.7215%	0.00	133,318.65	无	无	133,318.65
3	大基金二期	10.2503%	0.00	86,922.77	无	无	86,922.77
4	国投先导基金	7.9827%	0.00	67,693.68	无	无	67,693.68
合计		**97.4988%**	**0.00**	**826,790.22**		**-**	**826,790.22**

（四）发行股份购买资产的具体情况

股票种类	境内人民币普通股（A 股）	**每股面值**	根据《公司条例》第135条，公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票无面值
定价基准日	上市公司 2025 年第六次董事会决议公告日	**发行价格**	43.34 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价的 80%
发行数量	190,768,392 股，占发行后上市公司总股本的比例为 **9.89%**（不考虑募集配套资金）		
是否设置发行价格调整方案	□是 √否（在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整）		
锁定期安排	1、华虹集团本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则华虹集团通过本次交易取得的前述上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月； 2、上海集成电路基金本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。如果上海集成电		

	路基金符合《重组管理办法》第四十七条第三款第（一）项规定，则其本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 6 个月内不得进行转让； 3、大基金二期、国投先导基金本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让；如其取得前述上市公司股份时，对于用于认购上市公司股份的华力微股权权益持续拥有权益的时间不足 12 个月，则该等华力微股权对应的在本次交易中相应取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。 股份锁定期内，交易对方通过本次交易所取得的新增股份因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守上述股份限售安排。若上述限售期安排与届时有效的法律、法规、部门规章及规范性文件的规定不相符或与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关规定或监管意见相应调整。

二、募集配套资金情况

（一）募集配套资金概况

募集配套资金金额	755,628.60 万元		
发行对象	不超过 35 名特定对象		
募集配套资金用途	**项目名称**	**拟使用募集资金金额（万元）**	**使用金额占全部募集配套资金金额的比例**
	华力微技术升级改造项目	329,476.00	43.60%
	华力微特色工艺研发及产业化项目	56,152.60	7.43%
	补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用	370,000.00	48.97%
	合计	**755,628.60**	**100.00%**

（二）募集配套资金的具体情况

股票种类	A 股（人民币普通股）	**每股面值**	根据《公司条例》第 135 条，公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票无面值
定价基准日	本次募集配套资金的发行期首日	**发行价格**	价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除

			权、除息事项，上述发行价格将根据中国证监会及上交所颁布的规则作相应调整。
发行数量	上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。本次募集配套资金发行股份数量=本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股份发行价格。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，上述发行股份数量将根据中国证监会及上交所颁布的规则作相应调整。		
锁定期安排	本次募集配套资金的发行对象所认购的上市公司的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份因派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项增加的，亦应遵守上述约定。前述锁定期与适用法律或证券监管机构（包括但不限于中国证监会和上交所）的最新监管意见不相符的，将根据适用法律或相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。		

三、本次交易的性质

（一）本次交易不构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买华力微 97.4988%股权。本次交易拟购买资产最近一期末经审计的资产总额、资产净额及最近一年的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：

单位：万元

项目	资产总额与交易金额孰高	资产净额与交易金额孰高	营业收入
华力微 97.4988%股权	826,790.22	826,790.22	**510,114.63**
上市公司	**10,012,329.13**	**4,516,029.04**	**1,729,145.07**
指标占比	**8.26%**	**18.31%**	**29.50%**

注 1：上表华力微 97.4988%股权的“资产总额与交易金额孰高”、“资产净额与交易金额孰高”均取相应交易金额，“营业收入”取华力微 **2025** 年度营业收入；

注 2：上市公司、华力微的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的 **2025** 年度财务报表。

如上，本次交易中计算依据占上市公司相应指标比例均未超过 50%，因此本次交易不构成重大资产重组。

（二）本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方中，华虹集团系上市公司的间接控股股东，上海集成电路基金系上市公司董事曾担任董事的企业，根据《科创板上市规则》，本次交易构成关联交易。

上市公司召开董事会、股东大会审议**本次交易**相关议案时，关联董事、关联股东**均已**回避表决。

（三）本次交易不构成重组上市

本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司直接控股股东均为华虹国际，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均为上海市国资委，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市。

四、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司作为全球领先的特色工艺晶圆代工企业及行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业，主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务。公司以拓展特色工艺技术为基础，主要聚焦于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台。

标的公司主要为客户提供 12 英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。

标的公司与上市公司均拥有 65/55nm、40nm 制程代工工艺，通过本次交易，上市公司将进一步提升公司 12 英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服

务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。同时，通过研发资源整合与核心技术共享，双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应，加速技术创新迭代，共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。另外，上市公司将通过整合管控实现一体化管理，在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次的整合，通过降本增效实现规模效应，提升公司的市场占有率与盈利能力。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

截至 2025 年 **12 月 31 日**，上市公司总股本为 **1,737,614,193** 股，公司直接控股股东为华虹国际，间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委。根据标的资产的交易作价、本次发行股份购买资产的价格及股份支付的比例，本次交易拟向交易对方发行 190,768,392 股。本次交易前后（不考虑募集配套资金）上市公司股权结构变化情况如下：

股东名称	本次重组前		本次重组后（不考虑募集配套资金）	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	**820,333,688**	**47.21%**	**820,333,688**	**42.54%**
华虹国际	347,605,650	**20.00%**	347,605,650	**18.03%**
联和国际有限公司（Sino-Alliance International, Ltd.）	160,545,541	**9.24%**	160,545,541	8.33%
华虹集团	1,198,517	0.07%	125,530,570	**6.51%**
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	48,334,249	2.78%	68,390,263	3.55%
上海集成电路基金	-	-	30,761,109	1.60%
国投先导基金	-	-	15,619,216	0.81%
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金	**11,020,000**	**0.63%**	**11,020,000**	**0.57%**

股东名称	本次重组前		本次重组后（不考虑募集配套资金）	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	**10,697,339**	**0.62%**	**10,697,339**	**0.55%**
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	**9,267,853**	**0.53%**	**9,267,853**	**0.48%**
海通创新证券投资有限公司	8,155,000	0.47%	8,155,000	0.42%
国泰君安证裕投资有限公司	8,155,000	0.47%	8,155,000	0.42%
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	**6,077,517**	**0.35%**	**6,077,517**	**0.32%**
其他股东	**306,223,839**	**17.62%**	**306,223,839**	**15.88%**
合计	**1,737,614,193**	**100.00%**	**1,928,382,585**	**100.00%**

注：重组前股份数量、持股比例为截至2025年**12月31日**数据。

本次交易完成后，公司直接控股股东仍为华虹国际，间接控股股东仍为华虹集团，实际控制人仍为上海市国资委，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司财务报告及安永会计师**审阅**的**上市公司备考财务报表**，不考虑募集配套资金，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：

单位：万元

项目	2025年度/2025年12月31日		2024年度/2024年12月31日	
	上市公司	备考报表	上市公司	备考报表
资产总额	**10,012,329.13**	**10,610,932.80**	8,793,523.15	9,356,042.83
负债总额	**3,702,853.87**	**4,092,273.00**	2,521,468.25	2,965,008.50
归属于母公司股东权益	**4,516,029.04**	**4,725,213.57**	4,360,233.22	4,474,671.92
营业收入	**1,729,145.07**	**2,228,795.71**	1,438,830.77	1,927,405.55
利润总额	**-65,100.61**	**11,125.88**	-98,831.81	-36,817.13

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日		2024 年度/2024 年 12 月 31 日	
	上市公司	备考报表	上市公司	备考报表
净利润	**-80,714.30**	**-4,487.81**	-103,218.38	-41,203.70
归属于母公司股东净利润	**37,661.14**	**118,428.37**	38,057.62	95,531.55
基本每股收益（元/股）	**0.22**	**0.62**	0.22	0.50

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司合并范围内的子公司，根据模拟测算本次交易完成后上市公司资产规模、收入规模、盈利能力均有较大提升。

五、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序

（一）本次交易已经履行的决策和审批程序

截至本报告书签署日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易已经上市公司 2025 年第六次董事会会议、2025 年第九次董事会会议、**2026 年第三次董事会会议**审议通过；

2、本次交易已取得上市公司持股 5%以上股东的原则性意见；

3、本次交易已经交易对方有权内部决策机构授权或批准；

4、本次交易方案已经标的公司董事会和股东会审议批准；

5、本次交易涉及的标的资产评估报告经有权国有资产监督管理部门备案；

6、上市公司股东大会审议通过本次交易；

7、香港证监会及联交所必要的审批程序。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的决策和审批程序事项包括但不限于：

1、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、审查、备案或

许可（如适用）。

本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见

上市公司直接控股股东华虹国际、间接控股股东华虹集团已出具《关于上市公司本次交易的原则性意见》，原则性同意本次交易。

七、上市公司控股股东、董事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司控股股东已出具《关于股份减持计划的承诺函》

上市公司直接控股股东华虹国际已出具《关于股份减持计划的承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业无减持上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本企业不主动减持上市公司股份。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

3、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本企业承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。”

上市公司间接控股股东华虹集团已出具《关于股份减持计划的承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业无主动减持本企业直接及间接持有的

上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本企业不主动减持本企业直接及间接持有的上市公司股份，前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

3、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本企业承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。”

（二）上市公司董事、高级管理人员已出具《关于股份减持计划的承诺函》

上市公司董事、高级管理人员已出具《关于股份减持计划的承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，如本人持有上市公司股份的，本人无减持上市公司股份的计划。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，如本人根据自身实际情况需要或市场变化而减持上市公司股份的，本人将遵守有关法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，严格履行已经做出的关于股份锁定及减持的有关承诺，并及时履行信息披露义务。

3、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本人承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

4、本人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。”

八、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行上市公司信息披露义务

对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规的要求履行了现阶段必要的信息披露义务。上市公司将继续严格履行信息披露义务，按照相关法律法规的要求，及时、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

（二）确保本次交易的定价公平、公允

上市公司已聘请符合《证券法》规定的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，以确保本次交易的定价公允、公平、合理，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。

（三）严格执行相关决策程序

本次交易涉及的董事会、股东会等决策程序，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格执行法律法规以及公司制度中规定的程序进行决策审批。

（四）网络投票安排和中小股东单独计票

根据有关规定，上交所通过交易系统和互联网投票系统向全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票，以切实保护股东的合法权益。

针对审议本次交易的股东大会投票情况，上市公司对 A 股股东单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

（五）关联董事、关联股东回避表决

根据《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。上市公司在召

开董事会审议本次交易时，已提请关联董事回避表决相关议案；上市公司在召开股东大会审议本次交易时，已提请关联股东回避表决相关议案，从而充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）股份锁定安排

本次重组交易对方就认购股份的锁定期出具了承诺，具体内容详见本报告书“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

本次发行结束之日后，交易对方基于本次发行而享有的上市公司送股、配股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符，将根据相关监管规定进行相应调整。锁定期届满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。

（七）本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施

根据上市公司财务报告及安永会计师审阅的上市公司备考财务报表，本次交易完成前后，上市公司每股收益的变化情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度	
	交易前	备考数	交易前	备考数
基本每股收益（元/股）	0.22	0.62	0.22	0.50

如上市公司或标的公司未来盈利能力不及预期，本次交易存在导致上市公司即期回报被摊薄的可能。为了充分保护公司公众股东的利益，公司制定了防止本次交易摊薄即期回报的相关填补措施。公司制定填补回报措施不等于对未来利润作出保证。具体如下：

1、有效整合标的资产，加快释放协同效应

上市公司和标的公司均从事晶圆代工业务，本次交易系同行业并购整合，交易双方在工艺技术平台、客户资源、供应链管理、技术及产能等方面均具有显着的协同效应。交易完成后，上市公司将在资产、业务、人员、财务、机构等方面实施整合计划，充分发挥协同效应，增强上市公司盈利水平和抗风险能力。

2、进一步加强经营管理和内部控制，提高经营效率

本次交易完成后，公司将根据实际情况进一步完善公司的治理体系、管理体系和制度建设，加强企业经营管理和内部控制，健全激励与约束机制，提高上市公司日常运营效率，降低运营成本，更好地维护上市公司整体利益，有效控制上市公司经营和管理风险。

3、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

本次交易完成后，上市公司在继续遵循《公司章程》关于利润分配的相关政策的基础上，将根据中国证监会的相关规定，结合公司经营情况与发展规划，持续完善利润分配政策，优化投资回报机制，在保证上市公司可持续发展的前提下给予股东合理的投资回报，更好地维护上市公司股东及投资者利益。

4、相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

根据中国证监会相关规定，公司直接控股股东、间接控股股东和公司董事、高级管理人员为确保公司填补即期回报措施能够得到切实履行出具了相关承诺，具体内容详见本报告书“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

九、其他需要提醒投资者重点关注的事项

（一）本次交易独立财务顾问的证券业务资格

上市公司聘请国泰海通担任本次交易的独立财务顾问，国泰海通经中国证监会批准依法设立，具备财务顾问业务资格及保荐承销业务资格。

（二）信息披露查阅

本报告书的全文及中介机构出具的相关意见已在上交所网站披露，投资者应据此作出投资决策。

本报告书披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

重大风险提示

在评价本公司本次交易或作出投资决策时，除本报告书的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外，本公司特别提醒投资者认真考虑下述各项风险因素：

一、本次交易相关风险

（一）审批风险

截至本报告书签署日，本次交易尚未履行的决策程序及批准程序包括但不限于：

1、本次交易**经上交所审核通过并经中国证监会同意注册**；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、审查、备案或许可（如适用）。

本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险

由于本次交易涉及向上交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。在本次交易推进过程中，市场情况可能会发生变化或出现不可预知的重大事件，则本次交易可能无法按期进行或需重新进行，面临重新定价的风险。

除此之外，本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；

2、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、中止或取消的风险；

3、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

上述情形可能导致本次交易暂停、中止或取消，特此提醒广大投资者注意投资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并做出相应判断。

（三）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险

作为交易方案的一部分，上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。若国家法律、法规或其他规范性文件对发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。上述募集配套资金事项能否取得上交所审核通过、证监会的注册尚存在不确定性。此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。

（四）收购整合的风险

本次交易完成后，标的资产将纳入上市公司管理及合并范围，上市公司的业务规模、人员等将进一步扩大，上市公司也将面临经营管理方面的挑战。本次交易完成后，上市公司能否通过整合保持标的资产原有竞争优势并充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，提请投资者关注相关风险。

二、与标的公司相关的风险

（一）半导体行业周期性波动的风险

标的公司主要为客户提供 12 英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。半导体行业的发展与宏观经济整体发展密切相关，其下游市场需求受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，存在一定的周期性。未来，如果宏观经济环境持续低迷，或者通信、消费电子等下游市场需求发生波动，将可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。

（二）国际贸易摩擦的风险

近年来国际政治、经济形势日益复杂，国际贸易摩擦不断升级。有关国家针对半导体设备、材料、技术等领域颁布了一系列出口管制政策，对半导体行业相

关的技术和服务作出限制。若国际贸易摩擦持续或进一步加剧，标的公司生产经营可能受到不利影响。

（三）核心技术人员流失的风险

标的公司所处的晶圆制造行业属于技术密集型、人才密集型行业，优秀的研发人员团队是标的公司的核心竞争力及未来发展保障。在资本涌入和市场竞争日趋激烈背景下，半导体领域人才的竞争愈加激烈，若标的公司未能提供良好的发展路径、有吸引力的薪酬待遇及相应的激励考核机制，可能面临核心技术人员流失的风险，进而对标的公司技术研发能力与市场拓展能力产生负面影响。

（四）毛利率波动的风险

报告期各期，标的公司综合毛利率分别为 16.51%和 **23.69%**，标的公司的毛利率逐年有所提升。标的公司产品毛利率波动受诸多因素影响，未来，如果半导体行业整体情况发生不利变化，客户需求未达预期，从而影响到标的公司晶圆代工业务的产能利用率、销量及价格；或主要原材料价格大幅上涨等不利情况发生，标的公司在未来一定时期内可能面临毛利率波动的风险。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受企业经营业绩和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内外政治经济形势、资金供求关系、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，对本次交易事项本身的阐述和分析不能完全揭示投资者进行证券投资所面临的全部风险，上市公司的股价存在波动的风险。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，上市公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息供投资者做出投资判断，提请

广大投资者注意投资风险。

（二）不可抗力的风险

上市公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。提请投资者关注相关风险。

第一节 本次交易概况

一、本次交易的背景、目的及协同效应

（一）本次交易的背景

1、多项政策出台鼓励上市公司并购重组，收购华力微适逢其时

2024 年 4 月，中国证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，明确将优化资源配置，更大力度支持科技企业高水平发展，具体措施包括优先支持突破关键核心技术的科技型企业上市融资及并购重组；依法依规支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业上市；以及推动科技型企业高效实施并购重组，适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性，助力科技型企业提质增效、做优做强。

2024 年 6 月，中国证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，主要内容包括更大力度支持并购重组，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业，以及建立健全开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业股债融资、并购重组“绿色通道”。

2024 年 12 月，为深入贯彻党的二十届三中全会精神，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，落实资本市场改革任务，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，进一步提高资源配置效率，推动重大产业战略升级，深化上海“五个中心”建设，上海市人民政府办公厅制定《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027 年）》。

宏观政策和监管环境持续优化，上市公司启动并购重组适逢其时。

2、本次重组践行华虹公司上市承诺，符合市场预期

华虹公司科创板上市时，华虹集团曾向市场公开承诺“自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在

履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力微注入发行人。”本次重组，是华虹集团对于华虹公司科创板上市公开承诺的践行，符合市场预期。

（二）本次交易的目的

1、履行避免同业竞争承诺，切实保护中小股东利益

本次交易通过注入华力微，上市公司与华力微之间在 65/55nm、40nm 的同业竞争得到实质性解决。上市公司的资产规模和盈利能力将进一步增强，有效保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、提高上市公司资产质量和经营能力

华虹半导体聚焦于特色工艺，目前已覆盖至 65/55nm、40nm；华力微聚焦于 65/55nm 及 40nm 逻辑工艺，并在此基础上进一步开发特色工艺。本次重组完成后，华力微的 65/55nm 及 40nm 逻辑工艺及特色工艺技术将直接注入上市公司，上市公司将新增 3.8 万片/月的 65/55nm、40nm 产能，提高上市公司市场地位。本次并购重组将进一步提高上市公司资产质量，增强持续经营能力，符合全体股东利益。

3、提升股东价值回报，符合全体股东利益

本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司合并报表范围。预计本次交易的实施将提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平，有助于上市公司进一步扩充产能，提高持续经营能力。本次交易是上市公司优化产业布局、提高上市公司的竞争力，提高股东回报的重要举措，符合全体股东，特别是中小股东利益。

（三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司的业务协同性

1、标的公司具备科创属性

标的公司从事晶圆代工业务，主要工艺节点为 65/55nm、40nm，主要覆盖独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频、高压等工艺平台。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据国家统计局《战略性新兴产业分类

（2018）》（国家统计局令第 23 号），标的公司所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）、“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）及“电力电子基础元器件制造”（分类代码：6.5.2）。因此，标的公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条中的“（一）新一代信息技术领域：半导体和集成电路行业”，符合科创板行业定位要求。

2、标的公司与上市公司主营业务具有协同效应

上市公司与标的公司同属于晶圆代工领域，属于同行业。双方在工艺技术平台、客户资源、供应链管理、技术及产能等方面均具有显着的协同效应。

工艺平台方面，华力微的 65/55nm、40nm 覆盖独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频、高压等工艺平台，本次交易完成后，上市公司将进一步丰富工艺平台种类，满足市场多样化需求。

客户及供应商方面，不同客户对晶圆代工要求不同，本次交易完成后，上市公司工艺平台、技术等进一步丰富，有利于满足不同客户的多样化需求，提升整体竞争力；半导体设备、半导体材料供应商的全球行业集中度较高，本次交易完成后，公司规模将进一步扩大，产业链地位进一步增强。

技术及产能方面，本次交易有利于上市公司进一步丰富主营业务所需的 65/55nm、40nm 制程的相关技术，加速产品迭代、开发进程。标的公司拥有 3.8 万片/月产能，本次交易完成后，上市公司总产能将进一步提升，满足客户需求。

综上所述，上市公司与标的公司在工艺技术平台、客户资源、供应链管理、技术及产能等方面具有协同效应，本次交易将提升上市公司资产质量、增厚上市公司利润，有利于维护上市公司中小股东利益。

二、本次交易的方案概要

本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响本次

发行股份购买资产的实施。

（一）发行股份购买资产

上市公司拟以发行股份的方式购买华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金 4 名交易对方合计持有的华力微 97.4988%股权。本次交易完成后，华力微将成为上市公司全资子公司。

根据东洲评估出具的《评估报告》（东洲评报字【2025】第 2446 号），本次交易对华力微采用市场法、资产基础法进行评估，最终选用市场法结论作为最终评估结论。截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日，华力微所有者权益评估值为 848,000.00 万元。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定华力微 97.4988%股权的最终交易价格为 826,790.22 万元。

本次交易中，上市公司向各交易对方支付的交易对价及支付方式具体如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易股权比例	支付方式				向该交易对方支付总对价
			现金对价	股份对价	可转债	其他	
1	华虹集团	63.5443%	0.00	538,855.12	无	无	538,855.12
2	上海集成电路基金	15.7215%	0.00	133,318.65	无	无	133,318.65
3	大基金二期	10.2503%	0.00	86,922.77	无	无	86,922.77
4	国投先导基金	7.9827%	0.00	67,693.68	无	无	67,693.68
合计		**97.4988%**	**0.00**	**826,790.22**	**-**	-	**826,790.22**

（二）募集配套资金

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过 755,628.60 万元。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%，最终发行的股份数量将在本次交易获得上交所审核同意及中国证监会注册批复后，由上市公司董事会或

授权代表根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

本次募集资金具体用途如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
1	华力微技术升级改造项目	329,476.00	43.60%
2	华力微特色工艺研发及产业化项目	56,152.60	7.43%
3	补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用	370,000.00	48.97%
合计		**755,628.60**	**100.00%**

本次发行股份购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产行为的实施。在本次募集配套资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由公司自筹解决。

三、本次交易的性质

（一）本次交易不构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买华力微 97.4988%股权。本次交易拟购买资产最近一期末经审计的资产总额、资产净额及最近一年的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：

单位：万元

项目	资产总额与交易金额孰高	资产净额与交易净额孰高	营业收入
华力微 97.4988%股权	826,790.22	826,790.22	**510,114.63**
上市公司	**10,012,329.13**	**4,516,029.04**	**1,729,145.07**
指标占比	**8.26%**	**18.31%**	**29.50%**

注 1：上表华力微 97.4988%股权的“资产总额与交易金额孰高”、“资产净额与交易净额孰高”均取相应交易金额，“营业收入”取华力微 **2025** 年度营业收入；

注 2：上市公司、华力微的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的 **2025** 年度财务报表。

如上，本次交易中计算依据占上市公司相应指标比例均未超过 50%，因此本次交易不构成重大资产重组。

（二）本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方中，华虹集团系上市公司的间接控股股东，上海集成电路基金系上市公司董事曾担任董事的企业，根据《科创板上市规则》，本次交易预计构成关联交易。

上市公司召开董事会、**股东大会**审议本次交易相关议案时，关联董事、关联股东**均已**回避表决。

（三）本次交易不构成重组上市

本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司直接控股股东均为华虹国际，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均为上海市国资委，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市。

四、标的资产的评估情况

根据东洲评估出具的《评估报告》（东洲评报字【2025】第 2446 号），本次交易对华力微采用市场法、资产基础法进行评估，最终选用市场法结论作为最终评估结论。截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日，华力微报表归属于母公司所有者权益账面价值为 200,191.38 万元，评估值为 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定华力微 97.4988%股权的最终交易价格为 826,790.22 万元。

五、本次交易的具体方案

（一）发行股份购买资产

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，根据《公

司条例》第 135 条，公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票无面值，上市地点为上交所。

2、发行对象

本次发行股份购买资产的发行股份对象为华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金 4 名交易对方。

3、发行股份数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量＝以发行股份形式向各交易对方购买标的资产对应的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量＝向各交易对方发行股份的数量之和。

向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足 1 股部分由上市公司现金补足。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份数量也随之进行调整。

本次交易中，华力微股权的最终交易价格为 826,790.22 万元，均以股份方式支付，不足一股部分，现金补足。按照本次发行股票价格 43.34 元/股计算，本次交易购买资产的股份发行数量为 190,768,392 股，向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号	交易对方	股份对价（万元）	股份数量（股）
1	华虹集团	538,855.12	124,332,053
2	上海集成电路基金	133,318.65	30,761,109
3	大基金二期	86,922.77	20,056,014
4	国投先导基金	67,693.68	15,619,216
合计		**826,790.22**	**190,768,392**

本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。

4、定价基准日和发行价格

（1）定价基准日

本次发行股份的股票定价基准日为公司 2025 年第六次董事会决议公告日。

（2）发行价格

根据《重组管理办法》，本次发行股份购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

经交易各方友好协商，本次发行价格为 43.34 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，则将对发行价格作相应调整。

5、锁定期安排

交易对方通过本次交易取得上市公司股份的锁定期在严格遵守《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规的相关规定，以及中国证监会、上交所等证券监管机构要求的基础上，由上市公司与交易对方协商一致确定。具体股份锁定情况详见本报告书“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”之“（二）交易对方作出的重要承诺”。

本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。如前述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

6、过渡期损益安排

本次交易评估基准日至标的资产交割日内标的资产在运营过程中产生的收益及亏损均由上市公司享有。

7、滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

8、减值测试补偿

本次交易的减值测试期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，在减值测试期间每个会计年度结束后，由上市公司聘请符合《证券法》规定的评估机构对减值测试标的资产进行评估，并出具专项评估报告。根据评估结果，由上市公司对减值测试标的资产的合计价值在每个会计年度进行减值测试，并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具减值测试专项审核报告。

如减值测试标的资产在减值测试期间任何一个会计年度发生减值，则补偿方应按如下约定向上市公司进行补偿：期末减值额=本次交易总对价-该会计年度期末标的资产的评估值并扣除减值测试期间内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。补偿方应向上市公司补偿的金额=补偿方在本次交易中应获得的交易对价占本次交易总对价比例×期末减值额。

补偿方将优先以其在本次交易中获得的上市公司的股份进行补偿，补偿股份由上市公司以 1 元总价回购并予以注销，每年补偿的股份数量为：补偿金额/发行价格-减值测试期间内已补偿股份总数。在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已补偿的股份不冲回。补偿方在本次交易中获得的上市公司的股份不足以补偿的，补偿方应以现金进行补偿。

若上市公司在减值测试期间实施送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则上市公司应回购的股份数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数量×(1+送股或转增比例)。若补偿股份数量出现小数的情况，则应当向上取整作为补偿方应补偿股份的数量。补偿方在减值测试期间内就补偿股份已获分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额＝补偿股份截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×补偿股份数量。

（二）发行股份募集配套资金

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，根据《公司条例》第 135 条，公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票无面值，上市地点为上交所。

2、发行对象及发行股份数量

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过 755,628.60 万元。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。

在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，上述发行股份数量将根据中国证监会及上交所颁布的规则作相应调整。

3、发行股份的定价方式和价格

本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式，具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

4、锁定期安排

本次募集配套资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，同时遵照上述锁定期进行锁定。如前述锁定期的安排与监管机构的最新监管要求不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

5、募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于标的公司技术升级改造项目、特色工艺研发及产业化项目、补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。

本次募集资金具体用途如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
1	华力微技术升级改造项目	329,476.00	43.60%
2	华力微特色工艺研发及产业化项目	56,152.60	7.43%
3	补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用	370,000.00	48.97%
合计		**755,628.60**	**100.00%**

如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。本次募集配套资金到位前，上市公司可以根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

6、滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司作为全球领先的特色工艺晶圆代工企业及行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业，主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务。公司以拓展特色工艺技术为基础，主要聚焦于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台。

标的公司主要为客户提供 12 英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。

标的公司与上市公司均拥有 65/55nm、40nm 制程代工工艺，通过本次交易，上市公司将进一步提升公司 12 英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。同时，通过研发资源整合与核心技术共享，双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应，加速技术创新迭代，共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。另外，上市公司将通过整合管控实现一体化管理，在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次的整合，通过降本增效实现规模效应，提升公司的市场占有率与盈利能力。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

截至 2025 年 **12 月 31 日**，上市公司总股本为 **1,737,614,193** 股，公司直接控股股东为华虹国际，间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委。根据标的资产的交易作价、本次发行股份购买资产的价格及股份支付的比例，本次交易拟向交易对方发行 190,768,392 股。本次交易前后（不考虑募集配套资金）上市公司股权结构变化情况如下：

股东名称	本次重组前		本次重组后（不考虑募集配套资金）	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	**820,333,688**	**47.21%**	**820,333,688**	**42.54%**
华虹国际	347,605,650	**20.00%**	347,605,650	**18.03%**
联和国际有限公司（Sino-Alliance International, Ltd.）	160,545,541	**9.24%**	160,545,541	8.33%
华虹集团	1,198,517	0.07%	125,530,570	**6.51%**
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	48,334,249	2.78%	68,390,263	3.55%
上海集成电路基金	-	-	30,761,109	1.60%
国投先导基金	-	-	15,619,216	0.81%
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金	**11,020,000**	**0.63%**	**11,020,000**	**0.57%**
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	**10,697,339**	**0.62%**	**10,697,339**	**0.55%**
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	**9,267,853**	**0.53%**	**9,267,853**	**0.48%**
海通创新证券投资有限公司	8,155,000	0.47%	8,155,000	0.42%
国泰君安证裕投资有限公司	8,155,000	0.47%	8,155,000	0.42%
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	**6,077,517**	**0.35%**	**6,077,517**	**0.32%**
其他股东	**306,223,839**	**17.62%**	**306,223,839**	**15.88%**
合计	**1,737,614,193**	**100.00%**	**1,928,382,585**	**100.00%**

注：重组前股份数量、持股比例为截至2025年**12月31日**数据。

本次交易完成后，公司直接控股股东仍为华虹国际，间接控股股东仍为华虹

集团，实际控制人仍为上海市国资委，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司财务报告及安永会计师**审阅的上市公司备考财务报表，**不考虑募集配套资金，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日		2024 年度/2024 年 12 月 31 日	
	上市公司	备考报表	上市公司	备考报表
资产总额	**10,012,329.13**	**10,610,932.80**	8,793,523.15	9,356,042.83
负债总额	**3,702,853.87**	**4,092,273.00**	2,521,468.25	2,965,008.50
归属于母公司股东权益	**4,516,029.04**	**4,725,213.57**	4,360,233.22	4,474,671.92
营业收入	**1,729,145.07**	**2,228,795.71**	1,438,830.77	1,927,405.55
利润总额	**-65,100.61**	**11,125.88**	-98,831.81	-36,817.13
净利润	**-80,714.30**	**-4,487.81**	-103,218.38	-41,203.70
归属于母公司股东净利润	**37,661.14**	**118,428.37**	38,057.62	95,531.55
基本每股收益（元/股）	**0.22**	**0.62**	0.22	0.50

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司合并范围内的子公司，根据模拟测算本次交易完成后上市公司资产规模、收入规模、盈利能力均有较大提升。

七、本次交易的决策过程和审批情况

（一）已履行完毕的审批程序

截至本报告书签署日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易已经上市公司 2025 年第六次董事会会议、2025 年第九次董事会会议、**2026 年第三次董事会会议**审议通过；

2、本次交易已取得上市公司持股 5%以上股东的原则性意见；

3、本次交易已经交易对方有权内部决策机构授权或批准；

4、本次交易方案已经标的公司董事会和股东会审议批准；

5、本次交易涉及的标的资产评估报告经有权国有资产监督管理部门备案；

6、上市公司股东大会审议通过本次交易；

7、香港证监会及联交所必要的审批程序。

（二）本次交易尚需履行的审批程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于：

1、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、审查、备案或许可（如适用）。

本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

八、本次交易相关方所作出的重要承诺

本次交易相关方做出的重要承诺如下：

（一）上市公司及其董事、高级管理人员作出的重要承诺

1、上市公司作出的重要承诺

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其各自控制的机构（如有）不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投

	资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本企业及本企业董事、高级管理人员已向本次交易的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证本企业及本企业董事、高级管理人员所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业及本企业董事、高级管理人员为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业及本企业董事、高级管理人员将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业及本企业董事、高级管理人员关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业为依据中国香港法律适当设立且存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、截至本承诺函出具之日，本企业不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形：（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次交易涉及重大资产重组的除外；（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；（四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 3、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会或其他有权部门立案调查的情形；最近三十六个月内，本企业不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重的情形，不存在受到刑事处罚的情形；本企业不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形，不存在被证券交易所采取

	监管措施、纪律处分或被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施的情形；本企业不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 4、本企业最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 5、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本企业在本次交易中严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，遵循《华虹半导体有限公司之组织章程细则》及内部管理制度的规定，与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于本企业少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2、本企业及本企业相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。 3、本企业严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 4、本企业多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。在本企业召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 5、本企业与交易对方签署《保密协议》，此外，公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。本企业与本次交易拟聘请的各中介机构签署了《保密协议》，要求各中介机构及相关人员严格遵守保密义务。
关于不存在违规担保、关联方资金占用等情形的承诺函	1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业合并报表范围内子公司不存在违反相关法律、法规、规范性文件及本企业内部管理制度等规定违规对外提供担保的情况。 2、截至本承诺函出具日，本企业及本企业合并报表范围内子公司不存在资金、资产被本企业控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，不存在为本企业控股股东、实际控制人或其他关联方提供担保的情况。 3、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于保证不影响和干扰审核的承诺函	1、本企业保证遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员以及上海证券交易所上市审核委员会（以下简称“上市委”）委员、并购重组审核委员会（以下简称“重组委”）委员、科技创新咨询委员会（以下简称“咨询委”）委员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。 2、本企业保证不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人

	员、上海证券交易所上市委委员、重组委委员、咨询委委员或者其他利益关系人输送不正当利益： （1）以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利； （2）提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利； （3）安排显着偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易； （4）直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动； （5）其他输送不正当利益的情形。 3、本企业保证不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。 4、本企业保证遵守法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。

2、上市公司全体董事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本人及本人控制的机构（如有）不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本人不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本人保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本人已向本次交易的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整

	的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本人将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本人关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
关于股份减持计划的承诺函	1、截至本承诺函出具之日，如本人持有上市公司股份的，本人无减持上市公司股份的计划。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。 2、自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，如本人根据自身实际情况需要或市场变化而减持上市公司股份的，本人将遵守有关法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，严格履行已经做出的关于股份锁定及减持的有关承诺，并及时履行信息披露义务。 3、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本人承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 4、本人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或其他有权部门立案调查的情形。最近三十六个月内，本人不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重的情形，不存在受到刑事处罚的情形；本人不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形，不存在被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施的情形；本人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 2、本人最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、本人上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本人在本次交易中严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，遵循《华虹半导体有限公司之组织章程细则》及内部管理制度的规定，与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施。 2、本人在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。

	3、本人严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定进行内幕信息知情人登记。 4、本人保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 5、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应法律责任。
关于摊薄即期回报填补措施的承诺函	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、未来上市公司如实施股权激励计划，在本人合法权限范围内，促使拟公告的股权激励计划设置的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
关于减少和规范关联交易的承诺函	1、在本次交易完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业的关联交易，对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司及其控制的企业按照公平、公允等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务； 2、本人保证本人及本人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其控制的企业进行交易，不利用关联交易非法挪用、侵占、转移上市公司及其控制的企业的资金、利润、资产及其他资源，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其控制的企业及上市公司股东合法权益的行为； 3、本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的法律责任。上述各项承诺在本承诺人作为上市公司董事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。
关于保证不影响	1、本人保证遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，

和干扰审核的承诺函	不私下与审核人员、监管人员以及上海证券交易所上市审核委员会（以下简称“上市委”）委员、并购重组审核委员会（以下简称“重组委”）委员、科技创新咨询委员会（以下简称“咨询委”）委员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。 2、本人保证不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员、上海证券交易所上市委委员、重组委委员、咨询委委员或者其他利益关系人输送不正当利益： （1）以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利； （2）提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利； （3）安排显着偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易； （4）直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动； （5）其他输送不正当利益的情形。 3、本人保证不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。 4、本人保证遵守法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。

（二）交易对方作出的重要承诺

1、华虹集团

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及前述主体各自控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及前述主体各自控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。

	4、上述承诺内容真实、完整、准确，本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及前述主体各自控制的机构如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本企业已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。 5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业承诺不转让在华虹半导体拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华虹半导体董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于所持标的公司股权权属的承诺函	1、本企业合法拥有标的公司相应股权的全部权益（以下简称“标的资产”），包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持标的资产的情形，标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。在本次交易实施完毕之前，非经华虹半导体同意，本企业保证不在标的资产上设置质押等任何第三方权利。 2、本企业对标的公司的出资不存在未缴纳出资、虚报或抽逃注册资本的情形，标的公司历次股权变更均符合中国法律要求，真实、有效，不存在出资瑕疵、纠纷或潜在纠纷。 3、本企业拟转让的标的资产的权属清晰，不存在尚未了结或可预见的

	诉讼、仲裁等纠纷或者存在妨碍权属转移的其他情况，该等标的资产的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍，同时，本企业保证此种状况持续至标的资产登记至华虹半导体名下。 4、标的资产不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排，包括但不限于标的公司或本企业签署的所有协议或合同不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排、阻碍本企业转让标的资产的限制性条款；标的公司《公司章程》《股东协议》（如有）、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中，以及标的公司股东之间签订的合同、协议或其他文件中，不存在阻碍本企业转让所持标的资产的限制性条款。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本企业与上市公司就本次交易的相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，知悉本次交易的人员仅限于本企业少数核心管理层，限制了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围。 2、本企业及本企业相关人员在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。 3、本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交。 4、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 5、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 6、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。 3、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。 4、本企业及本企业主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或受到证券交易所监管措施、纪律处分的情况，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益或其他重大违法行为等情况。 5、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于股份锁定期的承诺函	1、本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本企业通过本次交易取得的前

	述上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。 2、在上述股份锁定期内，本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份锁定安排。 3、未来如果本企业将承担业绩承诺及补偿义务，本企业所持有的上述股份还应遵守相关业绩承诺及补偿协议中对于锁定期的要求。 4、上述股份锁定期届满后，该等股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 5、对于在本次交易前本企业已经持有的华虹半导体人民币普通股股份（以下简称“A 股股份”），自本次交易实施完成之日起十八个月内不得进行转让（但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述十八个月的限制）。本企业在本次交易前所持华虹半导体 A 股股份所派生的股份，如因上市公司进行权益分派、公积金转增股本所增加之股份等也应遵守上述股份锁定期的安排。 6、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份锁定或股份交易出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定或要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 7、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。本企业承诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。
关于本次交易减值补偿的承诺函	1、本企业确认，本次交易的标的公司华力微系采用市场法确定最终评估价值，因此上市公司在本次交易中拟取得的华力微 97.4988%股权（以下简称“减值测试标的资产”）应进行减值测试，如发生减值情形，本企业将依法承担相应的补偿义务。 2、本企业同意并承诺，本次交易的减值测试期间为本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度（以下简称“减值测试期间”）。 3、本企业同意，在减值测试期间每个会计年度结束之日起 3 个月内，由上市公司聘请符合《证券法》规定的评估机构对减值测试标的资产进行评估，并出具专项评估报告。根据评估结果，由上市公司对减值测试标的资产的合计价值在每个会计年度进行减值测试，并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具减值测试专项审核报告（以下简称“减值测试专项审核报告”）。 4、本企业同意，如减值测试标的资产在减值测试期间任何一个会计年度发生减值（以下简称“期末减值额”），在符合适用法律法规的前提下，则本企业承诺按如下约定向上市公司进行补偿： 期末减值额=本次交易总对价-该会计年度期末标的资产的评估值并扣除减值测试期间内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。 本企业应向上市公司补偿的金额（以下简称“补偿金额”）=本企业在本次交易中应获得的交易对价占本次交易总对价比例×期末减值额。 本企业承诺，将优先以本企业在本次交易中获得的上市公司的股份进行补偿，补偿股份由上市公司以 1 元总价回购并予以注销，每年补偿的股

	份数量为：补偿金额/发行价格-减值测试期间内已补偿股份总数。 在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已补偿的股份不冲回。 本企业在本次交易中获得的上市公司的股份不足以补偿的,本企业将以现金进行补偿。 若上市公司在减值测试期间实施送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则上市公司应回购的股份数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数量×（1+送股或转增比例）。若补偿股份数量出现小数的情况，则应当向上取整作为本企业应补偿股份的数量。 5、本企业承诺，在减值测试期间内就补偿股份已获分配的现金股利应作相应返还，计算公式如下：返还金额＝补偿股份截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×补偿股份数量。 6、本企业承诺，在上市公司确定本企业需补偿的金额并予以公告之日起三十（30）个工作日内，在符合适用法律法规的前提下，将本企业用于补偿的上市公司股份由上市公司以总价 1 元的对价回购，或将现金补偿金额足额支付至上市公司指定账户。 7、本企业承诺，不得通过转让、赠与、设定质押、股票收益权转让或其他权利限制等方式处置本企业于本次交易过程中取得的、处于锁定期内的上市公司股票。

2、上海集成电路基金

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员以及前述主体各自控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员以及前述主体各自控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员以及前述主体各自控制的机构如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息	1、本企业已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交

真实性、准确性和完整性的承诺函	易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。 5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业承诺不转让在华虹半导体拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华虹半导体董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于所持标的公司股权权属的承诺函	1、本企业合法拥有标的公司相应股权的全部权益（以下简称“标的资产”），包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持标的资产的情形，标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。在本次交易实施完毕之前，非经华虹半导体同意，本企业保证不在标的资产上设置质押等任何第三方权利。 2、本企业对标的公司的出资不存在未缴纳出资、虚报或抽逃注册资本的情形，标的公司历次股权变更均符合中国法律要求，真实、有效，不存在出资瑕疵、纠纷或潜在纠纷。 3、本企业拟转让的标的资产的权属清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷或者存在妨碍权属转移的其他情况，该等标的资产的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍，同时，本企业保证此种状况持续至标的资产登记至华虹半导体名下。 4、标的资产不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排，包括但不限于标的公司或本企业签署的所有协议或合同不存在禁止转让、限制转让

	的其他利益安排、阻碍本企业转让标的资产的限制性条款；标的公司《公司章程》《股东协议》（如有）、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中，以及标的公司股东之间签订的合同、协议或其他文件中，不存在阻碍本企业转让所持标的资产的限制性条款。 5、在标的资产权属变更登记至华虹半导体名下之前，本企业将审慎尽职地行使标的公司股东的权利，履行股东义务并承担股东责任，并尽合理的商业努力促使标的公司按照正常方式经营。未经过华虹半导体的事先书面同意，不自行或促使标的公司从事或开展与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务等行为。 6、本企业承诺及时进行本次交易有关的标的资产的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业自行承担。 7、本企业保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给华虹半导体造成的一切损失。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本企业与上市公司就本次交易的相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限制了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围。 2、本企业及本企业相关人员在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。 3、本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交。 4、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 5、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 6、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。 3、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。 4、本企业及本企业主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或受到证券交易所监管措施、纪律处分的情况，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益或其他重大违法行为等情况。 5、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

关于股份锁定期的承诺函	1、本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。如果本企业符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条第三款第（一）项规定，则本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 6 个月内不得进行转让。 2、在上述股份锁定期内，本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份锁定安排。 3、上述股份锁定期届满后，该等股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 4、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份锁定或股份交易出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定或要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 5、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。本企业承诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。

3、大基金二期

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员/本企业的执行事务合伙人、主要管理人员、能够控制本企业的合伙人以及前述主体各自控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员/本企业的执行事务合伙人、主要管理人员、能够控制本企业的合伙人以及前述主体各自控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员/本企业的执行事务合伙人、主要管理人员、能够控制本企业的合伙人以及前述主体各自控制的机构如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息	1、本企业已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交

真实性、准确性和完整性的承诺函	易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。 5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业承诺不转让在华虹半导体拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华虹半导体董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于所持标的公司股权权属的承诺函	1、本企业合法拥有标的公司相应股权的全部权益（以下简称“标的资产”），包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持标的资产的情形，标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。在本次交易实施完毕之前，非经华虹半导体同意，本企业保证不在标的资产上设置质押等任何第三方权利。 2、本企业对标的公司的出资不存在未缴纳出资、虚报或抽逃注册资本的情形，标的公司历次股权变更均符合中国法律要求，真实、有效，不存在出资瑕疵、纠纷或潜在纠纷。 3、本企业拟转让的标的资产的权属清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷或者存在妨碍权属转移的其他情况，该等标的资产的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍，同时，本企业保证此种状况持续至标的资产登记至华虹半导体名下。 4、标的资产不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排，包括但不限于标的公司或本企业签署的所有协议或合同不存在禁止转让、限制转让

	的其他利益安排、阻碍本企业转让标的资产的限制性条款；标的公司《公司章程》《股东协议》（如有）、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中，以及标的公司股东之间签订的合同、协议或其他文件中，不存在阻碍本企业转让所持标的资产的限制性条款。 5、在标的资产权属变更登记至华虹半导体名下之前，本企业将审慎尽职地行使标的公司股东的权利，履行股东义务并承担股东责任，并尽合理的商业努力促使标的公司按照正常方式经营。未经过华虹半导体的事先书面同意，不自行或促使标的公司从事或开展与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务等行为。 6、本企业承诺及时进行本次交易有关的标的资产的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业自行承担。 7、本企业保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给华虹半导体造成的一切损失。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本企业与上市公司就本次交易的相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，知悉本次交易的人员仅限于本企业少数核心管理层及必要的执行人员，限制了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围。 2、本企业及本企业相关人员在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。 3、本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交。 4、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 5、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 6、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。 3、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。 4、本企业及本企业主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或受到证券交易所监管措施、纪律处分的情况，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益或其他重大违法行为等情况。 5、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和

	重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于股份锁定期的承诺函	1、本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。如本企业取得前述华虹半导体股份时，对于用于认购华虹半导体股份的华力微股权权益持续拥有权益的时间不足 12 个月，则该等华力微股权对应的在本次交易中相应取得的华虹半导体股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。 2、在上述股份锁定期内，本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份锁定安排。 3、上述股份锁定期届满后，该等股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 4、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份锁定或股份交易出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定或要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 5、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。本企业承诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。

4、国投先导基金

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员/本企业的执行事务合伙人、主要管理人员、能够控制本企业的合伙人以及前述主体各自控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员/本企业的执行事务合伙人、主要管理人员、能够控制本企业的合伙人以及前述主体各自控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员/本企业的执行事务合伙人、主要管理人员、能够控制本企业的合伙人以及前述主体各自控制的机构如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法

	承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本企业已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。 5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业承诺不转让在华虹半导体拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华虹半导体董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于所持标的公司股权权属的承诺函	1、本企业合法拥有标的公司相应股权的全部权益（以下简称“标的资产”），包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持标的资产的情形，标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。在本次交易实施完毕之前，非经华虹半导体同意，本企业保证不在标的资产上设置质押等任何第三方权利。 2、本企业对标的公司的出资不存在未缴纳出资、虚报或抽逃注册资本的情形，标的公司历次股权变更均符合中国法律要求，真实、有效，不存在出资瑕疵、纠纷或潜在纠纷。 3、本企业拟转让的标的资产的权属清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷或者存在妨碍权属转移的其他情况，该等标的资产的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍，同时，本企业保证此种状况持续至标的资产登记至华虹半导体名下。

	4、标的资产不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排，包括但不限于标的公司或本企业签署的所有协议或合同不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排、阻碍本企业转让标的资产的限制性条款；标的公司《公司章程》《股东协议》（如有）、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中，以及标的公司股东之间签订的合同、协议或其他文件中，不存在阻碍本企业转让所持标的资产的限制性条款。 5、在标的资产权属变更登记至华虹半导体名下之前，本企业将审慎尽职地行使标的公司股东的权利，履行股东义务并承担股东责任，并尽合理的商业努力促使标的公司按照正常方式经营。未经过华虹半导体的事先书面同意，不自行或促使标的公司从事或开展与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务等行为。 6、本企业承诺及时进行本次交易有关的标的资产的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业自行承担。 7、本企业保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给华虹半导体造成的一切损失。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本企业与上市公司就本次交易的相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，知悉本次交易的人员仅限于本企业少数核心管理层，限制了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围。 2、本企业及本企业相关人员在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。 3、本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交。 4、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 5、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 6、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。 3、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。 4、本企业及本企业主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或受到证券交易所监管措施、纪律处分的情况，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益或其他重大违法行为等情况。

	5、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于股份锁定期的承诺函	1、本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。如本企业取得前述华虹半导体股份时，对于用于认购华虹半导体股份的华力微股权权益持续拥有权益的时间不足 12 个月，则该等华力微股权对应的在本次交易中相应取得的华虹半导体股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。 2、在上述股份锁定期内，本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份锁定安排。 3、上述股份锁定期届满后，该等股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 4、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份锁定或股份交易出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定或要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 5、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。本企业承诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。

（三）标的公司及其董监高作出的重要承诺

1、标的公司作出的重要承诺

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其各自控制的机构（如有）不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性	1、本企业及本企业董事、高级管理人员已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始

和完整性的承诺函	书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证本企业及本企业董事、高级管理人员所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业及本企业董事、高级管理人员为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业及本企业董事、高级管理人员将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业及本企业董事、高级管理人员关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形；最近三十六个月内，本企业不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重的情形，不存在受到刑事处罚的情形；本企业不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形；本企业不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 3、本企业最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁； 4、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本企业采取了必要且充分的保密措施，知悉本次交易的人员仅限于本企业少数核心管理层，限制了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围。本企业及本企业相关人员严格遵守了保密义务。 2、本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交。 3、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 4、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 5、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业

	将依法承担相应法律责任。

2、标的公司董事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本人及本人控制的机构（如有）不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本人不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与重大资产重组的情形。 3、本人保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本人已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本人将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本人关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形；最近三十六个月内，本人不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重的情形，不存在受到刑事处罚的情形；本人不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形；本人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 2、本人最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按

	期偿还大额债务、未履行承诺等情况，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、本人上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本人在本次交易中严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循《上海华力微电子有限公司章程》及内部管理制度的规定，采取了必要且充分的保密措施。 2、本人严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定进行内幕信息知情人登记。 3、本人保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应法律责任。

（四）上市公司控股股东作出的重要承诺

1、华虹集团

承诺事项	承诺内容
关于上市公司本次交易的原则性意见	本次交易将有利于提高上市公司资产质量，促进上市公司未来的业务发展，有利于增强上市公司竞争力，符合上市公司及全体股东的利益，本企业原则性同意本次交易。
关于股份减持计划的承诺函	1、截至本承诺函出具之日，本企业无主动减持本企业直接及间接持有的上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本企业不主动减持本企业直接及间接持有的上市公司股份，前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。 2、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 3、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本企业承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。
关于规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其下属公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行。 2、本企业将严格遵守相关法律法规和上市公司章程等文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不以任何

	形式非法占用上市公司的资金、资产，不要求上市公司违规向本企业提供任何形式担保，不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、本企业违反上述承诺的，本企业愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给上市公司及其下属公司造成的所有直接和间接损失。
关于避免同业竞争的承诺函	1、截至本承诺函签署之日，本企业及本企业控制的除华虹半导体及其控股子公司外的其他企业（以下简称“控制的其他企业”），与华虹半导体及其控股子公司不存在构成重大不利影响的同业竞争。 2、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业与华虹半导体及其控股子公司不存在构成重大不利影响的同业竞争，本企业及本企业控制的其他企业将采取有效措施避免新增与华虹半导体及其控股子公司构成重大不利影响的同业竞争的业务或活动。 3、本企业如违反上述承诺的，愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给华虹半导体及其控股子公司造成的所有直接和间接损失。 4、上述承诺在本企业作为华虹半导体间接控股股东期间有效。
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本企业已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。

	4、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或其他有权部门立案调查的情形；最近三十六个月内，本企业不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重的情形，不存在受到刑事处罚的情形；不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形，不存在被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施的情形；不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 2、本企业最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、针对本次交易，本企业采取了必要且充分的保密措施。 2、本企业严格控制本次交易参与人员范围，尽可能缩小知悉本次交易内幕信息知情人员的范围，做好内幕信息知情人员的登记；本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向华虹半导体提交。 3、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 4、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 5、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于保证上市公司独立性的承诺函	1、本次交易完成后，本企业在作为上市公司间接控股股东期间将严格遵守法律法规、规范性文件的要求，依法行使股东权利并履行股东义务，不利用间接控股股东地位谋取不当利益，本企业控制的其他企业与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。 2、本企业如因不履行或不适当履行上述承诺给上市公司及其相关股东造成损失的，应依法承担相应的赔偿责任。 3、本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业作为上市公司的间接控股股东期间持续有效。
关于摊薄即期回报填补措施的承	1、本企业承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

诺函	2、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺； 3、本企业承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
关于不存在违规担保、关联方资金占用等情形的承诺函	1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业的关联方（上市公司及其控股子公司除外）不存在违规占用上市公司及其控股子公司资金、资产的情形，不存在对上市公司及其控股子公司非经营性资金占用的情形，不存在上市公司及其控股子公司为本企业及本企业的关联方（上市公司及其控股子公司除外）提供担保的情形； 2、本次交易完成后，本企业及本企业的关联方将继续规范运作，未来不以任何形式违规占用上市公司及其控股子公司资金、资产或要求上市公司及其控股子公司违规提供担保； 3、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于保证不影响和干扰审核的承诺函	1、本企业保证遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员以及上海证券交易所上市审核委员会（以下简称“上市委”）委员、并购重组审核委员会（以下简称“重组委”）委员、科技创新咨询委员会（以下简称“咨询委”）委员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。 2、本企业保证不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员、上海证券交易所上市委委员、重组委委员、咨询委委员或者其他利益关系人输送不正当利益： （1）以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利； （2）提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利； （3）安排显着偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易； （4）直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动； （5）其他输送不正当利益的情形。 3、本企业保证不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。 4、本企业保证遵守法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。

2、华虹国际

承诺事项	承诺内容
关于上市公司本次交易的原则性意见	本次交易将有利于提高上市公司资产质量，促进上市公司未来的业务发展，有利于增强上市公司竞争力，符合上市公司及全体股东的利益，本企业原则性同意本次交易。
关于股份减持计划的承诺函	1、截至本承诺函出具之日，本企业无减持上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本企业不主动减持上市公司股份。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。 2、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 3、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本企业承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。
关于规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其下属公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行。 2、本企业将严格遵守相关法律法规和上市公司章程等文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不以任何形式非法占用上市公司的资金、资产，不要求上市公司违规向本企业提供任何形式担保，不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、本企业违反上述承诺的，本企业愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给上市公司及其下属公司造成的所有直接和间接损失。
关于避免同业竞争的承诺函	1、截至本承诺函签署之日，本企业及本企业控制的除华虹半导体及其控股子公司外的其他企业（以下简称“控制的其他企业”），与华虹半导体及其控股子公司不存在构成重大不利影响的同业竞争。 2、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业与华虹半导体及其控股子公司不存在构成重大不利影响的同业竞争，本企业及本企业控制的其他企业将采取有效措施避免新增与华虹半导体及其控股子公司构成重大不利影响的同业竞争的业务或活动。 3、本企业如违反上述承诺的，愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给华虹半导体及其控股子公司造成的所有直接和间接损失。 4、上述承诺在本企业作为华虹半导体控股股东期间有效。
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组	1、本企业及本企业控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月

情形的说明	内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本企业已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。 5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业承诺不转让在华虹半导体拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华虹半导体董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或其他有权部门立案调查的情形；最近三十六个月内，本企业不存在因违反法律、行

	政法规、规章受到行政处罚且情节严重的情形，不存在受到刑事处罚的情形；不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形，不存在被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施的情形；不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 2、本企业最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、针对本次交易，本企业采取了必要且充分的保密措施。 2、本企业严格控制本次交易参与人员范围，尽可能缩小知悉本次交易内幕信息知情人员的范围，做好内幕信息知情人员的登记；本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向华虹半导体提交。 3、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 4、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 5、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于保证上市公司独立性的承诺函	1、本次交易完成后，本企业在作为上市公司控股股东期间将严格遵守法律法规、规范性文件的要求，依法行使股东权利并履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，本企业控制的其他企业与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。 2、本企业如因不履行或不适当履行上述承诺给上市公司及其相关股东造成损失的，应依法承担相应的赔偿责任。 3、本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业作为上市公司的直接控股股东期间持续有效。
关于摊薄即期回报填补措施的承诺函	1、本企业承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益； 2、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺； 3、本企业承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给

	上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
关于不存在违规担保、关联方资金占用等情形的承诺函	1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业的关联方（上市公司及其控股子公司除外）不存在违规占用上市公司及其控股子公司资金、资产的情形，不存在对上市公司及其控股子公司非经营性资金占用的情形，不存在上市公司及其控股子公司为本企业及本企业的关联方（上市公司及其控股子公司除外）提供担保的情形； 2、本次交易完成后，本企业及本企业的关联方将继续规范运作，未来不以任何形式违规占用上市公司及其控股子公司资金、资产或要求上市公司及其控股子公司违规提供担保； 3、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于保证不影响和干扰审核的承诺函	1、本企业保证遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员以及上海证券交易所上市审核委员会（以下简称“上市委”）委员、并购重组审核委员会（以下简称“重组委”）委员、科技创新咨询委员会（以下简称“咨询委”）委员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。 2、本企业保证不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员、上海证券交易所上市委委员、重组委委员、咨询委委员或者其他利益关系人输送不正当利益： （1）以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利； （2）提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利； （3）安排显着偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易； （4）直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动； （5）其他输送不正当利益的情形。 3、本企业保证不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。 4、本企业保证遵守法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况

公司名称	华虹半导体有限公司
英文名称	HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED
证券简称	华虹公司
证券代码	688347.SH
股票上市地	上海证券交易所
注册地址	中国香港中环夏悫道 12 号美国银行中心 2212 室
办公地址	中国上海张江高科技园区哈雷路 288 号
法定代表人	-
成立日期	2005 年 1 月 21 日
上市日期	2023 年 8 月 7 日
公司网站	www.huahonggrace.com
联系电话	86-21-38829909
电子信箱	IR@hhgrace.com
邮政编码	201203

二、公司设立及股本变动情况

（1）公司设立及收购华虹 NEC

经国务院于 2004 年 12 月批示同意，为华虹 NEC 重组上市目的，华虹 NEC 中方股东华虹集团、张江集团、上海贝岭拟将其持有的华虹 NEC 股权划转到境外，并与华虹 NEC 外方股东合资设立拟上市公司，自行选择有利时机，到境外发行股票并在香港上市。

2005 年 1 月 21 日，公司在中国香港依据《公司条例》注册，设立时公司名称为“华虹半导体有限公司（Hua Hong Semiconductor Limited）”，设立时已发行股份数为 1 股，每股面值为 0.01 美元，该等已发行股份由 Harefield Limited 持有。

2005 年 3 月 3 日，华虹 NEC 相关股东、公司签订股权转让相关协议，约定华虹 NEC 当时全体注册于境内的股东分别将其持有的华虹 NEC 股权划转、转让

予相关境外主体，并由华虹公司向前述划转或转让完成后的华虹 NEC 全体股东发行股份购买其合计持有的华虹 NEC100%股权，前述事宜的具体情况如下表所示：

单位：万美元

华虹 NEC 原股东情况			第一步：华虹 NEC 境内股东将股权划转、转让予境外主体			第二步：公司发行股份购买华虹 NEC 全部股权		
股东名称	出资额	持股比例（%）	划入方/受让方	出资额	持股比例（%）	出售方	出售比例（%）	对价股份（股）
华虹集团	50,000	55.92	华虹国际	50,000	55.92	华虹国际	61.42	350,401,100
华虹国际	4,480	5.01	-	-	-			
张江集团	437	0.49	华虹国际	437	0.49			
中国日电	7,000	7.83	NEC	7,000	7.83	NEC	17.36	99,038,800
NEC	8,520	9.53	-	-	-			
上海贝岭	10,030	11.22	香港海华	10,030	11.22	香港海华	11.22	64,010,100
Newport	8,941	10.00	-	-	-	Newport	10.00	57,050,000
合计	**89,408**	**100.00**	-	**89,408**	**100.00**	-	**100.00**	**570,500,000**

注 1：根据华虹集团、华虹国际与张江集团、张江国际于 2005 年 3 月 3 日签订的境外信托契据及华虹集团、华虹国际与张江集团于 2005 年 3 月 3 日签订的股权托管及划转协议，张江集团将华虹 NEC 0.49%股权（即“华虹 NEC 权益”）委托华虹集团代管并划转至华虹国际，并授权华虹国际根据境外股权转让协议将其持有的华虹 NEC 权益置换为公司 0.49%股权（对应公司 2,795,450 股，即“公司权益”）；股权置换后，由华虹国际根据协议约定代张江集团持有及管理公司权益，并代表张江集团行使公司权益项下的股东权利以及履行相应的股东义务；张江集团根据协议约定保留公司权益项下的处分权、收益权等股东权利，并承担相应义务。

注 2：其中华虹国际所持有的公司 1 股股份系自 Harefield Limited 处以 0.01 美元的价格受让取得。

国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 2 月 4 日出具国资产权[2005]150 号《关于对上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》，核准华虹 NEC 中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司项目的资产评估报告。

中华人民共和国商务部分别于 2005 年 3 月 31 日、2005 年 4 月 30 日、2005

年 7 月 28 日核发商合批[2005]178 号《商务部关于同意上海华虹 NEC 电子有限公司向境外划转股权并在香港设立华虹半导体有限公司的批复》、商资批[2005]720 号《商务部关于同意上海华虹 NEC 电子有限公司股权转让等事宜的批复》、商资批[2005]1540 号《商务部关于同意上海华虹 NEC 电子有限公司转股的批复》，同意上述事宜。

中华人民共和国国家发展和改革委员会于 2005 年 5 月 8 日核发发改外资[2005]730 号《国家发展改革委关于上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权全部转移境外并在香港上市项目核准的批复》，同意上述事宜。

华虹国际、NEC、香港海华及 Newport 已于 2005 年 6 月 1 日被登记为公司股东，华虹 NEC 之股权已于 2005 年 10 月 9 日变更登记至公司名下。

上述华虹 NEC 收购完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	华虹国际	350,401,100 （其中 2,795,450 股系为张江集团托管）	61.42
2	NEC	99,038,800	17.36
3	香港海华	64,010,100	11.22
4	Newport	57,050,000	10.00
合计		**570,500,000**	**100.00**

（2）2014 年 10 月公司在香港联交所首次公开发行股票并上市

公司股东大会于 2014 年 9 月 20 日作出决议，同意公司公开发行股票，同时批准董事行使公司配发、发行及处置股份的一切权力（包括作出要约、订立协议、或授出将会或可能须配发及发行股份的证券的权力）。

根据公司公开披露的相关信息，公司于 2014 年 10 月以 11.25 港币/股的价格公开发行合计 228,696,000 股股份；本次发行完成后，公司已发行股份总数增至 1,033,871,656 股。2014 年 10 月 15 日，公司在香港联交所主板挂牌上市。

（3）2015 年 9 月第一期期权激励计划

公司股东特别大会于 2015 年 9 月 1 日作出决议，同意采纳股票期权计划，

并授权董事会自计划批准日 7 年内任何时间决定授予参与者按行权价认购一定数量公司股票的权利；该股票期权计划项下拟授出的所有期权及公司任何其他股票期权计划项下拟授出的任何期权获行使时可予发行的股票总数，合计不得超过当时的已发行股本总数的 10%，且该等股票期权计划项下首次授予的期权数量不超过公司总股本的 3%。

上海市国资委已于 2015 年 8 月 14 日出具沪国资委分配（2015）278 号《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划的批复》，原则同意上述期权激励计划。

根据公司股东大会的上述授权，公司董事会于 2015 年 9 月 4 日作出决议，同意于 2015 年 9 月 4 日向董事及雇员授出股票期权。公司本次授出 30,250,000 份期权，前述期权可按行权价 6.912 港元认购合计最多 30,250,000 股股票，本次期权分三期归属，并将于 2022 年 9 月 3 日失效。

（4）2018 年 11 月增资

公司于 2018 年 1 月 3 日与大基金签订《认购协议》，约定大基金（无论是通过其自身或是通过其指定人士）认购公司 242,398,925 股股份，认购价为每股 12.9002 港元；公司股东特别大会于 2018 年 2 月 14 日作出决议，同意前述股份认购事宜。大基金指定的主体鑫芯香港已于 2018 年 11 月 7 日完成前述股份认购。

华虹集团于 2017 年 12 月 15 日召开一届五十三次党委会，同意鑫芯香港入股公司；大基金已于 2017 年 12 月 15 日召开第二十次董事会审议通过鑫芯香港入股公司事宜，并就前述事宜于 2017 年 12 月 15 日出具了《国家集成电路产业投资基金重大项目核准意见表》。本次增资完成后，公司已发行股份总数增至 1,283,750,891 股。

（5）2018 年 12 月第二期股票期权计划第一次授予

公司董事会于 2018 年 12 月 18 日作出决议，同意于 2018 年 12 月 24 日及 2019 年 12 月 23 日向若干雇员和/或董事配发股票期权，但该等期权计划的实施

须根据国资监管部门的要求取得公司股东大会的批准为前提。公司于 2018 年 12 月 24 日向公司若干员工及当时的董事授出 34,500,000 份期权（该等期权须经公司股东大会批准后方可生效）。前述期权可按行权价 15.056 港元认购合计最多 34,500,000 股股票，其中，就副总裁及以上级别的职员（连同董事）而言，本次期权分四期归属；就其他职员而言，本次期权分三期归属；前述期权将于 2025 年 12 月 23 日失效。

上海市国资委于 2019 年 3 月 12 日出具沪国资委分配（2019）44 号《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划（二期）的批复》，原则同意《华虹半导体有限公司股权激励计划（二期）方案》，并应按有关规定提交公司股东大会审议。

公司股东特别大会于 2019 年 3 月 28 日作出决议，同意根据公司于 2018 年 12 月 24 日授出 34,500,000 份股票期权，并同意于 2019 年 12 月 23 日或前后进一步授出 4,000,000 份股票期权。

（6）2019 年 3 月第二期股票期权计划第二次授予

根据上述上海市国资委的批复及公司股东大会的授权，公司董事会于 2019 年 3 月 28 日作出决议，同意于 2019 年 3 月 29 日向唐均君授出 500,000 份期权，前述期权可按行权价 18.40 港元认购合计最多 500,000 股股票；本次期权分四期归属，并将于 2026 年 3 月 28 日失效。

（7）2019 年 12 月第二期股票期权计划第三次授予

根据上述上海市国资委的批复及公司股东大会的授权，公司董事会于 2019 年 11 月 12 日作出决议，同意于 2019 年 12 月 23 日向华虹无锡具有重要技术专长及/或担任核心管理职位的 101 名员工授予 2,482,000 份期权。前述期权可按行权价 17.952 港元认购合计最多 2,482,000 股股票，其中，就副总裁及以上级别的职员而言，本次期权分四期归属；就其他职员而言，本次期权分三期归属。前述期权将于 2026 年 12 月 22 日失效。

（8）2021 年 11 月公司股票期权计划调整

公司股东特别大会于 2021 年 11 月 26 日作出决议，鉴于现有股票期权计划限额已多数获使用，为使公司能够更灵活地向其雇员提供激励及奖励，同意将公司股票期权计划授出限额调整为 130,047,036 股股票。

（9）2023 年 8 月公司在上交所首次公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可[2023]1228 号《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，华虹公司向社会公开发行人民币普通股 407,750,000 股，每股发行价格 52 元。经上交所同意，华虹公司境内发行股票总数为 407,750,000 股，其中 103,974,252 股于 2023 年 8 月 7 日起在上交所科创板上市交易。

截至 2025 年 **12 月 31 日**，公司上交所 A 股股票总数未发生变动，为 407,750,000 股，联交所股票总数为 **1,329,864,193** 股，其变动系公司股票期权计划行权所致。

三、上市公司最近三十六个月控制权变动情况

截至本报告书签署日，最近三十六个月，上市公司直接控股股东为华虹国际，间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委，未发生控制权变动。

四、上市公司最近三年重大资产重组的基本情况

上市公司最近三年不存在重大资产重组的情形。

五、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预期变化情况

本次交易前后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。

六、上市公司控股股东及实际控制人情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，上市公司直接控股股东为华虹国际，间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委，上市公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	**820,333,688**	**47.21**
2	华虹国际	347,605,650	20.00
3	联和国际有限公司（Sino-Alliance International, Ltd.）	160,545,541	**9.24**
4	华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	48,334,249	2.78
5	**招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金**	**11,020,000**	**0.63**
6	**中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司**	**10,697,339**	**0.62**
7	**中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金**	**9,267,853**	**0.53**
8	海通创新证券投资有限公司	8,155,000	0.47
9	国泰君安证裕投资有限公司	8,155,000	0.47
10	**中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金**	**6,077,517**	**0.35**
合计		**1,430,191,837**	**82.31**

七、上市公司最近三年主营业务发展情况

华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司立足于先进“特色 IC+功率器件”的战略目标，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。

最近三年，上市公司主营业务未发生变更。

八、上市公司主要财务数据

（一）主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	**1,729,145.07**	1,438,830.77	1,623,187.40
营业利润	**-65,192.80**	-98,935.59	117,791.99

利润总额	**-65,100.61**	-98,831.81	117,754.41
净利润	**-80,714.30**	-103,218.38	84,736.19
归属于母公司股东的净利润	**37,661.14**	38,057.62	193,623.04
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	**22,893.89**	24,528.05	161,402.82
经营活动产生的现金流量净额	**506,542.13**	360,828.97	510,498.80
现金及现金等价物净增加额	**234,357.02**	-750,413.47	2,556,791.76
项目	**2025 年 12 月 31 日**	**2024 年 12 月 31 日**	**2023 年 12 月 31 日**
资产合计	**10,012,329.13**	8,793,523.15	7,622,635.11
负债合计	**3,702,853.87**	2,521,468.25	2,073,554.56
所有者权益合计	**6,309,475.27**	6,272,054.90	5,549,080.55
归属于母公司所有者权益合计	**4,516,029.04**	4,360,233.22	4,335,425.24

注：最近三年财务数据经审计

（二）主要财务指标

项目	**2025 年度**	**2024 年度**	**2023 年度**
基本每股收益（元）	**0.22**	0.22	1.31
稀释每股收益（元）	**0.22**	0.22	1.30
加权平均净资产收益率（%）	**0.85**	0.88	6.49
资产负债率（%）	**36.98**	28.67	27.20
毛利率（%）	**18.72**	17.43	27.10

九、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

截至本报告书签署日，上市公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

十、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况

截至本报告书签署日，最近三年内，上市公司及其现任董事、高级管理人员

不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形。

十一、上市公司遵纪守法情况

截至本报告书签署日，上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

第三节 交易对方基本情况

一、发行股份购买资产的交易对方

本次交易中，上市公司发行股份购买资产的交易对方为华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金。

（一）华虹集团

1、基本信息

企业名称	上海华虹（集团）有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 177 号
法定代表人	秦健
注册资本	**1,352,148.449311** 万元
统一社会信用代码	91310000132263312B
成立日期	1996 年 4 月 9 日
经营范围	组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业，咨询服务，资产管理，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注：上述注册资本为截至 2025 年 **12 月 31 日**数据。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）1996 年 4 月，设立

华虹集团成立于 1996 年 4 月，注册资本为 400,000 万元，其中中国电子信息产业集团有限公司出资 210,000 万元，上海仪电控股（集团）公司出资 190,000 万元，设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中国电子信息产业集团有限公司	210,000.00	52.50%
2	上海仪电控股(集团)公司	190,000.00	47.50%
合计		**400,000.00**	**100.00%**

（2）2009 年 3 月，分立减资

2009 年 3 月，经公司股东会决议（沪华虹股【2009】第 1 号）和《关于上海华虹（集团）有限公司之分立协议》，公司将所持上海华虹集成电路有限责任公司（占 90.28%）、北京华虹集成电路设计有限责任公司（占 10.00%）、上海新鑫投资有限公司（占 36.36%）、上海信虹投资管理有限公司（占 50.00%）、宁波钲芯科技有限责任公司（占 80.00%）和上海贝岭（占 27.80%）等 6 家公司的股权和货币资金 1,000.00 万元分立由中国电子信息产业集团有限公司持有，相应减少中国电子信息产业集团有限公司对公司的出资额 104,769.73 万元，同时增加上海金桥（集团）有限公司对公司的出资份额 357.92 万元，增加上海仪电（集团）有限公司对公司的出资份额 8,153.21 万元，增加上海联和投资有限公司对公司的出资份额 9,068.00 万元，资产交割日为 2009 年 6 月 30 日。另根据上海市国有资产监督管理委员会文件（沪国资委产【2009】20 号）批复，上海久事公司将持有公司 20.53%的股权及对应的出资额 100,000.00 万元无偿划转给上海联和投资有限公司。至此公司注册资本变更为 399,809.40 万元。

分立减资后华虹集团股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中国电子信息产业集团有限公司	188,230.27	47.08%
2	上海联和投资有限公司	109,068.00	27.28%
3	上海仪电控股(集团)公司	98,153.21	24.55%
4	上海金桥（集团）有限公司	4,357.92	1.09%
合计		**399,809.40**	**100.00%**

（3）2009 年 12 月，股份划转

2009 年 12 月，根据上海市国有资产监督管理委员会文件（沪国资委产【2009】679 号）批复，上海仪电（集团）有限公司将持有公司的股权 19.80%无偿划转给上海联和投资有限公司。

划转后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海联和投资有限公司	188,230.27	47.08%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
2	中国电子信息产业集团有限公司	188,230.27	47.08%
3	上海仪电控股（集团）公司	18,990.95	4.75%
4	上海金桥（集团）有限公司	4,357.92	1.09%
合计		**399,809.40**	**100.00%**

（4）2018 年 9 月，股权转让

2018 年 9 月 14 日，根据国务院国有资产监督管理委员会文件（国资产权【2018】644 号）批复，中国电子信息产业集团有限公司将 47.08%股权以非公开协议方式分别转让给上海国盛（集团）有限公司 23.54%股权，转让给上海国际集团有限公司 23.54%股权。2018 年 12 月 25 日，根据上海市浦东新区国有资产监督管理委员会文件（浦国资委【2018】154 号）批复，上海金桥（集团）有限公司将 1.09%股权以非公开协议方式转让至上海联和投资有限公司。

划转后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海联和投资有限公司	192,588.19	48.17%
2	上海国盛（集团）有限公司	94,115.13	23.54%
3	上海国际集团有限公司	94,115.13	23.54%
4	上海仪电（集团）有限公司	18,990.95	4.75%
合计		**399,809.40**	**100.00%**

（5）2019 年 11 月，增资

2019 年 11 月 21 日，根据上海市国有资产监督管理委员会文件（沪国资委产权（2019）308 号）批复，上海联和投资有限公司将其持有上海华力微电子有限公司 50.2283%股权和 1.8 亿元现金以非公开协议方式对华虹集团进行增资。该增资以华虹集团、华力微 2018 年 12 月 31 日经备案的净资产评估值为依据。增资完成后，华虹集团注册资本增加至 1,110,229.62 万元。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海联和投资有限公司	903,008.41	81.34%
2	上海国盛（集团）有限公司	94,115.13	8.48%
3	上海国际集团有限公司	94,115.13	8.48%
4	上海仪电（集团）有限公司	18,990.95	1.71%
合计		**1,110,229.62**	**100.00%**

（6）2019 年 12 月，增资

2019 年 12 月 30 日，根据上海市国资委文件（沪国资委评价〔2019〕375 号），上海市国资委以华虹集团 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 15,000.00 万元，其中 15,425.75 万元计入实收资本，425.75 万元冲减资本公积。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海联和投资有限公司	903,008.41	80.22%
2	上海国盛（集团）有限公司	94,115.13	8.36%
3	上海国际集团有限公司	94,115.13	8.36%
4	上海仪电（集团）有限公司	18,990.95	1.69%
5	上海市国资委	15,425.75	1.37%
合计		**1,125,655.37**	**100.00%**

（7）2020 年 6 月，股权划转

2020 年 6 月 8 日，根据上海市国资委文件（沪国资委产权（2020）126、127、128、129 号），上海联和投资有限公司将其持有华虹集团全部股权无偿划转给上海市国资委，该划转以 2019 年 12 月 31 日为基准日，以大华会计师出具的大华审字[2020]002645 号 2019 年年度审计报告为依据；同时，上海市国资委将其持有的华虹集团 10%、10%和 10%的股权分别无偿划转至上海国际集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司和上海仪电（集团）有限公司，上述划转以 2020 年 1 月 1 日为基准日，以中介机构出具的 2019 年年度审计报告为依据。

股权划转后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国资委	580,737.55	51.59%
2	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	18.36%
3	上海国际集团有限公司	206,680.67	18.36%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	11.69%
合计		**1,125,655.37**	**100.00%**

（8）2020 年 9 月，增资

2020 年 9 月 18 日，根据上海市国资委文件（沪国资委评价（2020）247 号），上海市国资委以**华虹集团** 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 50,000.00 万元，其中 50,792.36 万元计入实收资本，792.36 万元冲减资本公积。增资后华虹集团注册资本变更为 1,176,447.73 万元。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国资委	631,529.91	53.68%
2	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	17.57%
3	上海国际集团有限公司	206,680.67	17.57%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	11.18%
合计		**1,176,447.73**	**100.00%**

（9）2020 年 12 月，增资

2020 年 12 月 24 日，根据上海市国资委文件（沪国资委评价（2020）427 号），上海市国资委以华虹集团 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 30,000.00 万元，其中 30,475.42 万元计入实收资本，475.42 万元冲减资本公积。增资后华虹集团注册资本变更为 1,206,923.15 万元。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国资委	662,005.33	54.86%
2	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	17.12%
3	上海国际集团有限公司	206,680.67	17.12%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	10.90%
合计		**1,206,923.15**	**100.00%**

（10）2021 年 12 月，增资

2021 年 12 月 31 日，根据上海市国国资委文件（沪国资委评价（2021）411 号），上海市国资委以华虹集团 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 113,000.00 万元，其中 114,499.95 万元计入实收资本，1,499.95 万元冲减资本公积。增资后华虹集团注册资本变更为 1,321,423.10 万元。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国资委	776,505.27	58.76%
2	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	15.64%
3	上海国际集团有限公司	206,680.67	15.64%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	9.96%
合计		**1,321,423.10**	**100.00%**

（11）2022 年 12 月，增资

2022 年 12 月 30 日，根据上海市国资委文件（沪国资委评价（2023）8 号），上海市国资委以华虹集团 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 15,000.00 万元，其中 5,894.37 万元计入实收资本，9,105.63 万元计入资本公积，增资后华虹集团注册资本变更为 1,327,317.47 万元，相应股权结构变更为：上海市国资委出资 782,399.65 万元（占 58.95%），上海仪电（集团）有限公司出资 131,556.48 万元（占 9.91%），上海国盛（集团）有限公司出资 206,680.67 万元（占 15.57%），上海国际集团有限公司出资 206,680.67 万元（占 15.57%）。2023 年 7 月 11 日，根据股东会关于公司增加资本金及《公司章程》变更的决议，华虹集团确认实收资本及资本公积。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国资委	782,399.65	58.95%
2	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	15.57%
3	上海国际集团有限公司	206,680.67	15.57%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	9.91%
合计		**1,327,317.47**	**100.00%**

（12）2023 年 12 月，增资

2023 年 12 月 14 日，根据上海市国资委文件（沪国资委评价〔2023〕289 号），上海国有资产监督管理委员会以华虹集团 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 28,580 万元，其中 11,168.43 万元计入实收资本，17,411.57 万元计入资本公积。2024 年 2 月 20 日，根据上海市国资委文件（沪国资委评价（2024）40 号），上海市国资委以华虹集团 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 16,499 万元，其中 6,447.44 万元计入实收资本，10,051.56 万元计入资本公积。增资后华虹集团注册资本变更为 1,344,854.52 万元。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国资委	799,936.70	59.48%
2	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	15.37%
3	上海国际集团有限公司	206,680.67	15.37%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	9.78%
合计		**1,344,854.52**	**100.00%**

（13）2024 年 11 月，股权划转

2024 年 11 月 6 日，根据上海国有资产监督管理委员会文件（沪国资委产权（2024）204 号），将市国资委所持上海华虹（集团）有限公司 8%股权无偿划转至上海临港经济发展（集团）有限公司。上述股权划转以 2023 年 12 月 31 日经审计的被划转企业净资产值为依据，作为国家资本金（包括资本公积）处理。

本次划转后，华虹集团的股东情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国有资产监督管理委员会	692,348.34	51.48%
2	上海国际集团有限公司	206,680.67	15.37%
3	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	15.37%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	9.78%
5	上海临港经济发展（集团）有限公司	107,588.36	8.00%
合计		**1,344,854.52**	**100.00%**

（14）2025 年 1 月，增资

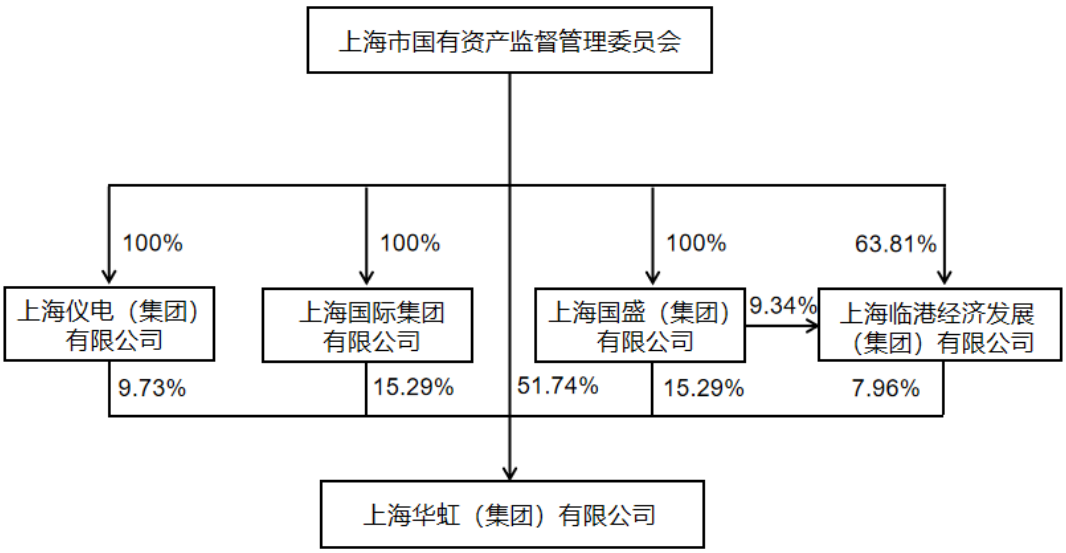
2025 年 1 月 15 日，根据上海市国有资产监督管理委员会文件（沪国资委评价（2025）14 号），上海国有资产监督管理委员会以华虹集团 2023 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 23,555 万元，其中 7,293.92 万元计入实收资本，16,261.08 万元计入资本公积。2025 年 3 月，根据华虹集团股东会决议，华虹集团本次增资后注册资本变更为 1,352,148.45 万元，并于 2025 年 9 月完成工商变更登记。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国有资产监督管理委员会	699,642.26	51.74%
2	上海国际集团有限公司	206,680.67	15.29%
3	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	15.29%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	9.73%
5	上海临港经济发展（集团）有限公司	107,588.36	7.96%
合计		1,352,148.45	100.00%

3、产权及控制关系

截至 2025 年 **12 月 31 日**，华虹集团产权控制关系如下：



截至 2025 年 **12 月 31 日**，华虹集团不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

4、主要股东及实际控制人情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，**华虹集团**的控股股东为上海市国有资产监督管理委员会，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

5、主营业务发展情况

华虹集团旗下业务包括集成电路制造、电子元器件分销、智能化系统应用等板块，最近三年主营业务未发生变更。

6、主要对外投资情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，除华力微外，华虹集团持股比例 30%以上的主要对外投资情况如下：

序号	企业名称	出资比例	经营范围/主营业务
1	华虹国际	100.00%	主要从事投资控股
2	上海华虹虹日电子有限公司	51.00%	主要从事电子元器件分销业务

序号	企业名称	出资比例	经营范围/主营业务
3	上海华虹计通智能系统股份有限公司	25.61%	公司的经营范围：设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统，自动售检票设备及系统，电子收款机及系统，相关智能仪器仪表及设备并提供安装服务；从事自行车租赁系统、智能卡 POS 机及相应的充值机、结算机系统、计算机、电子工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑智能化系统设计、建筑智能化工程施工，建筑工程设计、各类工程建设活动，软件开发，计算机系统服务，信息系统集成服务，人工智能应用软件开发，安全技术防范系统设计施工服务，非居住房地产租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4	上海华虹科技发展有限公司	50.00%	公司经营范围：电子技术、计算机、化工科技和生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资管理商务咨询、企业管理咨询(除经纪)，电子产品的销售，物业管理，【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
5	公司 A	63.54%	公司经营范围：开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
6	上海华虹投资发展有限公司	60.00%	经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7	上海华虹挚芯电子科技有限公司	93.02%	经营范围包括集成电路及配套产品的研制、销售，及以上相关领域的技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、是否属于私募基金及备案情况

华虹集团不属于私募基金，无需进行私募基金备案。

（二）上海集成电路基金

1、基本信息

企业名称	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
企业性质	股份有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 A 单元
法定代表人	李鑫

注册资本	2,480,000.00 万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL3AW02
成立日期	2016 年 12 月 7 日
经营范围	股权投资，创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注：上述注册资本为截至 2025 年 **12 月 31 日**数据。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2016 年 12 月，设立

上海集成电路基金系由上海科技创业投资(集团)有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海国际集团有限公司、上海浦东新兴产业投资有限公司、上海嘉定创业投资管理有限公司共同投资组建的股份有限公司(非上市、国有控股)，于 2016 年 12 月 7 日在上海市工商局登记注册，取得 91310000MA1FL3AW02 号企业法人营业执照。

设立时，上海集成电路基金的股东及其出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	1,000,000.00	35.0877%
2	上海汽车集团股权投资有限公司	600,000.00	21.0526%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	300,000.00	10.5263%
4	上海国际信托有限公司	300,000.00	10.5263%
5	上海国盛（集团）有限公司	200,000.00	7.0175%
6	上海国际集团有限公司	200,000.00	7.0175%
7	上海浦东新兴产业投资有限公司	200,000.00	7.0175%
8	上海嘉定创业投资管理有限公司	50,000.00	1.7544%
合计		**2,850,000.00**	**100.00%**

（2）2020 年 2 月，股权转让

2020 年 2 月，上海科技创业投资（集团）有限公司持有**部分**份额转让至上海国盛（集团）有限公司、上海国际集团有限公司，经上述股权转让后，上海集

成电路基金股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	875,000.00	30.7018%
2	上海汽车集团股权投资有限公司	600,000.00	21.0526%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	300,000.00	10.5263%
4	上海国际信托有限公司	300,000.00	10.5263%
5	上海国盛（集团）有限公司	262,500.00	9.2105%
6	上海国际集团有限公司	262,500.00	9.2105%
7	上海浦东新兴产业投资有限公司	200,000.00	7.0175%
8	上海嘉定创业投资管理有限公司	50,000.00	1.7544%
合计		**2,850,000.00**	**100.00%**

（3）2021 年 7 月，股权转让

2021 年 7 月，上海国际信托有限公司持有部份额转让至中保投齐芯（嘉兴）集成电路产业投资有限责任公司，经上述股权转让后，上海集成电路基金股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	875,000.00	30.7018%
2	上海汽车集团股权投资有限公司	600,000.00	21.0526%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	300,000.00	10.5263%
4	上海国盛（集团）有限公司	262,500.00	9.2105%
5	上海国际集团有限公司	262,500.00	9.2105%
6	上海浦东新兴产业投资有限公司	200,000.00	7.0175%
7	上海国际信托有限公司	180,000.00	6.3158%
8	中保投齐芯(嘉兴)集成电路产业投资有限责任公司	120,000.00	4.2105%
9	上海嘉定创业投资管理有限公司	50,000.00	1.7544%
合计		**2,850,000.00**	**100.00%**

（4）2023 年 11 月-12 月，股权转让

2023 年 11 月，上海汽车集团股权投资有限公司、上海国盛（集团）有限公司将其持有份额转让至中国人寿资产管理有限公司；2023 年 12 月，上海国际集

团有限公司将其持有的部分份额转让至中国中信金融资产管理股份有限公司，经上述股权转让后，上海集成电路基金股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	875,000.00	30.7018%
2	中国人寿资产管理有限公司	862,500.00	30.2632%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	300,000.00	10.5263%
4	上海浦东新兴产业投资有限公司	200,000.00	7.0175%
5	上海国际信托有限公司	180,000.00	6.3158%
6	上海国际集团有限公司	151,170.49	5.3042%
7	中保投齐芯(嘉兴)集成电路产业投资有限责任公司	120,000.00	4.2105%
8	中国中信金融资产管理股份有限公司	111,329.51	3.9063%
9	上海嘉定创业投资管理有限公司	50,000.00	1.7544%
合计		**2,850,000.00**	**100.00%**

（5）2024 年 6 月，减资

2024 年 6 月，上海集成电路基金召开 2024 年度第三次临时股东大会，决定将基金减持回收的资金及历年的利息收益等以减资的方式进行分配，共计减资分配 24 亿元。根据《发起人决议》及公司章程的规定，本次减资金额将按照减资时点各股东的实缴出资比例进行分配，减资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	801,315.68	30.7018%
2	中国人寿资产管理有限公司	789,868.32	30.2632%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	274,736.88	10.5263%
4	上海浦东新兴产业投资有限公司	183,158.00	7.0175%
5	上海国际信托有限公司	164,842.08	6.3158%
6	上海国际集团有限公司	138,440.41	5.3042%
7	中保投齐芯（嘉兴）集成电路产业投资有限责任公司	109,894.80	4.2105%
8	中国中信金融资产管理股份有限公司	101,954.39	3.9063%
9	上海嘉定创业投资管理有限公司	45,789.44	1.7544%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
合计		**2,610,000.00**	**100.00%**

（6）2024 年 12 月，股权转让

2024 年 12 月，上海国际集团有限公司将其持有份额转让至中保投智集芯（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙），经上述股权转让后，上海集成电路基金股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	801,315.68	30.7018%
2	中国人寿资产管理有限公司	789,868.32	30.2632%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	274,736.88	10.5263%
4	上海浦东新兴产业投资有限公司	183,158.00	7.0175%
5	上海国际信托有限公司	164,842.08	6.3158%
6	中保投智集芯(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)	138,440.41	5.3042%
7	中保投齐芯(嘉兴)集成电路产业投资有限责任公司	109,894.80	4.2105%
8	中国中信金融资产管理股份有限公司	101,954.39	3.9063%
9	上海嘉定创业投资管理有限公司	45,789.44	1.7544%
合计		**2,610,000.00**	**100.00%**

（7）2025 年 1 月，减资

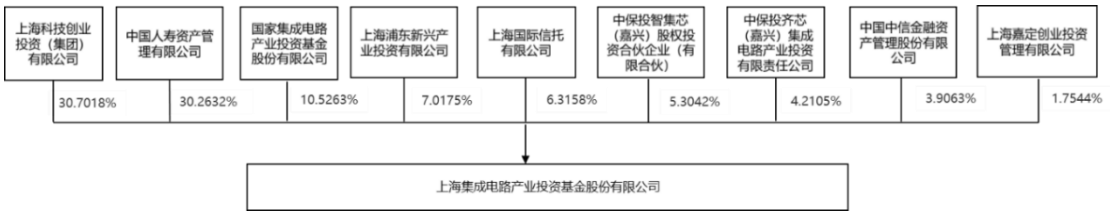
2025 年 1 月，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，决定将基金减持回收的资金及历年的利息收益等以减资的方式进行分配，共计减资分配 13 亿元。根据《发起人决议》及公司章程的规定，本次减资金额将按照减资时点各股东的实缴出资比例进行分配，减资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	761,403.34	30.7018%
2	中国人寿资产管理有限公司（代表“中国人寿-沪发 1 号股权投资计划”）	750,526.16	30.2632%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	261,052.69	10.5263%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
4	上海浦东新兴产业投资有限公司	174,035.25	7.0175%
5	上海国际信托有限公司	156,631.54	6.3158%
6	中保投智集芯（嘉兴）股权投资合伙企业(有限合伙)	131,544.95	5.3042%
7	中保投齐芯（嘉兴）集成电路产业投资有限责任公司	104,421.15	4.2105%
8	中国中信金融资产管理股份有限公司	96,876.20	3.9063%
9	上海嘉定创业投资管理有限公司	43,508.72	1.7544%
合计		**2,480,000.00**	**100.0000%**

3、产权及控制关系

截至 2025 年 **12 月 31 日**，上海集成电路基金产权控制关系如下：



截至 2025 年 **12 月 31 日**，上海集成电路基金不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

4、主要股东及实际控制人情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，经查阅上海集成电路基金的营业执照、公司章程等资料，并登录国家企业信用信息公示系统查询，上海集成电路基金股权结构比较分散，任一单一股东无法对上海集成电路基金的股东大会、董事会形成控制，且各股东之间无一致行动关系，因此上海集成电路基金无控股股东和实际控制人。

5、主营业务发展情况

上海集成电路基金成立于 2016 年 12 月，系为促进集成电路产业发展设立的公司制私募股权基金，最近三年主营业务未发生变更。

6、最近两年主要财务数据及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务数据

最近两年，上海集成电路基金主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	**4,667,857.14**	4,073,378.12
净资产	**4,162,087.09**	3,729,529.83
项目	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	**-**	80,835.70
净利润	**562,557.26**	30,847.73

注：**2024 年**财务数据为经**审计的合并财务报表数据，2025 年财务数据为未经**审计的合并财务报表数据。

（2）最近一年简要财务报表

①简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日
流动资产	**69,837.69**
非流动资产	**4,598,019.45**
资产总额	**4,667,857.14**
流动负债	**3,691.71**
非流动负债	**502,078.34**
负债总额	**505,770.05**
所有者权益	**4,162,087.09**

注：上述财务数据为**未经**审计的合并财务报表数据。

②简要合并利润表

单位：万元

项目	2025 年度
营业收入	**-**
利润总额	**749,720.47**
净利润	**562,557.26**

注：上述财务数据为**未经**审计的合并财务报表数据。

③简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度
经营活动产生的现金流量净额	-701.80
投资活动产生的现金流量净额	-59,918.77
筹资活动产生的现金流量净额	-130,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
现金及现金等价物净增加额	-190,620.57

注：上述财务数据为**未经**审计的合并财务报表数据。

7、主要对外投资情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，上海集成电路基金持股比例 30%**及**以上的主要对外投资情况如下：

序号	企业名称	出资比例	经营范围/主营业务
1	上海海临微集成电路有限公司	30.00%	一般项目：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、是否属于私募基金及备案情况

上海集成电路基金系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为 SEJ523。上海集成电路基金的基金管理人上海集成电路产业投资基金管理有限公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1068675。

（三）大基金二期

1、基本信息

企业名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
企业性质	股份有限公司
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 701-6
法定代表人	张新
注册资本	20,415,000 万元

统一社会信用代码	91110000MA01N9JK2F
成立日期	2019 年 10 月 22 日
经营范围	项目投资、股权投资；投资管理、企业管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

注：上述注册资本为截至 2025 年 **12 月 31 日**数据。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2019 年 10 月，设立

大基金二期总募集规模 2,041.50 亿元，由中华人民共和国财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、上海国盛（集团）有限公司、浙江富浙集成电路产业发展有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司、重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都天府国集投资有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京国谊医院有限公司、江苏聿泉集成电路产业投资有限公司、中移资本控股有限责任公司、安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）、安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）、福建省国资集成电路投资有限公司、深圳市深超科技投资有限公司、广州产业投资基金管理有限公司、黄埔投资控股（广州）有限公司、中国电信集团有限公司、联通资本投资控股有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）、福建三安集团有限公司、北京建广资产管理有限公司、协鑫资本管理有限公司、华芯投资管理有限责任公司共同发起，于 2019 年 10 月 22 日正式设立。

设立时，大基金二期的股东及其出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	中华人民共和国财政部	2,250,000.00	11.0213%
2	国开金融有限责任公司	2,200,000.00	10.7764%
3	中国烟草总公司	1,500,000.00	7.3475%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
4	上海国盛（集团）有限公司	1,500,000.00	7.3475%
5	浙江富浙集成电路产业发展有限公司	1,500,000.00	7.3475%
6	武汉光谷金融控股集团有限公司	1,500,000.00	7.3475%
7	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	7.3475%
8	成都天府国集投资有限公司	1,500,000.00	7.3475%
9	北京亦庄国际投资发展有限公司	1,000,000.00	4.8984%
10	北京国谊医院有限公司	1,000,000.00	4.8984%
11	江苏聿泉集成电路产业投资有限公司	1,000,000.00	4.8984%
12	中移资本控股有限责任公司	1,000,000.00	4.8984%
13	安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	750,000.00	3.6738%
14	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）	750,000.00	3.6738%
15	福建省国资集成电路投资有限公司	300,000.00	1.4695%
16	深圳市深超科技投资有限公司	300,000.00	1.4695%
17	广州产业投资基金管理有限公司	300,000.00	1.4695%
18	黄埔投资控股（广州）有限公司	200,000.00	0.9797%
19	中国电信集团有限公司	150,000.00	0.7348%
20	联通资本投资控股有限公司	100,000.00	0.4898%
21	中国电子信息产业集团有限公司	50,000.00	0.2449%
22	北京紫光通信科技集团有限公司	10,000.00	0.0490%
23	上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	0.0490%
24	福建三安集团有限公司	10,000.00	0.0490%
25	北京建广资产管理有限公司	10,000.00	0.0490%
26	协鑫资本管理有限公司	10,000.00	0.0490%
27	华芯投资管理有限责任公司	15,000.00	0.0735%
合计		20,415,000.00	100.0000%

（2）股东变更

2020 年 12 月，大基金二期召开股东大会，同意上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）与上海硅启企业管理合伙企业（有限合伙）完成股份转

让后，对公司章程中的股东名称及附录联系方式进行修正。2022 年 12 月，大基金二期召开股东大会，同意根据中国电子信息产业集团有限公司将其持有的 0.2449%股份（对应认股金 5.00 亿元）无偿划转至中电金投控股有限公司事宜对章程中记载股东信息进行修改。2022 年 12 月，大基金二期签署了章程修正案。2024 年 6 月，大基金二期召开股东大会，同意根据深圳市深超科技投资有限公司将其持有的 1.4695%股份（对应认股金 30.00 亿元）无偿划转至深圳市深超科技集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）事宜对章程中记载股东信息进行修改。**2025 年 11 月，大基金二期召开股东大会，审议通过关于引入广西投资引导基金有限责任公司（以下简称“广西引导基金”）并修正公司章程的提案，同意大基金二期引入广西投资引导基金作为公司股东，并完成涉及修改股东名册的章程修正案。**

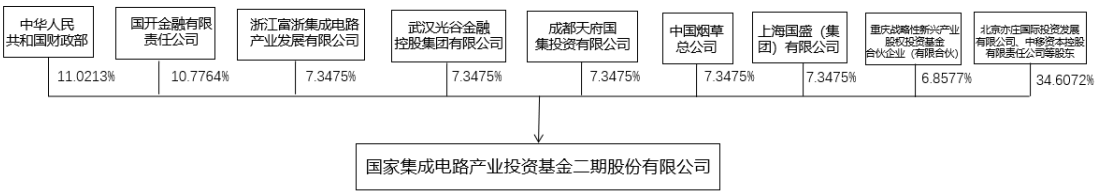
前述变更完成后，大基金二期的股东及其出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中华人民共和国财政部	2,250,000.00	11.0213%
2	国开金融有限责任公司	2,200,000.00	10.7764%
3	浙江富浙集成电路产业发展有限公司	1,500,000.00	7.3475%
4	武汉光谷金融控股集团有限公司	1,500,000.00	7.3475%
5	成都天府国集投资有限公司	1,500,000.00	7.3475%
6	中国烟草总公司	1,500,000.00	7.3475%
7	上海国盛（集团）有限公司	1,500,000.00	7.3475%
8	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	**1,400,000.00**	**6.8577%**
9	北京亦庄国际投资发展有限公司	1,000,000.00	4.8984%
10	中移资本控股有限责任公司	1,000,000.00	4.8984%
11	北京国谊医院有限公司	1,000,000.00	4.8984%
12	江苏聿泉集成电路产业投资有限公司	1,000,000.00	4.8984%
13	安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	750,000.00	3.6738%
14	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）	750,000.00	3.6738%
15	福建省国资集成电路投资有限公司	300,000.00	1.4695%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
16	深圳市深超科技集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	300,000.00	1.4695%
17	广州产业投资基金管理有限公司	300,000.00	1.4695%
18	黄埔投资控股（广州）有限公司	200,000.00	0.9797%
19	中国电信集团有限公司	150,000.00	0.7348%
20	联通资本投资控股有限公司	100,000.00	0.4898%
21	**广西投资引导基金有限责任公司**	**100,000.00**	**0.4898%**
22	中电金投控股有限公司	50,000.00	0.2449%
23	华芯投资管理有限责任公司	15,000.00	0.0735%
24	福建三安集团有限公司	10,000.00	0.0490%
25	协鑫资本管理有限公司	10,000.00	0.0490%
26	北京紫光通信科技集团有限公司	10,000.00	0.0490%
27	北京建广资产管理有限公司	10,000.00	0.0490%
28	上海矽启企业管理合伙企业（有限合伙）	10,000.00	0.0490%
合计		**20,415,000.00**	**100.0000%**

3、产权及控制关系

截至 2025 年 **12 月 31 日**，大基金二期的产权控制结构图如下：



截至 2025 年 **12 月 31 日**，大基金二期不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

4、主要股东及实际控制人情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，经查阅大基金二期的营业执照、公司章程等资料，并登录国家企业信用信息公示系统查询，大基金二期股权结构比较分散，任一单一股东无法对大基金二期的股东大会、董事会形成控制，且各股东之间无一致行动关系，因此大基金二期无控股股东和实际控制人。

5、主营业务发展情况

大基金二期成立于 2019 年 10 月，系为促进集成电路产业发展设立的公司制私募股权基金，最近三年主营业务未发生变更。

6、最近两年主要财务数据及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务数据

最近两年，大基金二期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	23,329,380.21	21,401,558.72
净资产	22,513,016.10	20,565,686.59
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	9,628.28	19,300.97

注： **上述**财务数据**均**为未经审计的合并财务报表数据。

（2）最近一年简要财务报表

①简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日
流动资产	23,329,367.18
非流动资产	13.03
资产总额	23,329,380.21
流动负债	1,306.96
非流动负债	815,057.15
负债总额	816,364.11
所有者权益	22,513,016.10

注：**上述**财务数据为未经审计的合并财务报表数据。

②简要合并利润表

单位：万元

项目	2025 年度
营业收入	9,628.28

项目	2025 年度
利润总额	-152,676.20

注：上述财务数据为未经审计的合并财务报表数据。

③简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度
经营活动产生的现金流量净额	-29,942.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,139,092.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,103,493.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
现金及现金等价物净增加额	-65,541.97

注：上述财务数据为未经审计的合并财务报表数据。

7、主要对外投资情况

截至 2025 年 12 月 31 日，大基金二期持股比例 30%以上的主要对外投资情况如下：

序号	企业名称	出资比例	经营范围/主营业务
1	华润润安科技（重庆）有限公司	38.04%	许可项目：货物进出口，进出口代理，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集成电路设计，集成电路制造，集成电路销售，电子元器件制造，电子元器件批发，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2	杭州长川智能制造有限公司	33.33%	一般项目：半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

序号	企业名称	出资比例	经营范围/主营业务
3	润西微电子（重庆）有限公司	33.00%	许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，科技中介服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4	杭州富芯半导体有限公司	31.22%	一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车充电销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5	合肥沛顿存储科技有限公司	31.05%	半导体器件和晶圆开发、设计、封装和测试及制造服务；电子器件开发、组装、测试服务；电子产品销售及服务；向第三方（包括股东及其关联方）提供咨询、技术支持及技术服务；自营和代理各类货物或技术进出口服务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、是否属于私募基金及备案情况

大基金二期系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为 SJU890。大基金二期的基金管理人华芯投资管理有限责任公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1009674。

（四）国投先导基金

1、基本信息

名称	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MADTAPYB6E
类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区中科路 1699 号 28 层 02 单元

执行事务合伙人	上海国投先导私募基金管理有限公司
认缴出资额	4,500,100.00 万元
成立日期	2024 年 7 月 22 日
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：上述认缴出资额为截至 2025 年 **12 月 31 日**数据。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2024 年 7 月，设立

国投先导基金系由上海国投先导私募基金管理有限公司、上海国经投资发展有限公司、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司、上海国有资本投资有限公司、上海汽车工业（集团）有限公司、上海国际集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司、海通创新证券投资有限公司、国泰君安证裕投资有限公司、上海申能诚毅股权投资有限公司和上海国际信托有限公司共同投资组建的有限合伙企业，于 2024 年 7 月 22 日在上海市工商局登记注册，取得 91310000MADTAPYB6E 号企业法人营业执照。

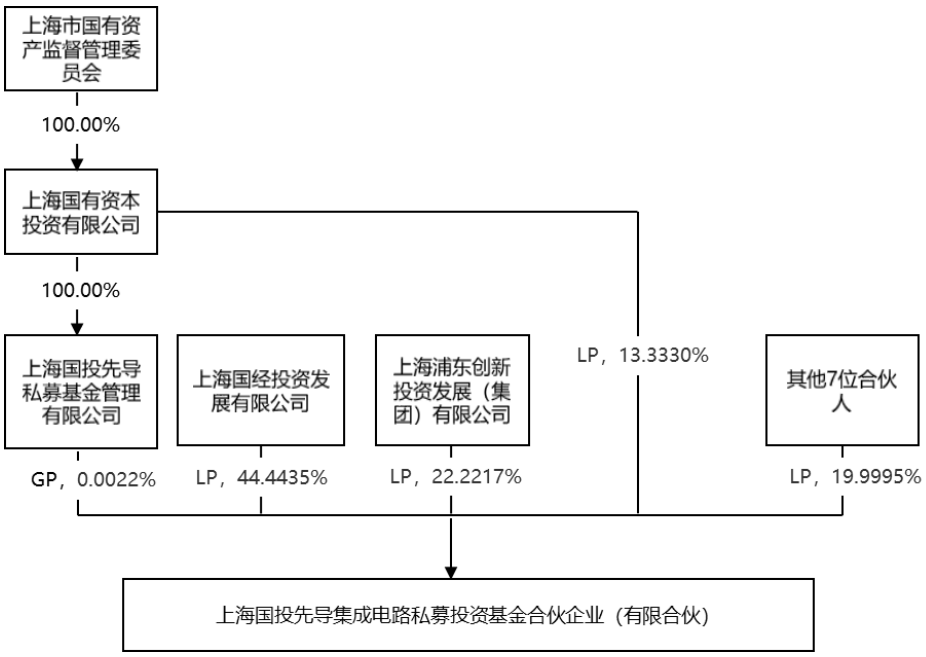
设立时，国投先导基金的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	上海国投先导私募基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.0022%
2	上海国经投资发展有限公司	有限合伙人	2,000,000.00	44.4435%
3	上海浦东创新投资发展（集团）有限公司	有限合伙人	1,000,000.00	22.2217%
4	上海国有资本投资有限公司	有限合伙人	600,000.00	13.3330%
5	上海汽车工业（集团）有限公司	有限合伙人	250,000.00	5.5554%
6	上海国际集团有限公司	有限合伙人	250,000.00	5.5554%
7	上海国盛（集团）有限公司	有限合伙人	200,000.00	4.4443%
8	海通创新证券投资有限公司	有限合伙人	50,000.00	1.1111%
9	国泰君安证裕投资有限公司	有限合伙人	50,000.00	1.1111%
10	上海申能诚毅股权投资有限公司	有限合伙人	50,000.00	1.1111%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
11	上海国际信托有限公司	有限合伙人	50,000.00	1.1111%
合计			**4,500,100.00**	**100.00%**

3、产权及控制关系

截至 2025 年 **12 月 31 日**，国投先导基金产权控制关系如下：



截至 2025 年 **12 月 31 日**，国投先导基金不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

国投先导基金系在中国证券投资基金业协会备案的有限合伙型私募股权投资基金（产品备案编号：SAMQ44）。作为一家有限合伙企业，国投先导基金的合伙人来自财政资金出资平台、国有企业、证券公司另类子公司、上市公司等多元化出资主体，无单一持有合伙份额 50%及以上的合伙人，亦无通过一致行动协议实际行使半数以上合伙人大会表决权的合伙人。此外，虽然上海国投先导私募基金管理有限公司作为国投先导基金的基金管理人、执行事务合伙人，但上海国投先导私募基金管理有限公司并未在国投先导基金的投资决策委员会、顾问委员会中委派半数以上委员，亦不能够单方面决定投资决策委员会、顾问委员会的表决结果。

综上所述，国投先导基金无实际控制人。

4、执行事务合伙人基本情况

国投先导基金的执行事务合伙人为上海国投先导私募基金管理有限公司，截至 2025 年 **12 月 31 日**，其基本情况如下：

企业名称	上海国投先导私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区中科路 1699 号第 28 层（实际楼层第 24 层）01 单元
法定代表人	温治
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91310000MADKU0K187
成立日期	2024 年 5 月 14 日
营业期限	2024 年 5 月 14 日至长期
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、穿透至最终出资人的情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，国投先导基金穿透至最终持有人情况如下：

层级	各层合伙人/出资人/股东	是否为最终持有人	最终持有人类型
1	上海国经投资发展有限公司	是	国有控股或管理主体
2	上海浦东创新投资发展（集团）有限公司	是	国有控股或管理主体
3	上海国有资本投资有限公司	是	国有控股或管理主体
4	上海国际集团有限公司	是	国有控股或管理主体
5	上海汽车工业（集团）有限公司	是	国有控股或管理主体
6	上海国盛（集团）有限公司	是	国有控股或管理主体
7	上海申能诚毅股权投资有限公司	-	-
7-1	申能（集团）有限公司	是	国有控股或管理主体
8	海通创新证券投资有限公司	-	-
8-1	国泰海通证券股份有限公司	是	上市公司

层级	各层合伙人/出资人/股东	是否为最终持有人	最终持有人类型
9	上海国际信托有限公司	-	-
9-1	上海浦东发展银行股份有限公司	是	上市公司
9-2	上海汽车集团股权投资有限公司	-	-
9-2-1	上海汽车集团股份有限公司	是	上市公司
9-3	上海新黄浦实业集团股份有限公司	是	上市公司
10	国泰君安证裕投资有限公司	-	-
10-1	国泰海通证券股份有限公司	是	上市公司
11	上海国投先导私募基金管理有限公司	-	-
11-1	上海国有资本投资有限公司	是	国有控股或管理主体

6、主营业务发展情况

国投先导基金主营业务为股权投资，成立以来主营业务未发生变化。

7、最近两年主要财务数据及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务数据

最近两年，国投先导基金主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	**2,205,956.15**	679,675.09
净资产	**2,206,214.09**	679,666.56
项目	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	**-**	2,817.52
净利润	**137,400.26**	1,566.56

注：**2024 年**财务数据为经**审计的合并财务报表数据，2025 年财务数据为未经**审计的合并财务报表数据。

（2）最近一年简要财务报表

①简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日
流动资产	**2,205,956.15**

项目	2025 年 12 月 31 日
非流动资产	-
资产总额	2,205,956.15
流动负债	-257.94
非流动负债	-
负债总额	-257.94
所有者权益	2,206,214.09

注：上述财务数据为**未经**审计的合并财务报表数据。

②简要合并利润表

单位：万元

项目	2025 年度
营业收入	-
利润总额	137,400.26
净利润	137,400.26

注：上述财务数据为**未经**审计的合并财务报表数据。

③简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度
经营活动产生的现金流量净额	252.86
投资活动产生的现金流量净额	-536,933.50
筹资活动产生的现金流量净额	720,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
现金及现金等价物净增加额	183,319.36

注：上述财务数据为**未经**审计的合并财务报表数据。

8、主要对外投资情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，国投先导基金不存在持股比例 50%以上的对外投资。

9、是否属于私募基金及备案情况

国投先导基金系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行

私募基金备案，基金编号为 SAMQ44。国投先导基金的基金管理人上海国投先导私募基金管理有限公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1074817。

（五）其他事项说明

1、交易对方之间的关联关系及情况说明

截至本报告书签署日，交易对方之间不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（上证发〔2025〕60 号）等项下的关联关系。

2、交易对方与上市公司的关联关系及向上市公司推荐董事、高级管理人员情况

交易对方与上市公司的关联关系情况如下：

（1）上海华虹（集团）有限公司为上市公司间接控股股东；

（2）上海集成电路产业投资基金股份有限公司的原董事孙国栋同时担任上市公司董事。

除此之外，截至本报告书签署日，交易对方与上市公司之间不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（上证发〔2025〕60 号）等项下的关联关系。

本次交易对方华虹集团系上市公司间接控股股东。截至本报告书签署日，上市公司现任董事白鹏、陈博、熊承艳由华虹集团推荐，上市公司高级管理人员均由上市公司董事会聘任。除此之外，本次交易对方不存在其他向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

3、交易对方及其主要负责人最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本报告书签署日，交易对方及其主要负责人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情况，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、交易对方及其主要负责人最近五年的诚信情况

截至本报告书签署日，交易对方及其主要负责人最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形，不存在重大失信的情形。

二、募集配套资金的交易对方

本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会的同意注册文件后，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。

第四节 标的公司基本情况

上市公司拟向华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金发行股份形式购买华力微 97.4988%股权，并通过子公司华虹宏力间接持有华力微 2.5012%股权，从而直接及间接合计持有华力微 100%股权，标的公司具体情况如下：

一、标的公司基本情况

公司名称	上海华力微电子有限公司
公司性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区高斯路 568 号
法定代表人	秦健
成立日期	2010 年 01 月 18 日
注册资本	2,036,192,198.06 元
统一社会信用代码	913100005500570876
经营范围	开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、标的公司历史沿革

（一）历史沿革

1、2010 年 1 月，华力微设立

华力微系由上海联和投资有限公司、华虹集团、华虹 NEC 及上海宏力半导体制造有限公司共同出资于 2010 年 1 月 18 日设立，设立时的注册资本为 660,000 万元，其中，上海联和投资有限公司出资 450,000 万元，持有华力微 68.1817%的股权；华虹集团出资 70,000 万元，持有华力微 10.6061%的股权；华虹 NEC 出资 70,000 万元，持有华力微 10.6061%的股权；上海宏力半导体制造有限公司出资 70,000 万元，持有华力微 10.6061%的股权；首期由上海联和投资有限公司出资 200,000 万元，其余部分由上海联和投资有限公司和其他各方股东在 2 年内出资完成。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 13 日出具的中瑞岳华

沪验字[2010]第 004 号《验资报告》，截至 2010 年 1 月 13 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的首期注册资本 200,000 万元。

2010 年 1 月 18 日，华力微取得上海市工商行政管理局核发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

华力微设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	450,000	200,000	68.18
2	华虹集团	70,000	-	10.61
3	华虹 NEC	70,000	-	10.61
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	-	10.61
合计		**660,000**	**200,000**	**100.00**

2、2010 年 4 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 15 日出具的沪立信佳诚验字（2010）第 1010 号《验资报告》，截至 2010 年 4 月 13 日，华力微已收到上海宏力半导体制造有限公司以货币缴纳的第二期注册资本 35,000 万元。

2010 年 4 月 29 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	450,000	200,000	68.18
2	华虹集团	70,000	-	10.61
3	华虹 NEC	70,000	-	10.61
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	10.61
合计		**660,000**	**235,000**	**100.00**

3、2010 年 10 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 8 日出具的沪立信佳诚验字（2010）第 1035 号《验资报告》，截至 2010 年 9 月 30 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第三期注册资本 100,000 万元。

2010 年 10 月 13 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	450,000	300,000	68.18
2	上海华虹（集团）有限公司	70,000	-	10.61
3	上海华虹 NEC 电子有限公司	70,000	-	10.61
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	10.61
合计		**660,000**	**335,000**	**100.00**

4、2010 年 12 月第一次增资

2010 年 11 月 20 日，华力微股东会作出决议，同意华力微注册资本由 660,000 万元增至 790,000 万元，新增注册资本 130,000 万元由上海联和投资有限公司以 130,000 万元的价格认缴。

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2010 年 11 月 26 日出具的沪立信佳诚验字（2010）第 1039 号《验资报告》，截至 2010 年 11 月 25 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第四期注册资本 58,083 万元。

2010 年 12 月 1 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	358,083	73.42
2	华虹集团	70,000	-	8.86

3	华虹 NEC	70,000	-	8.86
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**393,083**	**100.00**

5、2011 年 4 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 28 日出具的沪立信佳诚验字（2011）第 1011 号《验资报告》，截至 2011 年 4 月 28 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第五期注册资本 127,550 万元。

2011 年 4 月 28 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	485,633	73.42
2	华虹集团	70,000	-	8.86
3	华虹 NEC	70,000	-	8.86
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**520,633**	**100.00**

6、2011 年 8 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 2 日出具的沪立信佳诚验字（2011）第 1020 号《验资报告》，截至 2011 年 8 月 2 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第六期注册资本 71,917 万元。

2011 年 8 月 5 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	557,550	73.42
2	华虹集团	70,000	-	8.86

3	华虹 NEC	70,000	-	8.86
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**592,550**	**100.00**

7、2011 年 11 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 14 日出具的沪立信佳诚验字（2011）第 1030 号《验资报告》，截至 2011 年 11 月 14 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第七期注册资本 22,450 万元。

2011 年 11 月 18 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2	华虹集团	70,000	-	8.86
3	华虹 NEC	70,000	-	8.86
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**615,000**	**100.00**

8、2012 年 1 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2012 年 1 月 16 日出具的沪立信佳诚验字（2012）第 1002 号《验资报告》，截至 2012 年 1 月 16 日，华力微已收到华虹集团和华虹 NEC 以货币缴纳的第八期注册资本 140,000 万元。

2012 年 1 月 17 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2	华虹集团	70,000	70,000	8.86

3	华虹 NEC	70,000	70,000	8.86
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**755,000**	**100.00**

9、2014 年 2 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2014 年 2 月 14 日出具的沪立信佳诚验字（2014）第 1001 号《验资报告》，截至 2014 年 2 月 13 日，华力微已收到上海宏力半导体制造有限公司以货币缴纳的第九期注册资本 35,000 万元。

2014 年 2 月 19 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2	华虹集团	70,000	70,000	8.86
3	华虹 NEC	70,000	70,000	8.86
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	70,000	8.86
合计		**790,000**	**790,000**	**100.00**

10、2016 年 4 月股东变更

根据华虹 NEC 与上海宏力半导体制造有限公司于 2012 年 4 月 23 日签订的《上海华虹 NEC 电子有限公司与上海宏力半导体制造有限公司合并协议》，双方以新设合并方式设立公司，名称为“上海华虹宏力半导体制造有限公司”，合并后，华虹 NEC 与上海宏力半导体制造有限公司解散，其债权、债务全部由华虹宏力承继。据此，华虹 NEC 及上海宏力半导体制造有限公司持有的华力微股权均变更为由合并后的华虹宏力持有。

2016 年 4 月 7 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000055005708 76 的《营业执照》。

本次股东变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2	华虹宏力	140,000	140,000	17.72
3	华虹集团	70,000	70,000	8.86
合计		**790,000**	**790,000**	**100.00**

11、2016 年 12 月第二次增资

2016 年 11 月 18 日，华力微股东会作出《关于同意上海华力微电子有限公司增资的决议》，同意华力微注册资本由 790,000 万元增至 2,190,000 万元，其中上海联和投资有限公司以 520,000 万元的价格认缴新增注册资本 520,000 万元，上海集成电路产业基金以 880,000 万元的价格认缴新增注册资本 880,000 万元。

2016 年 12 月 14 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000055005708 76 的《营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	1,100,000	1,100,000	50.23
2	上海集成电路产业基金	880,000	880,000	40.18
3	华虹宏力	140,000	140,000	6.39
4	华虹集团	70,000	70,000	3.20
合计		**2,190,000**	**2,190,000**	**100.00**

12、2019 年 12 月第一次股权转让及第三次增资

2019 年 12 月 13 日，华力微股东会作出《关于上海华力微电子有限公司股权变更和增资的决议》，同意上海联和投资有限公司将其所持有的华力微 50.2283%股权（对应注册资本 1,100,000 万元）以 1,148,510 万元的价格转让给华虹集团；同意华力微注册资本由 2,190,000 万元增至 2,207,239.727995 万元，新增 17,239.727995 万元注册资本由华虹集团以 18,000.00 万元的价格进行认缴。

2019 年 12 月 25 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管

理局核发的统一社会信用代码为 91310000550057O876 的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	华虹集团	1,187,239.727995	1,187,239.727995	53.79
2	上海集成电路产业基金	880,000	880,000	39.87
3	华虹宏力	140,000	140,000	6.34
合计		**2,207,239.727995**	**2,207,239.727995**	**100.00**

13、2023 年 11 月第四次增资

2023 年 11 月 18 日，华力微股东会作出决议，同意华力微增资，增资方为华虹集团，大基金二期。

2023 年 11 月 28 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000550057O876 的《营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	股权比例（%）
1	上海华虹（集团）有限公司	53.85
2	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	30.98
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	10.24
4	上海华虹宏力半导体制造有限公司	4.93
合计		**100.00**

14、2025 年 4 月第五次增资

2025 年 3 月 28 日，华力微股东会作出决议，同意华力微增资，增资方**为**华虹集团，国投先导基金，大基金二期。

2025 年 4 月 30 日，华力微取得上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91310000550057O876 的《营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	股权比例（%）
1	上海华虹（集团）有限公司	63.54

2	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	15.72
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	10.25
4	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）	7.98
5	上海华虹宏力半导体制造有限公司	2.50
合计		**100.00**

15、2025 年 8 月，华力微分立

2025 年 6 月 26 日，华力微股东会通过了《关于公司分立的决议》（沪华力微股（2025）第 4 号），同意华力微进行分立，分立基准日为 2024 年 11 月 30 日，分立后华力微继续存续，同时将华力微的长期股权投资及相应的业务、资产、债权债务、人员及其他约定权利义务依法分出给新设公司；分立后，华力微的注册资本变更为 203,619.219806 万元，分立后的各公司股东持股比例与分立前保持一致，分立前的债务由分立后的华力微及新设公司承担连带责任。

2025 年 6 月 26 日，华力微于报纸发布了关于华力微分立事宜的公告。2025 年 6 月 27 日至 2025 年 7 月 4 日，华力微向债权人发出《债权人通知书》。

2025 年 8 月 21 日，华力微取得上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91310000550057087 6 的《营业执照》。

本次分立完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	华虹集团	129,388.277164	129,388.277164	63.54
2	上海集成电路产业基金	32,012.074045	32,012.074045	15.72
3	大基金二期	20,871.634314	20,871.634314	10.25
4	国投先导基金	16,254.404321	16,254.404321	7.98
5	华虹宏力	5,092.829962	5,092.829962	2.50
合计		**203,619.219806**	**203,619.219806**	**100.00**

（二）股东出资及合法存续情况

华力微历次股权变更均依法履行了工商管理部门登记和备案手续。截至本报告书签署日，华力微为合法设立并有效存续的企业法人，主体资格合法、有效，现有股东合法持有华力微的股权。

（三）最近三年增减资、改制及评估情况

最近三年，标的公司共发生两次增资，未发生股权转让或改制情况，具体情况如下：

时间	事项	交易各方	交易内容	定价依据	评估情况	是否履行必要的审议和批准程序
2023年11月	增资	华虹集团、大基金二期	具体情况详见本节之“二、/（一）历史沿革”	以评估报告为依据，协商定价	根据东洲评估出具的《上海华力微电子有限公司拟进行非同比例增资涉及的上海华力微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第2214号）作为定价依据	是
2025年4月	增资	华虹集团、大基金二期、国投先导基金	具体情况详见本节之“二、/（一）历史沿革”	以评估报告为依据，协商定价	根据东洲评估出具的《上海华力微电子有限公司拟进行非同比例增资所涉及的上海华力微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第2784号）作为定价依据	是

（四）最近三年申请首次公开发行股票并上市或作为上市公司重大资产重组交易标的的情况

最近三年内，标的公司不存在首次公开发行股票并上市的情况，且不存在作为上市公司重大资产重组交易标的的情况。

三、标的公司产权结构及控制关系

（一）股权结构

截至本报告书签署日，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	持股比例
1	华虹集团	1,293,882,771.64	63.5443%
2	上海集成电路基金	320,120,740.45	15.7215%
3	大基金二期	208,716,343.14	10.2503%
4	国投先导基金	162,544,043.21	7.9827%
5	华虹宏力	50,928,299.62	2.5012%
合计		**2,036,192,198.06**	**100.0000%**

截至本报告书签署日，华虹集团持有华力微 63.5443%的股权，系华力微的控股股东，上海市国资委为标的公司实际控制人。

（二）标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排、是否存在影响资产独立性的协议或其他安排

截至本报告书签署日，标的公司《公司章程》不存在可能对本次交易产生影响的内容，不存在对本次交易产生影响的相关投资协议，不存在可能对本次交易产生影响的设置或高级管理人员安排，亦不存在其他影响其资产独立性的协议或其他安排。

四、标的公司下属企业情况

截至本报告书签署日，标的公司无下属企业。

五、标的公司主要资产权属状况、主要负债及对外担保情况

（一）主要资产

1、主要固定资产

截至 2025 年 **12 月 31 日**，标的公司的固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产	账面原值	账面净值	成新率
厂务设施	**126,490.91**	**7,479.04**	**5.91%**
机器设备	**1,396,912.40**	**138,499.70**	**9.91%**
工具器具	**1,206.80**	**236.94**	**19.63%**
电脑通讯设备	**20,207.23**	**1,642.42**	**8.13%**

办公设备	94.00	15.43	16.42%
运输设备	72.33	23.77	32.86%
合计	**1,544,983.66**	**147,897.29**	**9.57%**

截至 2025 年 12 月 31 日，标的公司无自有房屋建筑物，主要经营性租赁物业情况如下：

出租方	租赁地址	租赁面积	租赁期限	用途
华虹宏力	上海市浦东新区张江高科技园区 13 街坊 2 丘厂房	91,563.11 平方米	2010 年 3 月 1 日至 2030 年 2 月 28 日	厂房
		化学品仓库、动力厂房和生产厂房	自验收合格交付之日起 20 年	
		192 平方米	2021 年 6 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	厂房

华力微以租赁方式使用上述房屋不违反法律、行政法规的强制性规定。

2、主要无形资产

公司生产经营所使用的无形资产主要包括专利权、IP 授权。

（1）专利权

截至 2025 年 12 月 31 日，华力微共拥有 1,933 项境内已授权专利，148 项境外已授权专利，具体情况详见本报告书附件一表 1、2。

（2）IP 授权

华力微通过与第三方 IP 供应商的合作，为客户提供不同种类的标准单元库、存储器编译器和其他 IP 类型。截至 2025 年 12 月 31 日，华力微获得的 IP 授权主要类型包括标准单元库、可编程存储类 IP、嵌入式非易失性存储 IP 及模拟、接口 IP 等。

（二）主要负债及或有负债情况

截至 2025 年 12 月 31 日，华力微主要负债情况如下：

单位：万元、%

项目	金额	占比
应付账款	71,583.60	16.37
合同负债	10,571.94	2.42

项目	金额	占比
应付职工薪酬	9,811.54	2.24
应交税费	378.46	0.09
其他应付款	7,888.69	1.80
一年内到期的非流动负债	56,308.32	12.88
其他流动负债	1,196.00	0.27
流动负债	157,738.56	36.08
长期借款	247,225.00	56.54
租赁负债	30,528.01	6.98
预计负债	127.56	0.03
递延收益	1,611.00	0.37
非流动负债	279,491.57	63.92
合计	437,230.13	100.00

1、主要负债情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，标的公司主要负债为长期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。

2、或有负债情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，标的公司不存在或有负债的情况。

（三）对外担保情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，标的公司不存在对外担保情况。

（四）资产的权利限制情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，标的公司抵押借款具体情况如下：

借款合同编号	借款人	贷款人	借款金额（万元）	借款期限	借款用途	借款利率	担保情况
3100201606100000054、3100201606100	华力微	委托贷款人：国开发展基金有限公司；受托贷款人：国家开发银行股份有限公司	300,000.00	2016 年 8 月 4 日-2026 年 8 月 3 日	产线建设	年利率 1.2%	华力微以评估值合计 152,243.77 万元的设备向委托贷款人提供抵押担保

00054001							
310020150610000015、310020150610000015001	华力微	委托贷款人：国开发展基金有限公司；受托贷款人：国家开发银行股份有限公司	100,000.00	2015年11月24日-2030年11月23日	产线投建	年利率1.2%	华力微以评估值合计116,263.96万元的设备向委托贷款人提供抵押担保
310020230110000002961	华力微	国家开发银行上海市分行、交通银行股份有限公司上海新区支行、上海银行股份有限公司徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行	96,000.00	2023年2月-2031年2月	研发	3%	华力微以评估值合计29,052.85万元的设备向贷款人提供抵押担保

（五）标的资产其他情况

1、是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况或者存在妨碍权属转移的其他情况

本次交易标的是华力微 97.4988%股权，截至本报告书签署日，标的公司不涉及重大诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

2、行政处罚或刑事处罚情况

报告期内，标的公司不存在因违反相关法律、法规而受到行政处罚或刑事处罚的情形。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告书签署日，标的公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

4、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关事项

本次交易不涉及其他立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等相关报批事项。

5、债权债务转移情况

本次交易完成后，标的公司仍作为独立存续的法人主体开展经营活动，所涉及的债权债务仍由标的公司承担，不涉及标的公司债权债务转移的情况。

6、涉及土地使用权、矿业权等资源类权利的说明

截至本报告书签署日，标的公司不涉及土地使用权、矿业权等资源类权利。

7、交易标的涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，华力微不存在许可他人使用自己重要资产的情况。除被授权使用 IP 核等专有技术外，不存在作为被许可方使用他人资产的情况。

六、标的公司主营业务情况

（一）所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、所处行业的行业主管部门及监管体制

标的公司主要从事半导体晶圆代工业务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司所处行业为第四条（一）中所规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）、“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）及“电力电子基础元器件制造”（分类代码：6.5.2）。

公司所处行业的主管部门为工信部，主要职责为：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优

化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业等。

中国半导体行业协会是半导体行业的主要自律组织和协调机构，其主要职责包括：贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好信息咨询工作；调查、研究、预测本行业产业与市场，汇集企业要求，反映行业发展呼声；广泛开展经济技术交流和学术交流活动；开展国际交流与合作；制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准等任务。

2、主要法律法规政策及产业政策

半导体行业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。近年来，国家相继出台各类法规政策，规范产业发展，鼓励产业成长。

半导体行业近期涉及的主要法律、法规和规范性文件如下：

序号	发布时间	发布机关	法律法规及政策	主要内容
1	2020 年	国务院	《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）	进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予集成电路产业和软件产业诸多优惠政策。明确在一定时期内，集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业（含掩模版、8 英寸及以上硅片生产企业）进口自用生产性原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备零配件，免征进口关税。
2	2021 年	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。
3	2021 年	发改委	《关于做好享受税收优惠政策的集成电路	享受税收优惠政策的企业条件和项目标准为集成电路线宽小于 65

序号	发布时间	发布机关	法律法规及政策	主要内容
			企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413号）	纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业。
4	2022 年	发改委、工信部、财政部、海关总署、国家税务总局	《关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2022〕390 号）	2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业是指集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业，集成电路线宽小于 0.5 微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业。
5	2023 年	发改委	《产业结构调整指导目录》（2024 本）	将“新型电子元器件：片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件”等纳入鼓励级
6	2025 年	工信部、市场监督管理总局	《电子信息制造业 2025－2026 年稳增长行动方案》	2025－2026 年，主要预期目标是：规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在 7%左右，加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到 5%以上。到 2026 年，预期实现营收规模和出口比例在 41 个工业大类中保持首位，5 个省份的电子信息制造业营收过万亿，服务器产业规模超过 4000 亿元，75 英寸及以上彩色电视机国内市场渗透率超过 40%，个人计算机、手机向智能化、高端化迈进。

（二）主要产品及用途情况

1、主营业务情况

华力微以逻辑工艺为基础，同时深耕特色工艺，为设计公司、IDM 公司和其他系统公司提供包括逻辑与射频、嵌入式/独立式非易失性存储器、高压等多元化工艺平台的晶圆代工及配套服务。

华力微在半导体制造领域拥有超过 15 年的技术积累，长期坚持自主创新，不断研发并掌握了特色工艺的关键核心技术，目前拥有中国大陆第一条全自动 12 英寸集成电路 Foundry 生产线，工艺水平达到 65/55nm、40nm 技术等级，设

计产能 3.8 万片/月。

华力微广泛的工艺组合为客户提供完整的技术解决方案，应用于通信、消费电子等终端产品市场，生产的芯片产品涵盖基带处理器、图像传感器、中小尺寸液晶屏驱动芯片、触控屏控制器、触控和显示驱动二合一芯片、无线连接射频、微处理器、智能卡、机顶盒集成芯片、电源管理芯片等。

2、主要产品及服务

报告期内，标的公司为客户提供的产品及服务未发生变化，主要向客户提供 12 英寸晶圆的特色工艺代工服务，在不同工艺平台上，按照客户需求为其制造多种类的半导体产品；同时为客户提供包括设计、测试等配套服务。

（1）晶圆代工服务

华力微紧密围绕市场需求，立足成熟技术节点与特色工艺平台，通过集中优势研发力量进行针对性攻关，持续深化与拓展其技术平台。通过多年不断地技术积累，现已涵盖逻辑与射频、嵌入式/独立式存储器、高压等多元化工艺平台。

1）逻辑与射频

华力微依托自身成熟的 55nm 逻辑工艺技术与量产经验，成功自主研发了 55nm 超低功耗工艺技术。该技术作为实现物联网与可穿戴设备芯片制造的关键，通过与国际领先的集成电路设计公司合作，重点优化了器件工作电压与漏电流控制，并开发出超高阈值电压器件，从而快速完成了工艺认证并实现量产出货。此项自主创新技术平台的建立，不仅助力华力微在超低功耗领域抢占市场先机，切入物联网与可穿戴设备市场，更以此为基点，向 40nm 技术节点延伸，成功开发了 40nm 低功耗逻辑平台及成套生产工艺。该平台采用超浅结、激光退火与多孔超低介电常数材料等先进技术，在性能与功耗之间实现优异平衡，并已进入量产阶段。平台不仅通过 Grade1 汽车电子级认证，助力公司获得 IATF16949 体系认证，更具备完善的设计环境，可支持丰富的单元库与 IP，多款产品已通过大规模量产验证，性能表现卓越。自 2015 年 3 月首批产品出货以来，华力微在汽车电子、数字电视、视频监控、蓝牙耳机等领域持续拓展，并于 2019 年实现射频工艺平台量产。

华力微依托 55nm 低功耗逻辑平台，像素工艺采用与客户合作开发的方式，2013 年成功打造了 55nmCIS 平台并成功导入首颗 CIS 手机类产品，2014 年起手机类产品开始规模量产。后续几年间华力微不断拓展 CIS 应用范围，成功开发了安监类、医疗类等产品。尤其是近 3 年，近红外监控、0.7 微米极小像素类等产品的开发和量产，使得华力微 CIS 应用进一步拓宽，范围涵盖旗舰手机前摄、PC、高端安防、指纹识别、车载等诸多领域。

2）嵌入式/独立式存储器

华力微基于自主开发的 55nm 低功耗平台，构建了 55nm 嵌入式闪存平台，通过引入 SONOS 工艺并优化 2T+SONOS 结构，显着提升了能效表现与工作灵活性，增强了系统兼容性并有效控制了成本。作为华力微的特色工艺，55nm 嵌入式闪存平台建立了完整的 SPICE 模型与 PDK，具备完善的设计数据库与 IP 资源，能够充分满足客户的多元化需求。相较于传统合封 MCU 方案，55nm 嵌入式闪存平台所实现的 MCU 类产品在工艺复杂度、成本结构及系统兼容性方面均表现出显着优势，具备更强的市场竞争力。目前，该平台主要聚焦于 MCU 类产品的工艺开发与性能提升，相关产品已广泛应用于消费电子、智能家居及工业控制等领域。

自 2017 年实现 55nmSONOS 存储技术大规模量产以来，华力微持续推进技术迭代，并于 2020 年成功突破 40nmSONOS 存储技术。55nmSONOS 技术具备低成本、低功耗与高可靠性等核心优势，产品覆盖低功耗存储、触控、高速 MCU、嵌入式 FPGA、智能卡、安全芯片及 NB-IOT 等多个领域，对我国实现信息安全和产业技术升级具有重要战略意义。

3）高压

华力微 55nm 高压工艺平台基于成熟的 55nm 低功耗平台构建，通过工艺流程架构的优化，成功集成了 1.2V 低压、5V/6V/8V 中压以及 32V 高压三类器件。这些器件在电气特性上相互独立，互不制约，可分别进行灵活调试，为不同系列产品的研发提供了充分的设计空间。该平台集成度高，能够全面满足液晶驱动芯片设计的多样化需求，性能达到业界领先水平。

基于此 55nm 高压平台，华力微成功开发了全国产 OLED 及其他全系列应用驱动芯片。通过与国内设计公司及知名面板厂商的紧密合作，华力微有效支持了本土设计企业的发展，共同构建了全系列驱动芯片完整产业链。依托驱动芯片市场的广阔前景以及华力微扎实的制造基础，该平台形成了具有自主知识产权的技术体系，可满足从低端到高端各类终端应用的需求，为“物联网”建设的持续推进提供了坚实支撑。

（2）配套服务

1）多元化设计服务

华力微建立了较为完善的设计服务支持平台，包括流片支持、内部 IP 设计、版图及验证、失效分析、测试设计等，能够为设计公司提供良好的设计流程、技术文件、IP 开发等必不可少的支持，为客户量产提供高效高质量的服务工作。

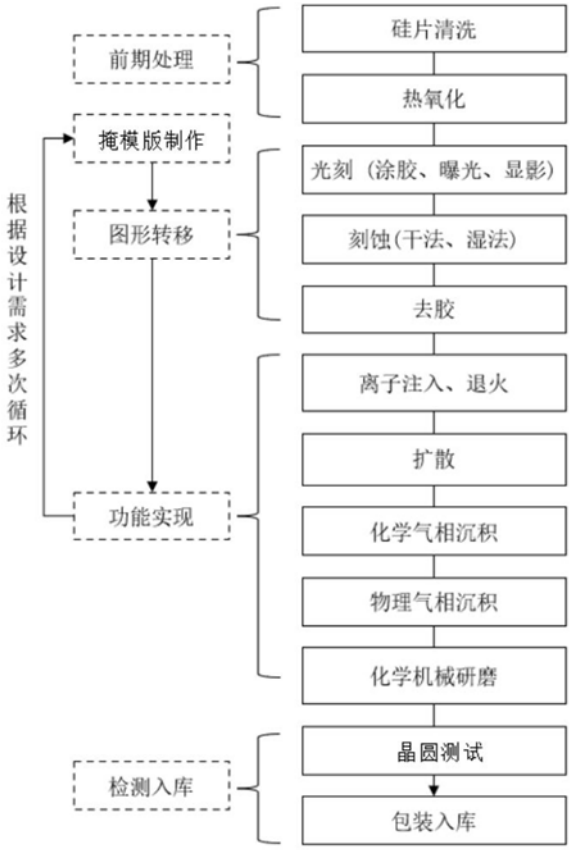
2）测试服务

华力微打造了一整套先进的测试、评估、分析平台，建设了涵盖产品工程、测试工程、可靠性工程、失效分析等精密设备硬件基础，为客户提供一站式设计验证、测试开发、电性物性分析、良率提升等配套服务。

（三）主要产品的工艺流程

1、主要产品工艺流程图

标的公司主要以晶圆代工模式从事半导体制造业务，一般性工艺流程如下：



2、工艺流程介绍

（1）前期处理

①硅片清洗

使用喷淋或沉浸的方式，先用多种化学品对半导体硅片进行清洗，再用超纯水对半导体硅片进行二次清洗去除残留的化学液。清洗工序的目的是去除半导体硅片表面的尘埃颗粒、残留有机物、表面金属离子等杂质，提高后续生长热氧化层的质量，保证后续工艺的稳定性（后续每步操作后亦有清洗工序）。

②热氧化

在高温氧气和惰性气体的环境下，在半导体硅片表面生成二氧化硅薄膜。

（2）掩模版制作

掩模版由其他专业厂商生产，标的公司当前不涉及掩模版制造业务。

（3）图形转移

①光刻

光刻主要由涂胶、曝光和显影三个步骤组成：A 涂胶：将光刻胶均匀地涂布在旋转的半导体硅片上；B 曝光：利用光刻机，通过特定波长的光线的照射，改变光刻胶的性质，将光掩模版上的电路图形转移到光刻胶上；C 显影：利用显影液，去除曝光后光刻胶中的可溶解部分，准确地使光刻胶上形成图形。

②刻蚀

刻蚀是在光刻后，有选择性地去除半导体硅片上未被光刻胶覆盖区域的材料。常见的刻蚀方法包括湿法刻蚀和干法刻蚀，其中：湿法刻蚀使用液态化学品进行刻蚀，干法刻蚀利用等离子体进行刻蚀。

③去胶

刻蚀完成后，去除半导体硅片上未被溶解的光刻胶。

（4）器件结构形成与功能实现

①离子注入、退火

在真空、低温的环境下，将特定种类的杂质离子以高能离子束的形式植入晶圆表面的特定区域，常见的离子元素种类包括硼、磷、砷等。离子注入后，在高温环境下消除离子注入导致的晶格缺陷，改变晶圆表面及内部的微观结构，以实现特定性能。

②扩散

在高温环境下，使杂质离子在不同离子浓度的区域间发生转移，改变和控制晶圆内杂质的类型、浓度和分布，形成不同电特性的区域，改变晶圆的电特性。

③化学气相沉积

利用不同分压的气态化学原材料在晶圆表面发生化学反应，并在晶圆表面沉积一层固态薄膜。

④物理气相沉积

利用溅射镀膜、真空蒸发、离子体镀膜、分子束外延等物理方法，轰击靶材，

在晶圆表面沉积一层固态薄膜。

⑤化学机械研磨

利用机械摩擦和化学反应对晶圆进行抛光，使晶圆表面平坦化。

（5）检测入库

①晶圆测试

晶圆加工完成后，使用探针等检测设备对晶圆性能进行测试，验证其功能是否符合工艺平台的规格要求。

②包装入库

将检测合格的晶圆真空包装后入库。

（四）主要经营模式、盈利模式和结算模式

1、采购模式

标的公司制定《采购审批制度》《采购管理规程》等制度规范采购行为，建立完善的采购管理体系和规程。标的公司采购活动，均按照年度预算的要求，由需求部门或主管部门根据实际的投资需求、运营需求，以请购单方式提出并经过审批，其中，生产用原材料和备件的请购由生产计划部物料控制科根据生产计划、库存量和交货期等提出。

生产计划部采购科收到请购需求后，核对请购单准确性，确认无误后依据采购需求开展采购活动。华力微根据不同采购类别确定恰当的采购方式和标准，依法开展招标采购活动与直接采购活动，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，达到科学、择优的采购目的，保证采购质量，提高经济效益，最大限度降低综合采购成本，所有采购行为均依据公司制度由相应的采购审批机构进行审批。

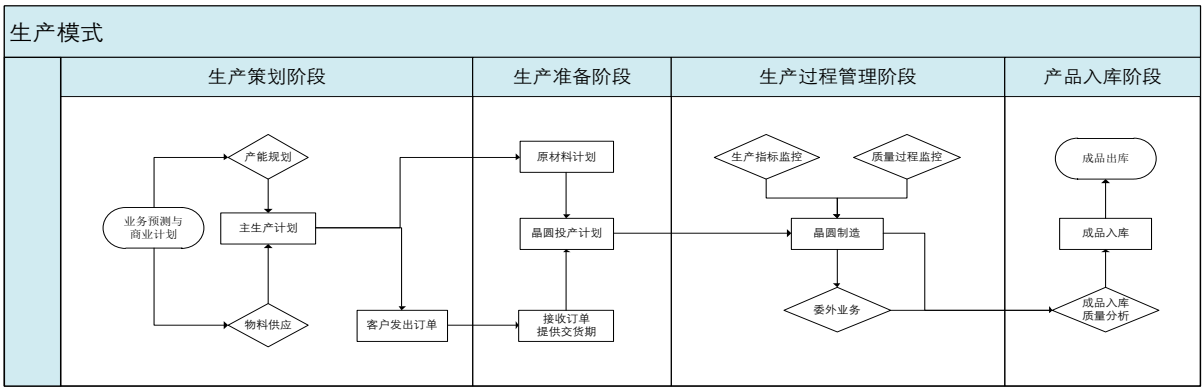
生产计划部采购科与供应商签署采购订单并跟踪交期，物流科负责运输、报关工作，仓储科负责来料的接收、存储工作，品质与可靠性部负责原材料的质量检验工作，固定资产、无形资产、服务等由用户部门进行检查、验收。各部门通力协作开展多元化、国产化工作，不断导入备选供应商，健全供应链体系，针对

关键物料的供应风险进行评估并制定相应对策，降低采购风险，以保持业务连续性。

2、生产模式

标的公司根据销售预测规划产能并确定主生产计划（即生产计划，依据市场预测与产能情况规划产品生产计划），按客户订单需求进行投产，产品从生产策划到成品出库主要经过四个阶段，分别为生产策划阶段、生产准备阶段、生产过程管理阶段以及产品入库阶段，具体流程如下：

（1）生产策划阶段



在生产策划阶段，销售部提供从客户处获取的未来的业务预测以及与客户达成的商业计划，生产计划部按照业务预测以及产能规划，根据客户需求、客户订单、产能、原材料供应情况和工艺技术准备情况，制定主生产计划。

（2）生产准备阶段

在生产准备阶段，物料控制科根据主生产计划制定原材料计划并协同采购及时准备原材料。生产计划部根据主生产计划及原材料计划制定投产计划。

（3）生产过程管理阶段

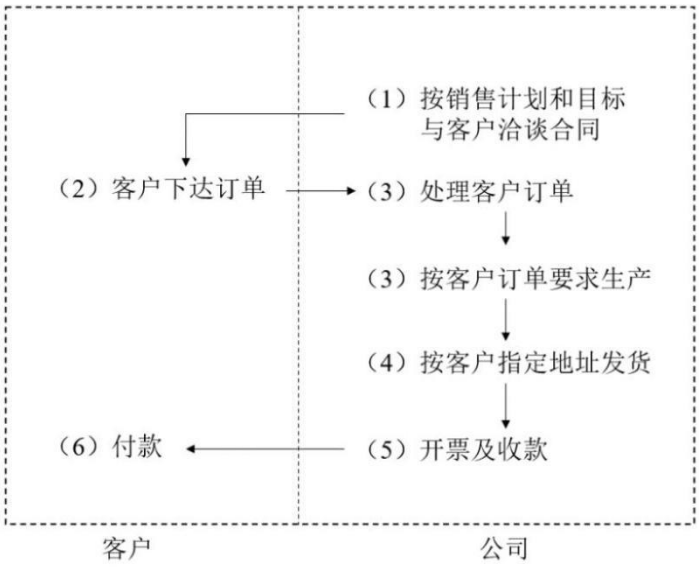
在生产过程管理阶段，制造部根据主生产计划及投产计划安排和管理晶圆生产，生产计划部监督生产周期、生产进度，产量等指标，品质与可靠性部负责产品的质量管控。生产计划部根据客户委外业务需求，安排晶圆相应委外业务。

（4）产品入库阶段

在产品入库阶段，完成全部生产流程的产品经检验合格后入库。

3、销售及结算模式

标的公司采用直销模式开展销售业务，与客户直接沟通并形成符合客户需求的解决方案，最终达成与客户签订订单。销售流程如下：



（1）制定销售计划

销售部门基于市场信息与客户需求拟订公司年度销售计划后，销售部门按照计划目标和客户沟通，并定期更新客户需求预测和情况，将客户需求的变化反馈回公司相关部门。

（2）签订合同和处理订单

与客户签订合同，达成业务关系后，销售人员根据客户需求将公司主管核准的报价单提供给客户，客户通过邮件或传真等方式向销售人员/客户服务人员下达订单，客户服务人员将订单下达到内部进行生产，并反馈预计交货时间给客户。

（3）生产制造

销售部门收到客户订单后按业务计划安排生产，生产计划部根据此业务计划结合产能情况制定相应的投入和产出计划并生成产品交货日期，公司根据客户的要求通过系统或邮件的方式及时告知客户产品的生产状态。

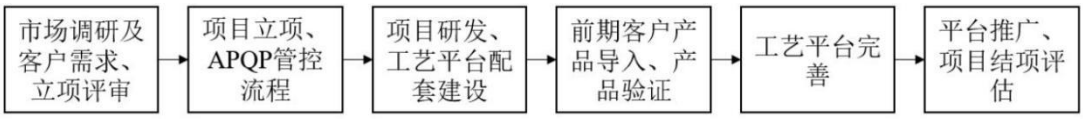
（4）发货与收款开票

产品生产完毕后通常由客户服务人员根据客户要求安排发货至指定地点或

客户上门提货。客户依据协议的付款周期安排付款，财务部在收到客户的付款后，进行财务复核并完成相关账务处理。

4、研发模式

标的公司的研发策略主要依靠自主研发对各类工艺平台进行技术创新与升级。公司为规范并加强项目运行过程的管理，建立了较为完善的研发体系及项目管理流程，明确项目组成员职责及目标，从项目的立项、研发及结案全过程进行规范，并通过新项目立项申请流程、产品质量先期策划规程等进行分阶段、系统性管理。公司的具体研发流程如下：



注：APQP 指 Advanced Product Quality Program，即产品质量先期策划。

5、盈利模式

公司主要从事基于不同工艺节点、不同技术的工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务从而实现收入和利润。

（五）主要产品生产及销售情况

1、主要产品的产能、产量、销量情况

报告期内，公司主要产品的产销情况如下：

单位：万片

项目	2025 年度	2024 年度
产能	**45.60**	45.60
产量	**46.82**	42.82
产能利用率	**102.68%**	93.89%
销量	**50.80**	47.94
产销率	**108.50%**	111.98%

注：产能、产量、销量按照 12 英寸统计，下同。

2、主要产品价格情况

报告期内，公司主要产品为晶圆，价格情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度
晶圆代工销售收入（万元）	486,616.87	427,226.82
销售数量（万片）	50.80	47.94
平均销售单价（元/片）	9,578.88	8,910.88

2025 年度销售单价较 2024 年度有所提升，主要系随着半导体市场逐步复苏，整体价格逐步调整上涨，2025 年度标的公司的平均销售价格相对较高。

3、主要产品及服务销售收入情况

报告期内，标的公司向客户提供多工艺平台的晶圆代工服务。标的公司按照工艺平台分类的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比
逻辑与射频	318,956.69	63.01%	276,767.85	61.79%
独立式非易失性存储器	82,205.81	16.24%	65,732.64	14.68%
高压	48,858.69	9.65%	52,954.99	11.82%
嵌入式非易失性存储器	36,595.69	7.23%	31,771.34	7.09%
其他	19,571.89	3.87%	20,685.64	4.62%
合计	506,188.77	100.00%	447,912.46	100.00%

4、报告期内前五大客户销售情况

报告期内，标的公司的前五大客户情况如下：

单位：万元

期间	序号	客户名称	销售收入	占营业收入比例
2025 年度	1	客户 A	123,973.29	24.30%
	2	客户 B	116,671.86	22.87%
	3	客户 C	87,497.76	17.15%
	4	客户 D	24,159.44	4.74%
	5	华虹集团	23,112.24	4.53%
	合计		375,414.59	73.59%
2024 年度	1	客户 A	127,858.15	25.63%

期间	序号	客户名称	销售收入	占营业收入比例
	2	客户 B	**91,370.45**	18.32%
	3	华虹集团	**77,183.93**	**15.47%**
	4	客户 C	74,730.06	14.98%
	5	客户 F	18,805.10	3.77%
	合计		**389,947.69**	**78.18%**

注：客户按最终控制方合并计算及列示。

报告期内，标的公司不存在向单个客户销售比例超过当年销售总额 50%的情况。

截至本报告书签署日，除受华虹集团控制的客户外，标的公司的董事、高级管理人员和核心技术人员、交易对方在上述客户中不存在持有 5%以上股份的情况。

（六）主要原材料、能源采购及供应情况

1、主要原材料采购情况

（1）主要材料采购情况

报告期内，标的公司生产经营所需的原材料主要包括硅片、化学品、气体、靶材等，主要原材料采购情况如下：

种类	项目	2025 年度	2024 年度
硅片	数量（万片）	**62.04**	44.85
	金额（万元）	**47,697.79**	37,765.22
	单价（元/片）	**768.85**	841.99
光刻类化学品	数量（L）	**1,144,682.15**	1,142,434.00
	金额（万元）	**31,435.96**	30,711.77
	单价（元/L）	**274.63**	268.83
化学品	数量（吨）	**14,299.73**	14,163.75
	金额（万元）	**17,166.45**	20,564.07
	单价（万元/吨）	**1.20**	1.45
研磨垫和研磨盘	数量（个）	**25,605.00**	30,603.00
	金额（万元）	**5,650.22**	8,685.62

种类	项目	2025 年度	2024 年度
	单价（万元/个）	**0.22**	0.28
大宗气体	数量（万立方米）	**13,254.82**	13,089.74
	金额（万元）	**7,490.96**	7,672.87
	单价（元/立方米）	**0.57**	0.59

注 1：列示的硅片为用于生产晶圆的硅片；

注 2：硅片、靶材单价按照 12 英寸统计。

（2）主要材料价格变动情况

报告期内，标的公司主要原材料和能源的平均采购价格的变动情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度
	平均采购单价	变动幅度	平均采购单价
硅片（元/片）	**768.85**	**-8.69%**	841.99
光刻类化学品（元/L）	**274.63**	**2.16%**	268.83
化学品（万元/吨）	**1.20**	**-17.24%**	1.45
研磨垫和研磨盘（万元/个）	**0.22**	**-21.43%**	0.28
大宗气体（元/立方米）	**0.57**	**-3.39%**	0.59

报告期内，标的公司硅片采购单价逐年下降，主要系上游供应商产能扩张，市场供应量增加，市场价格逐年下降。

光刻类化学品价格等原材料均属于较为常见的半导体材料，其价格随市场供需情况波动。

2、主要能源供应情况

报告期内，标的公司生产经营所需的能源主要为电、天然气和水：

种类	项目	2025 年度	2024 年度
电	数量（万度）	**26,239.11**	25,964.96
	金额（万元）	**16,441.46**	16,496.24
	单价（元/度）	**0.63**	0.64
天然气	数量（万立方米）	**387.18**	418.40
	金额（万元）	**1,606.18**	1,678.83

种类	项目	2025 年度	2024 年度
	单价（元/立方米）	**4.15**	4.01
水	数量（万吨）	**281.09**	280.48
	金额（万元）	**1,657.34**	1,653.77
	单价（元/吨）	**5.90**	5.90

报告期内，主要能源采购单价变动较小，**变动**系因市场价格波动所致。

3、报告期内前五大原材料及备品备件供应商采购情况

报告期内，标的公司前五大原材料及备品备件供应商情况如下：

单位：万元

序号	供应商	主要采购内容	金额	占比
2025 年度				
1	供应商 A	硅片、研磨液、光刻类化学品	**25,609.47**	**14.24%**
2	供应商 B	硅片	**18,602.30**	**10.35%**
3	供应商 C	光刻类化学品、研磨液、研磨垫和研磨盘	**12,230.93**	**6.80%**
4	供应商 D	硅片	**8,196.44**	**4.56%**
5	供应商 E	光刻类化学品、化学品等	**7,362.55**	**4.10%**
合计			**72,001.69**	**40.05%**
2024 年度				
1	供应商 A	硅片、研磨液、光刻类化学品	24,020.25	13.54%
2	供应商 C	光刻类化学品、研磨液、研磨垫和研磨盘	15,859.66	8.94%
3	供应商 B	硅片	14,965.19	8.44%
4	供应商 E	光刻类化学品、化学品等	8,417.91	4.75%
5	供应商 F	备品备件	7,616.96	4.30%
合计			**70,879.97**	**39.97%**

注：供应商按最终控制方合并计算并列示。

报告期内，标的公司不存在向单个供应商采购比例超过当年采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。

截至本报告书签署日，标的公司的董事、高级管理人员和核心技术人员、交易对方不存在控制上述供应商的情况。

（七）境外生产情况

报告期内，标的公司不存在在境外生产经营的情况。

（八）安全生产和环境保护情况

1、安全生产情况

报告期内，标的公司严格遵守国家有关安全生产方面的法律、法规、规章及其他规范性文件规定，建立并严格执行《华力安全生产责任制管理程序》《上海华力安全检查和隐患排查量化管理规程》《上海华力微电子有限公司生产安全事故应急救援综合预案》等制度。截至本报告书签署日，标的公司不存在因违反安全生产方面的法律、法规、规章及其他规范性文件规定而受到行政处罚的情形。未来，标的公司还将根据生产经营需要继续加大安全生产方面的投入。

2、环境保护情况

公司生产经营涉及的主要污染物包括废水、废气和固体废物。废水主要包括工艺设备产生的酸碱废水、含氟废水、含氨废水、有机废水、无机回收水、有机回收水、研废水、含铜废水，设备自带特气处理装置排水，工艺冷却水排水，空调洗净及冷凝水，纯水制备排水，循环冷却塔排水，酸性废气洗涤塔排水、碱性废气洗涤塔排水、酸性粉尘废气洗涤塔排水以及生活污水等；废气主要包括工艺酸性废气、碱性废气、有机废气、特殊气体工艺尾气、酸性粉尘废气、锅炉烟气、化学品供应废气、污水处理区废气等，固体废物主要包括危险废物、一般固废和生活垃圾。

报告期内，标的公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护的相关法律法规。标的公司已建立完善的环境保护内控管理制度，在生产环节已避免产品对环境的影响，在生产过程根据环保要求配置了相应的环保设施并采取了必要的控制措施。

标的公司主要废水处理设施包括一般废水处理系统有机废水处理系统、含氟

废水处理系统、高浓度含氨废水处理系统、低浓度含氨废水处理系统研磨废水处理系统、含铜废水处理系统、浓水回收系统、有机回收水系统、无机回收水系统等；主要废气处理设施包括酸性废气处理系统碱性废气处理系统、有机废气处理系统、特殊工艺废气处理系统、酸性粉尘废气处理系统等。对于固废，生活垃圾统一收集，暂存于单独设置的垃圾箱内，由环卫部门定期清运；危险废物，分类贮存于专用容器中，放置于独立的危险废物暂存间、废化学品空桶暂存区、专用废液储罐内，建立危险废物管理台账，及时委托有资质的危险废物经营单位进行处理处置，并严格执行转移联单制度；一般工业固废，放置于独立的一般固废暂存间内，委托具有资质的物资回收公司利用或由供应商定期回收。报告期内，上述环保设施、控制设施正常运行，生产过程中产生的废水、废气、噪声能够达到国家相关排放标准。

报告期内，标的公司不存在因违反安全和环境保护相关法律法规而被相关主管部门处以重大行政处罚的情形。公司生产经营符合国家和地方安全和环保要求。

（九）主要产品和服务的质量控制情况

1、质量控制标准

标的公司建立了完善的产品质量控制体系，已经通过的质量管理体系认证情况如下：

序号	认证标准	证书编号	有效期
1	IATF 16949:2016	209667-2016-AQ-RGC-IATF	2023-12-20 至 2026-12-19
2	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015	107019-2011-AQ-RGC-UKAS	2023-12-2 至 2026-12-1

2、质量控制措施

华力微根据 IATF 16949:2016、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 等质量管理体系相关要求制定了详细的质量控制制度，对产品生产和销售全过程实施严格的质量控制。华力微的控制措施覆盖了生产、采购、销售、研发等各个环节，涵盖了经营过程中的主要部门，通过多部门的有力协作和互相监督有效的确保了产品的质量控制。

3、质量纠纷情况

报告内，华力微持续优化各项流程，获得了客户的广泛认可，不存在因质量方面问题而导致重大纠纷或因质量方面的违法行为而受到过行政处罚的情形。

（十）核心技术及核心技术保护情况

1、主要产品生产技术阶段及使用核心技术情况

标的公司以自身发展战略与竞争优势为依托，经过长期技术积累与工艺迭代，在主要业务领域形成并掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术。标的公司核心技术来源主要通过自主研发，由自身研发团队进行研发与创新，对工艺流程及参数指标进行优化，形成了标的公司现有核心技术平台。

其中，标的公司在逻辑与射频、独立式/嵌入式非易失性存储器、高压等领域的多项核心技术达到国内领先或国际领先水平，并已大量应用于标的公司产品的批量生产中。

截至 2025 年 **12 月 31 日**，标的公司的主要核心技术平台情况如下：

序号	工艺平台	制程范围及核心技术平台	技术工艺特征及先进性表征	技术先进性	技术来源	生产阶段
1	逻辑与射频	55nm 和 40nm 低功耗逻辑与射频工艺、55nm 超低功耗工艺	标的公司与比利时微电子研发中心（IMEC）签订了 65nm 等 CMOS 芯片制造工艺联合开发与转移合作协议，以国际合作成果为基础，建立持续的技术开发和创新能力，自主研发 **55nm** 和 40nm 低功耗工艺、提供多样的工艺器件选择，满足不同应用产品的设计需求。射频工艺与逻辑工艺兼容，技术节点覆盖 55nm 和 40nm，具有金属氧化物金属电容器（MOM）、高 Q 电感以及噪声隔离深 N 阱结构等特色，可满足无线射频类芯片产品高灵敏度的需要。55nm 超低功耗工艺基于 55nm 低功耗工艺平台开发，核心工作电压降至 0.9V，功耗降低约 30%。	国内领先	自主研发	大批量生产
2		55nm 图像传感器芯片	标的公司具备全系列像素图像传感器工艺平台，像素尺寸覆盖 24 微米到 0.7 微米范围，像素分辨率覆盖 25 万到 5000 万像素范围，产品应用于智能手机，高端相机，安防监控，车载，医疗等多个领域	国内领先	自主研发	大批量生产
3	嵌入式非易失性存储器	SONOS 嵌入式非易失性存储器	与业界闪存技术合作方 Cypress 共同合作开发 55nmSONOS 嵌入式非易失性存储器工艺，在 CMOS 工艺上加入 4 张光罩，为客户提供集高可靠性、低功耗和低成本优势于一身的差异化解决方案。标的公司提供两种版本工艺：1.2V/2.5V 和 1.2V/5V，1.2V/2.5V 主要针对微型控制器和物联网产品，1.2V/5V 版本主要针对智能卡、金融卡、触控芯片等微控制器。	国际领先	自主研发	大批量生产
4	独立式非易失	独立式非易失性存储器	标的公司于 2016 年通过 SPI NOR Flash 产品验证，并进入大规模量产。65nmNOR Flash 已通过	国内领先	自主研发	大批量生产

序号	工艺平台	制程范围及核心技术平台	技术工艺特征及先进性表征	技术先进性	技术来源	生产阶段
	性存储器		IATF16949 认证。标的公司在 65nmNOR Flash 基础上，持续微缩尺寸，相继推出 55nm、50nm 以及 45nm 工艺技术并量产，45nmNOR flash 存储单元为当前全球最小			
5	高压	55nm 面板驱动芯片 55HV	55nm 高压工艺既有 32V 高压器件，又为 AMOLED 屏提供 8V 中压器件，为 LCD 屏提供 6V 中压器件，应用于主流的高分辨率的 DDIC 和 TDDI 需求，提供两种 SRAM cell 尺寸，满足智能手机、可穿戴设备等的应用差异需求	国内领先	自主研发	大批量生产

2、核心技术保护情况

（1）知识产权保护

标的公司为保护无形资产完整，明确科研成果归属，制定了知识产权管理的相关制度，建立了专利注册申请、商业秘密保护的多层次的知识产权管理体系。根据上述规定，对于通过标的公司职务工作形成的技术发明，以标的公司为主体向国家知识产权局申请注册专利，并对专利发明人发放奖金激励；如技术发明不适宜进行公开披露，由专利暨商秘评审委员会审议通过后可将其列为商业秘密保护。

（2）保密与竞业禁止制度

为确保职务作品归属，避免员工流动导致的技术秘密外泄，防范与员工之间的知识产权争议，标的公司与其主要技术人员在劳动合同、保密协议中约定相应保密及竞业条款，约束其对职务工作中形成的技术成果、商业信息负有保密责任。对于核心技术人员的离职情况将约定相应的提前通知期和竞业限制期限，离职人员在竞业限制期内不得设立、经营、参与任何与标的公司竞争的实体，不得在该等实体工作或提供服务、咨询等工作。

3、研发投入情况

（1）总体情况

报告期内，公司研发费用情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
研发费用	**24,495.07**	32,553.50
营业收入	**510,114.63**	498,797.09
研发费用占比	**4.80%**	**6.53%**
政府补助抵减的研发费用	**-1,398.10**	-1,292.30
政府补助抵减前的研发费用占比	**5.08%**	**6.79%**

公司坚持技术和产品的持续创新，报告期内始终保持较高的研发费用投入。报告期内分别为 32,553.50 万元和 **24,495.07** 万元，占各年营业收入的比例分别为 6.53%、**4.80%**。标的研发投入占营业收入比例逐年下降主要系标的公司前期已投入较多的研发工作，凭借持续的研发投入标的公司已经在成熟制程的基础上建立了较为完善的自有工艺平台，65/55nm、40nm 工艺已达到业界主流水平，因此研发投入逐年下降。

（2）研发费用构成

报告期内，公司研发费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	**11,689.55**	**47.72%**	13,168.36	40.45%
研究测试费用	**5,591.22**	**22.83%**	8,955.42	27.51%
折旧费用	**3,344.15**	**13.65%**	5,179.22	15.91%
摊销费用	**2,064.28**	**8.43%**	2,817.85	8.66%
维修维护费	**2,439.23**	**9.96%**	2,556.29	7.85%
燃料动力及水电费	**764.74**	**3.12%**	1,168.66	3.59%
政府补助抵减研发费用	**-1,398.10**	**-5.71%**	-1,292.30	-3.97%
合计	**24,495.07**	**100.00%**	**32,553.50**	**100.00%**

4、研发人员情况

标的公司建立了研发相关体系，辅以测试与外包、品质保证及工程验证等部门开展研发工作，并与制造与生产相关部门围绕制造工艺的各个环节展开配套衔

接，以保障公司从研发目标到实现工艺升级和晶圆制造的整个过程。

截至报告期末，标的公司拥有 **1,265** 名员工，其中包括 **134** 名研发技术人员，占员工总数比例为 10.60%。截至报告期末，标的公司共有 3 名核心技术人员。

（十一）核心技术人员情况

公司综合考虑员工职责、参与研发项目情况、在核心技术开发中所承担的角色与贡献程度等多方面因素，确定对公司发展有突出贡献、在公司主要产品研发中具有重要作用的员工为核心技术人员。

报告期内，标的公司核心技术人员稳定，未发生变动，共有 3 名核心技术人员，基本情况如下：

姓名	职务
王智	总裁
陈力钧	副厂长
孙昌	副厂长

上述核心技术人员的简历如下：

（1）王智

王智先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，工程师。王智先生曾任职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，2010 年加入上海华力微电子有限公司，现任上海华力微电子有限公司总裁（首席技术专家）。

（2）孙昌

孙昌先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。孙昌先生曾任职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、格罗方德半导体股份有限公司，2010 年加入上海华力微电子有限公司，现任上海华力微电子有限公司副厂长（首席技术专家）。

（3）陈力钧

陈力钧先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于

中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、联华电子（新加坡分公司）有限公司，2010 年加入上海华力微电子有限公司，现任上海华力微电子有限公司副厂长（首席技术专家）。

标的公司的核心技术人员均在半导体领域耕耘数十年，在不同的技术领域具有丰富的研发经验。其核心技术人员队伍稳定，其出色的研发能力保证了公司的市场敏锐度和科研水平，确保了公司的产品迭代能够紧跟行业发展趋势，亦满足客户终端产品的创新需求。在标的公司核心技术人员带领下，公司近几年先后取得上海市科学技术奖一等奖、中国专利优秀奖、国家企业技术中心、第三十四届上海市优秀发明选拔赛优秀创新金奖等诸多荣誉及奖项。

标的公司高度重视核心**技术人员**的激励。为打造稳定、高效、专业的研发团队，促进研发人员的科研创新热情，锁定核心员工，标的公司制定了一系列员工激励措施，以稳固公司的核心技术团队。

上述核心技术人员均与标的公司签署了劳动合同、保密与竞业限制合同。报告期内，标的公司核心技术人员队伍保持稳定，报告期内未发生变动。

七、标的公司主要财务数据

标的公司最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	**663,273.27**	625,889.26
负债总额	**437,230.13**	499,195.99
所有者权益	**226,043.14**	126,693.27
归属于母公司股东权益	**226,043.14**	126,693.27
项目	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	**510,114.63**	498,797.09
利润总额	**77,326.52**	52,152.40
净利润	**77,326.52**	52,152.40

八、本次交易已取得标的公司其他股东的同意，符合公司章程规定的股权转让前置条件

（一）公司章程规定的股权转让前置条件

标的公司现行有效的公司章程关于股权转让的约定中，涉及本次交易的相关内容如下：

“第三十五条 股东之间可以相互转让其全部或部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。”

（二）本次交易已取得标的公司股东的同意

标的公司已召开股东会，同意上市公司以发行股份的方式收购华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金所持有的华力微 97.4988%股权。

九、标的公司报告期会计政策及相关会计处理

（一）收入的确认原则和计量方法

1、收入确认的一般原则

标的公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中标的公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

标的公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，标的公司按照履约进度，

在一段时间内确认收入：（1）客户在标的公司履约的同时即取得并消耗标的公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制标的公司履约过程中在建的商品；（3）标的公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且标的公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，标的公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，标的公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度/投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，标的公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、收入确认的具体方法

（1）销售商品

标的公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品由客户签收或确认时商品的控制权转移，标的公司在该时点确认收入实现。

（2）提供服务

标的公司向客户提供的服务主要为测试服务等，在服务已完成，客户取得相关服务控制权时确认收入。

（二）标的公司会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异及对拟购买资产利润的影响

经查阅同行业上市公司年报等资料，标的公司主要会计政策和会计估计与同行业上市公司不存在重大差异，对标的公司利润无重大影响。

（三）模拟报表编制基础

1、模拟财务报表的编制基础

除下述事项外，标的公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，

在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制模拟财务报表。

（1）模拟华力微在本报告期内均已完成存续分立。华力微于 2025 年 8 月 21 日完成存续分立，华力微（分立前主体）分立为分立后的华力微（现存续主体）和新设主体。标的公司对 2025 年 8 月 21 日之前的报告期财务报表数据按照分立拆分原则，进行模拟拆分：即假设华力微于报告期初即已完成了存续分立，按照分立协议约定分立拆分原则完成财务数据的拆分。

（2）标的公司模拟于报告期期初即已执行华虹公司的会计估计及会计政策，并已作了追溯调整。

2、持续经营

标的公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3、记账基础和计价原则

标的公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）标的公司会计政策和会计估计与上市公司之间的差异及对拟购买资产利润的影响

标的公司的主要会计政策和会计估计与上市公司不存在重大差异。

（五）行业特殊的会计处理政策

标的公司所处行业不涉及行业特殊的会计处理政策。

第五节 本次交易发行股份情况

一、发行股份及购买资产

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，根据《公司条例》第 135 条，公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票无面值，上市地点为上交所。

（二）发行对象

本次发行股份购买资产的发行股份对象为华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金 4 名交易对方。

（三）发行股份数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量＝以发行股份形式向各交易对方购买标的资产对应的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量＝向各交易对方发行股份的数量之和。

向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足 1 股部分由上市公司现金补足。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份数量也随之进行调整。

本次交易中，华力微股权的最终交易价格为 826,790.22 万元，均以股份方式支付，不足 1 股部分，现金补足。按照本次发行股票价格 43.34 元/股计算，本次交易购买资产的股份发行数量为 190,768,392 股，向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号	交易对方	股份对价（万元）	股份数量（股）
1	华虹集团	538,855.12	124,332,053
2	上海集成电路基金	133,318.65	30,761,109
3	大基金二期	86,922.77	20,056,014
4	国投先导基金	67,693.68	15,619,216

序号	交易对方	股份对价（万元）	股份数量（股）
合计		826,790.22	190,768,392

本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。

（四）定价基准日和发行价格

1、定价基准日

本次发行股份的股票定价基准日为公司 2025 年第六次董事会决议公告日。

2、发行价格

根据《重组管理办法》，本次发行股份购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

经交易各方友好协商，本次发行价格为 43.34 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，则将对发行价格作相应调整。

（五）锁定期安排

交易对方通过本次交易取得上市公司股份的锁定期在严格遵守《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规的相关规定，以及中国证监会、上交所等证券监管机构要求的基础上，由上市公司与交易对方协商一致确定。具体股份锁定情况详见本报告书“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”之“（二）交易对方作出的重要承诺”。

本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则

办理。如前述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

（六）过渡期损益安排

本次交易评估基准日至标的资产交割日内标的资产在运营过程中产生的收益及亏损均由上市公司享有。

（七）滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

二、本次募集配套资金安排

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，根据《公司条例》第 135 条，公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票无面值，上市地点为上交所。

（二）发行对象及发行股份数量

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过 755,628.60 万元。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。

在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，上述发行股份数量将根据中国证监会及上交所颁布的规则作相应调整。

（三）发行股份的定价方式和价格

本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式，具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

（四）锁定期安排

本次募集配套资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，同时遵照上述锁定期进行锁定。如前述锁定期的安排与监管机构的最新监管要求不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

（五）募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于标的公司技术升级改造项目、特色工艺研发及产业化项目、补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。

本次募集资金具体用途如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
1	华力微技术升级改造项目	329,476.00	43.60%
2	华力微特色工艺研发及产业化项目	56,152.60	7.43%
3	补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用	370,000.00	48.97%

合计	**755,628.60**	**100.00%**

如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。本次募集配套资金到位前，上市公司可以根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（六）滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

（七）配套募集资金必要性分析

本次募集配套资金拟用于标的公司技术升级改造项目，特色工艺研发及产业化项目，补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。

其中，支付本次交易补充流动资金将有利于上市公司增加研发投入和营运资金，提高经营效率，增强经营能力，对公司发展战略的实施提供充分的资金支持。标的公司符合科创板定位，用于标的公司技术升级改造项目和特色工艺研发及产业化项目建设均系资金用于科技创新领域；特色工艺平台的丰富性是衡量半导体晶圆代工企业综合实力的重要考虑因素，标的公司亟需通过 12 英寸特色工艺技术升级改造项目和特色工艺研发及产业化项目提升相关工艺平台产品深度及广度，进一步提高公司核心竞争力以及抗风险能力；此外，为提升部分特色工艺平台的柔性制造能力，标的公司亟需优化现有工厂生产线、工艺程序、升级 12 英寸厂的部分老旧和产能瓶颈生产线设备，通过设备改造/替换提升产能利用率，将现有 12 英寸生产线全面升级，以满足多种特色工艺平台的柔性产能需求，进一步提高公司核心竞争力以及抗市场波动的风险能力。

综上所述，本次配套募集资金有利于缓解本次交易的资金支付压力、加大研发投入、提高经营效率、增强核心竞争力及提高抗风险能力，为上市公司未来发展提供资金支持。

（八）前次募集资金金额、使用情况及目前剩余情况

1、前次募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 6 日出具的《关于同意华虹半

导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,775.00 万股，每股发行价格为人民币 52.00 元，募集资金总额为 2,120,300.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 28,232.30 万元（含税）后，募集资金净额为 2,092,067.70 万元，上述资金于 2023 年 7 月 31 日已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“安永华明（2023）验字第 60985153_B02 号”《验资报告》。

2、前次募集资金使用情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，前次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资金额	累计投资金额	累计投入比例
1	华虹制造（无锡）项目	1,250,000.00	**1,236,651.71**	98.93%
2	8 英寸厂优化升级项目	200,000.00	**49,666.21**	**24.83%**
3	特色工艺技术创新研发项目	250,000.00	**97,606.37**	**39.04%**
4	补充流动资金	100,000.00	**100,045.30**	**100.05%**
5	超额募集资金	292,067.70	**-**	**-**
	合计	**2,092,067.70**	**1,483,969.59**	**70.93%**

注：补充流动资金截止报告期末累计投入金额超出该募集资金总额 **45.30** 万元，系募集资金专户产生的利息。

3、前次募集资金剩余情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，公司募投项目累计支出为 **1,483,969.59** 万元，募集资金账户余额为 **630,503.77** 万元。

第六节 标的资产评估作价基本情况

一、本次交易标的评估情况

（一）评估的基本情况

1、评估概况

本次交易中，标的资产的评估基准日为 2025 年 8 月 31 日，评估对象为华力微股东全部权益价值。标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果确定。

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 2446 号），以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日，评估机构采用资产基础法和市场法对华力微股东全部权益价值进行评估，并以市场法结果作为本次评估结论。截至评估基准日，华力微所有者权益账面值为 200,191.38 万元，股东全部权益价值为 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。

2、评估方法的选择

依据《资产评估执业准则—企业价值》，“执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、市场法、成本法（资产基础法）三种基本方法的适用性，选择评估方法。”“对于适合采用不同评估方法进行企业价值评估的，资产评估专业人员应当采用两种以上评估方法进行评估。”

资产基础法适用性分析：资产基础法的基本思路是按现行条件重建或重置被评估资产，潜在的投资者在决定投资某项资产时，所愿意支付的价格不会超过购建该项资产的现行购建成本。本评估项目能满足资产基础法评估所需的条件，即被评估资产处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态，具备可利用的历史经营资料。采用资产基础法可以满足本次评估的价值类型的要求。

市场法适用性分析：市场法的基本思路是通过与可比公司比较、修正来获取被评估单位市场价值。目前资本市场与被评估单位可比的上市公司满足数量条件，且披露信息相对充分，本次适合采用市场法评估。

收益法适用性分析：被评估单位系晶圆代工企业，晶圆代工行业受国际关系和宏观环境影响重大、行业周期性及不确定性较强、未来盈利情况难以可靠预测的情况。并且在当前国际半导体设备进口管制背景下，国内晶圆制造企业普遍依赖定期维护和部件更换等方式延长设备使用周期以维持生产连续性。然而，随着技术迭代加速、半导体设备国产化进程推进，以及老旧设备运维成本上升、经济性逐步下降等多重因素共同作用，华力微未来的设备维护与更新路径面临延续定期维护或是设备更替等多种情景，不同情景对应的设备清单、国产化比例及资本投入预算差异较大，因而存在较大不确定性。此类不确定性将导致企业未来的资本性支出计划与生产成本结构预测难度增大，相关风险也难以可靠量化。

收益法的适用前提是能够对企业未来收益及相关风险做出合理、可靠的预测。鉴于华力微在评估基准日时点所面临的上述设备更替与资本支出不确定性较高，管理层认为，在当前条件下对华力微未来年度的经营收益及风险无法形成具备合理依据的预测基础，因此本次评估不具备采用收益法的前提条件。

综上分析，本次评估确定采用资产基础法、市场法进行评估。

3、评估结果

（1）资产基础法评估结果

采用资产基础法对企业股东全部权益价值进行评估，得出被评估单位在评估基准日的评估结果如下：

评估基准日，被评估单位所有者权益账面值 200,191.38 万元，评估值 782,761.17 万元，评估增值 582,569.79 万元，增值率 291.01%。其中，总资产账面值 725,850.28 万元，评估值 1,306,836.22 万元，评估增值 580,985.94 万元，增值率 80.04%。总负债账面值 525,658.90 万元，评估值 524,075.05 万元，评估减值 1,583.85 万元，减值率 0.30%。

（2）市场法评估结果

采用市场法对企业股东全部权益价值进行评估，得出的评估基准日的评估结果如下：

被评估单位所有者权益账面值为 200,191.38 万元，评估值为 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。

（3）不同方法评估结果的差异分析

本次评估采用市场法得出的股东全部权益价值为 848,000.00 万元，比资产基础法测算得出的股东全部权益价值 782,761.17 万元高 65,238.83 万元。

不同评估方法的评估结果差异的原因主要是各种评估方法对资产价值考虑的角度不同，资产基础法是从企业各项资产现时重建的角度进行估算；市场法是从现时市场可比价格角度进行测算，导致各评估方法的评估结果存在差异。

（4）评估结论的选取

根据《资产评估执业准则—企业价值》，对同一评估对象采用多种评估方法时，应当结合评估目的、不同评估方法使用数据的质量和数量，采用定性或者定量的方式形成评估结论。

鉴于华力微属于晶圆加工产业，其主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含工艺路线、企业管理水平、人才技术团队、自创商誉等重要的无形资源的贡献。由于资产基础法的特性，其评估结果仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了价值评估，并不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的企业整体效应价值，对于被评估单位的工艺路线、企业管理水平、人才技术团队、自创商誉等重要的无形资源价值一般也难以在资产基础法中体现，资产基础法评估结果较市场法存在一定局限性。其次，市场法的数据采用可比上市公司的公开数据，近年来随着中国的股市日臻成熟，相对成熟的资本市场环境也提供了市场法定价的基础。

通过以上分析，我们选用市场法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论。经评估，被评估单位股东全部权益价值为人民币 8,480,000,000.00 元。大写：人民币捌拾肆亿捌仟万元整。

4、评估增值的主要原因

本次评估采用市场法的评估结论，正是基于采用市场法评估结论的原因，该公司拥有企业账面值上未反映的工艺路线、企业管理水平、人才技术团队、自创商誉等重要的无形资源价值，因此采用市场法**的评估价值**比账面值增值较大。

（二）评估假设

1、基本假设

（1）交易假设

交易假设是假定所有评估资产已经处在交易的过程中，资产评估师根据评估资产的交易条件等模拟市场进行价值评估。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

（2）公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

（3）企业持续经营假设

企业持续经营假设是假设被评估单位在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，其经营状况不会发生重大不利变化。

（4）资产按现有用途使用假设

资产按现有用途使用假设是指假设资产将按当前的使用用途持续使用。首先假定被评估范围内资产正处于使用状态，其次假定按目前的用途和使用方式还将继续使用下去，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件。

2、一般假设

（1）本次评估假设评估基准日后国家现行有关法律、宏观经济、金融以及

产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。

（2）本次评估没有考虑被评估单位及其资产将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对其评估结论的影响。

（3）假设被评估单位所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。

（4）被评估单位现在及将来的经营业务合法合规，并且符合其营业执照、公司章程的相关约定。

3、市场法评估特别假设

（1）假设被评估单位严格遵循企业会计准则及其相关规定，评估基准日及历史各期财务数据均真实、可靠；

（2）假设所选可比上市公司披露的财务与经营数据真实、可靠；

（3）除特殊说明外，假设资本市场的交易行为均基于公开、公平、自愿及公允的原则；

（4）未考虑遇有自然力及其他不可抗力因素的影响，也未考虑特殊交易方式可能对评估结论产生的影响。

（5）未考虑将来可能承担的抵押、担保事宜。

（三）资产基础法评估情况

1、货币资金

货币资金账面价值 3,003,522,065.14 元，包括现金、银行存款和其他货币资金。

（1）现金

现金存放在华力微财务室内，对于人民币现金按照账面值确定评估值，对于外币现金根据原币金额结合基准日相应外币汇率确认评估值。

（2）银行存款

银行存款为存放于各家银行的存款，分别按人民币账户和外币账户确认评估值，对人民币账户以核实后的账面值确认为评估值，对外币账户，在核实原币金额的基础上，按评估基准日汇率计算确认评估值。

（3）其他货币资金

其他货币资金系定期保证金和应收利息，以核实后的账面值确认评估值。

货币资金评估值为 3,003,522,065.14 元。

2、应收票据

应收票据账面价值 242,000.00 元，系企业因销售商品而收到的票据，以核实后的账面值确认评估值。

应收票据评估值为 242,000.00 元。

3、应收账款

应收账款账面价值 623,982,305.77 元，核算内容为货款。

在对应收账款核实无误的基础上，按照账龄分析法，估计出评估风险损失作为扣除额后，按预计可能收回的数额确定评估值。原坏账准备评估为零。

应收账款评估值为 623,982,305.85 元。

4、预付账款

预付账款账面价值 1,567,964.74 元，系预付的保险费、材料款等。

对于人民币款项以核实后的账面值确认评估值；对外币款项，在核实原币金额的基础上，按评估基准日汇率计算确认评估值。

预付账款评估值为 1,567,242.43 元。

5、其他应收款

其他应收款账面价值 395,760.58 元，系代收服务费、押金等。

在对其他应收款核实无误的基础上，评估人员进行了款项性质分析，其他应收款基本为关联单位的代收服务费、押金等款项，坏账的可能性很小，本次按照账面值确定评估值。

其他应收款评估值为 395,760.58 元。

6、存货

存货账面余额 1,400,621,922.38 元，已计提跌价准备 23,439,416.93 元，账面净额 1,377,182,505.45 元，包括原材料、在产品和产成品。

（1）原材料

原材料账面价值 695,209,853.26 元，主要为硅片、晶圆、化学原料等。

原材料根据清查核实后的数量乘以现行市场购买价，再加上合理的运杂费、损耗、验收整理入库费及其他合理费用确定评估值。被评估单位原材料采用实际成本核算，账面价值包括购置价及其他合理费用。对于价格变动较大的原材料，以评估基准日近期的市场价格并考虑合理费用作为评估值；对于价格变动不大的原材料，以核实后的账面值作为评估值。

原材料评估值为 695,209,853.26 元。

（2）产成品

产成品账面余额 274,336,075.41 元，计提跌价准备 23,439,416.93 元，系企业生产对外销售的芯片等产品。

产成品根据企业提供不含税售价，结合产品的销售费用、营业利润情况，按照正常产成品进行评估。

正常产品的评估值＝产成品数量×不含增值税销售单价－销售费用－销售税金及附加－所得税－部分净利润

＝产成品数量×不含税的销售单价×[1－销售费用率－销售税金及附加率－销售利润率×所得税税率－销售利润率×（1－所得税税率）×净利润折减率]

原账面计提的产成品跌价准备评估为零。

产成品评估值为 328,942,095.28 元。

（3）在产品

在产品账面价值 431,075,993.71 元，为在生产过程中的晶圆。

正常在产品根据企业提供不含税售价，结合产品的销售费用、营业利润情况，参考在产品的完工进度进行评估。

正常在产品的评估值=产成品数量×不含税的销售单价×产品完工进度×[1－销售费用率－销售税金及附加率－销售利润率×所得税税率－销售利润率×（1－所得税税率）×净利润折减率]

各项参数选取同产成品。

在产品评估值为 592,741,742.10 元。

综上，存货评估值为 1,616,893,690.64 元。

7、一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产账面价值 5,358,247.40 元，系一年内到期的长期应收款，以核实后的账面值确定评估值。

一年内到期的非流动资产评估值为 5,358,247.40 元。

8、其他流动资产

其他流动资产账面价值 9,846,229.24 元，系预提的增值税留抵税额，本次经过核实涉及无形资产的定价依据确认账面金额属实，本次按账面值评估。

其他流动资产评估值为 9,846,229.24 元。

9、长期应收款

长期应收款账面价值 63,624,638.57 元，系华力微长期出租设备的租赁收入，以核实后的账面值确认评估值。

长期应收款评估值为 63,624,638.57 元。

10、固定资产

（1）评估范围

纳入本次评估范围的设备类资产包括机器设备、运输设备和电子及其他设备。华力微拥有的账面记录的设备 28,122 台（套），按其不同用途分为机器、车辆、电子设备及其他设备三类。

1）机器设备 2,756 台（套），主要有：半导体器件加工专用设备等集成电路科研生产设备及其配套设施，以及安保系统、变配电设备、纯水废水废液系统、公用动力设备、化学品输运系统、洁净室系统及一般机电系统、特气系统、消防系统等配套系统，集成电路科研生产设备及其配套设施均为企业自行采购，经安装调试完成验收后投入使用，分布于净化车间，运行状况良好；配套系统主要分布于辅助生产楼。

2）车辆 2 辆，为别克商务车、本田奥德赛混合动力多用途乘用车各 1 辆。

3）电子设备及其他设备 25,364 台（套），主要有：光罩盒、叉车、磁盘列阵等网络设备、成像仪等仪器设备、办公家具、空调、投影仪、复印机、电视机、冰箱、电脑等，主要分布于辅助生产楼和各职能部门。

上述设备中 20,234 台（套）设备账面原值为零值，主要包括：机器设备 138 台（套），电子设备及其他设备 20,096 台（套）。账面原值为零值的原因包括供应商无偿赠送、因模拟报表口径变化原因调整部分资产一次性费用化处理，以及采用政府补助净额法核算等原因。

（2）评估方法

1）评估方法的选择

根据评估人员对企业设备资产进行了解后，由于该企业的设备除车辆外所涉及的设备市场交易面不活跃，难以获取可比的案例，故不适合采用市场法评估；委估设备系整体用于企业经营，不具有单独获利能力，或获利能力无法量化，故不适合采用收益法评估；企业设备资产资料较为完整，市场价格信息渠道较为丰富，各类贬值因素能较为可靠的计量，具备采用成本法评估的条件。

结合本次评估目的、经济行为以及价值类型，本次对设备资产主要采用成本法评估，对市场交易面较活跃的车辆采用市场法评估。

2）成本法介绍

成本法评估计算公式为：

评估值＝重置全价－实体性贬值－功能性贬值－经济性贬值

＝重置全价×综合成新率

①重置全价的确认

A、进口设备重置全价的确认

重置全价＝CIF 价×外汇中间价＋关税额＋增值税额＋外贸手续费＋银行财务费＋运杂费＋基础费＋安装调试费＋其他合理费用－可抵扣增值税额

B、国产设备重置全价的确认

重置全价＝重置现价＋运杂费＋基础费＋安装调试费＋其他合理费用－可抵扣增值税额

②综合成新率的确认

A、价值量较大的重点、关键设备成新率的确定

在年限法理论成新率的基础上，再结合各类因素进行调整，最终合理确定设备的综合成新率，计算公式：

综合成新率＝理论成新率×调整系数 K

其中：

理论成新率＝尚可使用年限÷（已使用年限＋尚可使用年限）×100%

调整系数 K＝K1×K2×K3×K4×K5 等，即：

综合成新率＝理论成新率×K1×K2×K3×K4×K5

各类调整因素主要为设备的原始制造质量、维护保养（包括大修理等）情况、设备的运行状态及故障频率、设备的利用率、设备的环境状况等。

尚可使用年限依据设备的实际运行状态确定。

B、价值量较小的一般设备及电子类设备成新率的确定

对于价值量较小的一般电子及其他设备，直接采用年限法确定成新率。

3）市场法介绍

对市场交易面较活跃的车辆采用市场法评估。

市场比较法是根据替代原理，将评估对象与在近期发生交易的类似车辆加以比较对照，从已发生交易的类似车辆的交易价格，通过交易日期、交易情况、个别因素等的修正，修正得到评估对象价值的一种评估方法，车辆市场法计算公式如下：

车辆市场价值＝可比交易实例不含税价×交易日期修正系数×交易情况修正系数×个别因素修正系数

关于车辆牌照费的确定：为加强上海市机动车总量控制，规范非营业性客车额度管理，根据上海市人民政府关于沪府发〔2016〕37 号《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》，非营业性客车额度是指通过拍卖方式取得，允许在本市中心城区通行的个人自用、单位公务等之需的非营业性客车上牌指标，包括个人客车额度和单位客车额度。

由于运用了拍卖这一市场化手段配置，从而使得上海客车牌照商品化，所以目前上海客车牌照除沪 C 和新能源客车外，单位公务之需的非营业性“沪”字客车牌照均需通过拍卖方式取得，根据目前我国牌照管理现状，近年陆续有广州、杭州、深圳、天津等牌照通过拍卖方式取得，以对其城市机动车进行总量控制，所以客车牌照市场价值客观存在。

综上所述，本次对上海非沪 C 客车、非新能源客车牌照的评估中，拟参照市场行情，考虑单位公务之需的非营业性客车牌照的价值。

车辆牌照费按上海国际商品拍卖有限公司公布的评估基准日当月上海市单位非营业性客车额度拍卖成交均价评估。

车辆牌照费不计成新率，直接加计入评估值中。

（3）评估结果

纳入本次评估范围的设备类资产评估结果概况如下表所示：

单位：元

设备名称	账面净值	评估净值	增值额	增值率%
机器设备	1,475,417,151.78	5,501,963,223.00	4,026,546,071.22	272.91
车辆	283,460.04	649,332.00	365,871.96	129.07
电子设备	34,177,178.98	83,123,022.00	48,945,843.02	143.21
合计	**1,509,877,790.80**	**5,585,735,577.00**	**4,075,857,786.20**	**269.95**

本次评估增值原因如下：

1）由于企业财务对设备类资产计提折旧较快，评估依据设备的经济寿命结合设备的实际状况确定成新率，比较客观地反映了设备的实际价值，二者有差异，致使评估增值，其次，企业目前共有 20,234 台（套）设备账面原值为零值，主要包括：机器设备 138 台（套），电子设备及其他设备 20,096 台（套）。账面原值为零值的原因包括供应商无偿赠送、采购后一次性费用化处理，以及采用政府补助净额法核算等原因，本次将上述设备纳入评估范围。

2）车辆账面价值中不包含车辆牌照费用，评估过程中将牌照的市场价值纳入评估范围，致使评估增值。

11、在建工程

（1）评估范围

在建工程-设备安装工程账面价值 137,406,487.45 元，为物理气相沉积氮化钽、铜薄膜设备、高覆盖率多晶硅成膜设备、技术授权及 IP 共享服务平台建造项目等，共 111 项。

（2）评估方法

根据本次在建工程—设备安装工程中的设备状况，评估方法阐述如下：

评估值＝设备费评估值＋安装费及其他评估值＋资金成本评估值

资金成本评估值＝在建工程含税重置价×贷款年利率×资金占用周期/2

对于账面金额在 50 万元以下的设备安装工程，由于金额较小，本次不再计算资金成本。

（3）评估结果

在建工程—设备安装工程账面值 137,406,487.45 元，评估值 138,164,520.65 元，增值 758,033.20 元，增值率 0.55%，本次评估考虑了自有资金投入的资金成本致使评估增值。

12、使用权资产

使用权资产账面值 381,184,687.24 元，系承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，以核实后账面值确定评估值。

使用权资产评估值为 381,184,687.24 元。

13、无形资产—其他无形资产

（1）评估范围

无形资产—其他无形资产账面原值 511,322,687.50 元，账面净值 129,892,439.12 元，主要为用于企业生产经营、日常管理和研发的软件、IP 和 License。

此外，华力微拥有账面未记录的无形资产共 2777 项，包括 2477 项专利（其中 2043 项已授权，434 项在实质审查阶段）和 10 项集成电路布图。

（2）评估方法

1）外购软件、IP：该类账面无形资产近年来价格变动幅度较小，虽在会计记账角度已计提摊销，实际仍可无限期使用，本次按照评估基准日的市场价格确定评估值。

2）License：该类账面无形资产近年来价格变动幅度较小，且账面已根据其许可使用年限进行摊销，在核实受益期和受益额无误的基础上按尚存受益期确定评估值。

3）专利及集成电路布图：根据形成无形资产的全部投入，考虑无形资产价值与成本的相关程度，通过计算其合理的成本、利润和相关税费后确定其重置成本，并考虑其贬值因素后得到评估对象无形资产市场价值。计算公式为：

评估值＝重置成本×（1－贬值率）

（3）评估结果

无形资产—其他无形资产的评估值为 1,623,460,317.71 元。

14、长期待摊费用

长期待摊费用账面价值 5,261,059.99 元，系厂房的装修费用摊销，以核实后的账面值确认评估值。

长期待摊费用评估值为 5,261,059.99 元。

15、其他非流动资产

其他非流动资产账面价值 9,158,613.76 元，系预付的设备款和房租。对于人民币款项以核实后的账面值确认评估值，对外币款项根据原币金额结合基准日相应外币汇率确认评估值。

其他非流动资产评估值为 9,123,906.56 元。

16、应付账款

应付账款账面值 739,718,274.62 元，主要系应付的材料款项、服务费等。对于人民币款项以核实后的账面值确认评估值；对外币款项，在核实原币金额的基础上，按评估基准日汇率计算确认评估值。

应付账款评估值为 739,718,275.18 元。

17、合同负债

合同负债账面值 122,937,129.98 元，系企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。对于人民币款项以核实后的账面值确认评估值；对外币款项，在核实原币金额的基础上，按评估基准日汇率计算确认评估值。

合同负债评估值为 123,208,639.40 元。

18、应付职工薪酬

应付职工薪酬账面值 6,380,958.76 元，主要系应付职工的保险费用，以核实后账面值确认评估值。

应付职工薪酬评估值为 6,380,958.76 元。

19、应交税费

应交税费账面值 7,712,047.55 元，主要系个人所得税、印花税和进口关税，以核实后的账面值确认评估值。

应交税费评估值为 7,712,047.55 元。

20、其他应付款

其他应付款账面值 112,634,872.55 元，主要系应付设备款、工程款、暂估职工奖金、服务费等，以核实后的账面值确认评估值。

其他应付款评估值为 112,634,872.55 元。

21、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债账面值 1,039,071,751.37 元，系一年内到期的借款、一年内到期的租赁负债和截止基准日应支付的借款利息，以核实后账面值确认评估值。

一年内到期的非流动负债评估值为 1,039,071,751.37 元。

22、其他流动负债

其他流动负债账面值 12,624,885.19 元，系与合同负债相应的销项税款，以核实后的账面值确认评估值。

其他流动负债评估值为 12,624,885.19 元。

23、长期借款

长期借款账面值 2,897,337,500.00 元，系向银行借入的长期借款，以核实后的账面值确认评估值。

长期借款评估值为 2,897,337,500.00 元。

24、租赁负债

租赁负债账面值 300,806,837.99 元，系承租人在租入资产确认使用权资产的同时确认的租赁负债，等于按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值，以核实后账面值确认评估值。

租赁负债评估值为 300,806,837.99 元。

25、预计负债

预计负债账面值 1,254,766.58 元，系企业计提的使用权资产到期后进行拆除内装并恢复原样的费用，以核实后的账面值确认评估值。

预计负债评估值为 1,254,766.58 元。

26、递延收益

递延收益账面值 16,110,000.00 元，主要系课题补助及项目补助等。

经清查，对于递延收益中的款项，华力微相关义务已完成，该补助未来无需归还，故本次评估为零。公司自成立之日起至今处于累计亏损状态，递延收益所涉及企业实际所得税率为零，故本次评估对相关递延收益评估为零而产生的递延所得税负债评估为零。

递延收益评估值为 0.00 元。

27、资产基础法评估结论

采用资产基础法对企业股东全部权益价值进行评估，得出被评估单位在评估基准日的评估结果如下：

评估基准日，被评估单位所有者权益账面值 200,191.38 万元，评估值 782,761.17 万元，评估增值 582,569.79 万元，增值率 291.01%。其中，总资产账面值 725,850.28 万元，评估值 1,306,836.22 万元，评估增值 580,985.94 万元，增值率 80.04%。总负债账面值 525,658.90 万元，评估值 524,075.05 万元，评估减值 1,583.85 万元，减值率 0.30%。

资产基础法评估结果汇总如下表所示：

单位：万元

项　　目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	502,209.71	526,180.75	23,971.04	4.77
非流动资产	223,640.57	780,655.47	557,014.90	249.07
长期应收款	6,362.46	6,362.46	0.00	0.00
固定资产	150,987.78	558,573.56	407,585.78	269.95
在建工程	13,740.65	13,816.45	75.80	0.55
使用权资产	38,118.47	38,118.47	0.00	0.00
无形资产	12,989.24	162,346.03	149,356.79	1,149.85
长期待摊费用	526.11	526.11	0.00	0.00
其他非流动资产	915.86	912.39	-3.47	-0.38
资产总计	**725,850.28**	**1,306,836.22**	**580,985.94**	**80.04**
流动负债	204,107.99	204,135.14	27.15	0.01
非流动负债	321,550.91	319,939.91	-1,611.00	-0.50
负债总计	**525,658.90**	**524,075.05**	**-1,583.85**	**-0.30**
所有者权益（净资产）	**200,191.38**	**782,761.17**	**582,569.79**	**291.01**

（四）市场法评估情况

1、市场法应用简介

（1）市场法定义

市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较以确定评估对象价值的评估方法。市场法实质是利用活跃交易市场上已成交的类似案例的交易信息或合理的报价数据，通过对比分析的途径确定委估企业或股权价值的一种评估技术。

市场法中常用的两种方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。上市公司比较法中的可比企业应当是公开市场上正常交易的上市公司，评估结论应当考虑流动性对评估对象价值的影响。

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具

体方法。运用交易案例比较法时，应当考虑评估对象与交易案例的差异因素对价值的影响。

（2）市场法特点

1）评估数据直接来源于市场，评估过程简单、直观；

2）评估方法以市场为导向，评估结果说服力强。

（3）市场法适用前提条件

1）必须有一个充分发展、活跃的资本市场；

2）存在三个及三个以上相同或类似的可比企业，可比企业应当与被评估企业属于同一行业，或者受相同经济因素的影响；

3）可比企业与被评估企业的价值影响因素明确，可以量化，相关资料可以搜集。

（4）市场法评估假设

1）假设被评估单位严格遵循企业会计准则及其相关规定，评估基准日及历史各期财务数据均真实、可靠；

2）假设所选可比上市公司披露的财务与经营数据真实、可靠；

3）除特殊说明外，假设资本市场的交易行为均基于公开、公平、自愿及公允的原则；

4）未考虑遇有自然力及其他不可抗力因素的影响，也未考虑特殊交易方式可能对评估结论产生的影响；

5）未考虑将来可能承担的抵押、担保事宜。

（5）市场法评估模型

1）上市公司比较法

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

2）交易案例比较法

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

鉴于 A 股资本市场可收集到至少三个与评估对象同行业的可比上市公司，且可以充分可靠的获取可比公司的经营和财务数据，本次选择上市公司比较法。

2、评估技术思路

本次上市公司比较法的基本评估思路如下：

（1）确定可比参照企业

由于被评估单位是一家非上市公司，其股权不具备公开交易流通市场，因此不能直接确定其市场价值。我们采用在国内上市公司中选用可比企业，可比企业的筛选过程如下：

1）根据被评估单位所在的行业、主要经营模式及产品类型进行初步筛选，筛选标准为：

①截至评估基准日至少有两年的上市历史，以避免市场信息不够充分及 IPO 效应、市场预期等因素造成的股价波动影响。

②与被评估单位同属于半导体制造或晶圆代工行业，主要经营模式为大规模投资、高资本支出及技术工艺持续投入的 IDM 或 Foundry 模式，且产品应用领域相似。

③评估基准日近期股票正常交易，未处于停牌等非正常交易状态，或未因基准日近期发生并购重组交易而使得股票价格异常波动。

④鉴于 ST 股票较可能因市场中的投机、炒作等因素使得股票价格较大程度偏离其实际价值，故将 ST 股票剔除出可比公司范围。

本次评估人员筛选与被评估单位同属于所属申银万国行业分类--电子--半导体--分立器件、集成电路制造的上市公司，共计 25 家上市公司，结合上述筛选标准进行筛选，具体如下所示：

证券代码	证券名称	上市日期	筛选过程
688249.SH	**晶合集成**	**2023-05-05**	**主要为 Foundry 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
688347.SH	华虹公司	2023-08-07	基准日近期存在停牌等非正常交易状态，剔除
688396.SH	**华润微**	**2020-02-27**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
688469.SH	芯联集成	2023-05-10	基准日近期发生并购重组，剔除
688691.SH	灿芯股份	2024-04-11	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688981.SH	中芯国际	2020-07-16	主要为 Foundry 模式，工艺制程存在较大差异，剔除
300456.SZ	赛微电子	2015-05-14	主要为 Foundry 模式，产品应用领域存在差异，剔除
600360.SH	*ST 华微	2001-03-16	ST 股票，股票价格较大程度偏离其实际价值，剔除
600460.SH	**士兰微**	**2003-03-11**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
600745.SH	闻泰科技	1996-08-28	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
603290.SH	斯达半导	2020-02-04	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
605111.SH	新洁能	2020-09-28	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688048.SH	长光华芯	2022-04-01	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
688167.SH	炬光科技	2021-12-24	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
688172.SH	**燕东微**	**2022-12-16**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
688230.SH	芯导科技	2021-12-01	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688261.SH	东微半导	2022-02-10	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688498.SH	源杰科技	2022-12-21	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
688689.SH	银河微电	2021-01-27	主要为半导体封测，经营模式差异较大，剔除
688693.SH	锴威特	2023-08-18	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688711.SH	宏微科技	2021-09-01	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
300046.SZ	台基股份	2010-01-20	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
300373.SZ	**扬杰科技**	**2014-01-23**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
300623.SZ	**捷捷微电**	**2017-03-14**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
300831.SZ	派瑞股份	2020-05-07	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除

初步筛选后，符合上述参照标准的公司概况如下表所示：

证券代码	证券名称	公司简介	主营业务构成
688249.SH	晶合集成	合肥晶合集成电路股份有限公司的主营业务是 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司的主要产品是 DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic。	集成电路晶圆制造代工：98.5703%；其他业务：1.4020%；其他：0.0277%
688396.SH	华润微	华润微电子有限公司的主营业务是功率半导体、智能传感器与智能控制等领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司的主要产品是 MOSFET、IGBT、功率二	产品与方案：50.9277%；制造与服务：46.3278%；其他业务：2.7445%

证券代码	证券名称	公司简介	主营业务构成
		极管、物联网应用专用 IC、功率 IC、光电耦合及传感、SiC、GaN。	
600460.SH	士兰微	杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件（LED 芯片和成品，SiC、GaN 功率器件）产品。	分立器件产品：48.4601%；集成电路：36.5858%；发光二极管产品：6.8476%；其他业务：4.4177%；其他：3.6887%
688172.SH	燕东微	北京燕东微电子股份有限公司的主营业务是产品与方案和制造与服务两类业务。公司的主要产品是产品与方案、制造与服务。	产品与方案：47.1756%；制造与服务：43.9067%；其他：5.7855%；其他业务：3.1323%
300373.SZ	扬杰科技	扬州扬杰电子科技股份有限公司的主营业务是功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试研发、生产、销售。公司的主要产品是半导体器件、半导体芯片、半导体硅片。	半导体器件：86.2474%；半导体芯片：8.3270%；半导体硅片：3.0766%；其他业务收入：2.3490%
300623.SZ	捷捷微电	江苏捷捷微电子股份有限公司的主营业务是功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售。公司的主要产品是晶闸管系列、防护器件系列、二极管系列、MOSFET 系列、IGBT 系列、厚模组件、碳化硅器件、其他。	功率半导体器件：66.9693%；功率半导体芯片：31.0471%；其他业务收入：1.3637%；功率器件封测：0.6199%

2）鉴于被评估单位是一家独立的晶圆代工厂，若可比上市公司的业务规模小于被评估单位且差距较大，则其可比性将相应减弱。此外，考虑到被评估单位在评估基准日的固定资产账面价值已基本计提完折旧，且其主要生产经营场所均来源于租赁，未拥有自有厂房及土地，本次筛选过程中选取设备类固定资产账面原值规模可比的样本。

经计算各公司设备类固定资产账面原值具体如下：

单位：亿元

证券代码	证券名称	设备类固定资产账面原值
688249.SH	晶合集成	373.37
688396.SH	华润微	208.96
600460.SH	士兰微	114.24
688172.SH	燕东微	67.74

证券代码	证券名称	设备类固定资产账面原值
300373.SZ	扬杰科技	47.07
300623.SZ	捷捷微电	54.72
被评估单位	**华力微**	**153.59**

最终筛选确定的可比上市公司概况如下表所示：

证券代码	证券名称	上市日期	公司简介	主营业务
688249.SH	晶合集成	2023-05-05	合肥晶合集成电路股份有限公司的主营业务是 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司的主要产品是 DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic。	12 英寸晶圆代工业务。
688396.SH	华润微	2020-02-27	华润微电子有限公司的主营业务是功率半导体、智能传感器与智能控制等领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司的主要产品是 MOSFET、IGBT、功率二极管、物联网应用专用 IC、功率 IC、光电耦合及传感、SiC、GaN。	芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营。
600460.SH	士兰微	2003-03-11	杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件（LED 芯片和成品，SiC、GaN 功率器件）产品。	电子元器件的研发、生产和销售。

（2）对被评估单位和可比参照企业的差异进行必要的调整

利用从公开、合法渠道获得的可比参照企业经营业务和财务各项信息，与被评估单位的实际情况进行比较、分析，并做必要的差异调整。

（3）选择确定价值比率

1）价值比率选择

价值比率通常包括资产价值比率、盈利价值比率、收入价值比率和其他特定价值比率，根据被评估单位所属行业特征、所处经营阶段等因素，在其中选择适用的价值比率，并计算各可比上市公司的价值比率。在选择过程中充分考虑了下

述因素：选择的价值比率有利于合理确定评估对象的价值；计算价值比率的数据口径及计算方式一致；应用价值比率时尽可能对可比参照企业和被评估单位间的差异进行合理调整。本次价值比率选取如下：

①资产价值比率

如市净率（P/B）、企业价值与总资产比率（EV/TBVIC）等。由于截止基准日被评估单位的主要固定资产账面净值率较低，导致基准日的净资产和总资产金额处于企业生命周期中的相对低位。相比之下，所选可比上市公司的平均净值率约为 50%，两者在资产基础上存在较大差异。尽管净资产和总资产受行业周期性波动的影响相对有限，但其数值在企业生命周期的不同阶段往往呈现显著差别。被评估单位当前的低净值状态反映了其资产已多年累计折旧、账面价值较低的现实，若此时采用 P/B 或 EV/TBVIC 等基于账面价值的价值比率进行评估，容易导致评估结果失真。因此本次评估未采用资产价值比率。

②盈利价值比率

如市盈率（P/E）、企业价值与息税前利润比率（EV/EBIT）、企业价值与息税折旧摊销前利润比率（EV/EBITDA）等。被评估单位作为一家晶圆代工企业，具有资本投入高、回报周期长的典型特征，在扣除高额折旧与摊销费用后，常于净利润及息税前利润（EBIT）层面呈现暂时性亏损或利润水平偏低的现象。此情况会导致市盈率（P/E）及企业价值与息税前利润比率（EV/EBIT）等价值比率失真。因此，上述价值比率不适用于本次评估。相比之下，企业价值与息税折旧摊销前利润比率（EV/EBITDA）通过将折旧摊销加回，消除了高资本支出特征对利润率的影响，更能公允地衡量被评估单位的持续盈利能力。因此本次评估采用企业价值与息税折旧摊销前利润比率（EV/EBITDA）。

③收入价值比率

如市销率（P/S）、企业价值与营业收入比率（EV/S）等。收入价值比率隐含的估值逻辑是企业的核心价值与其销售收入规模之间存在直接、稳定的线性关系。然而，对于晶圆代工企业而言，其核心价值主要取决于技术工艺等要素，最终综合体现为企业的持续盈利能力。盈利价值比率与晶圆代工行业的估值逻辑更为契合，因此，本次评估未采用收入价值比率。

2）相关性测试

评估人员对所选取的三家可比公司，以企业价值（EV）为因变量、息税折旧摊销前利润（EBITDA）为自变量，进行了 EV/EBITDA 价值比率的线性回归分析，相关分析结果如下表所示：

检验指标	EV/EBITDA
R	0.9461
R 方	0.8951

经相关性测试，EV/EBITDA 的 R 方较高，一般认为 R 方在 0.7 到 0.9 之间具有较高的拟合，意味着息税折旧摊销前利润与企业价值存在较强的正相关关系，故本次评估宜采用 EV/EBITDA 作为价值比率。

（4）确定评估结论

在调整并计算可比企业的价值比率后，结合被评估单位相应的财务数据或指标，计算得出被评估单位的企业价值，并通过对被评估单位的非经营性资产、负债和溢余资产价值进行调整，最终得到被评估单位股东全部权益价值。

（5）对流动性及控制权的考虑

本次市场法评估采用上市公司比较法，由于选取的可比公司为上市公司，而被评估单位为非上市公司，评估中考虑了流动性对评估对象价值的影响。

由于暂无针对中国市场的比较可靠且能让市场参与者均予认可的控制权溢价率或缺乏控制权折价率权威统计数据，本次市场法评估未考虑控制权对评估对象价值的影响。

3、市场法计算公式

企业价值与息税折旧摊销前利润比率（EV/EBITDA）

股东全部权益价值＝经营性企业价值（不含货币资金）－付息债务－少数股东权益＋非经营性资产、负债＋货币资金

经营性企业价值（不含货币资金）＝被评估单位息税折旧摊销前利润×被评估单位 EV/EBITDA

其中，被评估单位 EV/EBITDA＝修正后可比公司 EV/EBITDA 的加权平均值

＝Σ 可比公司 EV/EBITDA×可比公司 EV/EBITDA 修正系数×权重

可比公司 EV/EBITDA 修正系数＝∏影响因素 Ai 的调整系数

影响因素 Ai 的调整系数＝被评估单位系数/可比公司系数

4、市场法评估过程

（1）可比企业的选择

由于被评估单位是一家非上市公司，其股权不具备公开交易流通市场，因此不能直接确定其市场价值。我们采用在国内上市公司中选用可比企业，可比企业的筛选过程如下：

1）根据被评估单位所在的行业、主要经营模式及产品类型进行初步筛选，筛选标准为：

①截至评估基准日至少有两年的上市历史，以避免市场信息不够充分及 IPO 效应、市场预期等因素造成的股价波动影响。

②与被评估单位同属于半导体制造或晶圆代工行业，主要经营模式为大规模投资、高资本支出及技术工艺持续投入的 IDM 或 Foundry 模式，且产品应用领域相似。

③评估基准日近期股票正常交易，未处于停牌等非正常交易状态，或未因基准日近期发生并购重组交易而使得股票价格异常波动。

④鉴于 ST 股票较可能因市场中的投机、炒作等因素使得股票价格较大程度偏离其实际价值，故将 ST 股票剔除出可比公司范围。

本次评估人员筛选与被评估单位同属于所属申银万国行业分类--电子--半导体--分立器件、集成电路制造的上市公司，共计 25 家上市公司，结合上述筛选标准进行筛选，具体如下所示：

证券代码	证券名称	上市日期	筛选过程
688249.SH	**晶合集成**	**2023-05-05**	**主要为 Foundry 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
688347.SH	华虹公司	2023-08-07	基准日近期存在停牌等非正常交易状态，剔除
688396.SH	**华润微**	**2020-02-27**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
688469.SH	芯联集成	2023-05-10	基准日近期发生并购重组，剔除
688691.SH	灿芯股份	2024-04-11	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688981.SH	中芯国际	2020-07-16	主要为 Foundry 模式，工艺制程存在较大差异，剔除
300456.SZ	赛微电子	2015-05-14	主要为 Foundry 模式，产品应用领域存在差异，剔除
600360.SH	*ST 华微	2001-03-16	ST 股票，股票价格较大程度偏离其实际价值，剔除
600460.SH	**士兰微**	**2003-03-11**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
600745.SH	闻泰科技	1996-08-28	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
603290.SH	斯达半导	2020-02-04	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
605111.SH	新洁能	2020-09-28	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688048.SH	长光华芯	2022-04-01	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
688167.SH	炬光科技	2021-12-24	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
688172.SH	**燕东微**	**2022-12-16**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
688230.SH	芯导科技	2021-12-01	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688261.SH	东微半导	2022-02-10	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688498.SH	源杰科技	2022-12-21	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
688689.SH	银河微电	2021-01-27	主要为半导体封测，经营模式差异较大，剔除
688693.SH	锴威特	2023-08-18	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688711.SH	宏微科技	2021-09-01	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
300046.SZ	台基股份	2010-01-20	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
300373.SZ	**扬杰科技**	**2014-01-23**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
300623.SZ	**捷捷微电**	**2017-03-14**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
300831.SZ	派瑞股份	2020-05-07	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除

初步筛选后，符合上述参照标准的公司概况如下表所示：

证券代码	证券名称	公司简介	主营业务构成
688249.SH	晶合集成	合肥晶合集成电路股份有限公司的主营业务是 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司的主要产品是 DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic。	集成电路晶圆制造代工：98.5703%；其他业务：1.4020%；其他：0.0277%

证券代码	证券名称	公司简介	主营业务构成
688396.SH	华润微	华润微电子有限公司的主营业务是功率半导体、智能传感器与智能控制等领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司的主要产品是 MOSFET、IGBT、功率二极管、物联网应用专用 IC、功率 IC、光电耦合及传感、SiC、GaN。	产品与方案：50.9277%；制造与服务：46.3278%；其他业务：2.7445%
600460.SH	士兰微	杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件（LED 芯片和成品，SiC、GaN 功率器件）产品。	分立器件产品：48.4601%；集成电路：36.5858%；发光二极管产品：6.8476%；其他业务：4.4177%；其他：3.6887%
688172.SH	燕东微	北京燕东微电子股份有限公司的主营业务是产品与方案和制造与服务两类业务。公司的主要产品是产品与方案、制造与服务。	产品与方案：47.1756%；制造与服务：43.9067%；其他：5.7855%；其他业务：3.1323%
300373.SZ	扬杰科技	扬州扬杰电子科技股份有限公司的主营业务是功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试研发、生产、销售。公司的主要产品是半导体器件、半导体芯片、半导体硅片。	半导体器件：86.2474%；半导体芯片：8.3270%；半导体硅片：3.0766%；其他业务收入：2.3490%
300623.SZ	捷捷微电	江苏捷捷微电子股份有限公司的主营业务是功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售。公司的主要产品是晶闸管系列、防护器件系列、二极管系列、MOSFET 系列、IGBT 系列、厚模组件、碳化硅器件、其他。	功率半导体器件：66.9693%；功率半导体芯片：31.0471%；其他业务收入：1.3637%；功率器件封测：0.6199%

2）鉴于被评估单位是一家独立的晶圆代工厂，若可比上市公司的业务规模小于被评估单位且差距较大，则其可比性将相应减弱。此外，考虑到被评估单位在评估基准日的固定资产账面价值已基本计提完折旧，且其主要生产经营场所均来源于租赁，未拥有自有厂房及土地，本次筛选过程中选取设备类固定资产账面原值规模可比的样本。

经计算各公司设备类固定资产账面原值具体如下：

单位：亿元

证券代码	证券名称	设备类固定资产账面原值
688249.SH	晶合集成	373.37
688396.SH	华润微	208.96
600460.SH	士兰微	114.24
688172.SH	燕东微	67.74
300373.SZ	扬杰科技	47.07
300623.SZ	捷捷微电	54.72
被评估单位	**华力微**	**153.59**

最终筛选确定的可比上市公司概况如下表所示：

证券代码	证券名称	上市日期	公司简介	主营业务
688249.SH	晶合集成	2023-05-05	合肥晶合集成电路股份有限公司的主营业务是 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司的主要产品是 DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic。	12 英寸晶圆代工业务。
688396.SH	华润微	2020-02-27	华润微电子有限公司的主营业务是功率半导体、智能传感器与智能控制等领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司的主要产品是 MOSFET、IGBT、功率二极管、物联网应用专用 IC、功率 IC、光电耦合及传感、SiC、GaN。	芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营。
600460.SH	士兰微	2003-03-11	杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件（LED 芯片和成品，SiC、GaN 功率器件）产品。	电子元器件的研发、生产和销售。

（2）可比企业财务概况

可比企业一：士兰微（600460.SH）

公司全称：杭州士兰微电子股份有限公司

1）资产负债表（合并报表）

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
流动资产：			
货币资金	613,122.98	452,033.46	444,510.01
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	244,610.00	303,671.42	327,813.76
应收款项融资	93,839.37	151,269.10	192,637.98
预付款项	4,152.76	3,582.99	3,654.47
其他应收款合计	2,552.38	2,253.64	2,387.59
合同资产	0.00	0.00	0.00
存货	373,203.41	389,894.30	378,229.34
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,720.00	960.00	1,200.00
其他流动资产	15,329.26	31,437.47	13,912.33
流动资产合计	1,348,530.16	1,335,102.39	1,364,345.47
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	3,610.00	2,650.00	1,750.00
长期股权投资	67,830.28	127,834.49	147,654.84
其他权益工具投资	2,250.71	2,226.29	2,380.90
其他非流动金融资产	56,623.79	43,886.84	41,555.06
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	643,080.08	687,001.45	686,726.42
在建工程合计	149,717.00	180,666.10	207,442.93
使用权资产	1,221.08	763.74	839.25
无形资产	47,186.51	36,951.98	31,462.31
开发支出	2,619.90	4,872.77	9,382.82
商誉	24,535.99	24,507.00	24,507.00
长期待摊费用	10,177.79	7,209.44	6,702.13
递延所得税资产	10,736.87	15,788.13	14,577.91
其他非流动资产	22,638.42	10,236.49	11,561.12

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
非流动资产合计	1,042,228.41	1,144,594.71	1,186,542.71
资产总计	2,390,758.57	2,479,697.11	2,550,888.18
流动负债：			
短期借款	181,056.81	149,163.93	161,461.23
交易性金融负债	111.63	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	217,922.27	310,155.65	315,075.33
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	2,409.47	2,526.23	2,390.84
应付职工薪酬	38,896.57	41,966.48	29,584.98
应交税费	11,017.49	9,956.03	11,030.06
其他应付款合计	6,981.88	7,593.75	9,987.80
一年内到期的非流动负债	105,257.17	196,825.01	192,653.20
其他流动负债	227.62	295.63	160.50
流动负债合计	563,880.92	718,482.72	722,343.95
非流动负债：			
长期借款	343,094.60	260,300.26	347,305.44
应付债券	0.00	0.00	0.00
租赁负债	784.06	504.01	490.86
长期应付款合计	26,741.41	12,047.05	5,408.06
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	10,714.38	5,843.59	4,736.08
递延收益-非流动负债	11,857.93	13,584.62	15,085.78
其他非流动负债	91,684.17	86,576.66	89,016.44
非流动负债合计	484,876.54	378,856.18	462,042.65
负债合计	1,048,757.47	1,097,338.90	1,184,386.59
所有者权益(或股东权益)：			
归属于母公司所有者权益合计	1,202,160.63	1,221,478.52	1,230,102.77
少数股东权益	139,840.48	160,879.69	136,398.81

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
所有者权益合计	1,342,001.10	1,382,358.20	1,366,501.59

2）利润表（合并报表）

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
一、营业总收入	933,953.80	1,122,086.90	633,576.61
二、营业总成本	898,089.78	1,100,739.99	597,538.91
营业成本	726,479.50	907,870.61	504,223.06
税金及附加	3,829.74	5,271.47	2,532.51
销售费用	16,685.01	17,877.47	8,593.39
管理费用	37,866.14	46,075.83	23,036.89
研发费用	86,377.31	103,448.04	47,820.57
财务费用	26,852.08	20,196.56	11,332.50
公允价值变动收益	-61,282.20	-13,625.32	-2,331.78
投资收益	21,622.84	-775.48	-2,841.70
净敞口套期收益	0.00	0.00	0.00
汇兑收益	0.00	0.00	0.00
资产处置收益	1,108.96	-274.65	60.88
资产减值损失	9,387.11	30,833.39	20,329.81
信用减值损失	2,459.33	4,554.64	2,825.29
其他收益	9,655.22	18,643.15	8,592.32
三、营业利润	-4,877.60	-10,073.42	16,362.31
加：营业外收入	116.34	445.96	185.88
减：营业外支出	926.56	1,097.17	128.36
四、利润总额	-5,687.81	-10,724.63	16,419.83
减：所得税费用	767.95	-8,338.44	3,136.22
五、净利润	-6,455.76	-2,386.19	13,283.62
减：少数股东损益	-2,877.19	-24,372.98	-13,196.15
归属于母公司所有者的净利润	-3,578.58	21,986.78	26,479.77

上述数据摘自于士兰微历史定期报告。

可比企业二：晶合集成（688249.SH）

公司全称：合肥晶合集成电路股份有限公司

1）资产负债表（合并报表）

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
流动资产：			
货币资金	652,622.76	582,775.72	310,395.47
交易性金融资产	154,842.49	106,612.55	157,389.87
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	85,720.04	99,257.58	95,632.97
应收款项融资	377.71	13.07	258.65
预付款项	8,439.72	3,750.70	3,354.56
其他应收款合计	2,571.80	5,245.43	4,170.25
合同资产	0.00	0.00	0.00
存货	149,268.54	150,332.06	164,554.75
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	3,180.48	6,360.97
其他流动资产	140,689.44	23,219.06	41,381.92
流动资产合计	1,194,532.50	974,386.65	783,499.39
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	10,000.00	17,711.10	27,354.45
其他权益工具投资	10,366.92	13,424.43	17,444.90
其他非流动金融资产	30,653.50	60,738.86	50,616.15
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	2,287,260.63	2,479,217.17	2,671,579.01
在建工程合计	1,095,959.78	1,322,186.48	1,334,338.64
使用权资产	355.91	85.70	0.00
无形资产	135,802.02	131,341.88	137,113.98
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	8.87	0.00	0.00

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	50,687.84	40,765.67	98,702.02
非流动资产合计	3,621,095.46	4,065,471.30	4,337,149.12
资产总计	4,815,627.96	5,039,857.94	5,120,648.52
流动负债：			
短期借款	65,834.90	129,114.81	67,937.17
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	799,976.35	219,372.58	271,923.94
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	87,737.18	64,851.59	28,811.36
应付职工薪酬	11,638.49	17,094.28	21,061.78
应交税费	9,478.67	9,544.18	7,800.98
其他应付款合计	284,185.04	147,583.25	114,429.79
一年内到期的非流动负债	140,334.36	150,494.10	171,357.91
其他流动负债	2,475.00	4,521.77	6,656.28
流动负债合计	1,401,659.99	742,576.55	689,979.22
非流动负债：			
长期借款	1,151,003.04	1,558,942.96	1,669,458.48
应付债券	0.00	79,988.88	99,991.02
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款合计	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	977.20	700.83	1,225.90
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
递延收益-非流动负债	48,171.21	48,751.98	45,663.14
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	1,200,151.45	1,688,384.65	1,816,338.54
负债合计	2,601,811.44	2,430,961.20	2,506,317.76
所有者权益(或股东权益)：			

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
归属于母公司所有者权益合计	2,140,980.47	2,087,031.10	2,102,478.03
少数股东权益	72,836.05	521,865.65	511,852.73
所有者权益合计	2,213,816.52	2,608,896.75	2,614,330.76

2）利润表（合并报表）

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
一、营业总收入	724,354.14	924,925.23	519,845.47
二、营业总成本	724,299.13	889,949.83	497,180.83
营业成本	567,817.38	689,047.20	385,910.05
税金及附加	3,186.36	3,232.45	1,957.68
销售费用	5,019.63	5,483.66	2,817.30
管理费用	27,119.33	34,063.15	18,333.08
研发费用	105,751.18	128,397.52	69,482.02
财务费用	15,405.24	29,725.86	18,680.70
公允价值变动收益	1,133.40	771.60	997.75
投资收益	7,319.44	4,118.22	1,357.56
净敞口套期收益	0.00	0.00	0.00
汇兑收益	0.00	0.00	0.00
资产处置收益	2.34	0.07	0.00
资产减值损失	8,108.60	2,404.05	6,205.87
信用减值损失	-10.61	-174.97	13.74
其他收益	11,145.40	10,560.26	4,244.29
三、营业利润	11,557.58	48,196.47	23,044.63
加：营业外收入	601.39	217.73	160.07
减：营业外支出	224.93	168.25	0.00
四、利润总额	11,934.04	48,245.94	23,204.70
减：所得税费用	17.56	26.31	4.74
五、净利润	11,916.48	48,219.63	23,199.96
减：少数股东损益	-9,246.44	-5,064.43	-10,012.92
归属于母公司所有者的净利润	21,162.91	53,284.06	33,212.88

上述数据摘自于晶合集成历史定期报告。

可比企业三：华润微（688396.SH）

公司全称：华润微电子有限公司

1）资产负债表（合并报表）

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
流动资产：			
货币资金	1,173,652.79	868,294.30	893,689.13
交易性金融资产	6,200.08	2,978.39	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	155,442.95	185,302.92	209,681.80
应收款项融资	67,164.99	54,183.15	74,844.21
预付款项	6,302.52	5,474.46	6,939.98
其他应收款合计	1,803.39	319.26	701.31
合同资产	0.00	0.00	0.00
存货	196,574.29	209,642.48	213,370.04
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	3,587.57	8,808.96	9,479.90
流动资产合计	1,610,728.57	1,335,003.92	1,408,706.38
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	392,166.99	601,169.18	574,644.09
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	50,227.69	44,054.32	44,310.49
投资性房地产	279.81	3,840.81	3,757.76
固定资产合计	654,105.14	775,116.93	750,960.71
在建工程合计	76,476.36	34,865.18	43,587.64
使用权资产	10,417.80	8,342.90	7,683.92
无形资产	36,062.04	36,594.23	35,465.17
开发支出	0.00	0.00	0.00

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
商誉	18,532.66	52,543.54	52,543.54
长期待摊费用	3,094.94	3,848.03	2,728.98
递延所得税资产	9,781.77	10,316.94	10,396.03
其他非流动资产	59,652.22	4,986.99	19,209.26
非流动资产合计	1,310,797.41	1,575,679.04	1,545,287.61
资产总计	2,921,525.98	2,910,682.95	2,953,993.99
流动负债：			
短期借款	2,244.42	3,382.05	4,779.00
交易性金融负债	0.00	8,167.02	8,167.02
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	118,231.87	132,429.98	139,053.35
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	17,420.67	17,797.24	22,956.91
应付职工薪酬	57,776.56	56,308.37	45,534.33
应交税费	7,930.70	6,589.45	8,899.89
其他应付款合计	203,009.22	173,668.21	173,964.37
一年内到期的非流动负债	6,530.00	2,426.67	2,143.53
其他流动负债	13,645.44	12,535.73	13,611.27
流动负债合计	426,788.86	413,304.71	419,109.68
非流动负债：			
长期借款	90,665.96	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
租赁负债	7,728.96	6,422.44	6,032.96
长期应付款合计	0.00	0.00	48.20
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	1,455.59	2,177.20	2,056.48
递延所得税负债	9,510.27	7,394.97	7,261.25
递延收益-非流动负债	21,927.62	35,137.56	39,047.92
其他非流动负债	403.81	16,650.77	16,337.67
非流动负债合计	131,692.20	67,782.93	70,784.48
负债合计	558,481.06	481,087.65	489,894.17

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
所有者权益(或股东权益)：			
归属于母公司所有者权益合计	2,155,805.67	2,230,621.31	2,270,626.79
少数股东权益	207,239.24	198,974.00	193,473.03
所有者权益合计	2,363,044.92	2,429,595.31	2,464,099.82

2）利润表（合并报表）

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
一、营业总收入	990,060.39	1,011,852.58	521,817.88
二、营业总成本	852,588.28	917,504.73	471,978.20
营业成本	671,021.63	736,683.88	387,973.12
税金及附加	8,406.13	8,350.37	4,802.85
销售费用	16,717.28	15,819.09	7,965.26
管理费用	65,511.45	52,316.06	26,337.17
研发费用	115,411.23	116,711.32	54,794.38
财务费用	-24,479.45	-12,375.99	-9,894.58
公允价值变动收益	-698.23	-2,846.35	256.17
投资收益	8,574.85	-38,259.80	-23,155.15
净敞口套期收益	0.00	0.00	0.00
汇兑收益	0.00	0.00	0.00
资产处置收益	-494.02	-409.44	20.29
资产减值损失	2,553.45	7,423.00	2,147.16
信用减值损失	783.83	-136.26	85.41
其他收益	25,169.91	33,114.56	10,730.37
三、营业利润	166,687.33	78,660.07	35,458.78
加：营业外收入	2,256.61	986.55	251.26
减：营业外支出	267.85	183.12	18.60
四、利润总额	168,676.08	79,463.50	35,691.43
减：所得税费用	24,861.52	13,293.21	7,791.06
五、净利润	143,814.56	66,170.29	27,900.37
减：少数股东损益	-4,112.01	-10,075.70	-5,979.16

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
归属于母公司所有者的净利润	147,926.57	76,245.99	33,879.53

上述数据摘自于华润微历史定期报告。

（3）规范被评估单位和可比公司的财务报表

对于任何一个企业，其资产负债表可能既包括经营性资产、负债，又包括非经营性资产、负债和溢余资产；其利润表可能既包括与经营性资产相关的营业收入和支出，又包括与非经营性资产、负债和溢余资产相关的收入和支出。评估专业人员在用于市场法进行企业价值评估时，由于非经营收入和支出，非经营性资产、负债和溢余资产及其相关的收入和支出的影响，可能导致基于财务报表计算的价值比率不具有可比性，因此，本次评估运用市场法进行企业价值评估时，按照统一口径对可比对象和被评估企业财务报表中的非经营性资产、负债和溢余资产及其相关的收入和支出进行剥离，然后在最终的评估结果中加回非经营性资产、负债及溢余资产的价值。

有鉴于可比企业的非经营性资产和非经营性损益，无法像委估企业一样通过详细尽调获得，考虑到数据的可获得性，我们本次对非经营性资产和非经常性损益主要限定在以下会计科目：

1）非经营性资产（负债）

非经营性资产主要包括交易性金融资产、衍生金融资产、持有待售资产、债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产等会计科目，上述科目的全部金额一般都作为非经处理。

非经营性负债主要包括交易性金融负债、衍生金融负债、递延收益等会计科目，上述科目的全部金额一般都作为非经处理。

受制于数据的可获得性，非经营性资产和负债的评估值均等于账面值。

2）非经常性损益

调整后的经营性营业利润＝营业利润－需要调整的非持续营业收入＋需要调整的非持续营业成本和期间费用－其他收益－投资收益－净敞口套期收益－公允价值变动收益－信用减值损失－资产减值损失－资产处置收益

调整的非经常性损益主要包括其他收益、投资收益、净敞口套期收益、公允价值变动收益、信用减值损失、资产减值损失、资产处置收益等。

（4）价值比率的计算

经过上述分析过程，价值比率的计算如下：

单位：万元

具体指标	公式	待估对象	案例一	案例二	案例三
		华力微	士兰微	晶合集成	华润微
股价（元/股）	A		26.86	21.97	47.74
总股本（万股）	B		166,407.18	200,613.52	132,752.94
缺乏流动性折扣率	C		39.26%	39.26%	39.26%
扣除流动性折扣后市值	D=A×B×(1-C)		2,715,100.00	2,676,700.00	3,849,500.00
基准日非经营性资产、负债净额	E		193,340.81	252,780.46	608,688.12
经营性股权价值	F=D-E		2,521,759.19	2,423,919.54	3,240,811.88
付息债务	G		706,452.88	2,003,102.12	4,827.20
少数股东权益	H		136,398.81	511,852.73	193,473.03
货币资金	I		444,510.01	310,395.47	893,689.13
不含资金的经营性企业价值 EV	J=F+G+H-I		2,920,100.87	4,628,478.92	2,545,422.98
EBITDA	K	87,781.97	173,149.07	426,382.53	216,387.18
EV/EBITDA 值	L=J÷K		16.86	10.86	11.76

1）经营性股权价值的计算

经营性股权价值＝股东全部权益价值（上市公司市值）－非经营性资产负债评估值

其中：股东全部权益价值＝基准日股本总额×基准日前120日成交均价×（1－流动性折扣率）

2）非流通性折扣

由于选取的上市公司的价值是通过流通股的价格计算的，而委评公司非上市公司，因此通过修正后的价值比率计算出来的经营性股权价值需要考虑非流通折扣。

一般认为不可流通股与流通股之间的价格差异主要由下列因素造成：

①承担的风险

流通股的流通性很强，一旦发生风险后，流通股持有者可以迅速出售所持有股票，减少或避免风险。非流通股持有者在遇到同样情况后，则不能迅速做出上述反应而遭受损失。

②交易的活跃程度

流通股交易活跃，价格上升。非流通股缺乏必要的交易人数，另外非流通股一般数额较大，很多投资者缺乏经济实力参与非流通股的交易，因而，与流通股相比，交易缺乏活跃，价格较低。

由于选取的上市公司的价值是通过流通股的价格计算的，而委估企业是非上市公司，因此通过可比公司所在的流通市场计算得到的市值需要修正。

对于流动性折扣，评估人员参考新股发行定价估算方式进行测算，所谓新股发行定价估算方式就是根据国内上市公司新股IPO的发行定价与该股票正式上市后的交易价格之间的差异来研究缺乏流动性的方式。

评估人员根据筛选后可比公司的细分行业分类，收集了在该行业分类下距评估基准日上市满一年的所属行业公司新股的发行价，分别研究其与上市后第90交易日、120交易日、250交易日收盘价之间的关系，相关概况信息如下表所示：

证券代码	证券名称	首发价格	上市后90日收盘价	上市后120日收盘价	上市后250日收盘价	第90日流动性折扣	第120日流动性折扣	第250日流动性折扣
600360.SH	*ST华微	8.4200	23.1000	19.7000	16.0900	63.55%	57.26%	47.67%
600460.SH	士兰微	11.6000	16.1000	16.6000	35.0900	27.95%	30.12%	66.94%
603290.SH	斯达半导	12.7400	190.3266	215.5800	242.4160	93.31%	94.09%	94.74%
605111.SH	新洁能	19.9100	170.5000	166.5800	170.9505	88.32%	88.05%	88.35%

证券代码	证券名称	首发价格	上市后90日收盘价	上市后120日收盘价	上市后250日收盘价	第90日流动性折扣	第120日流动性折扣	第250日流动性折扣
688048.SH	长光华芯	80.8000	141.5232	110.8839	116.9314	42.91%	27.13%	30.90%
688167.SH	炬光科技	78.6900	99.7400	152.8600	93.7300	21.10%	48.52%	16.05%
688172.SH	燕东微	21.9800	22.8200	23.8300	17.5000	3.68%	7.76%	-25.60%
688230.SH	芯导科技	134.8100	90.5500	88.9800	83.7498	-48.88%	-51.51%	-60.97%
688249.SH	晶合集成	19.8600	18.5700	16.6800	14.3600	-6.95%	-19.06%	-38.30%
688261.SH	东微半导	130.0000	259.8600	299.8257	243.1371	49.97%	56.64%	46.53%
688347.SH	华虹公司	52.0000	43.4700	35.0100	31.3794	-19.62%	-48.53%	-65.71%
688396.SH	华润微	12.8000	58.0960	50.2398	61.5187	77.97%	74.52%	79.19%
688469.SH	芯联集成	5.6900	5.3300	5.2800	3.9300	-6.75%	-7.77%	-44.78%
688498.SH	源杰科技	100.6600	221.3500	437.8892	209.0988	54.52%	77.01%	51.86%
688689.SH	银河微电	14.0100	30.6329	40.8573	38.5684	54.26%	65.71%	63.67%
688691.SH	灿芯股份	19.8600	44.2566	55.5099	61.9895	55.13%	64.22%	67.96%
688693.SH	锴威特	40.8300	44.4300	26.1600	23.9836	8.10%	-56.08%	-70.24%
688711.SH	宏微科技	27.5100	120.8700	96.5443	89.8930	77.24%	71.51%	69.40%
688981.SH	中芯国际	27.4600	58.6400	61.5900	51.8800	53.17%	55.41%	47.07%
300046.SZ	台基股份	41.3000	36.2176	47.7013	59.1849	-14.03%	13.42%	30.22%
300373.SZ	扬杰科技	19.5000	54.4516	52.0239	52.3650	64.19%	62.52%	62.76%
300456.SZ	赛微电子	14.0100	103.2000	103.2000	86.9700	86.42%	86.42%	83.89%
300623.SZ	捷捷微电	27.6300	63.8216	70.0792	63.6609	56.71%	60.57%	56.60%
300831.SZ	派瑞股份	3.9800	19.7037	25.3133	10.1774	79.80%	84.28%	60.89%
均值						**40.09%**	**39.26%**	**31.63%**

本次评估采用上市后第90交易日、120交易日、250交易日流动性折扣率中位数39.26%确定为缺乏流动性折扣率。

3）不含资金的经营性企业价值EV

考虑到企业一方面可能有付息债务，而另一方面又存在货币资金，而这个和企业对于货币资金管理方式、风险偏好、运营资金季节性变动有关，因此为了剔除该因素的影响，在计算企业价值时剔除货币资金的影响，得出不含货币资金的企业价值用于计算各项价值比率，即本次企业价值EV均为不含货币资金的价值

（为方便表述，以下除非专门指出，则企业价值EV均为不含货币资金的价值）即：

企业价值EV＝全口径企业价值EV－非经营性资产负债评估值

全口径企业价值EV＝经营性股权价值＋付息债务＋少数股东权益－货币资金

受制于数据的可获得性以及数据的非重要性，少数股东权益的评估值均等于账面值。

4）经营性损益

本次评估基准日为2025年8月31日，鉴于各可比公司截止基准日仅披露了2025年中期财务报告，为确保经营数据在完整会计期间内具有可比性，本次评估被评估单位及各可比公司统一采用2024年度的财务数据作为损益比较基础。

（5）价值比率修正

本次评估依据从财务指标及非财务指标两个维度对被评估单位与可比公司间的差异进行量化。其中，财务指标主要涵盖企业的经营规模、偿债能力、营运能力及盈利能力；非财务指标涵盖企业的交易日期、交易情况、所处发展阶段、研发投入、设备成新度、主要经营模式等方面。在此基础上，结合行业特性和所选价值比率的内涵，我们对各项指标赋予了相应的权重。具体情况如下表所示：

特性指标			权重
财务指标	经营规模	资产总计	50%
		营业收入	50%
	偿债能力	资产负债率	50%
		流动比率	50%
	营运能力	流动资产周转次数	50%
		总资产周转次数	50%
非财务指标	交易日期		100%
	交易情况		100%
	发展阶段		100%
	研发投入		100%
	设备净值率		100%
	主要经营模式		100%

修正体系解释如下：

1）经营规模修正

不同企业经营规模是有差异的，在衡量市场地位、市场份额方面，营业收入、总资产是非常重要的指标。并购者在其他条件相同的情况下，会对经营规模更大的企业产生更大的并购动机。

本次经营规模的衡量指标采用营业收入、总资产等。本次通过对影响经营规模的两个指标进行打分修正，并根据各指标影响企业经营规模的重要程度赋予相应的权重，以修正后的打分加权分值来确定各指标的修正系数。

经营规模的修正是正向的，即经营规模越大，则向上修正，反之则向下修正。

2）偿债能力修正

企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力，是企业能否健康生存和发展的关键，反映企业财务状况和经营风险的重要标志。静态的讲，就是用企业资产清偿企业债务的能力；动态的讲，就是用企业资产和经营过程创造的收益偿还债务的能力。

偿债能力的衡量指标主要有流动比率、资产负债率等。本次通过对影响偿债能力的两个指标进行打分修正，并根据各指标影响企业偿债能力的重要程度赋予相应的权重，以修正后的打分加权分值来确定各指标的修正系数。

资产负债率修正的方向是反向的，即资产负债率越高，则向下修正；反之则向上修。流动比率修正的方向是正向的，即该指标越高，则向上修正，反之则向下修正。

3）运营能力修正

运营能力是指企业基于外部市场环境的约束，通过内部人力资源和生产资料的配置组合而对财务目标实现所产生作用的大小，通俗来讲，就是企业运用各项资产以赚取利润的能力。

企业营运能力的财务分析比率有：总资产周转次数、流动资产周转次数等。这些比率揭示了企业资金运营周转的情况，反映了企业对经济资源管理、运用的效率高低。企业资产周转越快，流动性越高，资产获取利润的速度就越快。

本次通过对总资产周转次数、流动资产周转次数进行打分修正，并根据各指标影响企业偿债能力的重要程度赋予相应的权重，以修正后的打分加权分值来确定各指标的修正系数。

运营能力修正是正向的，即周转率越高，则向上修正；反之则向下修。

4）盈利能力修正

本次采用企业价值与息税折旧摊销前利润比率（EV/EBITDA），由于该指标本身就是盈利类的价值比率，因此不宜再将盈利能力作为修正因素，因此该价值比率不进行盈利能力修正。

5）交易日期修正

资产的价格会因为不同的时间而发生变化，而可比企业的成交日期与评估时点通常不同。因此需要将可比企业在其成交日期时的价格调整到在评估时点的价格。这种对可比企业成交价格进行的调整，称为“市场状况调整”，或称“交易日期修正”。经过这一调整或修正之后，就将可比企业在其成交日期的价格变成了在评估时点的价格。

本次采用上市公司比较法，且计算口径均为评估基准日近期股票交易均价，因此不需要进行交易日期修正。

6）交易情况修正

可比企业的成交价格是实际发生的，它可能是正常的、公允的市场价值，也可能是某些特定条件、交易条款下的价格。由于要求评估对象价值是客观、公允的，所以可比企业的成交价格如果是不正常的，则应把它修正为正常的。这种对可比企业成交价格进行的修正，称为交易情况修正。

经过核查，评估人员认为，上市公司的交易价格均为活跃、公开交易下的正常市场交易价格，不需要进行交易情况修正。

7）发展阶段修正

可比公司可能处于不同的发展阶段，发展阶段对于企业价值的影响本质上源于市场对企业未来收益增长预期的差异。资本市场无论是对于企业的并购对价的估值逻辑还是对上市公司股权走势的判断均依赖于这一预期：增长预期越高，则估值水平相应提升；反之，则估值水平下调。

鉴于被评估单位目前已基本处于满产状态，其未来收益的增长将主要依赖于市场整体发展所带动的产品价格提升，进而推动收入与利润的同步增长。相比之下，本次所选的可比上市公司均处于发展期至成熟期，其增长驱动来源于产能扩张等多重因素，预期增长高于被评估单位。因此我们根据资本市场对于可比企业预期收益增长情况，对发展阶段进行修正。

我们对于发展阶段修正的修正幅度最大值为10个单位。

8）研发投入修正

研发投入指企业在产品、技术、材料、工艺、标准的研究、开发过程中发生的各种费用，包括：研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用；企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘兼职研发人员的劳务费；用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧或租赁费用等等。

衡量研发投入的重要的一个指标为研发费用率，即研发费用占营业收入的比率。研发费用率越高，代表着企业在创新能力和技术研发上的投入意愿越高，对企业未来保持先进性和盈利能力是利好。

研发费用率的修正是正向的，即研发费用率越高，则向上修正；反之则向下修。

9）设备净值率修正

生产设备净值率是衡量企业固定资产质量与技术状态的关键指标。净值率越高，表明设备的物理损耗越低，综合运行效率越可靠，通常也意味着其投产时间较近，具备更高的技术先进性与工艺水平。

对于晶圆代工企业而言，生产设备是其核心生产要素。较高的设备净值率不仅直接关联到更优异的产能性能，此外较新的设备状态通常预示着未来短期内所需的维护维修成本及大规模更新资本支出相对较低，有利于企业维持较好的现金流。

基于上述逻辑，本次对生产设备净值率进行修正。考虑到半导体设备的财务折旧年限短于使用寿命而使得账面净值率偏低，本次通过平均使用寿命调整财务折旧年限后再进行修正。

设备净值率对企业价值的影响为正向关系。净值率越高，则向上修正；反之则向下修。

10）其他因素参数

在半导体制造领域，主要存在两种商业模式：垂直整合制造模式（IDM）、代工模式（Foundry），二者在产业链定位、运营逻辑与价值创造上存在一定差异，具体对比如下：

①垂直整合制造模式（IDM）

IDM模式覆盖了从芯片设计、制造到封装测试的全产业链环节。

核心优势：

A、产业链整合能力：通过内部整合设计、制造与封测环节，IDM企业能够实现全流程的协同优化，有助于充分发掘技术潜力，并在产品性能、功耗及成本间取得最佳平衡。

B、产能自主与供应链安全：在市场供需紧张时，其自有产能可以优先保障内部需求，同时能快速响应市场价格变动，具备显著的供应链安全与竞争优势。

C、深层技术壁垒：由于覆盖了设计和制造，能够积累更多的技术和经验，从而形成更高的技术壁垒和核心竞争力。

经营风险：

A、运营风险较高：需要覆盖设计、制造与封测环节全产业链的生产流程，在市场波动尤其在下行周期，易导致利用率不足，运营风险较为集中。

B、管理复杂性与技术迭代速度不足：管理覆盖多领域的庞大组织，可能带来效率损耗。同时，由于需要覆盖设计、制造与封测环节全产业链的研发迭代和技术创新，其创新速度可能不及高度专业化的分工模式。

②代工模式（Foundry）

Foundry模式专注于芯片的制造、封装等单一或多个环节，不从事芯片设计，而是为专业的芯片设计公司（Fabless）提供服务。

核心优势：

A、技术快速迭代能力：通过专注于制造与封装环节的工艺技术，代工厂能够实现技术平台的快速迭代与优化，从而更敏捷地响应市场需求。

B、规模效应与成本优势：仅承担代工的职能，通过承接来自全市场的芯片设计公司订单，能够最大化地提升产能利用率，摊薄单位成本，实现规模效应。

C、开放的合作伙伴生态：因其不涉足竞争性的芯片设计业务，能够与众多Fabless公司建立合作关系，构建开放的产业生态。

经营风险：

A、产业链附加值不足：处于产业链中游，其附加值的实现依赖于Fabless公司的设计与终端市场需求，在响应特定客户深度定制需求时，能力可能受限。

B、抗市场波动能力较弱：产能利用率与盈利能力直接受下游订单波动影响，在行业景气度下行时面临的业绩压力更为直接。

综合上述因素考虑，虽然IDM模式存在运营风险集中、管理复杂与技术迭代速度不足的劣势，但其凭借全产业链整合所带来的协同优化、供应链自主可控以及更高的技术附加值，相较Foundry模式仍具备一定的优势。本次对IDM模式作向上修正，但考虑到商业模式不同也会影响到各自的财务指标，因此对商业模式的差异修正的最大值为5个点。

11）比较和打分表

项目		待估对象	案例一	案例二	案例三
		华力微	士兰微	晶合集成	华润微
价值比率 EV（不含货币资金）/EBITDA			16.86	10.86	11.76
交易日期修正	交易指数	100	100	100	100
	打分系数	100.0	100.0	100.0	100.0
交易情况修正	交易情况	正常市场交易	正常市场交易	正常市场交易	正常市场交易
	打分系数	100.0	100.0	100.0	100.0
发展阶段修正	预期收益增长	成熟期	发展期-成熟期	发展期-成熟期	发展期-成熟期
	打分系数	100.0	110.0	110.0	110.0
经营规模修正	资产总计（万元）	718,952.0	2,357,547.4	4,867,843.2	2,331,281.7
	打分系数	100.0	105.0	105.0	105.0
	营业收入	451,697.1	1,122,086.9	924,925.2	1,011,852.6
	打分系数	100.0	105.0	105.0	105.0
	小计	100.0	105.0	105.0	105.0
偿债能力修正	资产负债率	72.9%	49.6%	50.5%	19.0%
	打分系数	100.0	102.0	102.0	104.0
	流动比率	2.5	1.9	0.9	3.4
	打分系数	100.0	99.0	97.0	102.0
	小计	100.0	100.5	99.5	103.0
运营能力修正	流动资产周转次数	0.9	0.8	1.5	0.7
	打分系数	100.0	99.0	103.0	99.0
	总资产周转次数	0.6	0.5	0.2	0.4
	打分系数	100.0	99.0	97.0	98.0
	小计	100.0	99.0	100.0	98.5
研发投入修正	研发费用率	7.2%	9.2%	13.9%	11.5%
	打分系数	100.0	101.0	105.0	103.0
设备净值率修正	设备净值率	60.6%	78.1%	85.0%	68.8%
	打分系数	100.0	103.0	104.0	101.0

项目		待估对象	案例一	案例二	案例三
		华力微	士兰微	晶合集成	华润微
其他因素修正	商业模式	Foundry	IDM	Foundry	IDM
	打分系数	100.0	105.0	100.0	105.0

5、市场法评估结果

采用市场法对企业股东全部权益价值进行评估，得出的评估基准日的评估结果如下：

项目	案例一	案例二	案例三
	士兰微	晶合集成	华润微
价值比率 EV（不含货币资金）/EBITDA	16.86	10.86	11.76
交易日期修正	100/100	100/100	100/100
交易情况修正	100/100	100/100	100/100
发展阶段修正	100/110	100/110	100/110
经营规模修正	100/105	100/105	100/105
偿债能力修正	100/100.5	100/99.5	100/103
运营能力修正	100/99	100/100	100/98.5
盈利能力修正	100/100	100/100	100/100
研发投入修正	100/101	100/105	100/103
设备净值率修正	100/103	100/104	100/101
其他因素修正	100/105	100/100	100/105
修正后价值比率 EV/EBITDA	13.43	8.65	9.19
权重	33%	33%	33%
修正后价值比率×权重	4.48	2.88	3.06
加权修正后价值比率 EV/EBITDA	**10.42**		
标的企业 EBITDA	87,781.97		
全口径经营性企业价值（不含货币资金）	914,688.16		
减：付息债务	373,753.75		
减：少数股东权益	0.00		
经营性不含货币资金股权价值	540,934.41		
加：非经营性资产、负债	6,898.29		
加：货币资金	300,352.21		

项目	案例一	案例二	案例三
	士兰微	晶合集成	华润微
评估值			**848,000.00**

被评估单位股东权益账面值为 200,191.38 万元，评估值 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。

（五）评估结论

1、资产基础法评估结果

采用资产基础法对企业股东全部权益价值进行评估，得出被评估单位在评估基准日的评估结果如下：

评估基准日，被评估单位所有者权益账面值 200,191.38 万元，评估值 782,761.17 万元，评估增值 582,569.79 万元，增值率 291.01%。其中，总资产账面值 725,850.28 万元，评估值 1,306,836.22 万元，评估增值 580,985.94 万元，增值率 80.04%。总负债账面值 525,658.90 万元，评估值 524,075.05 万元，评估减值 1,583.85 万元，减值率 0.30%。

资产基础法评估结果汇总如下表所示：

单位：万元

项　　目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	502,209.71	526,180.75	23,971.04	4.77
非流动资产	223,640.57	780,655.47	557,014.90	249.07
长期应收款	6,362.46	6,362.46	0.00	0.00
固定资产	150,987.78	558,573.56	407,585.78	269.95
在建工程	13,740.65	13,816.45	75.80	0.55
使用权资产	38,118.47	38,118.47	0.00	0.00
无形资产	12,989.24	162,346.03	149,356.79	1,149.85
长期待摊费用	526.11	526.11	0.00	0.00
其他非流动资产	915.86	912.39	-3.47	-0.38
资产总计	**725,850.28**	**1,306,836.22**	**580,985.94**	**80.04**
流动负债	204,107.99	204,135.14	27.15	0.01
非流动负债	321,550.91	319,939.91	-1,611.00	-0.50
负债总计	**525,658.90**	**524,075.05**	**-1,583.85**	**-0.30**
所有者权益（净资产）	**200,191.38**	**782,761.17**	**582,569.79**	**291.01**

2、市场法评估结果

采用市场法对企业股东全部权益价值进行评估，得出的评估基准日的评估结果如下：

被评估单位所有者权益账面值为 200,191.38 万元，评估值为 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。

3、评估结论

本次评估采用市场法得出的股东全部权益价值为 848,000.00 万元，比资产基础法测算得出的股东全部权益价值 782,761.17 万元高 65,238.83 万元。

不同评估方法的评估结果差异的原因主要是各种评估方法对资产价值考虑的角度不同，资产基础法是从企业各项资产现时重建的角度进行估算；市场法是从现时市场可比价格角度进行测算，导致各评估方法的评估结果存在差异。

鉴于华力微属于晶圆加工产业，其主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含工艺路线、企业管理水平、人才技术团队、自创商誉等重要的无形资源的贡献。由于资产基础法的特性，其评估结果仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了价值评估，并不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的企业整体效应价值，对于被评估单位的工艺路线、企业管理水平、人才技术团队、自创商誉等重要的无形资源价值一般也难以在资产基础法中体现，资产基础法评估结果较市场法存在一定局限性。其次，市场法的数据采用可比上市公司的公开数据，近年来随着中国的股市日臻成熟，相对成熟的资本市场环境也提供了市场法定价的基础。

通过以上分析，我们选用市场法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论。

经评估，在评估基准日，上述各项假设条件成立的前提下，被评估单位股东全部权益价值为人民币 8,480,000,000.00 元。大写人民币：捌拾肆亿捌仟万元整。

（六）引用其他评估机构报告的内容

本次评估未引用其他评估机构或估值机构的报告。

（七）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明

1、华力微分立事项

2025 年 6 月 26 日，根据沪华力微股（2025）第 4 号股东会决议，全体股东一致同意公司存续分立的方案，采取存续分立的形式，将公司分立为存续公司华力微及新设公司。分立后的华力微继续运营位于中国（上海）自由贸易试验区高斯路 568 号的 12 英寸晶圆厂晶圆代工等相关的业务，并承继与之相关的资产、债权债务、人员及其他约定的权利义务，新设公司承继长期股权投资及相应的业务、资产、债权债务、人员及其他约定的权利义务。分立后的华力微与新设公司保持业务、资产、人员、财务、机构等方面的相互独立。公司于 2025 年 8 月 21 日完成了分立行为。分立后的华力微注册资本与新设公司的注册资本之和等于本次分立前华力微的注册资本。各股东在分立后的华力微与新设公司的持股比例，与本次分立前在华力微的持股比例一致。分立后的华力微为本次重组拟注入华虹公司的标的资产。

本次评估对象为分立后的华力微，基于此，评估工作以华力微在分立框架下编制的模拟财务报表及反映的业务实质为基础展开。

2、抵质押事项

截至评估基准日，华力微涉及的抵押、担保等事项如下：

借款合同编号	借款人	贷款人	借款金额（万元）	借款期限	借款用途	借款利率	担保情况
3100201606100000054 号借款合同	华力微	委托贷款人：国开发展基金有限公司；受托贷款人：国家开发银行股份有限公司	300,000.00	2016 年 8 月 4 日-2026 年 8 月 3 日	产线建设	年利率 1.2%	华力微以评估值合计 152,243.77 万元的设备向委托贷款人提供抵押担保
3100201506100000015001 号借款合同	华力微	委托贷款人：国开发展基金有限公司；受托贷款人：国家开发银行股份有限公司	100,000.00	2015 年 11 月 24 日-2030 年 11 月 23 日	产线投建	年利率 1.2%	华力微以评估值合计 116,263.96 万元的设备向委托贷款人提供抵押担保

3100202301100002961	华力微	国家开发银行上海市分行、交通银行股份有限公司上海新区支行、上海银行股份有限公司徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行	96,000.00	2023年2月-2031年2月	研发	3%	华力微以评估值合计29,052.85万元的设备向贷款人提供抵押担保

本次未考虑上述抵押或质押事项对评估结果的可能影响，提请报告使用人注意。

3、或有事项

截至2025年8月31日，华力微银行保函业务担保余额为人民币10,000,000.00元，最后一笔将于2026年2月10日到期。

截至2025年8月31日，华力微未履行完毕的不可撤销信用证未使用金额美元1,360,050.00（等值人民币9,660,435.15元），最后一笔将于2026年1月13日到期。

本次评估未考虑上述或有事项对评估值的影响。

（八）评估基准日至本报告书签署日之重要变化事项及其对评估及交易作价的影响

本次评估基准日至重组报告书出具日之间未发生对评估结果有重大影响的相关事项。

二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析

（一）董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的意见

1、评估机构的独立性

本次交易的评估机构东洲评估符合《证券法》的相关规定。东洲评估及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的或可预期的利害关系或冲突；评估机构具有独立性。

2、评估假设前提的合理性

评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。东洲评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，所选用的评估方法合理，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性。

4、评估定价的公允性

本次交易的交易各方参考标的资产的评估价值协商确定交易价格，标的资产的评估定价公允，本次交易标的资产定价方式合理，交易价格公允，未损害中小投资者利益。

评估价值分析原理、采用的模型、选取的估值指标等重要评估参数符合标的公司的实际情况，评估依据及评估结论合理。

综上，本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

（二）评估合理性的分析

标的资产所处行业地位、行业发展趋势、行业竞争及经营情况等内容详见本报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”。

本次交易评估作价综合考虑了标的资产历史年度经营业绩、财务情况、所在行业发展前景、行业竞争地位和经营情况，具有合理性。

（三）交易标的后续经营过程中政策、宏观环境、技术、行业、税收优惠等方面的变化趋势及应对措施及其对评估的影响

截至本报告书签署日，标的公司在后续经营过程中政策、宏观环境、技术、行业、重大合作协议、经营许可、技术许可、税收优惠等方面不存在重大不利变化。

（四）敏感性分析

在市场法评估模型中，可比公司评估基准日交易均价及缺乏流动性折扣率对市场法评估结果有较大的影响，故对可比公司评估基准日交易均价及缺乏流动性折扣率进行了敏感性分析，结果如下：

1、可比公司评估基准日均价变动的敏感性分析

以当前各可比公司评估基准日交易均价为基准，假设其他测算参数均保持不变，可比公司评估基准日交易均价变动对市场法评估值的敏感性分析如下（假设各可比公司评估基准日交易均价均变动幅度一致）：

单位：万元

股价变动率	评估值	股价每 1.0%变动评估值变动金额	评估值变动率	股价每 1.0%变动评估值变动率
-3.00%	821,000.00	10,000.00	-3.18%	1.18%
-2.00%	831,000.00	8,000.00	-2.00%	0.94%
-1.00%	839,000.00	9,000.00	-1.06%	1.06%
0.00%	848,000.00	-	-	-
1.00%	858,000.00	10,000.00	1.18%	1.18%
2.00%	867,000.00	9,000.00	2.24%	1.06%
3.00%	876,000.00	9,000.00	3.30%	1.06%

股价变动率	评估值	股价每 1.0%变动评估值变动金额	评估值变动率	股价每 1.0%变动评估值变动率
平均值		9,166.67	-	1.08%

从上表可知，在其他测算参数均保持不变的前提下，可比公司评估基准日股票交易均价每增长 1.0%对评估值的影响约为 9,166.67 万元，评估值变动率约为 1.08%。

2、缺乏流动性折扣率变动的敏感性分析

以当前缺乏流动性折扣率为基准，假设其他测算参数均保持不变，缺乏流动性折扣率变动对市场法评估值的敏感性分析如下：

单位：万元

缺乏流动性折扣率变动率	评估值	缺乏流动性折扣率每 1.0%变动评估值变动金额	评估值变动率	缺乏流动性折扣率每 1.0%变动评估值变动率
-3.00%	867,000.00	7,000.00	2.24%	0.83%
-2.00%	860,000.00	5,000.00	1.42%	0.59%
-1.00%	855,000.00	7,000.00	0.83%	0.83%
0.00%	848,000.00	-	-	-
1.00%	843,000.00	5,000.00	-0.59%	0.59%
2.00%	837,000.00	6,000.00	-1.30%	0.71%
3.00%	831,000.00	6,000.00	-2.00%	0.71%
平均值		6,000.00	-	0.71%

从上表可知，在其他测算参数均保持不变的前提下，缺乏流动性折扣率每降低 1.0%对评估值的影响约为 6,000.00 万元，评估值变动率约为 0.71%。

上述敏感性分析计算仅为揭示评估参数估计的不确定性对评估值的影响，以及说明评估结论存在的不确定性，但并不影响评估师基于已掌握的信息资料对相关评估参数作出的估计判断，也不影响评估结论的成立。

（五）交易标的与上市公司的协同效应

关于交易标的与上市公司的协同效应，详见本报告书“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景、目的及协同效应”之“（三）本次交易标的公司

的科创属性，与上市公司的业务协同性”之“2、标的公司与上市公司主营业务具有协同效应”。

（六）定价公允性分析

1、本次交易定价以评估值为基础，经充分市场博弈确定

本次交易拟购买资产为华力微 97.4988%股权。根据东洲评估出具的《资产评估报告》，评估机构采用资产基础法和市场法两种评估方法对华力微股东全部权益价值进行评估，最终选取市场法评估结果作为评估结论。截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日，华力微合并报表归属于母公司所有者权益账面价值为 200,191.38 万元，评估值为 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方充分协商，本次交易标的资产的最终交易价格为 826,790.22 万元。

本次交易最终交易定价以评估机构出具的评估值为参考，并经上市公司与交易对方基于标的公司历史业绩、未来发展战略与规划、行业发展趋势等多项因素综合协商确定，定价过程经过了充分市场博弈，交易定价合理、公允，未损害中小投资者利益。

2、可比上市公司分析

本次采用盈利价值比率 EV/EBITDA 对交易定价的公允性进行分析，考虑到被评估单位作为一家晶圆代工企业，具有资本投入高、回报周期长的典型特征，在扣除高额折旧与摊销费用后，常于净利润及息税前利润（EBIT）层面呈现暂时性亏损或利润水平偏低的现象。企业价值与息税折旧摊销前利润比率通过将折旧摊销加回，消除了高资本支出特征对利润率的影响，更能公允地衡量被评估单位的持续盈利能力，采用 EV/EBITDA 价值比率分析交易定价公允性具有合理性。

截至 2025 年 8 月 31 日，华力微及可比上市公司的 EV/EBITDA 价值比率情况如下表所示：

单位：万元

证券代码	证券简称	剔除货币资金经营性企业价值（EV）	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	EV/EBITDA
600460.SH	士兰微	2,920,100.87	173,149.07	16.86

证券代码	证券简称	剔除货币资金经营性企业价值（EV）	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	EV/EBITDA
688249.SH	晶合集成	4,628,478.92	426,382.53	10.86
688396.SH	华润微	2,545,422.98	216,387.18	11.76
平均值		**-**	**-**	**13.16**
中位数		**-**	**-**	**11.76**
华力微 100%股权		**914,688.16**	**87,781.97**	**10.42**

注1：可比公司剔除货币资金经营性企业价值（EV）=评估基准日总市值*（1－缺乏流动性折扣率）＋付息债务＋少数股东权益－非经营性资产、负债净额－货币资金，其中总市值采用截至2025年8月31日的交易数据计算，总市值以外的数据采用截至2025年6月30日的财务数据计算；

注2：息税折旧摊销前利润（EBITDA）数据采用2024年年度的财务数据计算。

综上，截至评估基准日，可比上市公司 EV/EBITDA 价值比率（已考虑缺乏流动性折扣）的平均值为 13.16 倍，中位数为 11.76 倍，本次交易华力微对应的 EV/EBITDA 价值比率为 10.42 倍，低于可比上市公司的 EV/EBITDA 价值比率。因此，本次交易作价合理，保护了上市公司全体股东的合法权益。

综上所述，本次评估标的资产股东全部权益价值评估结果客观反映了标的公司股权的市场价值，本次交易定价具有合理性。

三、上市公司独立董事对本次交易评估事项的意见

根据《重组管理办法》，上市公司独立董事对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价的公允性发表如下意见：

（一）本次评估机构的独立性

本次交易的评估机构东洲评估符合《证券法》的相关规定。东洲评估及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的或可预期的利害关系或冲突；评估机构具有独立性。

（二）本次评估假设前提的合理性

评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

（三）评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。东洲评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，所选用的评估方法合理，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性。

（四）评估定价的公允性

本次交易的交易各方参考标的资产的评估价值协商确定交易价格，标的资产的评估定价公允，本次交易标的资产定价方式合理，交易价格公允，未损害中小投资者利益。

评估价值分析原理、采用的模型、选取的估值指标等重要评估参数符合标的公司的实际情况，评估依据及评估结论合理。

综上，本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

第七节 本次交易合同的主要内容

一、发行股份购买资产协议及其补充协议

（一）合同主体、签订时间

2025 年 8 月 29 日，华虹半导体与华虹集团、上海集成电路产业基金、大基金二期、国投先导基金签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，并于 2025 年 12 月 31 日签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》，其中甲方为华虹半导体，乙方、丙方、丁方、戊方分别为华虹集团、上海集成电路产业基金、大基金二期、国投先导基金（以下合称为“资产出售方”）。

（二）交易价格及定价依据

标的资产的交易价格以甲方聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经国资监管有权单位备案的评估结果作为参考，由交易各方协商确定。

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 2446 号），东洲评估以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日，标的公司的股东全部权益评估值为 848,000.00 万元，交易各方参考该评估值，协商确定本次交易价格为 826,790.22 万元。

（三）支付方式

甲方以发行股份方式购买资产出售方合计持有的标的公司 97.4988%股份，交易总对价为 826,790.22 万元，均为股份支付。经各方协商一致，本次交易中标的资产的具体支付方式如下：

资产出售方	出售华力微股权比例(%)	总对价(万元)	支付方式及数额	
			股份对价(万元)	向该资产出售方发行的股份(股)
乙方	63.5443	538,855.12	538,855.12	124,332,053
丙方	15.7215	133,318.65	133,318.65	30,761,109
丁方	10.2503	86,922.77	86,922.77	20,056,014
戊方	7.9827	67,693.68	67,693.68	15,619,216
合计	**97.4988**	**826,790.22**	**826,790.22**	**190,768,392**

（四）交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

各方同意，过渡期内标的资产的盈利、亏损由甲方享有或承担。

（五）过渡期安排

过渡期内，资产出售方保证持续拥有标的资产的合法、完整的所有权，不以任何形式处置标的资产，确保标的资产不存在司法冻结、质押或其他类型权利负担；未经甲方事先书面同意，不会自行放弃任何因标的资产形成的物权或债权，亦不以标的资产承担任何其自身或他方的债务；未经甲方事先书面同意，不减少、增加华力微的注册资本，不对华力微采取任何合并、分立、中止经营、并购、重组、清算、申请破产或类似其他影响华力微经营的行为，不从事任何非正常的导致华力微价值减损的行为；未经甲方事先书面同意，宣布分配或者实际分配华力微的利润、股息或红利；未经甲方事先书面同意，不发起、寻求、磋商、谈判或进行其他任何形式的与华力微相关的股权性融资活动；未经甲方事先书面同意，不对华力微公司章程进行对本次交易构成实质性影响的调整；在华力微的日常经营过程中，保证华力微将谨慎、合理地对待其所拥有的资产和负担的债务，避免因未尽管理职责而发生的资产减损、负债增加的情形。

（六）标的资产交割

1、本次交易经中国证监会注册后，各方应根据相关法律法规的规定在中国证监会注册文件的有效期内共同负责办理完毕本次交易的实施工作。

2、各方确认交割审计基准日为标的资产交割日所在月份之前一个月的最后一日，甲方应聘请具有相关资质的审计机构对标的资产进行交割审计，并出具资产交割审计报告，该报告应作为各方确认标的资产过渡期损益的依据，相关审计费用由甲方承担。

3、各方同意，对标的资产的交割进行如下安排：

（1）自标的资产根据本协议的约定完成了过户至甲方名下的市场监督管理部门变更登记手续之日（简称“标的资产交割日”）起，即视为标的资产交割完毕，各方同意自标的资产交割日起，甲方按照华力微章程享有股东权利并承担相应的义务。资产出售方应协调华力微向甲方提交出资证明书并将甲方记载于华力

微的股东名册中；

（2）如后续各方就过渡期损益进行了约定的，相关方应根据具体协议的要求履行损益补偿义务（如需）。

4、各方同意，于标的资产完成交割后，甲方应依据上交所及登记结算机构的证券登记业务规则尽快办理将本次交易新增股份登记于资产出售方名下的证券登记手续。本次交易对价中现金支付部分的付款时间由各方另行友好协商确定。

（七）与资产相关的人员安排

本次交易不影响标的公司与其员工的劳动关系，原劳动合同继续履行。标的公司作为独立法人的身份不因本次交易而发生变化，因此，除非相关方另有约定，本次交易不涉及标的公司人员安置。

（八）合同的生效条件和生效时间

补充协议自各方签署之日起成立，除补充协议另有约定外，补充协议自发行股份购买资产协议生效之日起生效。

二、减值补偿协议

（一）合同主体、签订时间

2025 年 12 月 31 日，华虹半导体与华虹集团签署了减值补偿协议，华虹集团作为补偿方。

（二）减值测试资产

根据《评估报告》，本次交易的标的公司华力微系采用市场法确定最终评估价值，因此上市公司在本次交易中拟取得的华力微 97.4988%股权（以下简称“减值测试标的资产”）应进行减值测试。

（三）减值测试及补偿测算

1、本次交易的减值测试期为本次交易完成当年及其后两个会计年度（以下简称“减值测试期”）。

2、减值测试期届满后，上市公司应当聘请符合《证券法》规定的评估机构

对减值测试标的资产进行减值测试，并出具专项评估报告。根据评估结果，由上市公司对减值测试标的资产的合计价值在每个会计年度进行减值测试，并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具减值测试专项审核报告。如减值测试标的资产在减值测试期间任何一个会计年度发生减值(以下简称“期末减值额”)，则补偿方应按如下约定向上市公司进行补偿：

（1）期末减值额=本次交易总对价-该会计年度期末标的资产的评估值并扣除减值测试期间内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

（2）补偿方应向上市公司补偿的金额（以下简称“补偿金额”）=补偿方在本次交易中应获得的交易对价占本次交易总对价比例×期末减值额。

（3）补偿方将优先以其在本次交易中获得的上市公司的股份进行补偿，补偿股份由上市公司以 1 元总价回购并予以注销，每年补偿的股份数量为：补偿金额/发行价格-减值测试期间内已补偿股份总数。

（4）在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已补偿的股份不冲回。

（5）补偿方在本次交易中获得的上市公司的股份不足以补偿的，补偿方应以现金进行补偿。

3、若上市公司在减值测试期间实施送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 则上市公司应回购的股份数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数量×(1+送股或转增比例)。若补偿股份数量出现小数的情况, 则应当向上取整作为补偿方应补偿股份的数量。

4、补偿方在减值测试期间内就补偿股份已获分配的现金股利应作相应返还，计算公式如下：

返还金额＝补偿股份截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×补偿股份数量。

（四）补偿方案的实施

1、上市公司应在减值测试专项审核报告公开披露后三十个工作日或上市公

司确定的其他期限内，依据本协议的计算公式计算并确定补偿方需补偿的金额并予以公告（以下简称“补偿公告”）。补偿方应在补偿公告公开披露之日起三十个工作日内，将其用于补偿的上市公司股份由上市公司以总价 1 元的对价回购，或将现金补偿金额足额支付至上市公司指定账户。

2、补偿方承诺，其不得通过转让、赠与、设定质押、股票收益权转让或其他权利限制等方式处置其于本次交易过程中取得的、处于锁定期内的上市公司股票。

3、补偿方于本协议项下向上市公司补偿的金额总额累计不应超过其在本次交易中取得的总对价。

（五）合同的生效时间

本协议自双方签署之日起成立，自发行股份购买资产协议及其补充协议全部条款生效之日起生效。

（六）违约责任

1、本协议生效后，任何一方未能按本协议的约定履行其义务，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给守约方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。

2、若违约方的违约行为将导致守约方最终不能取得按照本协议的规定应当取得的利益，该违约方应当向守约方赔偿守约方预期取得的一切利益。

第八节 本次交易的合规性分析

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

（一）本次交易符合国家相关产业政策要求，不存在违反国家有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的情形

1、本次交易符合国家产业政策

本次交易拟购买标的资产为华力微 97.4988%股权。华力微主要从事集成电路晶圆代工业务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司业务所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，标的公司所处行业不属于限制类、淘汰类产业。因此，本次交易符合国家产业政策的规定。

2、本次交易符合环境保护、土地管理相关规定

本次交易不涉及环境保护报批事项。标的公司的主营业务不属于高耗能、高排放、重污染行业，报告期内不存在违反国家有关环境保护法律和行政法规规定而受到重大行政处罚的情形。本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

本次交易标的资产为华力微 97.4988%股权，不涉及土地使用权交易事项。

3、本次交易符合反垄断相关规定

本次交易中，参与集中的上市公司、标的公司上一年度营业额已达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》所规定的申报经营者集中的营业额标准；但本次交易前华虹集团直接持有标的公司 63.5443%的股权，本次交易后标的公司将成为上市公司的全资子公司，由于华虹集团仍系上市公司的间接控股股东，华虹集团将通过上市公司间接控制标的公司，因此本次交易未导致标的公司最终控制权发生变更。

通力律师已于 2025 年 9 月通过经营者集中反垄断业务系统提交本次交易是否需履行经营者集中申报义务的商谈申请。根据上海市市场监督管理局（国家市

场监督管理总局授权的华东地区行政监管单位）负责本次交易商谈申请的审查人员回复，本次交易前后，标的公司控制权未发生变更的情形下，无需履行经营者集中申报程序。

4、本次交易符合外商投资、对外投资相关规定

上市公司系注册于中国香港特别行政区的红筹企业，交易对方与标的公司均为内资企业。上市公司与标的公司均主要从事晶圆代工业务，均不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》所列的领域。本次交易涉及外商投资事宜、不涉及对外投资，需就外商投资事宜履行外商投资信息报告程序，上市公司将根据有关规定及本次交易时间进度办理相关手续。

（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据《证券法》《上市规则》等规定，上市公司股权分布发生变化不再具备上市条件是指“社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%，公司股本总额超过人民币 4 亿元的，社会公众持股的比例低于 10%。社会公众不包括：（1）持有上市公司 10%以上股份的股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人”。

根据截至 2025 年 12 月 31 日股份数量，本次交易完成后，华虹公司的股份总数最高将增加至 **1,928,382,585** 股，社会公众股股东持有的股份不低于华虹公司股本总额的 10%，华虹公司仍然符合上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次交易标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值作为定价参考依据，并由交易各方协商确定。上市公司董事会和独立董事均已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性和评估价值的公允性发表肯定性意见。

本次交易遵循公开、公平、公正的原则并履行合法程序，充分保护全体股东，特别是中小股东的利益。

因此，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司及其股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

（四）本次交易涉及的资产产权清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易标的资产为华力微 97.4988%股权。交易对方合法持有华力微股权，交易对方持有的华力微股份权属清晰，不存在被质押、查封、冻结等限制转让的情形，标的资产的过户和转移不存在法律障碍。

因此，本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

标的公司与上市公司均拥有 65/55nm、40nm 制程代工工艺，通过本次交易，上市公司将进一步提升公司 12 英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。同时，通过研发资源整合与核心技术共享，双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应，加速技术创新迭代，共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。另外，上市公司将通过整合管控实现一体化管理，在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次的整合，通过降本增效实现规模效应，提升公司的市场占有率与盈利能力。

因此，本次交易有利于上市公司增强其持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易前，上市公司已经按照有关法律、法规以及规范性文件的规定建立了法人治理结构和独立运营的公司管理体系，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于实际控制人及其关联人。本次交易完成后，华力微将成为华虹公司的全资子公司，华虹公司的业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于其实际控制人及其关联人。

因此，本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

（七）本次交易有利于上市公司形成或保持健全有效的法人治理结构

上市公司已经按照《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。华虹公司上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，华虹公司仍将保持其健全有效的法人治理结构。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形

本次交易前后，上市公司直接控股股东为华虹国际，间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委，本次交易预计不会导致公司控制权变更。因此不会构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定

（一）上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第 70013197_B01 号《审计报告》，华虹公司不存在最近一年财务会计报告被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的情形。本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

（二）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

截至本报告书签署日，上市公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定。

四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定

（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易

1、本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化

根据安永会计师**审阅**的**上市公司**备考**财务报表，模拟**本次交易**于 2024 年 1 月 1 日**完成，上市公司资产规模、收入规模、盈利能力将进一步增加。通过本次交易，上市公司将进一步提升公司 12 英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。综上所述，本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化。

2、本次交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易

（1）关联交易

本次交易前，上市公司已依照《公司法》《证券法》《科创板上市规则》及中国证监会、上交所的相关要求，制定了关联交易的相关规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行，日常关联交易按照市场原则进行。与此同时，上市公司独立

董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易发表必要意见。

本次交易完成后，标的公司华力微将成为上市公司全资子公司，上市公司将继续按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，规范本次交易完成后的关联交易，并按照有关法律、法规和监管规则等规定进行信息披露，以确保相关关联交易的合理性、必要性及定价公允，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

本次交易前标的公司的关联交易及本次交易前后关联交易变化情况详见本报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、/（四）本次交易前后上市公司关联交易的变化情况”。

（2）同业竞争

本次交易通过注入华力微，上市公司与控股股东控制的除上市公司及其控股子公司外其他公司在 65/55nm、40nm 的同业竞争得到实质性解决。本次重组是上市公司就之前的消除上述同业竞争问题承诺作出的具体行动，后续仍将遵守同业竞争承诺。

本次交易对上市公司同业竞争的影响详见本报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争情况”，本次交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不会新增同业竞争。

综上，本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（二）上市公司所购买资产与现有主营业务具有显着协同效应

本次交易标的公司所从事业务与上市公司业务之间具有显着协同效应，具体详见本报告书“第一节 本次交易概况”之“一、/（三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司的业务协同性”。

（三）上市公司已针对本次分期发行股份支付购买资产对价的履约保障措施作出了安排

本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价的情况。

五、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条及其适用意见的规定

根据《重组管理办法》第四十五条及其适用意见的相关规定和要求：

1、上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金。上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格 100%的，一并适用发行股份购买资产的审核、注册程序；超过 100%的，一并适用上市公司发行股份融资（以下简称“再融资”）的审核、注册程序。“拟购买资产交易价格”指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途除外。

2、考虑到募集资金的配套性，所募资金主要用于标的公司项目建设，补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用，标的公司项目建设。其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。上市公司本次交易收购标的公司 97.4988%股份的交易价格为 826,790.22 万元，以股份方式支付，不足一股部分，现金补足。本次拟募集配套资金的金额不超过 755,628.60 万元，未超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%。

本次交易募集配套资金以询价方式发行，募集配套资金拟用于标的公司项目建设，补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%，募集资金用途符合上述规定。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十五条及其适用意见的规定的要求。

六、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定

本次交易上市公司发行股份购买资产的发行价格为 43.34 元/股，不低于定价基准日（即华虹公司 2025 年第六次董事会会议决议公告日）前 120 个交易日华虹公司股票交易均价的 80%。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定。

七、本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定

本次交易的各交易对方已根据《重组管理办法》第四十七条的规定做出了股份锁定承诺，详见本报告书“第一节 本次交易概况”之“八、/（二）交易对方作出的重要承诺”。因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定。

八、本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《科创板股票上市规则》第 11.2 条和《重组审核规则》第八条的规定

根据《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《重组审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游，且与科创板上市公司主营业务具有协同效应。

（一）标的公司所处行业与上市公司处于同行业，符合科创板定位

标的公司从事晶圆代工业务，主要工艺节点为 65/55nm、40nm，主要覆盖独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频、高压等工艺平台。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），标的公司所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）、“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）及“电力电子基础元器件制造”（分类代码：6.5.2）。因此，标的公司

属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条中的“（一）新一代信息技术领域：半导体和集成电路行业”，符合科创板行业定位要求。

（二）标的公司与上市公司具有协同效应

本次交易所购买的资产与上市公司现有主营业务具有协同效应，详见本报告书“第一节 本次交易概况”之“一、/（三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司的业务协同性”。

综上，本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《科创板股票上市规则》第 11.2 条和《重组审核规则》第八条的规定。

九、中介机构关于本次交易符合《重组管理办法》规定发表的明确意见

独立财务顾问和律师核查意见详见本报告书“第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见”之“二、独立财务顾问对本次交易的结论性意见”和“三、法律顾问对本次交易的结论性意见”。

十、本次募集配套资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定

（一）本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十一条的规定

上市公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，具体而言：

1、上市公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情况；

2、上市公司最近一年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，上市公司不存在《发行注册管理办法》第十一条第（二）项规定的情形；

3、上市公司现任董事、高级管理人员最近三年未受到过中国证监会的行政

处罚，且最近一年未受到过证券交易所公开谴责；

4、截至本报告书签署日，上市公司或其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形；

5、最近三年上市公司控股股东、实际控制人不存在严重损害上市公司利益或上市公司投资者合法权益的重大违法行为；

6、最近三年上市公司不存在严重损害投资者合法权益或者社会公众利益的重大违法行为。

（二）本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十二条的规定

本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。本次募集配套资金拟用于标的公司技术升级改造项目，特色工艺研发及产业化项目，补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。本次募集配套资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；并非用于财务性投资，亦未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本次募集配套资金项目实施后，将不会与上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易，不会严重影响上市公司生产经营的独立性。因此，符合《发行注册管理办法》第十二条的规定。

（三）本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第五十五条、五十六条、五十七条、五十八条、五十九条的规定

根据上市公司 2025 年第九次董事会会议审议通过的本次重组方案，本次募集配套资金拟向不超过 35 名（含 35 名）的特定对象发行。特定对象包括符合中国法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等，符合《发行注册管理办法》第五十五条的规定。

根据上市公司 2025 年第九次董事会会议审议通过的本次重组方案，本次募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的

发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的 80%，具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定，符合《发行注册管理办法》第五十六条和第五十七条第一款的规定和第五十八条第一款的规定，不适用第五十七条第二款以及第五十八条第二款的规定。

本次募集配套资金的认购方所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。因此，本次募集配套资金的相关安排符合《发行注册管理办法》五十九条的规定。

第九节 管理层讨论与分析

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司 2024 年度及 **2025 年度审计**报告，本次交易前上市公司财务状况和经营成果情况如下：

（一）本次交易前上市公司财务状况分析

1、资产构成分析

上市公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产：				
货币资金	**3,527,432.75**	**35.23%**	3,249,478.54	36.95%
应收票据	**33,452.20**	**0.33%**	34,167.39	0.39%
应收账款	**166,456.27**	**1.66%**	166,179.84	1.89%
预付款项	**5,588.49**	**0.06%**	4,548.75	0.05%
其他应收款	**10,303.85**	**0.10%**	9,582.12	0.11%
存货	**534,103.75**	**5.33%**	495,255.31	5.63%
其他流动资产	**366,377.77**	**3.66%**	233,424.19	2.65%
流动资产合计	**4,643,715.08**	**46.38%**	**4,192,636.15**	**47.68%**
非流动资产：				
长期股权投资	**59,045.21**	**0.59%**	53,950.10	0.61%
其他权益工具投资	**336,538.00**	**3.36%**	207,968.00	2.37%
投资性房地产	**54,078.12**	**0.54%**	19,369.68	0.22%
固定资产	**3,243,942.85**	**32.40%**	2,863,356.73	32.56%
在建工程	**1,448,694.10**	**14.47%**	1,348,392.75	15.33%
使用权资产	**10,944.33**	**0.11%**	14,249.03	0.16%
无形资产	**59,337.73**	**0.59%**	64,260.73	0.73%
长期待摊费用	**100.37**	**0.00%**	17.92	0.00%
递延所得税资产	**-**	**-**	14,220.57	0.16%
其他非流动资产	**155,933.34**	**1.56%**	15,101.49	0.17%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
非流动资产合计	5,368,614.05	53.62%	4,600,887.00	52.32%
资产总计	10,012,329.13	100.00%	8,793,523.15	100.00%

报告期各期末，上市公司资产总额分别为 8,793,523.15 万元及 10,012,329.13 万元，2025 年末资产规模有所提升。其中，各期末流动资产占比分别为 47.68%及 46.38%，非流动资产占比分别为 52.32%及 53.62%。因上市公司不断进行产能扩建，固定资产及在建工程金额整体增加，上市公司非流动资产占比小幅提升。

（1）流动资产分析

报告期各期末，上市公司流动资产结构如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	3,527,432.75	75.96%	3,249,478.54	77.50%
应收票据	33,452.20	0.72%	34,167.39	0.81%
应收账款	166,456.27	3.58%	166,179.84	3.96%
预付款项	5,588.49	0.12%	4,548.75	0.11%
其他应收款	10,303.85	0.22%	9,582.12	0.23%
存货	534,103.75	11.50%	495,255.31	11.81%
其他流动资产	366,377.77	7.89%	233,424.19	5.57%
流动资产合计	4,643,715.08	100.00%	4,192,636.15	100.00%

报告期各期末，上市公司流动资产主要以货币资金、存货、应收账款及其他流动资产为主，各期末上述资产合计金额占流动资产总额比例分别为 98.85%和 98.94%。2025 年末，上市公司其他流动资产金额大幅提升，因上市公司新增大

额固定资产投资，增值税留抵税额呈大幅增加。

（2）非流动资产分析

报告期各期末，上市公司非流动资产结构如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	59,045.21	1.10%	53,950.10	1.17%
其他权益工具投资	336,538.00	6.27%	207,968.00	4.52%
投资性房地产	54,078.12	1.01%	19,369.68	0.42%
固定资产	3,243,942.85	60.42%	2,863,356.73	62.23%
在建工程	1,448,694.10	26.98%	1,348,392.75	29.31%
使用权资产	10,944.33	0.20%	14,249.03	0.31%
无形资产	59,337.73	1.11%	64,260.73	1.40%
长期待摊费用	100.37	0.00%	17.92	0.00%
递延所得税资产	-	-	14,220.57	0.31%
其他非流动资产	155,933.34	2.90%	15,101.49	0.33%
非流动资产合计	5,368,614.05	100.00%	4,600,887.00	100.00%

报告期各期末，上市公司非流动资产中占比较高的项目主要包括：固定资产、在建工程、其他权益工具投资，上述项目合计占比分别为 96.06%和 93.68%。

2、负债构成分析

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动负债：				
应付账款	234,522.37	6.33%	219,148.39	8.69%
预收款项	1,619.41	0.04%	1,757.78	0.07%
合同负债	95,785.37	2.59%	77,504.30	3.07%
应付职工薪酬	78,983.10	2.13%	59,434.77	2.36%
应交税费	16,259.12	0.44%	28,705.08	1.14%
其他应付款	517,009.26	13.96%	480,735.38	19.07%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
一年内到期的非流动负债	**286,055.52**	**7.73%**	205,312.25	8.14%
其他流动负债	**74,467.27**	**2.01%**	50,400.95	2.00%
流动负债合计	**1,304,701.43**	**35.24%**	**1,122,998.90**	**44.54%**
非流动负债：				
长期借款	**1,958,993.92**	**52.90%**	1,378,185.06	54.66%
租赁负债	**11,020.65**	**0.30%**	12,988.09	0.52%
长期应付款	**417,919.00**	**11.29%**	**-**	**-**
递延所得税负债	**10,218.87**	**0.28%**	7,296.21	0.29%
非流动负债合计	**2,398,152.44**	**64.76%**	**1,398,469.36**	**55.46%**
负债合计	**3,702,853.87**	**100.00%**	**2,521,468.25**	**100.00%**

（1）流动负债分析

报告期各期末，上市公司流动负债金额为 1,122,998.90 万元和 **1,304,701.43** 万元，占负债总额比例为 44.54%和 **35.24%，主要包括应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债等**。

（2）非流动负债分析

报告期各期末，上市公司非流动负债金额为 1,398,469.36 万元和 **2,398,152.44** 万元，占负债总额比例为 55.46%和 **64.76%**，主要由长期借款构成。**2025 年末，**上市公司非流动负债金额**及占负债总额比例大幅提升，主要系 2025 年新增 417,919.00 万元可回售金融工具从而导致长期应付款大幅增加**。

3、偿债能力分析

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产负债率	**36.98%**	28.67%
流动比率（倍）	**3.56**	3.73
速动比率（倍）	**3.15**	3.29

注：上述指标均以合并财务报表的数据为基础，计算公式如下：

（1）资产负债率=总负债期末数/总资产期末数；

（2）流动比率=流动资产期末数/流动负债期末数；

（3）速动比率=（流动资产期末数-存货期末数） /流动负债期末数。

报告期各期末，上市公司资产负债率分别为28.67%和**36.98%**，流动比率分别为**3.73**和**3.56**，速动比率分别为**3.29**和**3.15。2025**年度，由于上市公司应付资产采购款等流动负债增加，导致流动比率和速动比率有所下降，**同时由于长期借款、长期应付款等非流动负债大幅增加，导致资产负债率有所提升。**总体而言，上市公司资产负债率水平较低，流动比率和速动比率较高，短期和长期偿债能力较强。

（二）本次交易前上市公司盈利能力分析

1、营业收入及利润情况分析

单位：万元

项目	2025年度	2024年度
营业收入	**1,729,145.07**	1,438,830.77
营业利润	**-65,192.80**	-98,935.59
利润总额	**-65,100.61**	-98,831.81
净利润	**-80,714.30**	-103,218.38
归属于母公司股东的净利润	**37,661.14**	38,057.62

报告期各期，上市公司实现营业收入1,438,830.77万元和**1,729,145.07**万元，**报告期各期**，上市公司全年平均产能利用率接近**满产。2025年**华虹制造项目（华虹九厂）**产能快速爬坡，公司协同客户快速导入产品，整体营业收入快速增长。**

2、盈利能力指标分析

项目	2025年度	2024年度
销售毛利率	**18.72%**	17.43%
销售净利率	**-4.67%**	-7.17%
加权平均净资产收益率	**0.85%**	0.88%
基本每股收益（元/股）	**0.22**	0.22

注1：销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

注2：销售净利率=净利润/营业收入；

注3：加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算；

注4：基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润/发行在外的普通股加权平均数

2025 年度，上市公司销售毛利率、**销售净利率均**有所**提升，盈利能力向好**。

二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析

（一）行业发展概况

1、半导体行业概况

半导体是常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，由其制成的器件统称半导体产品，被广泛地应用于电子通信、计算机、网络技术、物联网、汽车等产业，是绝大多数电子设备的核心组成部分。半导体产品是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，也是电子产品的核心、信息产业的基石。

未来，在人工智能、新能源、工业智造、新一代移动通讯以及数据中心等应用领域的驱动下，半导体市场规模有望实现持续增长趋势。

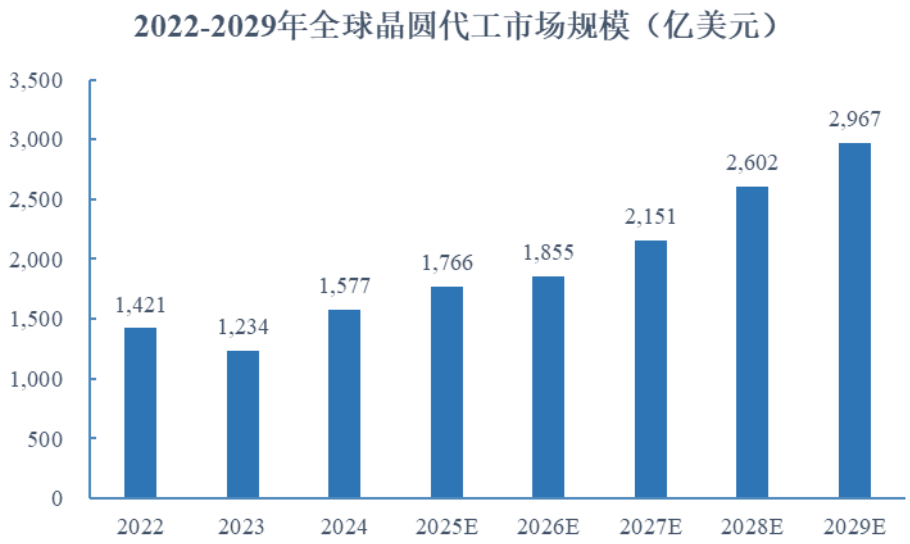
2、晶圆代工行业概况

（1）晶圆代工行业简介

晶圆代工行业源于半导体产业链的专业化分工，随着集成电路复杂度不断提高，设计与制造环节逐渐分离，形成了专注于晶圆制造的代工模式。晶圆代工企业不涉及芯片设计，而是依托先进的制程技术和庞大的生产线，为各类芯片设计公司提供晶圆制造服务，覆盖从光刻、刻蚀到薄膜沉积、离子注入等数百道工艺环节。晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的资本支出和人才投入，具有较高的进入壁垒。

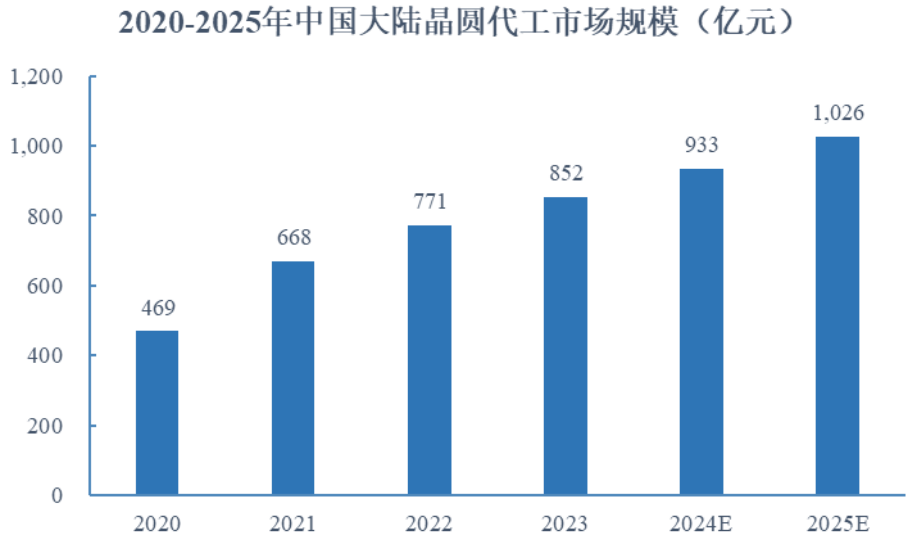
（2）晶圆代工行业市场规模

根据 TechInsights 统计，2018-2022 年，全球晶圆代工市场规模从 736 亿美元增长至 1,421 亿美元，年均复合增长率为 17.88%。2023 年，全球集成电路行业进入周期性低谷，晶圆代工市场随之下滑，市场规模下降至 1,234 亿美元。2024 年行业迎来上行周期，全球晶圆代工市场规模达到 1,577 亿美元，同比增长 27.80%，2024-2029 年的年均复合增长率预计达到 13.47%。



数据来源：2025 TechInsights McClean Report

由于中国是全球最大的半导体市场之一，尽管中国大陆晶圆代工行业起步较晚，但得益于国家产业政策支持和下游市场需求拉动，近年来发展速度较快。根据中商产业研究院的数据，2023 年中国大陆晶圆代工市场规模已达到 852 亿元左右，同比增长 10.51%，预计 2025 年中国大陆晶圆代工市场规模将达到 1,026 亿元。



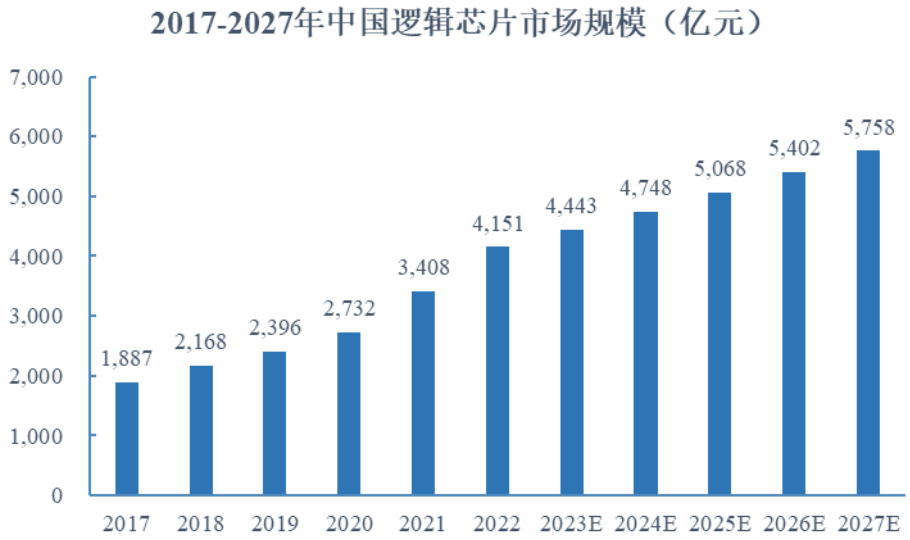
数据来源：IC Insights、中商产业研究院

3、下游产品行业概况

（1）逻辑芯片行业概况

逻辑芯片是以二进制为原理实现运算与逻辑判断的一种集成电路，主要包括CPU（中央处理器）、GPU（图形处理器）、ASIC（应用型专用集成电路）和 FPGA（现场可编程门列阵）等。作为现代信息基础设施中数据处理能力的核心载体，逻辑芯片广泛应用于服务器、计算机、通信设备和智能终端等领域，是半导体最大的单一细分市场。WSTS 数据显示，逻辑芯片在全球半导体市场中占比约 31%，市场规模居于首位。

中国大陆凭借庞大的电子信息制造业基础和持续增长的数字化需求，长期维持较高的逻辑芯片销售规模。根据 SIA 统计，2024 年中国逻辑芯片市场规模已达 4,748.1 亿元，未来在 AI、物联网和汽车电子等新兴领域持续渗透的背景下，其市场规模预计仍将保持长期增长态势。



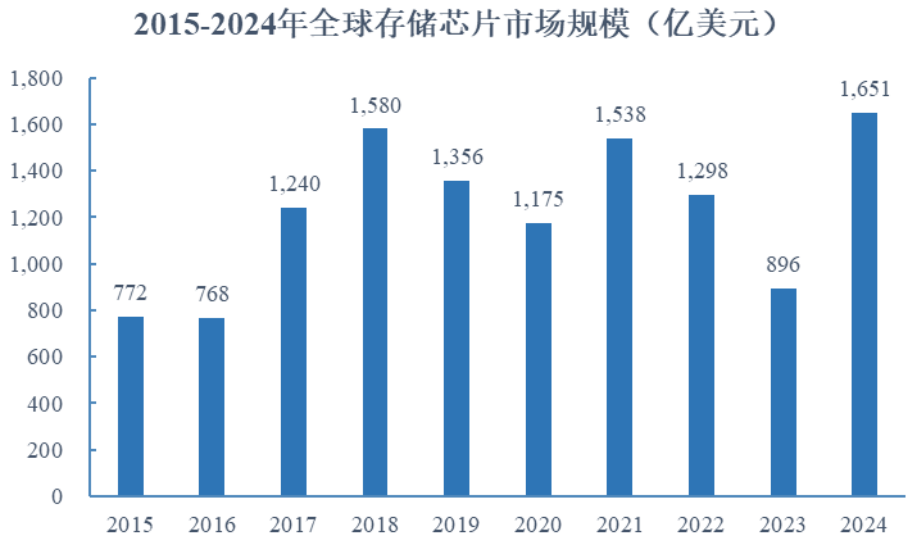
数据来源：SIA

（2）存储芯片行业概况

存储芯片是利用半导体电路保存二进制数据的一种集成电路，主要包括NAND Flash（闪存）、DRAM（动态随机存取存储器）等。存储芯片是半导体第二大细分市场，仅次于逻辑芯片，WSTS 数据显示，存储芯片市场占比约为 23%。

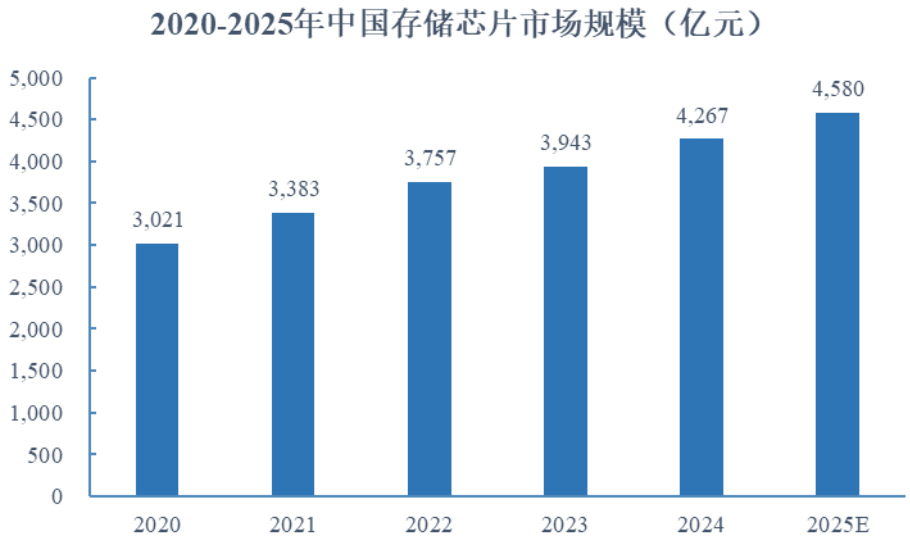
存储芯片具有典型的大宗商品属性，产品标准化程度高，不同厂商产品之间可替代性强，因而市场价格和销售额易受供需关系变动影响，呈现周期性波动特征。2023 年下半年起，在主要厂商前期减产、AI 服务器与智能终端对存储容量

需求上升、以及数据中心与大模型训练对高性能存储需求的共同推动下，全球存储芯片市场逐步回暖，有望开启上行周期。根据 SIA 数据，2024 年全球存储芯片市场规模达 1,651 亿美元。



数据来源：SIA、WSTS、电子信息产业网

在人工智能、物联网、云计算及消费电子等终端应用对存储容量和性能需求持续提升的背景下，中国存储芯片市场亦呈现稳步增长态势。根据中商产业研究发布的数据，2024 年中国存储芯片市场规模约为 4,267 亿元，预计 2025 年中国存储芯片市场规模将达 4,580 亿元。

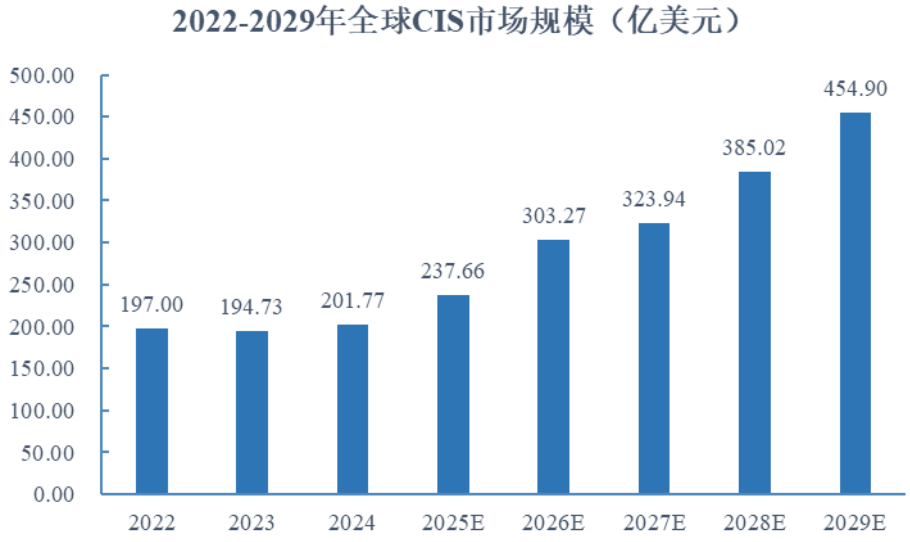


数据来源：中商产业研究院

（3）CMOS 图像传感器（CIS）行业概况

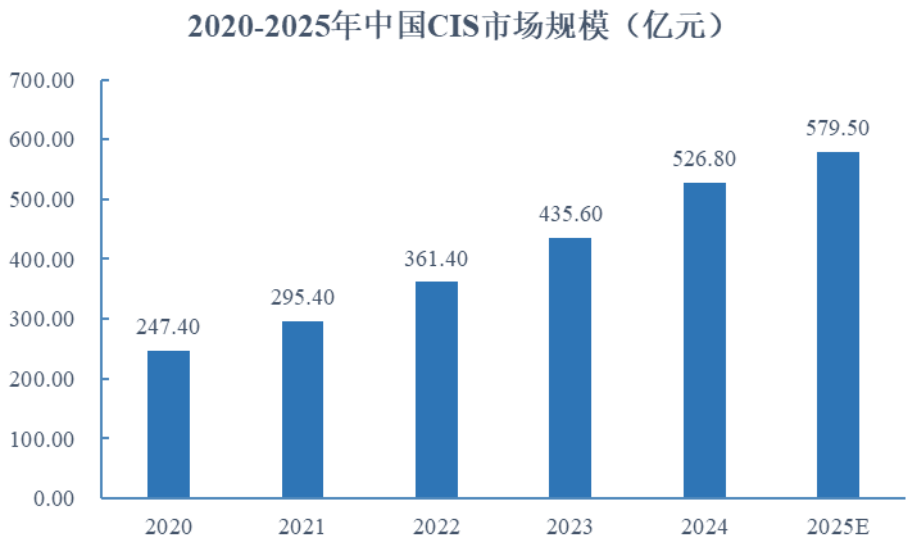
CMOS 图像传感器（CIS）是一种基于 CMOS 工艺的光电转换器件，能够将光学图像信号转换为电信号，广泛应用于智能手机、平板电脑、汽车影像、安防监控及医疗成像等领域。根据工艺结构的不同，CIS 可分为前照式（FSI）、背照式（BSI）和堆栈式（Stacked CIS）等类别。

根据 TechInsights 统计，全球 CIS 市场规模呈现持续稳定增长的态势，2024 年 CIS 市场规模达到 201.77 亿美元。受益于多摄系统普及、汽车 ADAS 视觉系统需求增长、机器视觉应用拓展等增长因素，预计 2024-2029 年全球 CIS 市场年均复合增长率将达到 17.66%。



数据来源：2025 TechInsights McClean Report

在中国市场方面，得益于国家政策对半导体及智能传感产业的支持、产业链上下游协同效应的增强，以及安防监控、智能汽车、AR/VR 等新兴应用领域的快速发展，中国 CIS 产业近年来持续成长。根据中商产业研究院的数据，2024 年中国 CIS 市场规模达到约 526.8 亿元，较上年增长 20.94%。预计在国产替代与技术升级的双重推动下，2025 年中国 CIS 市场规模将进一步增至 579.5 亿元。



数据来源：中商产业研究院

（二）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

半导体行业的发展程度是国家科技实力的重要体现，晶圆制造领域更是全球科技竞争的焦点。提升我国半导体相关产业的竞争力，已成为制造业升级的重要课题之一。近年来，国家各部门相继推出了一系列优惠政策，鼓励和支持行业发展。具体政策参见“第四节 标的公司基本情况”之“六、标的公司主营业务情况”之“（一）所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策”。

（2）半导体产业中心转移，国内半导体产业快速发展

中国大陆则成为半导体产业转移的核心地区。产业转移是市场需求、国家产业政策和资本驱动的综合结果。半导体行业目前呈现专业分工深度细化、细分领域高度集中的特点。目前，中国拥有最具活力的终端应用产业集群，全球最大且增速最快的半导体消费市场。巨大的下游市场配合积极的国家产业政策与活跃的社会资本，正在全方位、多角度地支持国内半导体行业发展。我国在人工智能、物联网、新能源、显示面板、LED 等高新技术行业经过多年发展已达到领先水平，也大力拉动了各类芯片产品的升级换代进程，也加速了国内半导体产业链进一步完善。

（3）新兴科技产业带来旺盛的市场需求

得益于 5G 通信、物联网、人工智能、云计算及大数据等新一代信息技术的规模化应用与深度融合，全球正经历一场深刻的数字化、智能化变革。在此背景下，下游应用市场呈现爆发式增长：智能手机持续向高性能与低功耗演进，便携式设备品类不断丰富，物联网终端实现海量连接，云服务基础设施加速扩容升级，汽车电子在电动化与自动驾驶趋势下价值量显著提升。这些终端产品的功能复杂化、性能高端化与市场普及化，共同驱动了对先进制程、特色工艺及各类半导体芯片的庞大需求，为全球集成电路产业创造了强劲的增长动力与广阔的发展空间。

2、不利因素

（1）与国际巨头仍存在差距

中国大陆半导体企业在顶尖技术积累与自主创新能力方面，与国际领先企业仍存在显著差距。尽管近年来政府与企业持续加大研发投入，但由于技术积淀薄弱、高端人才不足及资金实力有限等结构性因素，产业整体研发力量仍待加强。在全球半导体行业高度竞争的格局下，这种技术劣势预计将使中国大陆企业在未来一段时期内持续面临竞争压力。

（2）国内产业链薄弱

目前，中国大陆半导体产业链的配套能力有待加强，与晶圆制造配套的上下游产业仍在发展中，部分所需的设备以及原材料仍主要依赖进口。

（3）高端人才不足

晶圆代工行业对从业人员的知识结构、技术研发能力及行业经验积淀均设有较高门槛。当前，随着国内半导体产业进入高速发展周期，兼具系统化理论知识、前沿技术开发能力与深刻市场洞察力的复合型高端人才供给明显不足。这一结构性矛盾导致行业内领军人才及核心工程技术团队的需求缺口持续扩大，已在客观上对企业技术创新、产能扩张与战略升级形成制约，成为影响行业发展的重要因素。

（三）行业壁垒情况

1、技术壁垒

晶圆代工行业属于资本、人才及技术密集型行业，技术研发涉及多学科交叉，生产工艺流程复杂，行业具有较强的技术壁垒。对于行业新进入者而言，短期内无法突破核心技术，面临较高的技术壁垒。

2、人才壁垒

随着半导体行业技术的不断进步，对技术人才的专业性、经验要求和管理能力的要求也不断提升，已形成较高的门槛，拥有高端专业的人才是晶圆代工企业保持市场竞争的关键。晶圆代工企业需要拥有大量的多学科、多领域的专业人才，而高端人才的聘用成本较高，且集中于行业领先企业，使得行业新进入者短期内组建全面、优秀的人才团队的难度较大。

3、资金和规模壁垒

晶圆代工行业技术更新迭代快、资金投入大、研发周期长，属于资本、人才及技术密集型行业，固定资产投资的需求大、设备购置成本高。随着代工产品种类不断丰富、工艺节点不断发展，晶圆代工企业需要长期的研发投入以实现技术突破。若没有足够的资金支持，新进入者的竞争力与已经取得资金和规模优势的企业存在较大差异。

4、市场及客户壁垒

在晶圆代工领域，公司的技术创新与客户的长期协作密不可分，与下游芯片设计厂商建立长期稳定的合作关系，能够掌握行业、产品最新技术动态，及时了解和把握客户最新需求，准确地进行晶圆代工服务更新升级，确保公司产品在市场竞争中保持竞争优势，同时积累产品行业应用经验，完善产品性能，提高产品质量水平。因此，客户对其长期合作的晶圆代工企业黏性较大，对新进入者构成了市场及客户壁垒。

（四）行业特征

1、行业主要经营模式及特点

根据所包含的生产环节的不同，半导体产业的企业经营模式一般可分为垂直整合模式（IDM 模式）、晶圆代工模式（Foundry 模式）和无晶圆厂模式（Fabless

模式），标的公司属于晶圆代工模式。

序号	项目	模式
1	垂直整合模式（IDM 模式）	涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试以及后续的产品销售等环节
2	晶圆代工模式（Foundry 模式）	不涵盖芯片设计环节，专门负责晶圆制造，为芯片产品公司提供晶圆代工服务
3	无晶圆厂模式（Fabless 模式）	不涵盖晶圆制造环节和封装测试环节，专门负责芯片设计和后续的产品销售，将晶圆制造和封装测试外包给专业的晶圆制造、封测企业

晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的资本支出和人才投入，具有较高的进入壁垒。

2、行业发展趋势

随着下游应用场景新需求的不断涌现，半导体产品种类不断增多。为满足市场对于产品功能、性能等特性的差异化需求，IDM 厂商与晶圆代工厂商等涉及晶圆制造环节的企业不断研发创新晶圆制造工艺技术，并演进形成了差异化的制造工艺。晶圆制造工艺大致可分为先进逻辑工艺与特色工艺。

先进逻辑工艺沿着摩尔定律发展，侧重于不断缩小晶体管线宽，主要追求产品的高运算速度，主要应用于高性能计算、中央处理器（CPU）等领域芯片产品的制造。先进逻辑工艺的行业代表企业为台积电。

与沿着摩尔定律不断追求晶体管缩小的先进逻辑工艺不同，特色工艺不完全追求器件的缩小，而是通过持续优化器件结构与制造工艺最大化发挥不同器件的物理特性以提升产品性能及可靠性。特色工艺主要用于制造功率器件 MCU、智能卡芯片、电源管理芯片、射频芯片、传感器等，上述产品被广泛应用于新能源汽车、工业智造、新一代移动通讯、物联网、新能源、消费电子等众多应用领域。特色工艺的行业代表企业为华虹半导体。

（五）行业周期性、区域性及季节性特征

1、周期性

受到全球宏观经济波动、行业景气度等因素影响，半导体行业存在一定的周期性。因此，半导体行业的发展与宏观经济整体发展密切相关。全球宏观经济尽

管在较长时期内保持增长趋势，但不排除出现周期性波动的可能性。

2、区域性

全球主要半导体制造厂商主要分布在欧洲、美洲及日韩等经济发达地区，国内半导体制造厂商亦主要集中在经济较发达地区，如中国台湾、长三角、珠三角地区。

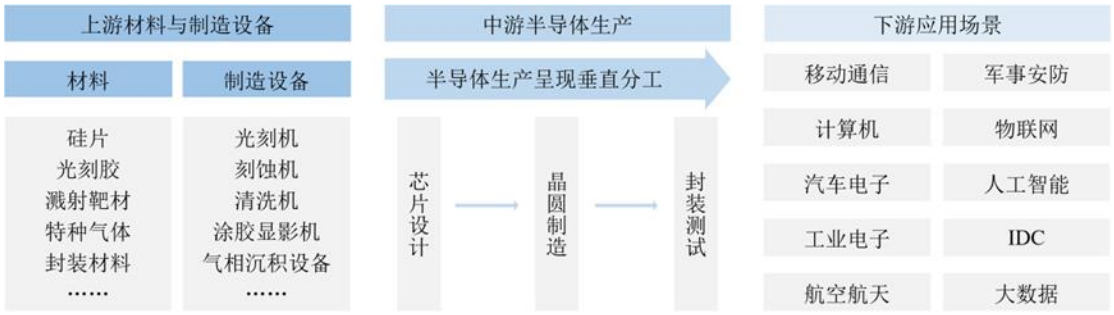
3、季节性

半导体产品下游应用范围较广，因此不具备明显的季节性特征。

（六）行业与上下游联系情况

半导体行业呈现垂直化分工格局，上游包括半导体材料、半导体制造设备等；中游为半导体生产，具体可划分为芯片设计、晶圆制造、封装测试；半导体产业下游为各类终端应用。

半导体产业链分工图



（七）行业竞争格局和行业内主要企业

1、行业竞争格局

在全球晶圆代工领域，竞争格局呈现显著的梯队化特征。台积电凭借其在先进制程领域的绝对技术优势和全球客户生态，占据行业主导地位。联华电子、格芯等企业则聚焦成熟制程与特色工艺，通过差异化竞争确立自身市场定位。国内晶圆代工领域，因起步较晚，与国外同行业公司仍有一定差距，近十年来，受益于国际电子制造产业的转移，半导体供应链安全考量下的国产化浪潮加剧下，中芯国际、华虹公司等国内企业不断投入研发，提升自身产品竞争力，使得我国晶圆代工水平不断提高，竞争实力不断加强。

2、行业内主要企业

除上市公司外，行业内主要企业情况如下：

（1）台积电（2330.TW）

台积电在晶圆代工行业排名第一，其主营业务为集成电路及其他半导体芯片的制造、销售、封装测试与电脑辅助设计及光罩制造等代工服务。台积电的产品包括提供一系列广泛的晶圆制造工艺，包括制造 CMOS 逻辑、混合信号、射频(RF)、嵌入式存储器以及双极型互补金属氧化物半导体(BiCMOS，结合使用 CMOS 晶体管和双极型晶体管)混合信号技术等。此外，TSMC 还提供设计服务、掩膜制造、TSMC3DFabricTM 先进封装和硅堆叠技术以及测试服务。台积电在北美、欧洲、日本、中国大陆等地设有子公司或办事处，提供全球客户的业务与技术服务。2025 年，台积电实现营业收入 38,090.54 亿新台币，净利润 17,178.83 亿新台币。

（2）中芯国际（688981.SH）

中芯国际是行业内知名的集成电路晶圆代工企业，向全球客户提供 8 英寸和 12 英寸晶圆代工与技术服务。公司总部位于中国上海，拥有全球化的制造和服务基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座 8 英寸和 12 英寸晶圆厂。公司还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务。2025 年，中芯国际实现营业收入 673.23 亿元，净利润 72.09 亿元。

（3）联华电子（2303.TW）

联华电子股份有限公司成立于 1980 年，总部位于中国台湾，于 1985 年在台湾证券交易所上市（股票代码：2303.TW），于 2000 年在纽交所上市（股票代码：UMC.NYSE），为 IC 产业各项主要应用产品生产芯片。2025 年，联华电子实现营业收入 2,421.47 亿新台币，净利润 417.16 亿新台币。

（4）格芯（GFS.O）

格芯股份有限公司（原：Global Foundries Inc.）成立于 2009 年，总部位于美国，拥有德国德累斯顿、美国奥斯汀和纽约州等多座工厂。格罗方德的产品主要

应用于移动、汽车自动化、沟通网络和数据中心、物联网市场等领域。2025 年，格罗方德实现营业收入 67.91 亿美元，净利润 8.85 亿美元。

（5）晶合集成（688249.SH）

晶合集成成立于 2015 年，主要提供 150nm 至 40nm 的晶圆代工服务，所代工的为显示驱动芯片（DDIC）、微控制器（MCU）、CMOS 图像传感器（CIS）、电源管理（PMIC）、逻辑应用（Logic）等。2025 年，晶合集成实现营业收入 108.85 亿元，净利润 4.66 亿元。

（6）芯联集成（688469.SH）

芯联集成成立于 2018 年，主要从事 MEMS、IGBT、MOSFET、模拟 IC、MCU 的研发、生产、销售，为汽车、新能源、工控、家电等领域提供一站式芯片系统代工方案。2024 年，芯联集成实现营业收入 65.09 亿元，净利润-22.47 亿元。

（7）华润微（688396.SH）

华润微成立于 2004 年，主要采用 IDM 经营模式并同时对外提供半导体制造、封测服务，拥有芯片设计、掩模制造、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，在分立器件及集成电路领域具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了较为先进的特色工艺和系列化的产品线。2024 年，华润微实现了营业收入 101.19 亿元，净利润 6.62 亿元。

（8）士兰微（600460.SH）

士兰微成立于 1997 年，前身是杭州士兰电子有限公司，是一家专业从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设计、生产与销售的高新技术企业，士兰微目前的主要产品是集成电路以及相关的应用系统和方案，主要包括半导体分立器件、MCU 电路、电源管理电路、LED 照明驱动电路、LED 显示驱动/控制电路等产品。2024 年，士兰微实现了营业收入 112.21 亿元，净利润-0.24 亿元。

（八）标的公司核心竞争力及行业地位

1、核心竞争力

（1）先进的 12 英寸成熟工艺平台与规模优势

华力微拥有中国大陆首条全自动 12 英寸集成电路代工生产线，设计月产能达 3.8 万片，具备规模优势。在引进比利时微电子研发中心（IMEC）65nm 工艺的基础上，通过自主研发和技术攻关，成功开发了拥有自主知识产权的 55/40nm 逻辑工艺技术平台，并在逻辑与射频、嵌入式非易失性存储器、独立式非易失性存储器、高压工艺平台形成了多元的产品组合。标的公司 65/55nm、40nm 工艺已达到业界主流水平，形成了在成熟制程节点上的显著竞争优势。

（2）差异化工艺布局与持续创新能力

华力微在成熟制程的基础上建立了较为完善的自有工艺平台，形成了差异化的技术组合。与此同时，标的公司积极与国际领先企业开展合作，引入并量产 SONOS 嵌入式 Flash 技术，以更低光罩层数和更高可靠性实现成本与性能的双重优化，充分体现了华力微在特色工艺上的持续创新能力与竞争壁垒。

（3）自主研发与本土化积累优势

标的公司通过组建本土研发团队，自主开发了 40nm 低功耗逻辑平台，采用超浅结、激光退火、多孔超低介电材料等先进技术，实现了性能与功耗的最佳平衡，并已实现规模量产。华力微在 65/55nm、40nm 逻辑工艺平台的持续拓展中，逐步形成了持续的技术迭代能力。凭借持续的研发投入与本土化积累，标的公司在国内晶圆代工领域构建了鲜明的差异化优势与长期竞争力。

（4）优质客户群体与市场应用优势

标的公司深耕逻辑与射频、嵌入式非易失性存储器、独立式非易失性存储器、高压工艺方向的各类产品组合。其中，65/55nm 射频工艺在国内代工厂中占据主流地位，主要客户均为业内排名前列企业；嵌入式存储器产品广泛应用于 MCU、智能卡等芯片；40nm 逻辑工艺平台则支撑 ISP 芯片量产，服务于手机、安防监控、车载电子、AIoT 等市场。凭借在成熟节点上逻辑工艺与特色工艺的结合和深耕，华力微产品覆盖通信、消费电子等多元市场，保持较强的竞争韧性与成长空间。

2、行业地位

标的公司拥有中国大陆首条全自动 12 英寸集成电路代工生产线，超过 15 年的 12 英寸晶圆代工技术积累，通过多年积累，标的公司 65/55nm、40nm 工艺已达到业界主流水平，形成了在成熟制程节点上的显著竞争优势。

三、标的公司的财务状况和盈利能力分析

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

报告期各期末，标的公司资产按流动性划分的构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	**454,215.07**	**68.48**	382,054.33	61.04
非流动资产	**209,058.20**	**31.52**	243,834.93	38.96
合计	**663,273.27**	**100.00**	**625,889.26**	**100.00**

报告期各期末，标的公司总资产规模分别为 625,889.26 万元和 **663,273.27** 万元，其中报告期各期末的流动资产占比分别为 61.04%和 **68.48**%。

（1）流动资产分析

报告期各期末，标的公司流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	**259,217.74**	**57.07**	148,092.13	38.76
应收票据	**-**	**-**	1,000.00	0.26
应收账款	**65,588.39**	**14.44**	63,591.05	16.64
预付款项	**797.08**	**0.18**	81.29	0.02
其他应收款	**38.80**	**0.01**	48.19	0.01
存货	**125,517.63**	**27.63**	158,536.09	41.50
一年内到期的非流动资产	**1,302.87**	**0.29**	-	-

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
其他流动资产	**1,752.56**	**0.39**	10,705.58	2.80
合计	**454,215.07**	**100.00**	**382,054.33**	**100.00**

报告期各期末，标的公司流动资产分别为 382,054.33 万元和 **454,215.07** 万元，主要包括货币资金、应收账款、存货。报告期各期末，上述流动资产合计占流动资产总额的比例分别为 96.90%和 **99.14%**。

① 货币资金

报告期各期末，标的公司货币资金构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
库存现金	**3.85**	**0.00**	4.00	0.00
银行存款	**258,214.65**	**99.61**	143,759.50	97.07
其他货币资金	**0.16**	**0.00**	101.20	0.07
未到期应收利息	**999.09**	**0.39**	4,227.43	2.85
合计	**259,217.74**	**100.00**	**148,092.13**	**100.00**

报告期各期末，标的公司货币资金分别为 148,092.13 万元和 **259,217.74** 万元，主要为银行存款。**2025 年末**，标的公司货币资金相比 2024 年末有所增加，主要原因系标的公司经营业务规模增长且销售回款**良好**。

② 应收票据

报告期各期末，标的公司应收票据情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	1,000.00
合计	-	**1,000.00**

2024 年末，标的公司应收票据金额为 1,000.00 万元，占流动资产的比例为 0.26%，**该**应收票据为银行承兑汇票且信用减值风险低，因此未计提坏账准备。

③ 应收账款

报告期各期末，标的公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应收账款余额	**74,044.50**	69,651.87
减：坏账准备	**8,456.11**	6,060.83
应收账款账面价值	**65,588.39**	63,591.05
应收账款账面价值占营业收入比重	**12.86%**	12.75%

1）应收账款变动情况分析

报告期内，标的公司应收账款账面价值分别为 63,591.05 万元和 **65,588.39** 万元，占流动资产的比例分别为 16.64%和 **14.44%**，应收账款账面价值较为稳定。报告期内，公司加强客户回款管理，销售回款情况**良好**。

2）应收账款构成及坏账准备计提情况

报告期各期末，标的公司应收账款具体坏账准备计提情况如下：

单位：万元

2025 年 12 月 31 日					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	**74,044.50**	**100.00**	**8,456.11**	**11.42**	**65,588.39**
小计	**74,044.50**	**100.00**	**8,456.11**	**11.42**	**65,588.39**
2024 年 12 月 31 日					
项目	**账面余额**		**坏账准备**		**账面价值**
	账面余额	**比例（%）**	**金额**	**计提比例（%）**	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	69,651.87	100.00	6,060.83	8.70	63,591.05
小计	**69,651.87**	**100.00**	**6,060.83**	**8.70**	**63,591.05**

3）应收账款账龄情况

报告期各期末，标的公司应收账款账龄具体情况如下：

单位：万元、%

账龄	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	**68,700.61**	**92.78**	64,415.66	92.48
1-2 年	**1,349.28**	**1.82**	575.29	0.83
2-3 年	**512.06**	**0.69**	4,660.92	6.69
3 年以上	**3,482.55**	**4.70**	**-**	-
合计	**74,044.50**	**100.00**	**69,651.87**	**100.00**

报告期内，标的公司应收账款的账龄分布主要集中在 1 年以内，占比分别为 92.48%和 **92.78%**，1 年以内应收账款占比有所提升。标的公司 1 年以上应收账款占比较低，应收账款整体质量良好，应收账款已充分、谨慎计提坏账。

4）应收账款前五名客户

报告期各期末，标的公司应收账款余额前五名客户的具体情况如下：

单位：万元、%

序号	客户名称	应收账款余额	占比
2025 年 12 月 31 日			
1	**客户 B**	**24,548.81**	**33.15**
2	**客户 C**	**11,156.57**	**15.07**
3	**客户 A**	**10,289.15**	**13.90**
4	**华虹集团**	**7,544.25**	**10.19**
5	**客户 G**	**3,053.12**	**4.12**
合计		**56,591.91**	**76.43**
2024 年 12 月 31 日			
1	客户 A	18,409.23	26.43
2	客户 B	15,117.19	21.70
3	客户 C	13,391.84	19.23
4	客户 H	6,582.00	9.45
5	华虹集团	3,507.75	5.04
合计		**57,008.01**	**81.85**

注：客户按最终控制方合并计算并列示。

④ 预付款项

报告期内，标的公司预付款项主要系生产经营过程中提前支付的保险费及设备采购款。报告期各期末，标的公司预付款项金额分别为 81.29 万元及 797.08 万元，占流动资产总额比例分别为 0.02%及 0.18%，占比较小，账龄主要在一年以内。

⑤ 其他应收款

报告期各期末，标的公司其他应收账款净额分别为 48.19 万元及 38.80 万元，占流动资产的比例分别为 0.01%及 0.01%，金额及占比较小。

⑥ 存货

报告期各期末，标的公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	60,298.69	-	60,298.69
在产品	45,872.31	590.40	45,281.92
产成品	22,418.21	2,481.18	19,937.03
合计	128,589.21	3,071.58	125,517.63
项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	59,835.40		59,835.40
在产品	48,970.13	3,991.20	44,978.93
产成品	56,262.36	2,540.59	53,721.76
合计	165,067.88	6,531.79	158,536.09

报告期各期末，标的公司存货账面价值分别为 158,536.09 万元和 125,517.63 万元，占流动资产的比例分别为 41.50%和 27.63%。报告期各期末，标的公司存货账面价值逐年减少，主要系下游产业的持续发展，标的公司产品市场需求持续增长且销售规模持续扩大，导致报告期各期末产成品规模降低。

报告期各期末，标的公司对库存商品和在产品按照成本与可变现净值孰低计量并计提存货跌价准备；标的公司的原材料均处在正常使用有效期内且未出现明

显市场跌价情形，因此未对其计提存货跌价准备。报告期各期末，标的公司存货跌价准备金额分别为 6,531.79 万元和 3,071.58 万元，存货跌价准备计提比例分别为 3.96%和 2.39%。

⑦ 一年内到期的非流动资产

报告期各期末，标的公司一年内到期的非流动资产具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应收款	1,302.87	-
合计	1,302.87	-

2025 年末，标的公司一年内到期的非流动资产为 1,302.87 万元，占流动资产比例为 0.29%，占比较小，主要为一年内到期的长期应收款，款项性质为融资租赁款。

⑧ 其他流动资产

报告期各期末，标的公司其他流动资产具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
增值税留抵税额	1,752.56	10,705.58
合计	1,752.56	10,705.58

报告期各期末，标的公司其他流动资产分别为 10,705.58 万元和 1,752.56 万元，占流动资产比例分别为 2.80%和 0.39%，均为增值税留抵税额。

（2）非流动资产分析

报告期各期末，标的公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
长期应收款	5,642.88	2.70	-	-
固定资产	147,897.29	70.74	175,269.05	71.88
在建工程	7,503.12	3.59	3,438.57	1.41

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
使用权资产	**35,264.09**	**16.87**	43,748.62	17.94
无形资产	**11,873.62**	**5.68**	15,178.02	6.22
长期待摊费用	**463.41**	**0.22**	654.54	0.27
其他非流动资产	**413.78**	**0.20**	5,546.13	2.27
合计	**209,058.20**	**100.00**	**243,834.93**	**100.00**

报告期各期末，标的公司非流动资产总额分别为 243,834.93 万元和 **209,058.20** 万元。标的公司非流动资产以固定资产、使用权资产、无形资产为主，报告期各期末，上述非流动资产合计占非流动资产总额的比例分别为 96.05% 和 **93.29%**。

① 长期应收款

2025 年末，标的公司长期应收款为 **5,642.88** 万元，占非流动资产的比例分别为 **2.70%**，系新增融资租赁款。

② 固定资产

报告期各期末，标的公司固定资产情况如下：

单位：万元

时间	项目	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
2025 年 12 月 31 日	厂务设施	**126,490.91**	**119,011.87**	**-**	**7,479.04**
	机器设备	**1,396,912.40**	**1,258,412.70**	**-**	**138,499.70**
	工具器具	**1,206.80**	**969.87**	**-**	**236.94**
	电脑通讯设备	**20,207.23**	**18,564.81**	**-**	**1,642.42**
	办公设备	**94.00**	**78.56**	**-**	**15.43**
	运输设备	**72.33**	**48.56**	**-**	**23.77**
	合计	**1,544,983.66**	**1,397,086.37**	**-**	**147,897.29**
2024 年 12 月 31 日	厂务设施	125,039.49	118,143.04	-	6,896.45
	机器设备	1,396,763.59	1,230,353.50	-	166,410.10
	工具器具	1,096.12	917.27	-	178.84
	电脑通讯设备	20,306.66	18,602.06	-	1,704.60
	办公设备	120.43	95.32	-	25.11

时间	项目	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
	运输设备	401.20	347.25	-	53.95
	合计	**1,543,727.49**	**1,368,458.44**	**-**	**175,269.05**

报告期各期末，标的公司固定资产净值分别为 175,269.05 万元和 **147,897.29** 万元，占非流动资产比例分别为 71.88%和 **70.74%**。标的公司固定资产主要为机器设备、厂务设施和电脑通讯设备，均为生产经营必备资产，使用状况良好，报告期各期末不存在因市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置导致固定资产可收回金额低于账面价值的情形，无需计提减值准备。

③ 在建工程

报告期各期末，标的公司在建工程情况如下：

单位：万元

时间	项目	账面余额	减值准备	账面价值
2025 年 **12 月 31 日**	机器设备	**6,631.98**	-	**6,631.98**
	工具器具	**0.71**	-	**0.71**
	电脑通讯设备	**4.60**	-	**4.60**
	无形资产	**865.83**	-	**865.83**
	合计	**7,503.12**	**-**	**7,503.12**
2024 年 12 月 31 日	机器设备	2,585.05	-	2,585.05
	工具器具	1.07	-	1.07
	电脑通讯设备	38.50	-	38.50
	无形资产	813.95	-	813.95
	合计	**3,438.57**	**-**	**3,438.57**

报告期各期末，标的公司在建工程账面价值分别为 3,438.57 万元和 **7,503.12** 万元，占非流动资产比例分别为 1.41%和 **3.59%。2025 年末**，标的公司在建工程账面价值较 2024 年末增加 **4,064.55** 万元，增幅 **118.20%**，主要系标的公司拟扩大生产规模并于 2025 年新增购置机器设备所致，该部分新增在建工程目前暂未达到预计可使用状态，尚不能正式投入使用，因此尚未转入固定资产。

④ 使用权资产

报告期各期末，标的公司使用权资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
账面原值	**76,943.23**	76,864.62
累计折旧	**41,679.14**	33,116.00
账面价值	**35,264.09**	43,748.62

报告期各期末，标的公司使用权资产的账面价值分别为 43,748.62 万元和 **35,264.09** 万元，占非流动资产比例分别为 17.94%和 **16.87%**，主要为房屋及建筑物租赁，报告期内使用权资产账面价值下降主要系随着剩余租赁期的减少而下降。

⑤ 无形资产

报告期各期末，标的公司无形资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	**50,956.18**	**50,963.68**
软件	**2,292.60**	2,296.75
技术使用权	**30,884.65**	30,945.04
外购知识产权	**17,778.93**	17,721.89
二、累计摊销合计	**39,082.56**	**35,785.66**
软件	**2,284.14**	2,285.07
技术使用权	**19,334.08**	16,611.35
外购知识产权	**17,464.34**	16,889.24
三、减值准备	**-**	**-**
四、账面价值合计	**11,873.62**	**15,178.02**
软件	**8.46**	11.68
技术使用权	**11,550.57**	14,333.69
外购知识产权	**314.59**	832.65

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 15,178.02 万元和 **11,873.62** 万元，占非流动资产比例分别为 6.22%和 **5.68%**。标的公司无形资产主要为软件、技术使用权及外购知识产权，不存在账面价值低于可收回金额的情况，因此未计提减值准备。

⑥ 长期待摊费用

报告期各期末，标的公司长期待摊费用账面价值分别为 654.54 万元和 **463.41** 万元，主要为待摊销的装修费及系统迁移扩容项目中的实施服务费，长期待摊费用占各期末资产总额的比例分别为 0.27%、**0.22%**，占比较低。

⑦ 其他非流动资产

报告期各期末，标的公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
预付设备使用费	-	5,158.51
预付租赁税款	**349.82**	387.62
预付设备款	**63.95**	-
合计	**413.78**	**5,546.13**

报告期各期末，标的公司其他非流动资产分别为 5,546.13 万元和 **413.78** 万元，占非流动资产比例分别为 2.27%和 **0.20%**，主要为预付设备使用费、预付租赁税款和预付设备款。

2024 年末，标的公司其他非流动资产金额较大主要系存在预付的设备使用费，2025 年，标的公司结束设备使用并对该笔预付款项进行结算，故其账面金额于 **2025 年末**减少至 0 万元。

2、负债结构分析

报告期内，标的公司负债的构成如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动负债	**157,738.56**	**36.08**	215,132.89	43.10
非流动负债	**279,491.57**	**63.92**	284,063.10	56.90
合计	**437,230.13**	**100.00**	**499,195.99**	**100.00**

报告期各期末，标的公司总负债规模分别为 499,195.99 万元和 **437,230.13** 万元，其中报告期各期末的流动负债占比分别为 43.10%和 **36.08%**。

（1）流动负债分析

报告期各期末，标的公司流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
应付账款	**71,583.60**	**45.38**	88,012.62	40.91
合同负债	**10,571.94**	**6.70**	11,994.26	5.58
应付职工薪酬	**9,811.54**	**6.22**	13,390.40	6.22
应交税费	**378.46**	**0.24**	1,055.16	0.49
其他应付款	**7,888.69**	**5.00**	10,638.83	4.95
一年内到期的非流动负债	**56,308.32**	**35.70**	88,722.62	41.24
其他流动负债	**1,196.00**	**0.76**	1,319.00	0.61
合计	**157,738.56**	**100.00**	**215,132.89**	**100.00**

报告期各期末，标的公司流动负债分别为 215,132.89 万元和 **157,738.56 万元，**主要包括应付账款、合同负债、**应付职工薪酬、**其他应付款和一年内到期的非流动负债。报告期各期末，上述流动负债合计占流动负债总额的比例分别为 **98.90%和 99.00%**。

① 应付账款

报告期各期末，标的公司应付账款按性质划分如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付材料款	**31,434.54**	45,859.92
应付费用其他类	**40,149.06**	42,152.71
合计	**71,583.60**	**88,012.62**

标的公司应付账款主要系应付材料款和应付其他款，其中应付其他款包括设备维保费、清洗费、废料处理费等经营性支出。报告期内，标的公司应付账款余额分别为 88,012.62 万元和 **71,583.60** 万元，**2025** 年末应付账款**余额**有所**下降**，主要系标的公司**偿付部分供应商**材料**采购**款所致。

② 合同负债

报告期各期末，标的公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
预收货款	**10,571.94**	11,994.26
合计	**10,571.94**	**11,994.26**

报告期各期末，标的公司合同负债金额分别为 11,994.26 万元和 **10,571.94** 万元，主要**为**预收货款。

③ 应付职工薪酬

报告期各期末，标的公司应付职工薪酬的余额分别为 13,390.40 万元和 **9,811.54** 万元。标的公司应付职工薪酬主要为应付职工的工资、奖金和补贴等。

④ 应交税费

报告期各期末，标的公司应交税费余额分别为 1,055.16 万元和 **378.46** 万元，主要为应交的个人所得税、印花税等。

⑤ 其他应付款

报告期各期末，标的公司其他应付款按款项性质分类如下：

单位：万元

款项性质	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付设备及工程等相关款	**5,997.56**	8,306.41
代收代付款项	**519.00**	493.26
应付费用	**788.52**	1,294.19
代扣代缴个人社保	**248.18**	304.62
其他	**335.42**	240.34
合计	**7,888.69**	**10,638.83**

报告期各期末，标的公司其他应付款分别为 10,638.83 万元和 **7,888.69** 万元，占流动负债比重分别为 4.95%和 **5.00%。2025 年末较 2024 年末金额有所减少，主要系标的公司偿付部分供应商设备及工程款所致**。

⑥ 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，标的公司一年内到期的非流动负债的情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	**47,691.84**	80,374.34
一年内到期的租赁负债	**8,616.49**	8,348.28
合计	**56,308.32**	**88,722.62**

报告期各期末，标的公司一年内到期的非流动负债余额分别为 88,722.62 万元和 **56,308.32** 万元，占流动负债的比例分别为 41.24%和 **35.70%**，主要系一年内到期的长期借款及一年内到期的租赁负债。**2025 年末，标的**公司一年内到期的非流动负债较 2024 年末**减少**，主要系一年内到期的**长期借款减少**所致。

⑦ 其他流动负债

标的公司其他流动负债均为待转销项税额，报告期各期末余额分别为 1,319.00 万元和 **1,196.00** 万元，占流动负债比例分别为 0.61%和 **0.76%**，占比较小。

（2）非流动负债分析

报告期各期末，标的公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
长期借款	**247,225.00**	**88.46**	242,800.00	85.47
租赁负债	**30,528.01**	**10.92**	39,003.30	13.73
预计负债	**127.56**	**0.05**	648.80	0.23
递延收益	**1,611.00**	**0.58**	1,611.00	0.57
合计	**279,491.57**	**100.00**	**284,063.10**	**100.00**

报告期各期末，标的公司非流动负债分别为 284,063.10 万元和 **279,491.57** 万元，主要包括长期借款和租赁负债。报告期各期末，上述非流动负债合计占非流动负债总额的比例分别为 99.20%和 **99.38%**。

① 长期借款

报告期各期末，标的公司长期借款余额分别为242,800.00万元和**247,225.00**万元，占非流动负债比例分别为**85.47%**和**88.46%**，报告期内长期借款余额**略有**增加主要系新增银行借款以满足日常营运资金需求。

② 租赁负债

报告期各期末，标的公司租赁负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
租赁付款额	**42,629.81**	52,785.42
减：未确认融资费用	**3,485.31**	5,433.84
减：一年内到期的租赁负债	**8,616.49**	8,348.28
合计	**30,528.01**	**39,003.30**

报告期各期末，标的公司租赁负债的账面价值分别为 39,003.30 万元和**30,528.01**万元，占非流动负债比例分别为13.73%和**10.92%**，报告期内租赁负债余额下降主要系随着剩余租赁期的减少而下降。

③ 预计负债

报告期各期末，标的公司预计负债的账面价值分别为648.80万元和**127.56**万元，占非流动负债比例分别为0.23%和**0.05%**，占比较小。

④ 递延收益

报告期各期末，标的公司递延收益的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
与收益相关的政府补助	1,611.00	1,611.00
与资产相关的政府补助	-	-
合计	**1,611.00**	**1,611.00**

报告期各期末，标的公司递延收益金额分别为 1,611.00 万元和 1,611.00 万元，占非流动负债比例分别为0.57%和**0.58%**，占比较小，主要为与收益相关的政府补助。

3、主要财务指标分析

（1）偿债能力分析

①主要偿债能力指标

报告期内，标的公司偿债能力相关指标如下：

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
流动比率（倍）	**2.88**	1.78
速动比率（倍）	**2.08**	1.04
资产负债率（%）	**65.92**	79.76
息税折旧摊销前利润（万元）	**135,823.75**	121,917.01
利息保障倍数（倍）	**9.84**	8.08

注 1：流动比率=流动资产/流动负债
注 2：速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
注 3：资产负债率=总负债/总资产×100%
注 4：息税折旧摊销前利润=利润总额＋利息费用＋折旧+摊销
注 5：利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

报告期各期末，标的公司流动比率分别 1.78 和 **2.88**，速动比率分别为 **1.04** 和 **2.08**，资产负债率分别为 79.76%和 **65.92%**，息税折旧摊销前利润分别为 121,917.01 万元和 **135,823.75** 万元，利息保障倍数分别为 **8.08** 和 **9.84**，标的公司流动比率、速动比率、**息税折旧摊销前利润**及利息保障倍数逐年提升，资产负债率持续下降，整体偿债能力向好。

②与同行业可比公司的比较

报告期内，标的公司主要偿债能力指标与同行业可比上市公司对比情况如下：

指标	可比上市公司	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（部分可比上市公司数据为 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
流动比率（倍）	华润微	3.16	3.23
	士兰微	1.93	1.86
	晶合集成	**1.43**	1.31
	芯联集成	1.30	1.79
	华虹公司	**3.56**	3.73

指标	可比上市公司	2025年12月31日/2025年度（部分可比上市公司数据为2025年9月30日/2025年1-9月）	2024年12月31日/2024年度
	中芯国际	**2.36**	1.73
	可比公司平均	**2.29**	**2.28**
	标的公司	**2.88**	**1.78**
速动比率（倍）	华润微	2.67	2.72
	士兰微	1.38	1.32
	晶合集成	**1.11**	1.11
	芯联集成	0.92	1.43
	华虹公司	**3.15**	3.29
	中芯国际	**1.81**	1.38
	可比公司平均	**1.84**	**1.88**
	标的公司	**2.08**	**1.04**
资产负债率（%）	华润微	17.62	16.53
	士兰微	48.97	44.25
	晶合集成	**47.30**	48.23
	芯联集成	42.24	41.68
	华虹公司	**36.98**	28.67
	中芯国际	**33.00**	35.17
	可比公司平均	**37.69**	**35.76**
	标的公司	**65.92**	**79.76**
息税折旧摊销前利润（万元）	华润微	101,922.27	201,502.83
	士兰微	97,814.58	141,077.53
	晶合集成	**497,676.61**	439,653.06
	芯联集成	110,148.22	214,571.36
	华虹公司	**517,074.42**	367,482.34
	中芯国际	**3,775,532.30**	3,156,231.50
	可比公司平均	**850,028.07**	**753,419.77**
	标的公司	**135,823.75**	**121,917.01**
利息保障倍数（倍）	华润微	162.28	19.50
	士兰微	2.09	0.59
	晶合集成	**2.24**	1.97

指标	可比上市公司	2025年12月31日/2025年度（部分可比上市公司数据为2025年9月30日/2025年1-9月）	2024年12月31日/2024年度
	芯联集成	-8.68	-5.34
	华虹公司	**-0.33**	-0.43
	中芯国际	**3.92**	3.98
	可比公司平均	**26.92**	**3.38**
	标的公司	**9.84**	**8.08**

注：**截至目前，华润微、士兰微及芯联集成尚未披露2025年年度报告，故流动比率、速动比率、资产负债率及利息保障倍数数据源自2025年第三季度报告，且上述**公司2025年第三季度报告未披露折旧与摊销明细，故息税折旧摊销前利润源自2025年半年度报告。

报告期内，标的公司流动比率处于可比上市公司范围区间内，2024年末速动比率均低于可比上市公司，主要系受到公司产品生产、交付情况、自身业务发展及生产需求等因素影响，标的公司存货规模**相对较大，2025年，公司货币资金增加导致流动资产金额提升，同时流动负债金额有所下降，故2025年末速动比率提升并处于可比上市公司范围区间内**。

报告期内，标的公司资产负债率显著高于可比上市公司，主要系标的公司资产规模较小，同时可比公司主要为上市公司，股权融资渠道多元化，标的公司目前主要以债务融资为主。

2024年度，标的公司息税折旧摊销前利润低于可比上市公司，主要**系**标的公司业务规模小于同行业可比公司；**2025年度，标的公司销售规模扩大，故息税折旧摊销前利润有所提升，超过芯联集成，处于可比上市公司范围区间内。**

报告期内，标的公司利息保障倍数均显著高于除华润微以外的其他可比上市公司，主要系报告期内标的公司业绩快速增长，盈利水平对利息支出覆盖程度较高，偿债能力显著提升。

（2）营运能力分析

①主要营运能力指标

报告期内，标的公司营运能力相关指标如下：

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
应收账款周转率（次/年）	7.97	7.49
存货周转率（次/年）	2.96	2.23
总资产周转率（次/年）	0.73	0.66

注 1：总资产周转率=营业收入/总资产期初期末平均账面价值

注 2：应收账款周转率＝营业收入/应收账款期初期末平均账面价值

注 3：存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面价值

报告期内，标的公司应收账款周转率分别为 7.49 和 7.97，存货周转率分别为 2.23 和 2.96，总资产周转率分别为 0.66 和 0.73。2025 年度，标的公司主要营运能力指标均有所提升，资产运营和周转情况及应收账款管理良好。

②与同行业可比公司的比较

报告期内，标的公司与同行业可比上市公司主要营运能力指标比较如下：

指标	可比上市公司	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（部分可比上市公司数据为 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
应收账款周转率（次/年）	华润微	6.64	7.34
	士兰微	4.18	4.34
	晶合集成	9.99	10.00
	芯联集成	5.23	6.85
	华虹公司	10.40	9.02
	中芯国际	14.81	17.99
	可比公司平均	**8.54**	**9.26**
	标的公司	**7.97**	**7.49**
存货周转率（次/年）	华润微	3.62	3.63
	士兰微	2.73	2.38
	晶合集成	5.04	4.60
	芯联集成	3.01	3.09
	华虹公司	2.73	2.53
	中芯国际	2.25	2.32
	可比公司平均	**3.23**	**3.09**
	标的公司	**2.96**	**2.23**

指标	可比上市公司	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（部分可比上市公司数据为 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产周转率（次/年）	华润微	0.36	0.35
	士兰微	0.52	0.46
	晶合集成	0.21	0.19
	芯联集成	0.22	0.20
	华虹公司	**0.18**	0.18
	中芯国际	0.19	0.17
	可比公司平均	**0.28**	**0.26**
	标的公司	**0.73**	**0.66**

注：**截至目前，华润微、士兰微及芯联集成尚未披露 2025 年年度报告，故上述指标源自 2025 年第三季度报告，且上述**公司 2025 年 1-9 月应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率均已年化**。**

报告期内，标的公司业务与生产经营稳步开展，并逐步加强应收账款回款管理，应收账款周转率处于可比上市公司范围区间内。

2024 年度，由于标的公司当期业务规模较小，以及公司产品生产、交付情况、自身业务发展及生产需求等因素，存货周转率显著低于可比上市公司。**2025 年度，公司产品市场需求增长且销售规模持续扩大，存货周转率有所提升，超过士兰微、华虹公司及中芯国际。**

报告期内，标的公司总资产周转率显著高于可比上市公司，主要系标的公司资产规模显著小于可比公司。

4、现金使用分析

（1）经营活动产生的现金使用分析

报告期内，标的公司经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	**536,756.58**	543,648.08
收到的税费返还	**17,621.54**	5,254.21
收到其他与经营活动有关的现金	**17,106.70**	18,321.56

项目	2025 年度	2024 年度
经营活动现金流入小计	**571,484.83**	**567,223.84**
购买商品、接受劳务支付的现金	**329,540.54**	286,878.73
支付给职工以及为职工支付的现金	**62,835.67**	58,545.28
支付的各项税费	**1,033.87**	6,111.20
支付其他与经营活动有关的现金	**9,310.57**	9,928.23
经营活动现金流出小计	**402,720.65**	**361,463.44**
经营活动产生的现金流量净额	**168,764.18**	**205,760.40**

报告期各期，标的公司经营活动现金流量净额分别为 205,760.40 万元和 **168,764.18** 万元，**2025** 年度经营活动现金流量净额**有所下降**主要**系**标的公司**经营业务**规模**增长并增加原材料采购所致**。

（2）投资活动产生的现金使用分析

报告期内，标的公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	**205.48**	3.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	**205.48**	**3.05**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	**23,205.84**	5,410.45
投资支付的现金		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	**23,205.84**	**5,410.45**
投资活动产生的现金流量净额	**-23,000.36**	**-5,407.40**

报告期各期，标的公司投资活动现金流量净额分别为-5,407.40 万元和-**23,000.36** 万元，标的公司报告期内持续进行固定资产、无形资产和其他长期资

产的构建，因此投资活动现金流出金额较大。

（3）筹资活动产生的现金使用分析

报告期内，标的公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
吸收投资收到的现金	**21,826.41**	300.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	**-**	-
取得借款收到的现金	**91,755.00**	106,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	**-**	-
筹资活动现金流入小计	**113,581.41**	**106,300.16**
偿还债务支付的现金	**120,010.00**	75,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	**6,840.62**	5,094.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	**-**	-
支付其他与筹资活动有关的现金	**10,768.43**	390,581.09
筹资活动现金流出小计	**137,619.05**	**470,675.75**
筹资活动产生的现金流量净额	**-24,037.63**	**-364,375.59**

报告期各期，标的公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-364,375.59 万元和**-24,037.63** 万元，其中，2024 年度筹资活动产生的现金流量净额大额为负，主要系因分立事项而预留部分现金所致。

（二）盈利能力分析

1、盈利能力整体情况

报告期内，标的公司利润表主要科目情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	**510,114.63**	**498,797.09**
减：营业成本	**389,257.34**	416,460.22
税金及附加	**423.98**	1,165.53
销售费用	**631.45**	1,011.37
管理费用	**12,907.69**	14,311.14
研发费用	**24,495.07**	32,553.50

项目	2025 年度	2024 年度
财务费用	**6,207.74**	-14,057.32
加：其他收益	**3,308.17**	3,835.52
信用减值损失	**-2,395.29**	2,019.48
资产减值损失	**-2,411.79**	-1,007.22
资产处置收益	**2,580.52**	36.17
二、营业利润	**77,272.96**	**52,236.60**
加：营业外收入	**144.95**	465.45
减：营业外支出	**91.39**	549.65
三、利润总额	**77,326.52**	**52,152.40**
减：所得税费用	**0.00**	0.00
四、净利润	**77,326.52**	**52,152.40**

2、营业收入分析

（1）营业收入构成

报告期内，标的公司营业收入构成如下表所示：

单位：万元，%

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	**506,188.77**	**99.23**	447,912.46	89.80
其他业务收入	**3,925.86**	**0.77**	50,884.63	10.20
合计	**510,114.63**	**100.00**	**498,797.09**	**100.00**

报告期内，标的公司主营业务主要为晶圆代工，主营业务收入分别为447,912.46万元和**506,188.77**万元，占营业收入的比例分别为89.80%和**99.23%**。

报告期内，标的公司的其他业务收入主要为企业管理服务费收入、技术开发收入等。2024 年标的公司其他业务收入金额及占比较高，主要系技术开发服务业务具有偶发性。

（2）主营业务收入按产品划分

报告期内，标的公司主营业务收入按产品分类情况如下：

单位：万元，%

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例
晶圆代工	486,616.87	96.13	427,226.82	95.38
其他主营业务	19,571.89	3.87	20,685.64	4.62
合计	506,188.77	100.00	447,912.46	100.00

报告期内，标的公司晶圆代工业务实现大幅增长，主要系2024年以来全球半导体市场迎来逐步复苏，标的公司晶圆代工收入实现快速增长。报告期内，其他主营业务收入主要系为客户提供掩模版、探针卡等为主营业务配套相关服务实现的收入。

（3）主营业务收入按区域划分

报告期内，标的公司主营业务收入的地区构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例
中国境内	256,980.05	50.77	221,891.01	49.54
中国港澳台	124,619.13	24.62	93,003.68	20.76
新加坡	121,092.24	23.92	130,007.40	29.03
亚洲其他	292.48	0.06	353.49	0.08
北美	3,204.87	0.63	2,656.88	0.59
合计	506,188.77	100.00	447,912.46	100.00

报告期内，标的公司中国境内地区收入分别为221,891.01万元和256,980.05万元，中国境外收入分别为226,021.45万元、249,208.72万元，收入规模整体呈增长趋势。

（4）主营业务收入季节性波动情况

报告期内，标的公司主营业务收入分季节性收入如下：

单位：万元，%

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例
一季度	118,044.65	23.32	97,076.43	21.67
二季度	125,965.53	24.89	112,603.45	25.14
三季度	134,193.38	26.51	112,701.72	25.16
四季度	127,985.21	25.28	125,530.86	28.03
合计	506,188.77	100.00	447,912.46	100.00

报告期内，标的公司主营业务收入各季度占比相对稳定。

3、营业成本分析

（1）营业成本构成

报告期内，标的公司营业成本构成如下表所示：

单位：万元，%

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	387,503.46	99.55	415,192.69	99.70
其他业务成本	1,753.88	0.45	1,267.52	0.30
合计	389,257.34	100.00	416,460.22	100.00

（2）主营业务成本按产品划分

报告期内，标的公司主营业务成本按业务类别分类情况如下：

单位：万元，%

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例
晶圆代工	371,783.04	95.94	397,019.89	95.62
其他主营业务	15,720.42	4.06	18,172.80	4.38
合计	387,503.46	100.00	415,192.69	100.00

报告期内，标的公司主营业务各类产品成本变动趋势与收入变动情况基本保持一致。

（3）主营业务成本按成本属性划分

报告期内，标的公司主营业务成本按要素构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例
直接材料	**53,092.76**	**13.70**	61,999.32	14.93
直接人工	**11,301.04**	**2.92**	10,549.29	2.54
制造费用	**323,109.66**	**83.38**	342,644.08	82.53
合计	**387,503.46**	**100.00**	**415,192.69**	**100.00**

报告期内，标的公司主营业务成本主要为直接材料和制造费用，其中直接材料主要为生产晶圆的硅片原材料等，制造费用主要包括固定资产折旧、无形资产摊销、间接材料及人工等。

4、毛利及毛利率分析

报告期内，标的公司主营业务分业务类别毛利率情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度
主营业务毛利率	**23.45%**	7.30%
其他业务毛利率	**55.32%**	97.51%
综合毛利率	**23.69%**	**16.51%**

报告期内，标的公司的综合毛利率分别为 16.51%和 **23.69%**。2024 年全球半导体迎来市场的逐步复苏，随着标的公司销售规模逐步扩大、产能利用率提升，报告期各期主营业务毛利率逐年提升。报告期内，标的公司的其他业务毛利率波动较大，主要系 2024 年度标的公司技术开发服务收入金额较大，该项业务具有偶发性且相关技术成果主要在前期技术经验积累的基础上形成，导致其他业务整体毛利率水平较高。

报告期内，标的公司毛利率按产品划分情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度
晶圆代工	**23.60%**	7.07%
其他主营业务收入	**19.68%**	12.15%
主营业务毛利率	**23.45%**	**7.30%**

标的公司与可比公司的毛利率分析对比情况如下：

可比公司	2025 年度（部分可比公司数据为 2025 年 1-9 月）	2024 年度
华虹公司	**18.72%**	17.43%
晶合集成	**25.52%**	25.50%
中芯国际	**21.62%**	18.59%
华润微	26.44%	27.19%
士兰微	19.58%	19.09%
芯联集成	3.97%	1.03%
平均值	**19.31%**	**18.14%**
标的公司	**23.69%**	**16.51%**

注：截至目前华润微、士兰微及芯联集成尚未披露 2025 年年度报告，故前述上市公司数据期间为 2025 年 1-9 月。

随着下游市场需求的逐步回升，报告期内标的公司的毛利率水平逐年提升，2024 年度标的公司与同行业可比公司毛利率基本处于同一水平，**2025 年度**标的公司毛利率已高于同行业平均水平。

5、期间费用分析

报告期内，标的公司期间费用构成如下：

单位：万元，%

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	费用率	金额	费用率
销售费用	**631.45**	**0.12**	1,011.37	0.20
管理费用	**12,907.69**	**2.53**	14,311.14	2.87
研发费用	**24,495.07**	**4.80**	32,553.50	6.53
财务费用	**6,207.74**	**1.22**	-14,057.32	-2.82
合计	**44,241.95**	**8.67**	**33,818.69**	**6.78**

2024 年度，标的公司汇兑收益及利息收入较高，因此财务费用率相对较低。

（1）销售费用

①销售费用构成

报告期内，标的公司销售费用明细情况如下：

单位：万元，%

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	**487.43**	**77.19**	853.76	84.42
其他	**144.02**	**22.81**	157.61	15.58
合计	**631.45**	**100.00**	**1,011.37**	**100.00**

报告期内，标的公司销售费用主要由职工薪酬构成，销售费用分别 1,011.37 万元和 **631.45** 万元。

②同行业销售费用率比较

报告期内，标的公司与同行业可比上市公司销售费用率比较如下：

可比公司	2025 年度（部分可比公司数据为 2025 年 1-9 月）	2024 年度
华虹公司	**0.45%**	0.48%
晶合集成	**0.56%**	0.59%
中芯国际	**0.45%**	0.49%
华润微	1.54%	1.56%
士兰微	1.44%	1.59%
芯联集成	1.29%	0.66%
平均值	**0.96%**	**0.90%**
标的公司	**0.12%**	**0.20%**

注：截至目前华润微、士兰微及芯联集成尚未披露 2025 年年度报告，故前述上市公司数据期间为 2025 年 1-9 月。

报告期内，标的公司销售费用率与同行业可比上市公司不存在显著差异。标的公司销售费用率略低于同行业可比上市公司，与同为代工模式的华虹公司、晶合集成、中芯国际基本接近，略低于 IDM 模式的华润微、士兰微，符合标的公司的业务特点。

（2）管理费用

①管理费用构成

报告期内，标的公司管理费用明细情况如下：

单位：万元，%

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	**5,072.86**	**39.30**	6,801.17	47.52
专业服务费	**1,617.69**	**12.53**	1,582.11	11.06
使用权资产折旧费	**1,847.90**	**14.32**	1,680.68	11.74
折旧费用	**464.23**	**3.60**	532.87	3.72
摊销费用	**3.22**	**0.02**	7.35	0.05
日常运营费用	**1,290.64**	**10.00**	1,396.57	9.76
保险费	**620.60**	**4.81**	656.89	4.59
办公费	**331.33**	**2.57**	342.36	2.39
环境保护费	**278.62**	**2.16**	225.54	1.58
安保费	**225.98**	**1.75**	223.84	1.56
修理费	**206.06**	**1.60**	237.49	1.66
其他	**948.58**	**7.35**	624.28	4.36
合计	**12,907.69**	**100.00**	**14,311.14**	**100.00**

报告期内，标的公司管理费用主要由职工薪酬、折旧摊销、专业服务费等构成，管理费用分别 14,311.14 万元和 **12,907.69 万元**。

②同行业管理费用率比较

报告期内，标的公司与同行业可比上市公司管理费用率比较如下：

可比公司	2025 年度（部分可比公司数据为 2025 年 1-9 月）	2024 年度
华虹公司	**4.90%**	5.65%
晶合集成	**3.72%**	3.68%
中芯国际	**5.10%**	6.64%
华润微	5.16%	5.17%
士兰微	3.72%	4.11%
芯联集成	2.43%	2.13%
平均值	**4.17%**	**4.56%**
标的公司	**2.53%**	**2.87%**

注：截至目前华润微、士兰微及芯联集成尚未披露 2025 年年度报告，故前述上市公司数据期间为 2025 年 1-9 月。

报告期内，标的公司管理费用率与同行业可比上市公司不存在显著差异。随着收入规模增长，标的公司管理费用率**有所**下降，2024 年度及**2025 年度**管理费用率略低于同行业可比公司平均水平，但不存在显著差异。

（3）研发费用

①研发费用构成

报告期内，标的公司研发费用构成如下：

单位：万元，%

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	**11,689.55**	**47.72**	13,168.36	40.45
研究测试费用	**5,591.22**	**22.83**	8,955.42	27.51
折旧费用	**3,344.15**	**13.65**	5,179.22	15.91
摊销费用	**2,064.28**	**8.43**	2,817.85	8.66
维修维护费	**2,439.23**	**9.96**	2,556.29	7.85
燃料动力及水电费	**764.74**	**3.12**	1,168.66	3.59
政府补助抵减研发费用	**-1,398.10**	**-5.71**	-1,292.30	-3.97
合计	**24,495.07**	**100.00**	**32,553.50**	**100.00**

报告期内，标的公司研发费用主要由职工薪酬、折旧与摊销等构成，研发费用分别为 32,553.50 万元和 **24,495.07 万元**。

②同行业研发费用率比较

报告期内，标的公司与同行业可比上市公司研发费用率比较如下：

可比公司	2025 年度（部分可比公司数据为 2025 年 1-9 月）	2024 年度
华虹公司	**11.40%**	11.30%
晶合集成	**13.35%**	13.88%
中芯国际	**8.20%**	9.42%
华润微	10.55%	11.53%
士兰微	7.91%	9.22%
芯联集成	27.46%	28.30%

可比公司	2025 年度（部分可比公司数据为 2025 年 1-9 月）	2024 年度
平均值	13.14%	13.94%
标的公司	4.80%	6.53%

注：截至目前华润微、士兰微及芯联集成尚未披露 2025 年年度报告，故前述上市公司数据期间为 2025 年 1-9 月。

报告期内，标的公司研发费用率低于可比公司的平均水平，主要系可比公司中如芯联集成主要产品涵盖 MEMS、IGBT、MOSFET、模拟 IC、MCU 等，晶合集成主要产品涵盖驱动芯片（DDIC）、CMOS 图像传感器（CIS）、微控制器（MCU）、电源管理（PMIC）、逻辑应用（Logic）等，而标的公司聚焦核心优势领域，晶圆代工产品以逻辑芯片、CMOS 图像传感器为主，且前期已投入较多的研发工作，凭借持续的研发投入标的公司已经在成熟制程的基础上建立了较为完善的自有工艺平台，65/55nm、40nm 工艺已达到业界主流水平，因此研发费用率相对较低。

（4）财务费用

①财务费用构成

报告期内，标的公司财务费用明细情况如下：

单位：万元，%

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比
利息支出	8,743.21	140.84	7,363.63	-52.38
减：利息收入	10,582.66	170.48	16,742.47	-119.10
汇兑损益	8,039.34	129.51	-4,693.93	33.39
其他	7.84	0.13	15.45	-0.11
合计	6,207.74	100.00	-14,057.32	100.00

报告期内，标的公司的财务费用主要由利息支出、利息收入、汇兑损益构成，财务费用分别为-14,057.32 万元和 6,207.74 万元。2025 年度，标的公司的财务费用变动主要系外币汇率变动导致汇兑损益波动所致。

②同行业财务费用率比较

报告期内，标的公司与同行业可比上市公司财务费用率比较如下：

可比公司	2025 年度（部分可比公司数据为 2025 年 1-9 月）	2024 年度
华虹公司	**0.65%**	1.45%
晶合集成	**3.55%**	3.21%
中芯国际	**-0.55%**	-3.17%
华润微	-1.54%	-1.22%
士兰微	1.76%	1.80%
芯联集成	3.10%	4.44%
平均值	**1.16%**	**1.09%**
标的公司	**1.22%**	**-2.82%**

注：截至目前华润微、士兰微及芯联集成尚未披露 2025 年年度报告，故前述上市公司数据期间为 2025 年 1-9 月。

报告期内，标的公司财务费用率与同行业可比上市公司不存在显著差异。标的公司财务费用率略低于可比公司的平均水平，主要系标的公司**账面**资金**产生**一定利息收入。

6、利润表其他项目分析

（1）其他收益

报告期内，标的公司的其他收益情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
政府补助	**82.99**	126.32
增值税加计抵减	**3,145.61**	3,601.83
三代手续费返还	**79.57**	107.37
合计	**3,308.17**	**3,835.52**

报告期内，标的公司其他收益分别为 3,835.52 万元和 **3,308.17** 万元，主要包括增值税加计抵减以及政府补助等。

（2）信用减值损失

报告期内，标的公司信用减值损失全部为当期计提的应收账款坏账损失，金额分别为 2,019.48 万元和**-2,395.29** 万元。

（3）资产减值损失

报告期内，标的公司资产减值损失全部为存货跌价损失，金额分别为-1,007.22 万元和**-2,411.79 万元**。

（4）资产处置收益

报告期内，标的公司资产处置收益全部为固定资产处置收益，金额分别为 36.17 万元和 **2,580.52** 万元。

（5）非经常性损益

报告期内，标的公司非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
非流动资产处置损益	**2,533.63**	32.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	**3,154.38**	2,244.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	**100.45**	-80.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	**-**	47,100.00
减：所得税影响金额	**-**	-
扣除所得税影响后的非经常性损益	**5,788.46**	**49,296.48**

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系标的公司技术开发服务收入。

报告期内，标的公司非经常性损益分别为 49,296.48 万元、**5,788.46** 万元，主要系计入当期损益的政府补助和技术开发服务收入。

四、上市公司对拟购买资产的整合计划及管控安排

（一）上市公司对拟购买资产的整合计划

本次交易前，标的公司与上市公司均为华虹集团控股子公司，制程均包含 65/55nm、40nm，均从事特色工艺平台晶圆代工。通过本次交易，标的公司将成为上市公司全资子公司，消除上市公司与华力微的同业竞争，增加上市公司晶圆代工规模，有利于上市公司发挥在研发、生产、销售等方面的协同效应，支持标的公司扩大业务规模、提高经营业绩。为了提高本次交易的整合绩效以及更好的发挥协同效应，上市公司从公司经营和资源配置等角度出发，拟在业务、资产、

财务、人员、机构等方面与标的公司进行进一步整合，并制定如下整合措施。

1、业务整合

本次交易完成前，标的公司与上市公司存在竞争关系。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，标的公司的生产经营将由上市公司控制，相关生产经营安排将纳入上市公司的管理体系。上市公司与标的公司将在采购、生产、研发、销售等方面实现更全面的资源共享和优势互补，实现业务协同发展。

2、资产整合

本次交易完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司，其仍保留独立的法人地位，享有独立的法人财产权利，资产仍将保持独立。标的公司将依据自身产能规划需求制定重要资产的购买及处置规划，并履行上市公司相关审批程序。同时，上市公司依托自身管理水平及资本运作能力，结合标的公司市场发展前景及实际情况进一步优化资源配置，提高资产利用率，增强上市公司和标的公司的综合竞争力。

3、财务整合

本次交易完成后，上市公司拟将标的公司并入上市公司的财务管理体系，上市公司将推动标的公司在财务管理系统、会计核算体系、内控管理制度等方面与上市公司保持一致，相关财务工作安排及财务流程审批等事项，将由上市公司进行统一审批管理，以确保标的公司能够有效执行符合上市公司要求的各项财务会计和内控管理制度。

4、人员整合

一方面，为保证本次交易完成后标的公司原有团队的稳定性及竞争优势的持续性，上市公司将保持标的公司原有的业务团队；另一方面，为丰富和完善标的公司的业务团队和管理团队，满足标的公司的业务开拓需要，上市公司也将适时为标的公司引进优质人才。

5、机构整合

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，日常运营和治理

将严格按照《公司法》《证券法》、上市公司相关管理制度和内控制度体系《公司章程》及上交所和中国证监会的规定执行。

上市公司将在逐步统一管理机制的前提下，维持标的公司现有组织架构稳定，强化上市公司对标的公司在业务、财务、合规等方面的管理与控制，保证上市公司对标的公司重大事项的决策和控制权，降低标的公司内部控制风险，提高标的公司整体决策和规范运作水平。

（二）上市公司对拟购买资产的管控安排

1、股东会

上市公司在本次交易完成后直接及间接持有标的公司 100%的股权，将享有100%的表决权作出股东决定，有权决定标的公司归属于股东会职权范围内的全部事项，能够在标的公司的经营方针、投资计划、财务预算和决算以及其他重大事项的决策中发挥主导作用。

2、董事会

本次交易完成后，标的公司将改组董事会，改组后董事会成员将均由上市公司委派，在董事会层面控制标的公司，能够在标的公司的经营计划、投资方案、财务预算和决算、高级管理人员的任免、以及其他重大事项的决策中发挥主导作用。

3、高级管理人员

本次交易完成后，标的公司的日常业务经营由上市公司管理团队统一负责。标的公司高级管理人员对标的公司董事会负责。据此，上市公司可以通过董事会对标的公司管理团队进行监督和管理。

4、财务控制

本次交易完成后，上市公司将把标的公司并入公司财务管理体系。标的公司的相关财务工作安排及财务流程审批等事项，将由上市公司按照统一的内部制度进行统一审批管理，以确保标的公司能够有效执行符合上市公司要求的各项财务会计和内控管理制度。

（三）上市公司能有效控制标的公司并纳入合并报表范围的依据

1、《企业会计准则》的相关规定

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定：“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。投资方享有现时权利使其目前有能力主导被投资方的相关活动，而不论其是否实际行使该权利，视为投资方拥有对被投资方的权力。”

“除非有确凿证据表明其不能主导被投资方相关活动，下列情况，表明投资方对被投资方拥有权力：（1）投资方持有被投资方半数以上的表决权的。（2）投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的。”

2、上市公司能有效控制标的公司并纳入合并报表范围的分析

本次交易完成后，上市公司将直接及间接合计持有标的公司 100%股权，并且董事会成员均由上市公司委派，拥有对标的公司的实质性权利，通过实际参与并决定标的公司的相关活动享有可变回报，同时可运用对标的公司的实质性权利影响可变回报金额，从而能够控制标的公司。

因此，上市公司能有效控制标的公司并纳入合并报表范围的依据充分，符合《企业会计准则》的规定。

五、本次交易对上市公司持续经营能力影响

（一）本次交易对上市公司盈利能力驱动因素、持续经营能力的影响

华虹半导体聚焦于特色工艺，目前已覆盖至 65/55nm、40nm；华力微聚焦于 65/55nm 及 40nm 逻辑工艺，并在此基础上进一步开发特色工艺。本次重组完成后，华力微的 65/55nm 及 40nm 逻辑工艺及特色工艺技术将直接注入上市公司，上市公司将新增 3.8 万片/月的 65/55nm、40nm 产能，提高上市公司市场地位。本次并购重组将进一步提高上市公司资产质量，增强持续经营能力，符合全体股东利益。

（二）上市公司未来经营中的优势和劣势

1、经营优势

本次交易完成后，上市公司将新增 3.8 万片/月的 65/55nm、40nm 产能，提高上市公司产能及市场地位。

工艺平台方面，华力微的 65/55nm、40nm 覆盖独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频、高压等工艺平台，本次交易完成后，上市公司将进一步丰富工艺平台种类，满足市场多样化需求。

客户及供应商方面，不同客户对晶圆代工要求不同，本次交易完成后，上市公司工艺平台、技术等进一步丰富，有利于满足不同客户的多样化需求，提升整体竞争力；半导体设备、半导体材料供应商的全球行业集中度较高，本次交易完成后，公司规模将进一步扩大，产业链地位进一步增强。

技术及产能方面，本次交易有利于上市公司进一步丰富主营业务所需的 65/55nm、40nm 制程的相关技术，加速产品迭代、开发进程。标的公司拥有 3.8 万片/月产能，本次交易完成后，上市公司总产能将进一步提升，满足客户需求。

2、经营劣势

与台积电为代表的国际晶圆代工巨头相比，上市公司在工艺节点、经营规模等方面仍存在一定的差距。上市公司长期发展战略聚焦于特色工艺，因此在最先进的工艺节点方面与行业内的国际巨头存在差距，从而造成公司无法提供更为全面的晶圆代工产品。此外，在产能规模与收入方面，上市公司亦与行业巨头企业存在差距，对上市公司争夺高端晶圆代工市场、提升规模经济效应、产品议价能力及市场竞争力造成影响。

（三）本次交易完成后资产负债率情况、上市公司财务安全性情况

本次交易完成前后上市公司的资产负债结构与偿债能力分析如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度		2024 年 12 月 31 日/2024 年度	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
流动资产	**4,643,715.08**	**5,092,411.97**	4,192,636.15	4,567,887.28

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度		2024 年 12 月 31 日/2024 年度	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
非流动资产	**5,368,614.05**	**5,518,520.83**	4,600,887.00	4,788,155.55
资产总计	**10,012,329.13**	**10,610,932.80**	8,793,523.15	9,356,042.83
流动负债	**1,304,701.43**	**1,446,995.92**	1,122,998.90	1,321,600.79
非流动负债	**2,398,152.44**	**2,645,277.08**	1,398,469.36	1,643,407.71
负债合计	**3,702,853.87**	**4,092,273.00**	2,521,468.25	2,965,008.50
流动比率（倍）	**3.56**	**3.52**	3.73	3.46
速动比率（倍）	**3.15**	**3.06**	3.29	2.96
资产负债率	**36.98%**	**38.57%**	28.67%	31.69%

注：上述指标均以合并财务报表的数据为基础，计算公式如下：

（1）资产负债率=总负债期末数/总资产期末数；

（2）流动比率=流动资产期末数/流动负债期末数；

（3）速动比率=（流动资产期末数-存货期末数） /流动负债期末数。

根据《备考审阅报告》，本次交易完成后上市公司资产负债率将有所提升。本次交易完成后，上市公司货币资金等流动性资产较为充裕，偿债能力较强，本次交易不会对上市公司财务安全性造成重大不利影响。

（四）与本次交易有关的企业合并的会计政策及会计处理

本次交易系同一控制下企业合并，上市公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 214 号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（证监会公告[2023]57 号）相关规定编制备考合并报表，对上市公司财务状况、持续经营能力无重大不利影响。

（五）本次交易后对上市公司商誉的影响

1、本次交易前标的公司商誉的形成过程、金额及减值情况

本次交易前，标的公司不存在商誉。

2、本次交易完成后上市公司商誉情况

本次交易前，上市公司不存在商誉。本次交易系同一控制下企业合并，本次交易完成后，上市公司依然不存在商誉，不存在因本次交易新增相关的商誉减值

风险。

六、本次交易对上市公司盈利能力影响的分析

（一）本次交易后，上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）**审阅**的**上市公司备考财务报表**，以及上市公司 2024 年度、**2025 年度**审计报告，上市公司于本次交易完成前后的每股收益变动如下：

项目	2025 年度		2024 年度	
	交易前	交易后（备考合并）	交易前	交易后（备考合并）
归属于母公司股东权益（万元）	**4,516,029.04**	**4,725,213.57**	4,360,233.22	4,474,671.92
归属于母公司所有者的净利润（万元）	**37,661.14**	**118,428.37**	38,057.62	95,531.55
基本每股收益（元/股）	**0.22**	**0.62**	0.22	0.50

注：上述备考合并财务数据未考虑募集配套资金的影响。

如本次交易实施，上市公司归属于母公司股东权益、归属于母公司所有者净利润及基本每股收益等将会有所提升。

（二）本次交易对上市公司未来资本性支出的影响

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，标的公司的未来资本性支出将纳入上市公司整体资本支出规划中。上市公司将结合其资金状况和未来发展计划，合理规划和统筹标的公司的资本性支出。同时，上市公司将利用自身上市主体的融资功能，通过自有资金、再融资、银行贷款等多种方式筹集资金，以满足上市公司和标的公司未来的资本性支出需求。

（三）本次交易职工安置方案及执行情况

本次交易不涉及职工安置方案。

（四）本次交易成本情况

本次交易所产生的相关税费由相关各责任方承担，为本次交易提供服务的相

关中介服务费用主要包括：财务顾问费、审计验资费、资产评估费、律师服务费等，上述费用均为本次交易所需必要费用，相关费用参考市场价格确定，不存在价格不公允、利益输送等情形。整体而言，本次交易费用不会对上市公司相关财务指标造成较大影响。

第十节 财务会计信息

一、标的公司的财务会计信息

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，标的公司最近两年的主要财务数据如下：

（一）资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	**259,217.74**	148,092.13
应收票据	**-**	1,000.00
应收账款	**65,588.39**	63,591.05
预付款项	**797.08**	81.29
其他应收款	**38.80**	48.19
存货	**125,517.63**	158,536.09
一年内到期的非流动资产	**1,302.87**	-
其他流动资产	**1,752.56**	10,705.58
流动资产合计	**454,215.07**	**382,054.33**
非流动资产：		
长期应收款	**5,642.88**	-
固定资产	**147,897.29**	175,269.05
在建工程	**7,503.12**	3,438.57
使用权资产	**35,264.09**	43,748.62
无形资产	**11,873.62**	15,178.02
长期待摊费用	**463.41**	654.54
其他非流动资产	**413.78**	5,546.13
非流动资产合计	**209,058.20**	**243,834.93**
资产合计	**663,273.27**	**625,889.26**
流动负债：		
应付账款	**71,583.60**	88,012.62
合同负债	**10,571.94**	11,994.26

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	**9,811.54**	13,390.40
应交税费	**378.46**	1,055.16
其他应付款	**7,888.69**	10,638.83
一年内到期的非流动负债	**56,308.32**	88,722.62
其他流动负债	**1,196.00**	1,319.00
流动负债合计	**157,738.56**	**215,132.89**
非流动负债：		
长期借款	**247,225.00**	242,800.00
租赁负债	**30,528.01**	39,003.30
预计负债	**127.56**	648.80
递延收益	**1,611.00**	1,611.00
非流动负债合计	**279,491.57**	**284,063.10**
负债合计	**437,230.13**	**499,195.99**
实收资本	**203,619.22**	187,364.82
资本公积	**5,572.01**	-
专项储备	**196.94**	-
未分配利润	**16,654.97**	-60,671.55
所有者权益合计	**226,043.14**	**126,693.27**
负债和所有者权益总计	**663,273.27**	**625,889.26**

（二）利润表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	**510,114.63**	**498,797.09**
其中：营业收入	**510,114.63**	498,797.09
二、营业总成本	**433,923.27**	**451,444.44**
其中：营业成本	**389,257.34**	416,460.22
税金及附加	**423.98**	1,165.53
销售费用	**631.45**	1,011.37
管理费用	**12,907.69**	14,311.14
研发费用	**24,495.07**	32,553.50
财务费用	**6,207.74**	-14,057.32

项目	2025 年度	2024 年度
加：其他收益	**3,308.17**	3,835.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	**-2,395.29**	2,019.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	**-2,411.79**	-1,007.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	**2,580.52**	36.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**77,272.96**	**52,236.60**
加：营业外收入	**144.95**	465.45
减：营业外支出	**91.39**	549.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**77,326.52**	**52,152.40**
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**77,326.52**	**52,152.40**
（一）按经营持续性分类		
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	**77,326.52**	52,152.40
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	**-**	-
（二）按所有权归属分类		
1．归属于母公司所有者的净利润	**77,326.52**	52,152.40
2．少数股东损益	**-**	-
六、其他综合收益的税后净额	**-**	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	**-**	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	**-**	-
七、综合收益总额	**77,326.52**	**52,152.40**
归属于母公司所有者的综合收益总额	**77,326.52**	52,152.40
归属于少数股东的综合收益总额	**-**	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

（三）现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	**536,756.58**	543,648.08

项目	2025 年度	2024 年度
收到的税费返还	17,621.54	5,254.21
收到其他与经营活动有关的现金	17,106.70	18,321.56
经营活动现金流入小计	571,484.83	567,223.84
购买商品、接受劳务支付的现金	329,540.54	286,878.73
支付给职工以及为职工支付的现金	62,835.67	58,545.28
支付的各项税费	1,033.87	6,111.20
支付其他与经营活动有关的现金	9,310.57	9,928.23
经营活动现金流出小计	402,720.65	361,463.44
经营活动产生的现金流量净额	168,764.18	**205,760.40**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205.48	3.05
投资活动现金流入小计	205.48	3.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,205.84	5,410.45
投资活动现金流出小计	23,205.84	5,410.45
投资活动产生的现金流量净额	-23,000.36	**-5,407.40**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,826.41	300.16
取得借款收到的现金	91,755.00	106,000.00
筹资活动现金流入小计	113,581.41	106,300.16
偿还债务支付的现金	120,010.00	75,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,840.62	5,094.66
支付其他与筹资活动有关的现金	10,768.43	390,581.09
筹资活动现金流出小计	137,619.05	470,675.75
筹资活动产生的现金流量净额	-24,037.63	**-364,375.59**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,271.19	**5,298.66**
五、现金及现金等价物净增加额	114,454.99	**-158,723.93**
加：期初现金及现金等价物余额	143,763.50	302,487.43
六、期末现金及现金等价物余额	258,218.49	**143,763.50**

二、上市公司备考合并财务报表

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）**审阅**的**上市公司**备考**财务报表，模拟**本次交易**于 2024 年 1 月 1 日完成，**上市公司最近**两年**的主要财务数据如下：

（一）备考合并资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	**3,786,650.50**	3,397,570.68
应收票据	**33,452.20**	35,167.39
应收账款	**232,044.66**	229,770.89
预付款项	**6,385.57**	4,630.04
其他应收款	**4,721.23**	2,388.88
存货	**659,621.38**	653,791.40
一年内到期的非流动资产	**1,302.87**	-
其他流动资产	**368,233.56**	244,568.01
流动资产合计	**5,092,411.97**	**4,567,887.28**
非流动资产：		
长期应收款	**5,642.88**	-
长期股权投资	**59,045.21**	53,950.10
其他权益工具投资	**320,036.00**	200,930.40
投资性房地产	**36,673.32**	-
固定资产	**3,408,797.52**	3,057,530.27
在建工程	**1,456,197.22**	1,351,831.32
使用权资产	**10,988.16**	14,555.83
无形资产	**64,579.43**	73,912.89
长期待摊费用	**563.78**	672.46
递延所得税资产	**-**	14,512.28
其他非流动资产	**155,997.29**	20,260.00
非流动资产合计	**5,518,520.83**	**4,788,155.55**
资产合计	**10,610,932.80**	**9,356,042.83**
流动负债：		
应付账款	**301,430.04**	300,880.32
预收款项	**41.65**	**-**
合同负债	**106,357.32**	89,498.56

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	**88,794.64**	72,825.17
应交税费	**16,637.58**	29,760.24
其他应付款	**524,324.06**	490,956.82
一年内到期的非流动负债	**333,747.35**	285,959.74
其他流动负债	**75,663.27**	51,719.95
流动负债合计	**1,446,995.92**	**1,321,600.79**
非流动负债：		
长期借款	**2,206,218.92**	1,620,985.06
租赁负债	**11,020.65**	12,988.09
长期应付款	**417,919.00**	**-**
预计负债	**0.02**	527.35
递延收益	**1,611.00**	1,611.00
递延所得税负债	**8,507.50**	7,296.21
非流动负债合计	**2,645,277.08**	**1,643,407.71**
负债合计	**4,092,273.00**	**2,965,008.50**
股东权益：		
股本	**3,500,488.66**	3,465,470.33
资本公积	**706,754.46**	693,037.15
其他综合收益	**138,778.21**	55,597.51
专项储备	**196.94**	-
盈余公积	**185,489.44**	170,368.19
未分配利润	**193,505.87**	90,198.75
归属于母公司股东权益合计	**4,725,213.57**	**4,474,671.92**
少数股东权益	**1,793,446.23**	**1,916,362.41**
股东权益合计	**6,518,659.80**	**6,391,034.33**
负债和所有者权益总计	**10,610,932.80**	**9,356,042.83**

（二）备考合并利润表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	**2,228,795.71**	**1,927,405.55**
其中：营业收入	**2,228,795.71**	1,927,405.55

项目	2025 年度	2024 年度
二、营业总成本	**2,143,226.58**	**1,900,280.18**
其中：营业成本	**1,787,918.16**	1,597,673.33
税金及附加	**12,646.54**	10,540.31
销售费用	**8,450.10**	7,862.72
管理费用	**96,129.04**	94,154.00
研发费用	**222,510.94**	185,521.06
财务费用	**15,571.80**	4,528.77
其中：利息费用	**55,612.29**	74,059.54
利息收入	**53,350.40**	89,252.46
加：其他收益	**39,056.96**	26,383.74
投资收益	**3,095.11**	1,099.09
其中：对联营企业的投资收益	**3,095.11**	1,097.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	**-2,330.98**	1,949.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	**-117,611.99**	-93,294.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	**3,201.90**	-100.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**10,980.13**	**-36,836.71**
加：营业外收入	**254.08**	596.83
减：营业外支出	**108.33**	577.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**11,125.88**	**-36,817.13**
减：所得税费用	**15,613.69**	4,386.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**-4,487.81**	**-41,203.70**
（一）按经营持续性分类		
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	**-4,487.81**	-41,203.70
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-
（二）按所有权归属分类		
1．归属于母公司所有者的净利润	**118,428.37**	95,531.55
2．少数股东损益	**-122,916.18**	-136,735.25
六、其他综合收益的税后净额	**-**	**—**
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	**83,180.70**	9,738.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	**-**	**-**
1. 其他权益工具投资公允价值变动	**90,614.76**	4,709.22
2. 权益法下不能转损益的其他综合亏损	**-**	-476.52

项目	2025 年度	2024 年度
3. 外币财务报表折算差额	-6,272.76	4,753.88
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 外币财务报表折算差额	-1,161.30	752.25
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	**78,692.89**	**-31,464.87**
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,609.08	105,270.39
归属于少数股东的综合收益总额	-122,916.18	-136,735.25
八、每股收益		
基本每股收益	0.62	0.50
稀释每股收益	0.62	0.50

第十一节 同业竞争和关联交易

一、同业竞争情况

（一）本次交易前同业竞争情况

本次交易前，华力微与上市公司均从事 65/55nm、40nm 晶圆代工业务，双方的同类业务为相同工艺节点下的重合工艺平台的代工业务，即 65/55nm、40nm 工艺节点下的独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器和逻辑与射频三个重合工艺平台。双方在技术工艺转换、设备技术参数调整方面构建了一定的壁垒，上市公司和华力微的工艺技术存在一定的差异，但双方基于各自的工艺技术提供的代工服务不存在实质性差异，存在同业竞争，但不构成重大不利影响。

（二）本次交易后同业竞争情况

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，上市公司直接及间接持有标的公司 100%的股权。本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人变化。本次交易将解决上市公司首次公开发行股票并上市时的同业竞争，本次交易完成后，上市公司控股股东及其控制的其他企业将均不存在对上市公司构成重大不利影响的同业竞争。

（三）避免同业竞争的措施

为避免本次重组完成后可能产生的同业竞争情形，上市公司直接控股股东华虹国际、间接控股股东华虹集团已出具《关于避免同业竞争的承诺函》：具体内容请参见本报告书“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”之“（四）上市公司控股股东作出的重要承诺”。

二、关联交易情况

（一）本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方中，华虹集团系上市公司的间接控股股东，上海集成电路基金系上市公司董事曾担任董事的企业，根据《科创板上市规则》，本次交易构成关联交易。

（二）标的公司关联方

1、直接或者间接控制公司的法人

序号	关联方名称	关联关系
1	华虹集团	控股股东，直接持有标的公司 63.54%的股权
2	上海市国资委	标的公司实际控制人

2、直接或间接持有公司 5%以上股权的法人或者其他组织

序号	关联方名称	关联关系
1	上海集成电路基金	直接持有标的公司 15.72%的股权
2	大基金二期	直接持有标的公司 10.25%的股权
3	国投先导基金	直接持有标的公司 7.98%的股权
4	上海科技创业投资（集团）有限公司	间接持有标的公司 5.52%的股权
5	上海国际集团有限公司	间接持有标的公司 9.77%的股权
6	上海国盛（集团）有限公司	间接持有标的公司 9.77%的股权
7	上海仪电（集团）有限公司	间接持有标的公司 6.21%的股权
8	上海临港经济发展（集团）有限公司	间接持有标的公司 5.08%的股权
9	上海国投先导私募基金管理有限公司	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人
10	上海国有资本投资有限公司	持有上海国投先导私募基金管理有限公司 100%股权的股东

3、控股股东以及直接持有标的公司 5%以上股权的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织(标的公司及其控股子公司除外)

序号	关联方名称	关联关系
1	华虹国际	华虹集团持有其 100%股权
2	Hua Hong International (Americas), Inc.	华虹国际控股子公司
3	华虹半导体	华虹集团间接控制的企业
4	HHGrace Semiconductor USA, Inc.	华虹半导体持有其 100%的股权
5	HHGrace Semiconductor Japan Co., Ltd.	华虹半导体持有其 100%的股权
6	力鸿科技有限公司(Global Synergy Technology Limited)	华虹半导体持有其 100%的股权
7	Grace Semiconductor Manufacturing Corporation	华虹半导体持有其 100%的股权
8	上海华虹宏力半导体制造有限公司	华虹半导体持有其 100%的股权

序号	关联方名称	关联关系
9	**华虹宏力半导体（无锡）有限公司**	**上海华虹宏力半导体制造有限公司持有 100%的股权**
10	华虹半导体制造（无锡）有限公司	华虹半导体持有其 21.90%的股权，上海华虹宏力半导体制造有限公司持有其 29.10%的股权
11	华虹半导体（无锡）有限公司	华虹半导体持有其 22.22%的股权，上海华虹宏力半导体制造有限公司持有其 28.78%的股权
12	华宏置业（无锡）有限公司	华虹半导体（无锡）有限公司持有其 100%的股权
13	Hua Hong Semiconductor International, Inc.	华虹集团控制的企业
14	上海华虹挚芯电子科技有限公司	华虹集团持有其 93.0212%的股权
15	挚芯电子（上海）有限公司	上海华虹挚芯电子科技有限公司持有其 100%的股权
16	上海华虹投资发展有限公司	华虹集团持有其 60%的股权，上海华虹宏力半导体制造有限公司持有其 20%的股权
17	上海华虹虹日电子有限公司	华虹集团持有其 51%的股权
18	虹日国际电子（香港）有限公司	上海华虹虹日电子有限公司持有其 100%的股权
19	上海华虹科技发展有限公司	华虹集团持有其 50%的股权，上海华虹宏力半导体制造有限公司持有其 50%的股权
20	上海华虹置业有限公司	上海华虹科技发展有限公司持有其 100%的股权
21	上海华锦物业管理有限公司	上海华虹科技发展有限公司持有其 100%的股权
22	上海华虹计通智能系统股份有限公司	华虹集团持有其 25.32%的股份，系华虹集团控股子公司
23	上海华虹智联信息科技有限公司	上海华虹计通智能系统股份有限公司持有其 100%的股权
24	上海翊客湾科技有限公司	上海华虹计通智能系统股份有限公司持有其 100%的股权
25	客户 H	曾受华虹集团控制
26	成都微光集电科技有限公司	曾受华虹集团间接控制
27	上海微镓集成电路有限公司	曾受华虹集团间接控制
28	上海芯势能企业管理咨询中心(有限合伙)	曾受华虹集团间接控制
29	上海微迈睿科技有限公司	上海芯势能企业管理咨询中心（有限合伙）持有其 60%的股权
30	公司 A	华虹集团控制的公司
31	上海华力集成电路制造有限公司	公司 A 控制的公司
32	公司 B	公司 A 控制的公司

4、标的公司的董事、监事、高级管理人员（包括报告期内或报告期前 12 个月内曾任职的人员）

序号	关联方名称	关联关系
1	秦健	董事长
2	周利民	副董事长
3	李鑫	副董事长
4	雷海波	董事
5	陈博	董事
6	姚健	董事
7	熊承艳	董事
8	吴亮东	董事
9	许向辉	董事
10	王智	总裁
11	曹佳旎	财务负责人
12	张素心	报告期内曾任董事
13	傅红岩	报告期内曾任董事
14	彭红兵	报告期内曾任董事
15	唐均君	报告期内曾任董事
16	冯雪静	报告期内曾任董事
17	王靖	报告期**前 12 个月内**曾任董事
18	黄中俊	报告期**前 12 个月内**曾任董事
19	徐任重	报告期内曾任监事
20	章霞	报告期内曾任监事
21	张恪	报告期内曾任监事
22	王鼎	报告期**前 12 个月内**曾任监事
23	吕煜坤	报告期内曾任**高级管理人员**
24	苏国良	报告期内曾任高级管理人员
25	倪立华	报告期内曾任高级管理人员
26	柯陈宾	报告期内曾任高级管理人员
27	范永洁	报告期内曾任高级管理人员
28	朱骏	报告期内曾任高级管理人员
29	魏峥颖	报告期内曾任高级管理人员
30	王艳生	报告期内曾任高级管理人员

序号	关联方名称	关联关系
31	张悦	报告期内曾任高级管理人员
32	邵华	报告期内曾任高级管理人员

注：上述人员关系密切的家庭成员亦属于标的公司的关联方。

5、标的公司控股股东的董事、监事、高级管理人员（包括报告期内或报告期前 12 个月内曾任职的人员）

序号	关联方名称	关联关系
1	秦健	华虹集团董事长
2	赵蓉	华虹集团董事
3	李军	华虹集团董事
4	朱伟强	华虹集团董事
5	李向农	华虹集团董事
6	梁晓丽	华虹集团董事
7	魏巍	华虹集团董事
8	徐任重	华虹集团副总裁
9	陈剑波	华虹集团副总裁
10	周利民	华虹集团副总裁
11	陈博	华虹集团副总裁
12	周磊	报告期内曾任华虹集团董事
13	张素心	报告期内曾任华虹集团董事
14	张卫	报告期内曾任华虹集团董事
15	姜海涛	报告期内曾任华虹集团董事
16	张国铭	报告期内曾任华虹集团董事
17	王靖	报告期前 12 个月内曾任华虹集团董事
18	李一萌	报告期内曾任华虹集团监事
19	陈一敏	报告期内曾任华虹集团监事
20	任志宏	报告期内曾任华虹集团监事
21	郭丽娟	报告期前 12 个月内曾任华虹集团监事

6、前述关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除标的公司以外的法人（或者其他组织）

前述关联自然人控制或担任董事（不含同为双方独立董事）、高级管理人员

的法人或其他组织亦构成标的公司的关联方。除前文已列示关联方之外，标的公司的董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的其他主要法人或者其他组织亦构成标的公司的关联方。

关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员（不含同为双方独立董事）的除上述企业外的其他与公司存在关联交易企业如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	华海清科股份有限公司	华虹集团原董事报告期内曾任其董事

（三）标的公司关联交易

1、采购货物/接受服务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
上海华力集成电路制造有限公司	采购货物	**28,955.61**	27,858.28
公司 B	采购货物	**548.69**	12.83
上海华虹虹日电子有限公司	采购货物	**1,431.90**	3,847.58
上海华虹挚芯电子科技有限公司	采购货物	**100.82**	162.16
挚芯电子（上海）有限公司	采购货物	**54.20**	1.36
华海清科股份有限公司	采购货物	**1.06**	12.08
小计		**31,092.28**	**31,894.28**
上海华力集成电路制造有限公司	接受服务	**6,621.44**	3,156.28
公司 B	接受服务	**3.33**	7.19
小计		**6,624.77**	**3,163.47**
合计		**37,717.04**	**35,057.75**

（1）上海华力集成电路制造有限公司

1）采购货物

①BSI 晶圆代工产品

报告期内，标的公司向华力集采购 BSI 晶圆代工产品。鉴于目前标的公司与华力集对外销售的中高端 CIS（CMOS 图像传感器）产品需由 FSI 工序加上 BSI

工序完成，而标的公司自身不具备 BSI 工艺生产制造能力，华力集不具备 FSI 工艺生产制造能力，且双方分段加工形成最终产品也在大规模量产中得到客户端的充分验证，因此标的公司向华力集采购 BSI 晶圆代工服务具有必要性和合理性。

②受托加工服务

报告期内，由于晶圆制造过程涉及的工艺复杂、工序繁多，基于整体产线运行效率最优化的原则，华力集向标的公司在部分产品工序生产受限时提供加工服务，并按照成本计价。

2）接受服务

报告期内，华力集向标的公司提供管理咨询、办公等相关服务，双方按照实际发生情况结算。

2、销售货物/提供服务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
上海华力集成电路制造有限公司	销售货物	**20,649.56**	27,116.78
公司 B	销售货物	**209.87**	-
摯芯电子（上海）有限公司	销售货物	**-**	62.84
上海复旦微电子集团股份有限公司	销售货物	**7,021.18**	5,434.62
小计		**27,880.61**	**32,614.24**
上海华力集成电路制造有限公司	提供服务	**1,669.90**	2,272.18
公司 B	提供服务	**526.78**	567.84
摯芯电子（上海）有限公司	提供服务	**-**	7.18
上海复旦微电子集团股份有限公司	提供服务	**571.93**	800.85
小计		**2,768.61**	**3,648.05**
公司 B	技术开发	**-**	47,100.00
小计		**-**	**47,100.00**
合计		**30,649.22**	**83,362.29**

注 1：上海复旦微电子集团股份有限公司为标的公司母公司华虹集团董事于报告期内担任董事兼总经理的公司（2025 年 6 月 18 日委任），因此关联交易仅列示 2025 年度交易额及 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日交易额。

（1）上海华力集成电路制造有限公司

1）销售货物

①FSI 晶圆代工产品

报告期内，标的公司向华力集销售 FSI 晶圆代工产品。鉴于目前标的公司与华力集对外销售的中高端 CIS（CMOS 图像传感器）产品需由 FSI 工序加上 BSI 工序完成，而标的公司自身不具备 BSI 工艺生产制造能力，华力集不具备 FSI 工艺生产制造能力，且双方分段加工形成最终产品也在大规模量产中得到客户端的充分验证，因此标的公司向华力集销售 FSI 晶圆代工产品具有必要性和合理性。

②受托加工服务

报告期内，由于晶圆制造过程涉及的工艺复杂、工序繁多，基于整体产线运行效率最优化的原则，标的公司向华力集在部分产品工序生产受限时提供加工服务，并按照成本计价。

2）提供服务

报告期内，标的公司向华力集提供管理咨询、办公、物业管理等相关服务，双方按照实际发生情况结算。

（**2**）公司 B

报告期内，标的公司向公司 B 提供技术授权服务，双方以第三方评估机构出具的评估报告作为定价基准，双方交易具备合理性。

3、委托贷款

单位：万元

委托人	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 12 月 31 日
上海华虹（集团）有限公司	-	13,755.00	-	13,755.00

4、关联租赁

（1）标的公司作为出租方

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2025 年度确认的租赁收入	2024 年度确认的租赁收入
上海华力集成电路制造有限公司	房屋及建筑物	**56.14**	57.11
公司 B	设备	**138.46**	-
合计		**194.60**	**57.11**

报告期内，华力集鉴于现有生产条件受限，需要租赁标的公司洁净厂房进行生产，经双方协商，基于集成电路生产配套环境的特殊性，华力集向标的公司租赁放置生产专用设备的洁净厂房、配套生产设施及各项资源。

报告期内，标的公司向公司 B 融资租出设备，**2025 年度**确认设备融资租赁利息收入 **138.46** 万元。

（2）标的公司作为承租方

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2025 年度		
		支付的租金	承担的租赁负债利息支出	使用权资产重估调整
上海华虹宏力半导体制造有限公司	房屋及建筑物	**9,959.56**	**1,947.02**	**78.60**

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2024 年度		
		支付的租金	承担的租赁负债利息支出	使用权资产重估调整
上海华虹宏力半导体制造有限公司	房屋及建筑物	9,784.63	2,325.00	113.66

报告期内，标的公司租赁上海华虹宏力厂房及洁净室等用于生产经营，2024 年度以及 **2025 年度**支付的租金分别为 9,784.63 万元和 **9,959.56** 万元。

5、关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
公司 B	融资租出设备	5,929.30	-

6、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
关键管理人员薪酬	**1,621.28**	3,652.70

7、其他关联交易

单位：万元

交易类型	关联方名称	2025 年度	2024 年度
由关联方代收代付水电物业费	上海华虹宏力半导体制造有限公司	**20,372.47**	20,358.29

报告期内，标的公司租赁上海华虹宏力厂房及洁净室等用于生产经营，华虹宏力代收代付标的公司在租赁场地内消耗的电费、水费、物业费等费用。

8、关联方应收应付款

（1）应收账款

单位：万元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
上海华力集成电路制造有限公司	**7,506.77**	**701.89**	3,388.60	399.44
公司 B	**37.48**	**11.47**	119.15	0.53
上海复旦微电子集团股份有限公司	**44.01**	**0.50**	299.77	1.34
合计	**7,588.27**	**713.86**	**3,807.52**	**401.30**

（2）其他应收款

单位：万元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
上海华力集成电路制造有限公司	**1.22**	**-**	0.42	**-**
合计	**1.22**	**-**	**0.42**	**-**

（3）长期应收款（含一年内到期的非流动资产）

单位：万元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
公司 B	**6,945.75**	**-**	**-**	**-**
合计	**6,945.75**	**-**	**-**	**-**

（4）其他非流动资产

单位：万元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
上海华虹宏力半导体制造有限公司	**349.82**	387.62
上海华力集成电路制造有限公司	**-**	5,158.51
合计	**349.82**	**5,546.13**

（5）应付账款

单位：万元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
上海华力集成电路制造有限公司	**8,696.55**	8,579.55
公司 B	**-**	12.83
上海华虹宏力半导体制造有限公司	**4,675.94**	6,280.70
上海华虹虹日电子有限公司	**31.97**	1,547.41
上海华虹挚芯电子科技有限公司	**21.25**	47.69
挚芯电子（上海）有限公司	**33.49**	1.36
华海清科股份有限公司	**0.01**	0.20
合计	**13,459.20**	**16,469.74**

（6）其他应付款

单位：万元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
上海华力集成电路制造有限公司	**215.12**	702.28
公司 B	**0.11**	3.32
上海华虹宏力半导体制造有限公司	**573.89**	417.38
合计	**789.13**	**1,122.99**

（7）租赁负债（含一年内到期的非流动负债）

单位：万元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
上海华虹宏力半导体制造有限公司	**39,144.50**	47,078.44
合计	**39,144.50**	**47,078.44**

（四）本次交易前后上市公司关联交易的变化情况

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，标的公司向上市公司关联方的销售及采购等事项将形成新增关联交易，同时标的公司与上市公司之间的关联交易在本次重组完成后将予以消除。

整体而言，相关新增关联销售占上市公司营业收入比例极低，不会对上市公司独立性造成影响。未来对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上市公司继续严格按照相关法律、法规的规定及公司相关制度的规定，进一步完善交易决策程序，加强公司治理和信息披露，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

（五）本次交易完成后规范关联交易的措施

本次交易前，上市公司已依照《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规相关要求制定了完善的关联交易制度体系，在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度中对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的审议程序以及关联交易的披露等事项进行了相关规定并严格执行。与此同时，上市公司的独立董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时、充分发表意见。

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司将继续按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，规范本次交易完成后的关联交易，并按照有关法律、法规和监管规则等规定进行信息披露，以确保相关关联交易定价的合理性、公允性和合法性，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

第十二节 风险因素

一、本次交易相关风险

（一）审批风险

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的决策和审批程序事项包括但不限于：

1、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、审查、备案或许可（如适用）。

本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险

由于本次交易涉及向上交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。在本次交易推进过程中，市场情况可能会发生变化或出现不可预知的重大事件，则本次交易可能无法按期进行或需重新进行，面临重新定价的风险。

除此之外，本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；

2、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、中止或取消的风险；

3、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

上述情形可能导致本次交易暂停、中止或取消，特此提醒广大投资者注意投资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并做出相应判断。

（三）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险

本次交易完成后，公司总股本将扩大。根据上市公司《备考审阅报告》，本次发行股份购买资产完成后不存在摊薄上市公司当期的每股收益的情况。考虑到本次交易拟通过向特定对象发行股票的方式募集配套资金，最终的发行数量及价格将按照证券监管机构的相关规定确定，因此存在上市公司的总股本因为募集配套资金而进一步扩大，从而导致上市公司即期回报指标被摊薄的风险。

为应对本次交易未来可能导致上市公司每股收益摊薄的潜在风险，上市公司根据自身经营特点制定了填补回报的措施，但该等填补回报的措施不等于对上市公司未来盈利作出的保证，提请投资者关注本次重组摊薄即期回报的风险。

（四）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险

作为交易方案的一部分，上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。若国家法律、法规或其他规范性文件对发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。上述募集配套资金事项能否取得上交所审核通过、证监会的注册尚存在不确定性。此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。

（五）收购整合的风险

本次交易完成后，标的资产将纳入上市公司管理及合并范围，上市公司的业务规模、人员等将进一步扩大，上市公司也将面临经营管理方面的挑战。本次交易完成后，上市公司能否通过整合保持标的资产原有竞争优势并充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，提请投资者关注相关风险。

二、与标的公司相关的风险

（一）半导体行业周期性波动的风险

标的公司主要为客户提供 12 英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。半导体行业的发展与宏观经济整体发展密切相关，其下游市场需求受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，

存在一定的周期性。未来，如果宏观经济环境持续低迷，或者通信、消费电子等下游市场需求发生波动，将可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。

（二）国际贸易摩擦的风险

近年来国际政治、经济形势日益复杂，国际贸易摩擦不断升级。有关国家针对半导体设备、材料、技术等领域颁布了一系列出口管制政策，对半导体行业相关的技术和服务作出限制。若国际贸易摩擦持续或进一步加剧，标的公司生产经营可能受到不利影响。

（三）核心技术人员流失的风险

标的公司所处的晶圆制造行业属于技术密集型、人才密集型行业，优秀的研发人员团队是标的公司的核心竞争力及未来发展保障。在资本涌入和市场竞争日趋激烈背景下，半导体领域人才的竞争愈加激烈，若标的公司未能提供良好的发展路径、有吸引力的薪酬待遇及相应的激励考核机制，可能面临核心技术人员流失的风险，进而对标的公司技术研发能力与市场拓展能力产生负面影响。

（四）技术研发的风险

晶圆代工行业属于资本、人才及技术密集型领域，从晶圆制造工艺到下游产品需求等技术更新的迭代速度较快。未来，如果受到研发投入不足、硬件限制或技术人才流失等因素影响，标的公司可能无法及时推出契合市场需求且具备成本效益的技术平台，或技术迭代大幅落后于产品应用的工艺要求，可能导致标的公司技术被赶超或替代，竞争力和市场份额有所下降，从而影响标的公司后续发展。

（五）技术泄密的风险

在半导体行业的发展与竞争中，相应的知识产权保护体系至关重要，也是获取竞争优势与长期发展的关键要素。标的公司拥有大量工艺技术积累，但由于技术保护措施的局限性、技术人员的流动性及其他不可控因素，标的公司仍存在核心技术泄密的风险，从而对公司在技术方面的竞争优势产生不利影响。

（六）毛利率波动的风险

报告期各期，标的公司综合毛利率分别为 16.51%和 23.69%，标的公司的毛

利率逐年有所提升。标的公司产品毛利率波动受诸多因素影响，未来，如果半导体行业整体情况发生不利变化，客户需求未达预期，从而影响到标的公司晶圆代工业务的产能利用率、销量及价格；或主要原材料价格大幅上涨等不利情况发生，标的公司在未来一定时期内可能面临毛利率波动的风险。

（七）资产负债率较高的风险

报告期各期末，标的公司资产负债率分别为 79.76%和 65.92%，显著高于可比上市公司。标的公司所处晶圆代工行业属于技术密集型和资本密集型行业，生产线建设和研发资金需求较高。未来，如果标的公司因行业景气度变化等原因导致经营活动现金净流量下降，可能给公司带来短期的流动性风险，影响公司产能和业务规模提升，对公司业务造成不利影响。

（八）应收账款坏账的风险

报告期各期末，标的公司应收账款账面余额分别为 63,591.05 万元及 65,588.39 万元，应收账款规模随着经营规模的扩大持续上升，未来可能随着经营规模的扩大进一步上升。虽然标的公司主要客户目前发生坏账的可能性较小，但如果未来应收账款回款情况不理想或主要客户自身发生重大经营困难而导致标的公司无法及时收回货款，需要计提应收账款减值准备，进而影响标的公司盈利水平。

（九）汇率波动的风险

标的公司的记账本位币为人民币，而部分交易采用美元等外币结算。报告期内，标的公司汇兑损益分别为 4,693.93 万元及-8,039.34 万元。标的公司在经营过程中重视外币资产和外币负债在规模上的匹配，合理控制外汇风险敞口。但未来如果境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，标的公司仍将面临汇兑损失的风险。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受企业经营业绩和

发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内外政治经济形势、资金供求关系、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，对本次交易事项本身的阐述和分析不能完全揭示投资者进行证券投资所面临的全部风险，上市公司的股价存在波动的风险。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，上市公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息供投资者做出投资判断，提请广大投资者注意投资风险。

（二）不可抗力的风险

上市公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。提请投资者关注相关风险。

第十三节 其他重要事项

一、拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方是否存在对拟购买资产的非经营性资金占用

截至本报告书签署日，标的公司不存在股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的情形。

二、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形

本次交易完成前后，上市公司均不存在资金、资产被控股股东、实际控制人占用的情形。

上市公司不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形。

三、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况

《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定：“本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：（一）与他人新设企业、对已设立的企业增资或者减资；（二）受托经营、租赁其他企业资产或者将经营性资产委托他人经营、租赁；（三）接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产；（四）中国证监会根据审慎监管原则认定的其他情形。”

在本次交易前 12 个月内，上市公司不存在与本次交易相关的购买、出售同一或相关资产的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情形。

四、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况

本次交易对上市公司财务指标的影响详见本报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“五、/（三）本次交易完成后资产负债率情况、上市公司财务安全性情况”。总体而言，本次交易前后上市公司资产负债结构较为合理，不存在因本次交易大量增加负债的情况。

五、本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易完成前，上市公司已根据适用的法律、法规和规范性文件的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《信息披露境内代表工作细则》等规章制度，建立了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。

本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化，上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等规章制度的建设与实施，维护上市公司及中小股东的利益。

六、重大事项披露前股票价格波动情况的说明

因筹划本次交易事项，经向上交所申请，华虹公司股票自 2025 年 8 月 18 日开市起停牌，重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 15 日，涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交易日（2025 年 7 月 18 日）。华虹公司（688347.SH）、上证科创板 50 成份指数（000688.SH）、半导体行业指数（886063.WI）的累计涨跌幅如下：

项目	停牌前第 21 个交易日（2025 年 7 月 18 日）	停牌前第 1 个交易日（2025 年 8 月 15 日）	涨跌幅
华虹公司（688347.SH）股票收盘价（元/股）	52.93	78.50	48.31%

项目	停牌前第 21 个交易日	停牌前第 1 个交易日	涨跌幅
	（2025 年 7 月 18 日）	（2025 年 8 月 15 日）	
上证科创板 50 成份指数（000688.SH）	1,007.53	1,101.29	9.31%
半导体行业指数（886063.WI）	5,478.67	6,069.34	10.78%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			39.00%
剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅			37.53%

注：以上数据均为当日收盘价或收盘点数。

本次交易停牌前 20 个交易日期间，剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日期间内的累计涨跌幅超过 20%，公司特此提示风险如下：

1、中国证监会可能将对公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险；

2、如公司本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易进程将被暂停并可能被终止。

在本次交易的筹划过程中，上市公司已根据法律法规及证券监管部门的有关规定，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务，同时，上市公司按照上交所的要求进行了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的填报和提交。

七、本次重组对中小投资者权益保护的安排

本次交易对中小投资者权益保护的安排详见本报告书“重大事项提示”之“八、本次交易对中小投资者权益保护的安排”。

八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东关于本次重组的原则性意见，详见本报告书“重大事项提示”之“六、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见”。上市公司控股股东、

董事、高级管理人员自首次披露本次交易相关信息之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划，详见本报告书“重大事项提示”之“七、上市公司控股股东、董事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。

九、本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

截至本报告书签署日，本次交易相关主体均未发现存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

因此，本次交易的相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

十、本次交易完成后利润分配政策及相应安排

本次交易完成后，上市公司将继续执行现行有效的现金分红相关政策。同时上市公司将根据中国证监会、上交所及相关法律法规的要求，不断完善利润分配制度。

十一、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

（一）上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

1、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。

3、公司按照上海证券交易所的要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料

4、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。

5、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保密义务。

（二）本次交易的内幕信息知情人自查期间

根据《重组管理办法》《格式准则第 26 号》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规和规范性文件的规定，上市公司针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为申请股票停牌日前 6 个月至重组报告书披露之前一日止，即 2025 年 2 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日**（以下简称“自查期间”）**。

（三）本次交易的内幕信息知情人核查范围

1、上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；

2、上市公司控股股东；

3、交易对方及其主要负责人及有关知情人员；

4、标的公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；

5、相关中介机构及具体业务经办人员；

6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；

7、上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

（四）本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况

1、法人买卖华虹公司股票的情况

除国泰海通外，其他内幕信息知情机构在自查期间不存在通过二级市场买卖上市公司股票的情形。自查期间内，国泰海通买卖华虹公司股票具体情况如

下：

单位：股

名称	部门/子公司	业务类型	股份变动数量	自查期末持股数
国泰海通	证券衍生品投资部	证券买入	2,407,458	19,385
		证券卖出	2,506,481	
		ETF 赎回成分券增加	40,400	
		ETF 申购成分券减少	17,983	
	权益客需部	证券买入	9,490,689	1,896,549
		证券卖出	7,698,352	
	国泰海通资产管理有限公司	证券买入	3,169,602	308,989
		证券卖出	3,710,535	
	上海海通证券资产管理有限公司	证券买入	-	-
		证券卖出	400	
	国泰君安国际控股有限公司	证券买入	659,722	14,294
		证券卖出	657,600	
	海通国际证券集团有限公司	自营持仓买入	50,911	2,944
		自营持仓卖出	50,911	
		代客持仓买入	314,520	
		代客持仓卖出	311,576	

针对上述股票买卖行为，国泰海通作出如下说明和承诺：“本公司严格遵守了中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关法律法规的要求，建立了严格的信息隔离墙制度，各业务之间在机构设置、人员安排、信息系统、资金账户等方面独立运作、分开管理，以控制内幕信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免公司与客户之间、客户与客户之间以及公司员工与公司、客户之间的利益冲突。

上述股票买卖行为与本次重组事项无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形，本公司也未泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

除上述买卖情况外，本公司在自查期间内无买卖上市公司股票的行为；本公

司无泄漏有关信息或者建议他人买卖华虹公司股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。”

2、自然人买卖华虹公司股票情况

自查期间内，相关自然人买卖上市公司股票的情况具体如下：

单位：股

序号	姓名	职务/关系	交易日期/期间	期间累计买入	期间累计卖出	自查期末持股数
1	雷海波	标的公司董事	2025 年 10 月 9 日至 2025 年 12 月 5 日	1,400	900	500
2	雷书懿	标的公司董事雷海波之子女	2025 年 6 月 30 日至 2025 年 9 月 24 日	4,300	4,300	0
3	倪立华	曾任标的公司执行副总裁	2025 年 2 月 17 日至 2025 年 5 月 13 日	343,529	363,529	0
4	柯陈宾	曾任标的公司执行副总裁	2025 年 7 月 15 日至 2025 年 9 月 2 日	30,000	30,000	0
5	王惠贤	曾任标的公司董事冯雪静之母亲	2025 年 3 月 26 日至 2025 年 5 月 29 日	1,370	1,370	0
6	张莉琴	曾任标的公司高级副总裁邵华之配偶	2025 年 9 月 3 日、2025 年 9 月 24 日	4,643	4,643	0
7	卞达开	交易对方相关人员	2025 年 11 月 3 日、2025 年 11 月 4 日	782	782	0

针对上述自查期间买卖股票的行为，该等人员均已分别出具自查报告或说明与承诺，相关主要内容如下：

（1）雷海波

针对前述交易情况，雷海波出具声明与承诺如下：

“1、本人买卖股票的账户实际系由本人亲属操作，本人对其通过本人股票账户买卖上市公司股票的行为并不知情。本人亲属在自查期间内交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息；本人亲属自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于其对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属不存在其他买卖上市公司股票的情形。

3、本人未向本人亲属泄露本次交易的信息，亦未以明示或暗示的方式建议

其买卖上市公司的股票；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人同意督促本人亲属将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对雷海波亲属使用其股票账户进行交易的情况，其亲属出具声明与承诺如下：

“1、本人亲属用于购买上市公司股票的账户均系由本人实际操作，本人亲属对本人通过其股票账户买卖上市公司股票的行为并不知情；本人在自查期间内通过前述账户交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息，本人自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人不存在其他通过本人账户或操作他人账户买卖上市公司股票的情形。

3、本人在自查期间不存在自本人亲属、本次交易内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易相关内幕信息的情况，不存在本次交易内幕信息知情人明示或暗示本人买卖上市公司股票的情况；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人愿意将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易

期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

（2）雷书懿

针对前述交易情况，雷书懿出具声明与承诺如下：

“1、本人买卖股票的账户实际系由本人亲属操作，本人对其通过本人股票账户买卖上市公司股票的行为并不知情。本人亲属在自查期间内交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息；本人亲属自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于其对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人不存在其他买卖上市公司股票的情形。

3、本人在自查期间不存在自本人亲属、本次交易内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易相关内幕信息的情况，不存在本次交易内幕信息知情人明示或暗示本人买卖上市公司股票的情况；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人同意督促本人亲属将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对雷书懿亲属使用其股票账户进行交易的情况，其亲属出具声明与承诺如下：

“1、本人亲属用于购买上市公司股票的账户均系由本人实际操作，本人亲属对本人通过其股票账户买卖上市公司股票的行为并不知情；本人在自查期间内通过前述账户交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息，本人自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人不存在其他通过本人账户或操作他人账户买卖上市公司股票的情形。

3、本人在自查期间不存在自本人亲属、本次交易内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易相关内幕信息的情况，不存在本次交易内幕信息知情人明示或暗示本人买卖上市公司股票的情况；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人愿意将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

（3）倪立华、柯陈宾、卞达开

针对前述交易情况，倪立华、柯陈宾、卞达开分别出具声明与承诺如下：

“1、本人用于购买上市公司股票的账户系本人自有账户。本人在自查期间内交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息；本人自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况

下，基于对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属不存在其他买卖上市公司股票的情形。

3、本人不存在泄漏有关内幕信息或者委托或建议他人购买上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人愿意将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

（4）王惠贤

针对前述交易情况，王惠贤出具声明与承诺如下：

“1、本人用于购买上市公司股票的账户系本人自有账户。本人在自查期间内通过前述账户交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息，本人自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人不存在其他通过本人账户或操作他人账户买卖上市公司股票的情形。

3、本人在自查期间不存在自本人亲属、本次交易内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易相关内幕信息的情况，不存在本次交易内幕信息知情人明示或暗示本人买卖上市公司股票的情况；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人愿意将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对王惠贤股票账户交易情况，其亲属冯雪静出具声明与承诺如下：

“1、本人亲属用于购买上市公司股票的账户系其自有账户。本人亲属在自查期间内交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息；本人亲属自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于其对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属不存在其他买卖上市公司股票的情形。

3、本人未向本人亲属泄露本次交易的信息，亦未以明示或暗示的方式建议其买卖上市公司的股票；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人同意督促本人亲属将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

（5）张莉琴

针对前述交易情况，张莉琴出具声明与承诺如下：

“1、本人买卖股票的账户实际系由本人亲属操作，本人对其通过本人股票账户买卖上市公司股票的行为并不知情。本人亲属在自查期间内交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息；本人亲属自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于其对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人不存在其他买卖上市公司股票的行为。

3、本人在自查期间不存在自本人亲属、本次交易内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易相关内幕信息的情况，不存在本次交易内幕信息知情人明示或暗示本人买卖上市公司股票的情况；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人同意督促本人亲属将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对张莉琴股票账户交易情况，其亲属邵华出具声明与承诺如下：

“1、本人亲属用于购买上市公司股票的账户实际由本人操作，本人亲属对本人通过其股票账户买卖上市公司股票的行为并不知情。本人在自查期间内交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息；本人自查期间内通过本人亲属之股票账号买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价

值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属不存在其他通过本人账户或操作他人账户买卖上市公司股票的情形。

3、本人未向本人亲属泄露本次交易的信息，亦未以明示或暗示的方式建议其买卖上市公司的股票；本人不存在泄漏有关内幕信息或者委托或建议他人购买上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人愿意将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

十二、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息

本报告书已按照相关法律法规对本次交易的有关信息作了如实披露，除上述事项外，不存在其他应披露而未披露的能够影响股东及其他投资者作出合理判断的有关本次交易的信息。

第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见

一、独立董事意见

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，独立董事对公司董事会审议事项进行了认真审议，并仔细查阅了相关资料。独立董事基于其独立判断，发表了如下独立意见：

1、根据《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司具备本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项条件，符合上述法律、法规及规范性文件的相关规定。

2、公司拟将购买资产的支付方式从发行股份及支付现金调整为发行股份。本次交易方案调整符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的规定，本次交易方案调整不构成重大调整。

3、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的制定符合公司的实际情况，具备可行性和可操作性。该方案的实施有利于公司主营业务的发展，提升市场竞争力，增强持续经营能力，未损害中小股东的利益。

4、为完成本次交易，公司已根据《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定编制了《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，相关草案及其摘要符合公司的实际情况，具备可行性和可操作性。

5、鉴于本次交易所涉及的审计及评估工作已完成，为进一步明确公司与交易对方在本次交易中所涉及的权利义务、本次交易标的资产的交易对价、支付方

式及股份发行数量等相关事项，同意公司与上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等标的公司股东签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》。

6、为明确本次交易中标的资产涉及的减值测试、补偿安排及相关方的权利义务，同意公司与上海华虹（集团）有限公司签订附生效条件的《减值补偿协议》。

7、本次发行股份购买资产的交易对方中，华虹集团系上市公司的间接控股股东，上海集成电路基金系上市公司董事曾担任董事的企业，根据《重组管理办法》以及《科创板股票上市规则》等规定，本次交易预计构成关联交易。

8、本次交易中计算依据占上市公司相应指标比例未超过 50%，因此本次交易不构成重大资产重组。本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司直接控股股东均为华虹国际，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均为上海市国资委，本次交易不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市。

9、本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条规定。

10、本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

11、本次交易的标的资产符合科创板定位，所属行业与公司处于同行业，与公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高公司持续经营能力，本次交易符合《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《重组审核规则》第八条的规定。

12、本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号》第三十条所规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

13、本次交易停牌前 20 个交易日期间，剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日期间内的累计涨幅超过 20%。在筹划本次交易事项过程中，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，

采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。同时，公司按照上海证券交易所的要求完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的填报和提交。

14、公司不存在《注册管理办法》第十一条所规定不得向特定对象发行股票的情形。

15、在本次交易前 12 个月内，上市公司不存在与本次交易相关的购买、出售同一或相关资产的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情形。

16、公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，公司及公司董事、高级管理人员没有利用该等信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

17、公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定，就本次交易提交的法律文件合法、有效。

18、本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

19、审议通过关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告。

20、本次交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告为定价依据，并由交易双方协商确定，符合有关法规规定，交易定价具备公允性、合理性，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

21、公司就本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施符合相关法律法规及中国证监会的相关规定，有利于董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，有利于保障中小投资者利益，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东作出了相关承诺。

22、公司在本次交易中聘请中介机构的行为合法合规，符合《关于加强证券

公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕22 号）的规定。

23、上海华虹（集团）有限公司根据香港《公司收购、合并及股份购回守则》的相关规定申请清洗豁免，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

24、根据香港《公司收购、合并及股份购回守则》规则 25 条，本次交易按有关规则视为特别交易，须取得香港证监会执行人员同意，且需要独立财务顾问的公开声明，表示其认为特别交易的条款属公平合理，及独立股东于股东大会上通过投票方式批准特别交易。

二、独立财务顾问对本次交易的结论性意见

公司聘请了国泰海通证券作为本次交易的独立财务顾问。独立财务顾问按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《监管指引第 6 号》《格式准则第 26 号》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，通过尽职调查和对上市公司董事会编制的重组报告书等信息披露文件的审慎核查，并与上市公司、交易对方、本次交易的法律顾问、审计机构、评估机构等相关方经过充分沟通后认为：

“1、本次交易符合《重组办法》第十一条、第四十三条、第四十四条的规定，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的情形；

2、本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十一条的规定；

3、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；

4、本次交易根据资产评估结果定价，所选取的评估方法具有适当性，评估假设前提具有合理性，重要评估参数取值具有合理性，评估结论和评估定价具有公允性；本次交易拟购买资产定价具有合理性，发行股份购买资产的股份定价具有合理性；

5、本次交易有利于增强上市公司持续经营能力、改善上市公司财务状况，

本次交易有利于上市公司的持续发展，不存在损害股东合法权益的问题；

6、本次交易有利于上市公司提升市场地位和经营业绩，有利于增强上市公司的持续发展能力；

7、本次交易合同约定的资产交付安排不会导致上市公司在本次交易后无法及时获得标的资产的风险，标的资产交付安排相关的违约责任切实、有效；

8、本次重组构成关联交易，关联交易程序的履行符合相关规定，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形；

9、上市公司已在重组报告书中，就本次重组完成后可能出现即期回报被摊薄的情况，提出填补每股收益的具体措施，该等措施具有可行性、合理性；

10、标的资产符合科创板定位，所属行业与上市公司处于同行业；标的公司与上市公司具有协同效应。本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条的规定；

11、本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三方中介机构的行为。上市公司除聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、备考审阅机构、评估机构以外，还聘请了创升融资有限公司担任本次交易的中国香港独立财务顾问、聘请了 Herbert Smith Freehills Kramer（香港律所）担任本次交易的中国香港法律顾问、聘请大华国际（香港）会计师事务所有限公司担任本次交易标的公司港股审计机构、聘请了安永会计师事务所担任本次交易上市公司港股备考审阅机构以及聘请了北京向实启源管理咨询有限公司为上市公司提供申报文件制作、底稿电子化等服务，除此以外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。”

三、法律顾问对本次交易的结论性意见

公司聘请了通力律师作为本次交易的法律顾问。法律顾问认为：

“华虹半导体有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

的交易各方均具备参与本次交易的主体资格；本次交易方案的内容符合法律、法规以及规范性文件的要求；本次交易符合《重组办法》和《发行办法》规定的各项实质条件；本次交易在取得本法律意见书所述必要的批准、授权后，其实施不存在法律障碍。”

第十五节 本次交易有关中介机构情况

一、独立财务顾问

机构名称：国泰海通证券股份有限公司

负责人：朱健

住所：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层

联系电话：021-38676666

传真：021-38676666

项目主办人：李淳、聂绪雯

项目协办人：陈是来、肖翔云、乔宏图、陈亚聪

项目组成员：陈宁、蒋浩威、毛正晔、陈家仪、张俊鑫、沈灿杰、熊烨、曾蕴也、倪晓伟、卢程鹏、叶一民、林毅、冯文彬、王俊杰、李鸿仁

二、律师事务所

机构名称：上海市通力律师事务所

负责人：韩炯

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

联系电话：862131358666

传真：862131358600

经办律师：陈军、夏青

三、标的资产审计机构

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨晨辉

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

联系电话：010-58350011

传真：010-58350006

经办注册会计师：王胤、李春姣

四、上市公司备考审阅机构

机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：毛鞍宁

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

经办注册会计师：杨磊、王顺华

五、资产评估机构

机构名称：上海东洲资产评估有限公司

负责人：徐峰

住所：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

联系电话：021-52402166

传真：021-62252086

经办资产评估师：余哲超、王欣

第十六节 声明与承诺

一、上市公司全体董事声明

本公司及全体董事承诺本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

白鹏	叶峻	孙国栋
熊承艳	陈博	张祖同
王桂埙	封松林	

华虹半导体有限公司

年 月 日

二、上市公司审核委员会声明

本公司及全体审核委员会委员承诺本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体审核委员会委员签名：

张祖同	熊承艳	封松林

华虹半导体有限公司

年 月 日

三、上市公司全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体非董事高级管理人员签名：

Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）	周卫平	华光平
陈一敏	**Larry Maohui Ge 葛茂晖**	

华虹半导体有限公司

年 月 日

四、独立财务顾问声明

本公司及本公司经办人员同意《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中引用的本公司出具的独立财务顾问报告的内容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将依法承担连带赔偿责任。

本公司及本公司经办人员已对本次重组申请文件中引用的其他中介机构意见在专业领域范围内保持职业怀疑，运用职业判断进行独立分析、调查或复核，并作出独立判断。如本次交易申请文件因引用其他机构意见导致出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将依法承担相应责任。

法定代表人（董事长）：

朱　健

项目主办人：

李　淳　　聂绪雯

项目协办人：

陈是来　　肖翔云

乔宏图　　陈亚聪

国泰海通证券股份有限公司

年　月　日

五、法律顾问声明

本所及本所经办律师同意华虹半导体有限公司在《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）及其摘要引用本所出具的法律意见书的相关内容，并已对重组报告书及其摘要中所引用的法律意见书的内容进行了审阅，确认重组报告书及其摘要不致因前述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

上海市通力律师事务所 负责人：_____

韩 炯

（公章）

经办律师：_____

陈 军

_____

夏 青

年 月 日

六、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，确认重组报告书与本所出具的上海华力微电子有限公司审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对华虹半导体有限公司在重组报告书及其摘要中引用的上述审计报告等文件的内容无异议，确认重组报告书及其摘要不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

_____ _____

王 胤 李春姣

会计师事务所负责人：

_____

杨晨辉

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

七、备考审阅机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），确认重组报告书中引用的经审阅的备考合并财务报表的内容，与本所出具的备考合并财务报表审阅报告(报告编号：安永华明（2026）专字第 70013197_B04 号)的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对华虹半导体有限公司在重组报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认重组报告书不致因上述报告而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供华虹半导体有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项交易使用，不适用于其他用途。

签字注册会计师：

_____ _____

杨磊 王顺华

会计师事务所负责人：

_____

毛鞍宁

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

八、资产评估机构声明

本公司及签字资产评估师同意本报告书及其摘要中引用本公司出具的评估报告<<东洲评报字[2025]第 2446 号>>的相关内容。

本公司及经办评估师已对本报告书及其摘要中引用的本公司出具的评估报告的相关内容进行了审阅,确认本报告书及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

本公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本公司未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。

法定代表人：

徐峰

签字评估师：

余哲超　　王欣

上海东洲评估有限公司

年　月　日

（本页无正文，为《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之盖章页）

华虹半导体有限公司

年 月 日

第十七节 备查文件

一、备查文件

1、上市公司关于本次交易的董事会决议；

2、上市公司独立董事关于本次交易的独立意见；

3、《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》《减值补偿协议》；

4、国泰海通证券出具的独立财务顾问报告；

5、通力律师出具《法律意见书》；

6、大华会计师出具的《审计报告》、安永会计师出具的《备考审阅报告》；

7、东洲评估师出具的《资产评估报告》；

8、其他备查文件。

二、备查地点

存放公司：华虹半导体有限公司

地址：中国上海市浦东新区哈雷路 288 号

电话：86-21-38829909

传真：86-21-38829909

附件一：标的公司拥有的主要专利权

表 1：标的公司拥有的主要境内已授权专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1	缺陷源检测方法	发明	ZL202310465632.4	2023-04-26	申请日起二十年	原始取得
2	一种半导体测试结构、失效定位方法及电子设备	发明	ZL202310171806.6	2023-02-24	申请日起二十年	原始取得
3	版图图形边缘分割方法	发明	ZL202211390612.7	2022-11-08	申请日起二十年	原始取得
4	OPC 修正方法	发明	ZL202211343909.8	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
5	目标版图优化方法	发明	ZL202211343908.3	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
6	基于派工规则的自适应铜化学机械抛光设备智能排程控制方法	发明	ZL202211343857.4	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
7	一种 CMP LK 机台清洗端漏液检测装置及检测方法	发明	ZL202211056056.X	2022-08-31	申请日起二十年	原始取得
8	一种缺陷检测方法	发明	ZL202211053151.4	2022-08-29	申请日起二十年	原始取得
9	一种电容测试结构及测试方法	发明	ZL202211042217.X	2022-08-29	申请日起二十年	原始取得
10	一种数模混合的高精度建立保持时间测量电路及其实现方法	发明	ZL202210963404.5	2022-08-11	申请日起二十年	原始取得
11	像素结构、图像传感器及终端	发明	ZL202210899224.5	2022-07-28	申请日起二十年	原始取得
12	缺陷监控方法及缺陷监控系统	发明	ZL202210744426.2	2022-06-27	申请日起二十年	原始取得
13	SONOS 存储器的光刻返工方法	发明	ZL202210614756.X	2022-05-30	申请日起二十年	原始取得
14	缺陷样品的制备方法及互连结构缺陷的失效分析方法	发明	ZL202210438345.X	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
15	版图的局部图形密度分析方法	发明	ZL202210420874.7	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
16	图像传感器的制作方法	发明	ZL202210419104.0	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
17	半导体结构及其制造方法	发明	ZL202210418472.3	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
18	冲洗装置及半导体制造设备	发明	ZL202210304776.7	2022-03-22	申请日起二十年	原始取得
19	抽气阀门、抽气阀门开闭方法及负压腔体组件	发明	ZL202210289042.6	2022-03-22	申请日起二十年	原始取得
20	图像传感器的制造方法	发明	ZL202210287629.3	2022-03-22	申请日起二十年	原始取得
21	一种双端口 SRAM 控制电路及其控制方法	发明	ZL202210190775.4	2022-02-28	申请日起二十年	原始取得
22	一种 PVD 机台	发明	ZL202210102716.7	2022-01-27	申请日起二十年	原始取得
23	缺陷自分类方法及系统	发明	ZL202111681769.0	2021-12-30	申请日起二十年	原始取得
24	基于 Q-time 容时区间站点断线的智能调控方法及系统	发明	ZL202111626368.5	2021-12-28	申请日起二十年	原始取得
25	一种干泵尾管和离子注入机	发明	ZL202111626346.9	2021-12-28	申请日起二十年	原始取得
26	一种晶圆缺陷扫描方法及系统	发明	ZL202111448042.8	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
27	一种检查光刻工艺微小失焦的方法	发明	ZL202111437342.6	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
28	承载台边缘位置平坦度的监控方法	发明	ZL202111437339.4	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
29	一种阈值电压的测量方法及其系统	发明	ZL202111436114.7	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
30	一种深度加速集成电路版图光刻工艺热点检查的方法	发明	ZL202111436108.1	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
31	一种全局工艺角模型的建模方法	发明	ZL202111436051.5	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
32	一种横向扩散金属氧化物半导体的子电路模型构建方法	发明	ZL202111433629.1	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
33	一种高压器件的栅氧层及其制造方法	发明	ZL202111276185.5	2021-10-29	申请日起二十年	原始取得
34	图像传感器的制造方法	发明	ZL202111276184.0	2021-10-29	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
35	浅沟槽隔离及通孔刻蚀工艺刻蚀窗口的方法	发明	ZL202111266553.8	2021-10-28	申请日起二十年	原始取得
36	基于整数规划的产品生产计划的制定方法	发明	ZL202111153447.9	2021-09-29	申请日起二十年	原始取得
37	机台联动性的监控方法及监控系统	发明	ZL202111006801.5	2021-08-30	申请日起二十年	原始取得
38	一种半导体反应设备及其位置校准方法	发明	ZL202111005062.8	2021-08-30	申请日起二十年	原始取得
39	FINFET 多输入标准单元版图结构及半导体器件	发明	ZL202111005046.9	2021-08-30	申请日起二十年	原始取得
40	缺陷忽视区域的自计算方法及装置	发明	ZL202110865251.6	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
41	一种垂直栅半导体器件的制备方法	发明	ZL202110865250.1	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
42	半导体器件的制备方法	发明	ZL202110865223.4	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
43	显影方法及显影装置	发明	ZL202110865198.X	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
44	OPC 热点的修补方法	发明	ZL202110865191.8	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
45	半导体器件的制备方法	发明	ZL202110865147.7	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
46	测试结构及测试方法	发明	ZL202110748238.2	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
47	自动物料传输系统及自动化物料传输方法	发明	ZL202110748236.3	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
48	浅沟槽隔离能力测试结构及其测试方法	发明	ZL202110728159.5	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
49	通孔层的 OPC 热点的修补方法	发明	ZL202110728158.0	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
50	计算机存储介质、禁跑货物预警系统及方法	发明	ZL202110728140.0	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
51	MOSFET 本征电压的模拟计算方法	发明	ZL202110728116.7	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
52	图像传感器及其制造方法	发明	ZL202110607036.6	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
53	TEM 样品的制备方法	发明	ZL202110593171.X	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
54	与非型闪存器件的接触孔制造方法	发明	ZL202110593161.6	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
55	半导体器件	发明	ZL202110593143.8	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
56	在制品数量的预测方法及预测系统	发明	ZL202110591292.0	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
57	掩模板及监控遮光板位置的方法	发明	ZL202110591286.5	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
58	闪存器件及其制造方法	发明	ZL202110591283.1	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
59	一种 SONOS 器件的制作方法	发明	ZL202110469842.1	2021-04-28	申请日起二十年	原始取得
60	测试结构及测试方法	发明	ZL202110469820.5	2021-04-28	申请日起二十年	原始取得
61	晶圆背面清洁装置、浸没式光刻机及晶圆背面清洁方法	发明	ZL202110469812.0	2021-04-28	申请日起二十年	原始取得
62	电阻失配模型及提取方法	发明	ZL202110354884.0	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
63	版图结构及芯片的测试方法	发明	ZL202110354882.1	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
64	一种图像传感器的制作方法	发明	ZL202110343076.4	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
65	监控特殊形貌颗粒缺陷的方法	发明	ZL202110343035.5	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
66	MOS 器件闪烁噪声模型及提取方法	发明	ZL202110343014.3	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
67	光掩模结构和光刻设备	发明	ZL202110342840.6	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
68	三维结构的天线效应的判断方法	发明	ZL202110342820.9	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
69	半导体器件的制备方法	发明	ZL202110342807.3	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
70	化学机械研磨工艺模型的预测方法	发明	ZL202110340990.3	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
71	晶边缺陷自动对焦系统及方法和计算机存储介质	发明	ZL202110340985.2	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
72	半导体生产制造中 lot 实时追踪及分析方法及系统	发明	ZL202110278683.7	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
73	针对 SRAM 图形 OPC 一致性检测的方法	发明	ZL202110278678.6	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
74	带失效分析标尺的电迁移测试结构	发明	ZL202110278611.2	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
75	一种固定宽度的单位方块电阻建模方法	发明	ZL202110274611.5	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
76	一种晶圆切割方法	发明	ZL202110274604.5	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
77	一种查询中断晶圆批次 LOT 的方法及系统	发明	ZL202110274242.X	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
78	一种栅约束 NPN 三极管型 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL202110209885.6	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
79	或非型闪存器件及其制造方法	发明	ZL202110209863.X	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
80	NOR FLASH 的形成方法	发明	ZL202110209862.5	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
81	一种缺陷检测方法	发明	ZL202110209860.6	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
82	NOR FLASH 的形成方法	发明	ZL202110209856.X	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
83	一种栅约束 NPN 三极管型 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL202110209122.1	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
84	一种闪存存储器字线驱动电路	发明	ZL202110209114.7	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
85	一种具有数据保持功能的低功耗静态随机存取存储器电路	发明	ZL202110209113.2	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
86	或非型闪存器件及其制造方法	发明	ZL202110209103.9	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
87	基于神经网络的存储器地址的测试方法及测试装置	发明	ZL202110167504.2	2021-02-07	申请日起二十年	原始取得
88	芯片的图形密度的分析方法、装置及电子设备	发明	ZL202110119198.5	2021-01-28	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
89	一种光阻供应系统	发明	ZL202110117648.7	2021-01-28	申请日起二十年	原始取得
90	一种基于 WCF 的分布式报表系统	发明	ZL202110117638.3	2021-01-28	申请日起二十年	原始取得
91	一种异常检测方法及装置	发明	ZL202110105541.0	2021-01-26	申请日起二十年	原始取得
92	半导体结构分析方法	发明	ZL202110105536.X	2021-01-26	申请日起二十年	原始取得
93	半导体测试结构及测试方法	发明	ZL202110103680.X	2021-01-26	申请日起二十年	原始取得
94	推挽结构输出电路	发明	ZL202011563490.8	2020-12-25	申请日起二十年	原始取得
95	用于 SAR-ADC 中差分输出共模电压可控的 DAC 电路及其控制方法	发明	ZL202011563240.4	2020-12-25	申请日起二十年	原始取得
96	一种版图 DRC 违例的对比和定位方法	发明	ZL202011563235.3	2020-12-25	申请日起二十年	原始取得
97	efuse 单元结构、efuse 单元的双列结构及 efuse 单元结构的应用电路	发明	ZL202011562191.2	2020-12-25	申请日起二十年	原始取得
98	涂胶显影设备的稳压装置以及涂胶显影设备	发明	ZL202011486095.4	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
99	掩模版及其制备方法、光刻机	发明	ZL202011486091.6	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
100	炉管工艺的派工优化方法	发明	ZL202011486070.4	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
101	半导体结构及其制备方法	发明	ZL202011486015.5	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
102	分裂栅闪存单元	发明	ZL202011483368.X	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
103	光罩位置匹配装置及其匹配方法、光刻机	发明	ZL202011483312.4	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
104	晶圆缺陷扫描系统及扫描方法和计算机存储介质	发明	ZL202011483296.9	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
105	图像传感器的制备方法	发明	ZL202011483214.0	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
106	一种浅沟槽隔离的制备方法	发明	ZL202011377953.1	2020-11-30	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
107	一种具有线性对数输出的 CIS 传感器	发明	ZL202011363476.3	2020-11-27	申请日起二十年	原始取得
108	半导体芯片缺陷定位方法和定位模块	发明	ZL202011362183.3	2020-11-27	申请日起二十年	原始取得
109	用于表征 PN 结耗尽区特征的 WAT 测试结构和方法	发明	ZL202011355641.0	2020-11-27	申请日起二十年	原始取得
110	阻变存储器及其制造方法	发明	ZL202011353688.3	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
111	CMOS 图像传感器的像素结构及像素结构的形成方法	发明	ZL202011353401.7	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
112	半导体结构及其制备方法	发明	ZL202011353399.3	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
113	SPICE 寿命模型的建模方法、调参方法及建模系统	发明	ZL202011347826.7	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
114	DFM 综合评分方法	发明	ZL202011347795.5	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
115	存储器阈值电压均匀性的电性测试方法	发明	ZL202011347770.5	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
116	SPICE 模型仿真系统及仿真方法	发明	ZL202011265291.9	2020-11-13	申请日起二十年	原始取得
117	光刻工艺热点的光学邻近修正的方法	发明	ZL202011199811.0	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
118	无回滞效应硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL202011196327.2	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
119	测试结构、测试结构版图及其形成方法和测试方法	发明	ZL202011192438.6	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
120	VT-BS 模型的先进工艺控制方法、系统及半导体设备	发明	ZL202011191797.X	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
121	栅极氧化层的形成方法	发明	ZL202011191792.7	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
122	改善顶层金属互联层表面缺陷的工艺方法	发明	ZL202011191791.2	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
123	半导体结构的刻蚀方法	发明	ZL202011187636.3	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
124	光学邻近修正方法	发明	ZL202011187204.2	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
125	半导体结构及其制备方法	发明	ZL202011187190.4	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
126	一种用于检测曝光机台透镜眩光程度的光掩膜版及方法	发明	ZL202011125663.8	2020-10-20	申请日起二十年	原始取得
127	一种硅控整流器及其制造方法	发明	ZL202011095029.4	2020-10-14	申请日起二十年	原始取得
128	基于自对准双重图形的产品良率在线评估系统及评估方法	发明	ZL202011094785.5	2020-10-14	申请日起二十年	原始取得
129	一种硅控整流器及其制造方法	发明	ZL202011094759.2	2020-10-14	申请日起二十年	原始取得
130	监测光刻机漏光情况的方法	发明	ZL202011026687.8	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
131	一种栅约束硅控整流器及其实现方法	发明	ZL202011026662.8	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
132	像素图形的预处理方法	发明	ZL202011026644.X	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
133	晶圆缺陷的监控方法	发明	ZL202011026627.6	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
134	提高版图边缘格点的预测准确率的方法	发明	ZL202011024116.0	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
135	一种栅约束硅控整流器及其实现方法	发明	ZL202011024063.2	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
136	一种栅约束硅控整流器及其实现方法	发明	ZL202011024051.X	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
137	CMOS 图像传感器的制作方法	发明	ZL202011024012.X	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
138	晶圆缺陷的验证方法	发明	ZL202011024000.7	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
139	改善栅极刻蚀形貌稳定性的方法和刻蚀设备	发明	ZL202011023983.2	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
140	双重图形氧化硅芯轴制备方法	发明	ZL202010894940.5	2020-08-31	申请日起二十年	原始取得
141	接触孔光刻工艺热点的光学邻近修正方法	发明	ZL202010891829.0	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
142	快速热退火设备	发明	ZL202010884966.1	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
143	提升静电吸盘使用寿命的方法	发明	ZL202010884946.4	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
144	一种高精度温度模型校准方法及系统	发明	ZL202010884907.4	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
145	增强二维图形 OPC 模型精度的方法	发明	ZL202010884893.6	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
146	半导体结构的制备方法	发明	ZL202010884286.X	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
147	改善通孔刻蚀残留的方法	发明	ZL202010884276.6	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
148	退火设备的温度监控方法	发明	ZL202010884274.7	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
149	金属层光刻工艺热点的修复方法	发明	ZL202010884271.3	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
150	一种高利用率的电阻并联结构	发明	ZL202010884261.X	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
151	判断研磨头的胶膜是否扭曲的方法	发明	ZL202010884254.X	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
152	闪存存储器及其制造方法	发明	ZL202010884241.2	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
153	优化冗余图形的方法	发明	ZL202010884240.8	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
154	MOSFET 阈值电压的 SPICE 子电路模型建模方法	发明	ZL202010884236.1	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
155	刻蚀工艺的切换方法	发明	ZL202010840249.9	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
156	掩膜版及其制备方法	发明	ZL202010833559.8	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
157	提高金属层和通孔层之间的覆盖率的 OPC 处理方法	发明	ZL202010833535.2	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
158	版图的特征图形的识别方法	发明	ZL202010832188.1	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
159	深沟槽隔离结构的制备方法及半导体结构	发明	ZL202010832187.7	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
160	绿色版图的认证方法及预警点的风险性的判断方法	发明	ZL202010832185.8	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
161	光刻标记、对准标记及对准方法	发明	ZL202010832174.X	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
162	图像传感器金属栅格版图的生成方法及金属栅格光罩图形	发明	ZL202010832168.4	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
163	提高 OPC 修正效率的方法	发明	ZL202010832140.0	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
164	栅氧化层测试结构及其制造方法、栅氧化层测试基板	发明	ZL202010811326.8	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
165	一种集成电路数字后端设计的方法和系统	发明	ZL202010803517.X	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
166	只读存储器阵列结构、电子设备、扩展方法及编码方法	发明	ZL202010802417.5	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
167	版图图形密度的分析方法	发明	ZL202010802392.9	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
168	判断扫描电子显微镜机台是否倾斜的方法	发明	ZL202010802383.X	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
169	一种优化光学邻近效应修正中曝光辅助图形的方法	发明	ZL202010802375.5	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
170	电可编程熔丝系统及其编程方法、读取方法	发明	ZL202010762700.X	2020-07-31	申请日起二十年	原始取得
171	可编程电路及其编程方法、读取方法	发明	ZL202010760424.3	2020-07-31	申请日起二十年	原始取得
172	一种深沟槽隔离栅格结构的制造方法	发明	ZL202010745346.X	2020-07-29	申请日起二十年	原始取得
173	晶片传送装置及 PVD 机台	发明	ZL202010717946.5	2020-07-23	申请日起二十年	原始取得
174	温度控制电路、装置、芯片封装测试系统	发明	ZL202010717932.3	2020-07-23	申请日起二十年	原始取得
175	半导体结构的形成方法	发明	ZL202010717830.1	2020-07-23	申请日起二十年	原始取得
176	一种压控振荡器结构及锁相环	发明	ZL202010717303.0	2020-07-23	申请日起二十年	原始取得
177	一种 SONOS 存储器及其制造方法	发明	ZL202010698851.3	2020-07-20	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
178	半导体测试结构及测试方法	发明	ZL202010695542.0	2020-07-16	申请日起二十年	原始取得
179	提升高压集成电路防负电流闩锁能力的保护环及实现方法	发明	ZL202010694335.3	2020-07-17	申请日起二十年	原始取得
180	提升高压集成电路防负电流闩锁能力的保护环及实现方法	发明	ZL202010693328.1	2020-07-17	申请日起二十年	原始取得
181	电迁移测试结构	发明	ZL202010611427.0	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
182	MOSFET 器件的全局工艺角模型的建模方法	发明	ZL202010611393.5	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
183	电迁移测试结构	发明	ZL202010611392.0	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
184	MPW 多产品联测的数据处理方法、存储介质及计算机设备	发明	ZL202010609717.1	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
185	版图分析管控标准的计算方法及版图分析的管控方法	发明	ZL202010609716.7	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
186	转移管的垂直栅及 CMOS 传感器的形成方法	发明	ZL202010609712.9	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
187	晶圆缺陷检测方法及系统	发明	ZL202010577852.2	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
188	下字线驱动读辅助电路和版图设计	发明	ZL202010577071.3	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
189	晶背缺陷图检索及预警方法、存储介质及计算机设备	发明	ZL202010577051.6	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
190	OPC 修正通孔的选择方法	发明	ZL202010576117.X	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
191	时钟信号调节电路和方法以及模拟电路	发明	ZL202010576116.5	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
192	失效数据修复电路和方法、非挥发性存储器、可读存储介质	发明	ZL202010576095.7	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
193	一种网格图形统一尺寸的方法、存储介质及计算机设备	发明	ZL202010576089.1	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
194	版图图形精准匹配的检查方法	发明	ZL202010576088.7	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
195	金属线版图设计规则检查方法	发明	ZL202010576086.8	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
196	冗余图形的检测方法	发明	ZL202010479608.2	2020-05-29	申请日起二十年	原始取得
197	源极跟随管及 CMOS 传感器的形成方法	发明	ZL202010478077.5	2020-05-29	申请日起二十年	原始取得
198	晶圆缺陷监控系统及其监控方法	发明	ZL202010414919.0	2020-05-15	申请日起二十年	原始取得
199	一种通用的芯片测试系统、测试方法及存储介质	发明	ZL202010414915.2	2020-05-15	申请日起二十年	原始取得
200	RRAM 阻变结构的形成方法	发明	ZL202010413713.6	2020-05-15	申请日起二十年	原始取得
201	一种硅控整流器及其制造方法	发明	ZL202010350856.7	2020-04-28	申请日起二十年	原始取得
202	一种硅控整流器及其制造方法	发明	ZL202010350852.9	2020-04-28	申请日起二十年	原始取得
203	NMOS 器件的制备方法	发明	ZL202010345511.2	2020-04-27	申请日起二十年	原始取得
204	NMOS 晶体管器件速度的补偿方法	发明	ZL202010344615.1	2020-04-27	申请日起二十年	原始取得
205	金属线自对准二次成型工艺方法	发明	ZL202010344600.5	2020-04-27	申请日起二十年	原始取得
206	SONOS 存储器及其制作方法	发明	ZL202010231443.7	2020-03-27	申请日起二十年	原始取得
207	一种双向硅控整流器及其制备方法	发明	ZL202010231324.1	2020-03-27	申请日起二十年	原始取得
208	一种堆叠电容、闪存器件及其制造方法	发明	ZL202010224926.4	2020-03-26	申请日起二十年	原始取得
209	晶圆边缘缺陷检测系统及方法	发明	ZL202010183596.9	2020-03-16	申请日起二十年	原始取得
210	一种设置研磨时间上限和研磨时间下限的方法及装置	发明	ZL202010183587.X	2020-03-16	申请日起二十年	原始取得
211	一次性可编程器件的制造方法及一次	发明	ZL202010164411.X	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	性可编程器件					
212	一种检测晶圆缺陷的方法及装置	发明	ZL202010159765.5	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
213	存储器的形成方法	发明	ZL202010159638.5	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
214	SONOS 器件的制作方法	发明	ZL202010159625.8	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
215	半导体的形成方法	发明	ZL202010159624.3	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
216	改善光刻机对准的方法	发明	ZL202010159622.4	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
217	过曝图形漏报错的检查方法、计算机设备及存储介质	发明	ZL202010104683.0	2020-02-20	申请日起二十年	原始取得
218	一种单元标记及其设计方法	发明	ZL202010104156.X	2020-02-20	申请日起二十年	原始取得
219	一种 efuse 熔丝的版图结构	发明	ZL202010063863.9	2020-01-20	申请日起二十年	原始取得
220	一种并行冗余修正电路	发明	ZL202010053416.5	2020-01-17	申请日起二十年	原始取得
221	检测闪存位线之间漏电结构的制造方法及漏电检测方法	发明	ZL201911360934.5	2019-12-25	申请日起二十年	原始取得
222	缺陷监控方法	发明	ZL201911360930.7	2019-12-25	申请日起二十年	原始取得
223	减小关键尺寸漂移的方法	发明	ZL201911360926.0	2019-12-25	申请日起二十年	原始取得
224	写入辅助电路、存储器及写入操作方法	发明	ZL201911359172.7	2019-12-25	申请日起二十年	原始取得
225	冗余结构及其形成方法	发明	ZL201911334713.0	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
226	浮栅型闪存的制作方法	发明	ZL201911334533.2	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
227	半导体器件的形成方法	发明	ZL201911334529.6	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
228	对准方法及校准方法	发明	ZL201911334523.9	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
229	光罩组件以及光刻方法	发明	ZL201911334500.8	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
230	标准单元库的测试方法	发明	ZL201911334496.5	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
231	用于形成空气间隔的存储器制造方法	发明	ZL201911291112.6	2019-12-16	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
232	闪存的制造方法及闪存	发明	ZL201911261707.7	2019-12-10	申请日起二十年	原始取得
233	半导体测试结构及测试方法	发明	ZL201911261700.5	2019-12-10	申请日起二十年	原始取得
234	半导体器件的形成方法	发明	ZL201911260210.3	2019-12-10	申请日起二十年	原始取得
235	阻变存储器及其制造方法	发明	ZL201911255220.8	2019-12-09	申请日起二十年	原始取得
236	测试方法	发明	ZL201911255219.5	2019-12-09	申请日起二十年	原始取得
237	半导体结构、晶体管、可变电容及元器件	发明	ZL201911252048.0	2019-12-09	申请日起二十年	原始取得
238	芯轴图形的形成方法	发明	ZL201911204018.2	2019-11-29	申请日起二十年	原始取得
239	闪存器件的形成方法	发明	ZL201911204016.3	2019-11-29	申请日起二十年	原始取得
240	跳线装置	发明	ZL201911194919.8	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
241	版图优化方法	发明	ZL201911193288.8	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
242	检测晶片上下层叠对的方法和设备	发明	ZL201911186817.1	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
243	改善铝焊盘结晶缺陷的方法	发明	ZL201911186786.X	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
244	硅控整流器及其制造方法	发明	ZL201911186720.0	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
245	硅控整流器及其制造方法	发明	ZL201911186693.7	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
246	进样密封装置、气相色谱-质谱联用仪及色谱柱更换方法	发明	ZL201911185508.2	2019-11-27	申请日起二十年	原始取得
247	测试结构、失效分析定位方法及失效分析方法	发明	ZL201911183955.4	2019-11-27	申请日起二十年	原始取得
248	改善 2D-NAND 侧墙倾斜的方法	发明	ZL201911183942.7	2019-11-27	申请日起二十年	原始取得
249	电平转换电路	发明	ZL201911173830.3	2019-11-26	申请日起二十年	原始取得
250	占空比 50%的连续整数分频器及包括其的锁相环电路	发明	ZL201911162944.8	2019-11-25	申请日起二十年	原始取得
251	掩膜版和标准片及对准图形误差补偿	发明	ZL201911162936.3	2019-11-25	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	方法					
252	金属硬质掩模一体化刻蚀方法及其控制系统	发明	ZL201911162919.X	2019-11-25	申请日起二十年	原始取得
253	光刻层掩膜版的制备方法、离子注入方法	发明	ZL201911147979.4	2019-11-21	申请日起二十年	原始取得
254	晶圆缺陷扫描方法	发明	ZL201911137379.X	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
255	MOS 器件的制造方法	发明	ZL201911136246.0	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
256	去胶设备、顶针监控方法和去胶工艺	发明	ZL201911136237.1	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
257	一种缺陷观测机台及其的图像分析补偿方法	发明	ZL201911133518.1	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
258	TechLEF 文件验证方法及其验证系统	发明	ZL201911133493.5	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
259	存储器读取速度调节电路	发明	ZL201911133050.6	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
260	n 倍驱动两输入与非门标准单元及其版图	发明	ZL201911133036.6	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
261	一种垂直栅 CMOS 图像传感器及制造方法	发明	ZL201911133006.5	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
262	一种改善小像素 CMOS 图像传感器性能的结构和工艺方法	发明	ZL201911132999.4	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
263	字线制作方法	发明	ZL201911095517.2	2019-11-11	申请日起二十年	原始取得
264	产品关键层的平均相似度计算方法及产品良率预测方法	发明	ZL201911090135.0	2019-11-08	申请日起二十年	原始取得
265	确定合适的 OPC 修正程序的方法及装置、掩膜版及优化方法	发明	ZL201911089066.1	2019-11-08	申请日起二十年	原始取得
266	晶背扫描仪、晶背扫描方法和晶圆扫	发明	ZL201911089034.1	2019-11-08	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	描方法					
267	浅沟槽隔离结构及其形成方法、半导体器件的制作方法	发明	ZL201911046453.7	2019-10-30	申请日起二十年	原始取得
268	水循环装置及水循环系统	发明	ZL201911025742.9	2019-10-25	申请日起二十年	原始取得
269	刻蚀方法以及半导体器件的制造方法	发明	ZL201911024501.2	2019-10-25	申请日起二十年	原始取得
270	一种内嵌硅控整流器的 PMOS 器件及其实现方法	发明	ZL201910969259.X	2019-10-12	申请日起二十年	原始取得
271	无回滞效应硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201910969256.6	2019-10-12	申请日起二十年	原始取得
272	基于 FDSOI 结构的电平转换单元电路及版图设计方法	发明	ZL201910969246.2	2019-10-12	申请日起二十年	原始取得
273	一种提取用于透射电子显微镜的待测样品的方法	发明	ZL201910968721.4	2019-10-12	申请日起二十年	原始取得
274	RRAM 阻变结构下电极的工艺方法	发明	ZL201910914898.6	2019-09-26	申请日起二十年	原始取得
275	原子层沉积法形成氮化物膜的方法	发明	ZL201910912457.2	2019-09-25	申请日起二十年	原始取得
276	版图图形密度的分析方法	发明	ZL201910906283.9	2019-09-24	申请日起二十年	原始取得
277	Flash 器件耐久性能测试方法	发明	ZL201910898039.2	2019-09-23	申请日起二十年	原始取得
278	改善刻蚀腔体缺陷的方法	发明	ZL201910897996.3	2019-09-23	申请日起二十年	原始取得
279	一种评估 CIS 产品不同机台白色像素差异的方法	发明	ZL201910897871.0	2019-09-23	申请日起二十年	原始取得
280	电迁移可靠性测试结构及电迁移可靠性测试方法	发明	ZL201910897833.5	2019-09-23	申请日起二十年	原始取得
281	一种应用于锁相环的基于频率比较的锁定指示电路及方法	发明	ZL201910891665.9	2019-09-20	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
282	聚合物的去除方法	发明	ZL201910891638.1	2019-09-20	申请日起二十年	原始取得
283	光源优化方法、光源优化装置、光刻系统及光刻方法	发明	ZL201910891431.4	2019-09-20	申请日起二十年	原始取得
284	浸没式光刻工艺中晶圆表面残水缺陷的改善方法	发明	ZL201910891416.X	2019-09-20	申请日起二十年	原始取得
285	浅沟道隔离结构中的孔洞缺陷的检测方法	发明	ZL201910849214.9	2019-09-09	申请日起二十年	原始取得
286	套刻精度修正方法	发明	ZL201910818292.2	2019-08-30	申请日起二十年	原始取得
287	金属互连线填充方法	发明	ZL201910818279.7	2019-08-30	申请日起二十年	原始取得
288	CMOS 传感器及 CMOS 传感器的形成方法	发明	ZL201910816560.7	2019-08-30	申请日起二十年	原始取得
289	改善栅极氧化层的方法及半导体器件的制造方法	发明	ZL201910816556.0	2019-08-30	申请日起二十年	原始取得
290	一种栅约束硅控整流器 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL201910809929.1	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
291	一种栅约束硅控整流器 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL201910809608.1	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
292	缺陷扫描机台间高匹配度扫描程式的快速建立方法	发明	ZL201910809109.2	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
293	版图修正方法	发明	ZL201910809085.0	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
294	一种化学机械研磨机台缺陷检测方法	发明	ZL201910809015.5	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
295	一种栅约束硅控整流器 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL201910809013.6	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
296	阻变存储器的制备方法	发明	ZL201910808942.5	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
297	一种新型栅控 P-i-N 二极管 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL201910808934.0	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
298	金属填充缺陷的检测结构及其方法	发明	ZL201910808932.1	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
299	栅约束硅控整流器 ESD 器件及其制作方法	发明	ZL201910808916.2	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
300	半导体器件的形成方法	发明	ZL201910808827.8	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
301	一种内嵌硅控整流器的 PMOS 器件及其实现方法	发明	ZL201910808797.0	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
302	标准晶片及其制造方法	发明	ZL201910808692.5	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
303	振荡器	发明	ZL201910777059.4	2019-08-22	申请日起二十年	原始取得
304	晶圆表面电荷消除装置及方法	发明	ZL201910777052.2	2019-08-22	申请日起二十年	原始取得
305	一种建立晶圆背面图形数据库的方法	发明	ZL201910777051.8	2019-08-22	申请日起二十年	原始取得
306	一种栅控 P-i-N 二极管及其制造方法	发明	ZL201910763000.X	2019-08-19	申请日起二十年	原始取得
307	一种截取锥清洗装置及使用方法	发明	ZL201910762887.0	2019-08-19	申请日起二十年	原始取得
308	一种晶圆表面超小尺寸缺陷检测方法	发明	ZL201910762878.1	2019-08-19	申请日起二十年	原始取得
309	一种晶圆缺陷标记装置及晶圆缺陷标记方法	发明	ZL201910698776.8	2019-07-31	申请日起二十年	原始取得
310	半导体器件的形成方法	发明	ZL201910698753.7	2019-07-31	申请日起二十年	原始取得
311	套准标记及其形成方法	发明	ZL201910678518.3	2019-07-25	申请日起二十年	原始取得
312	OPC 修正程序的 MRC 取值方法	发明	ZL201910678510.7	2019-07-25	申请日起二十年	原始取得
313	电迁移测试结构及方法	发明	ZL201910677450.7	2019-07-25	申请日起二十年	原始取得
314	一种具备修正功能的 antifuse 电路	发明	ZL201910670124.3	2019-07-24	申请日起二十年	原始取得
315	闪存的分裂栅极的制造方法	发明	ZL201910659098.4	2019-07-22	申请日起二十年	原始取得
316	触点单元结构及其构成的矩阵探针卡	发明	ZL201910643613.X	2019-07-17	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
317	离线量产产品工艺参数调整方法及其调整系统	发明	ZL201910571300.8	2019-06-28	申请日起二十年	原始取得
318	闪存的制造方法、闪存储器及光罩掩膜版	发明	ZL201910541255.1	2019-06-21	申请日起二十年	原始取得
319	色谱柱辅助安装工具及色谱柱安装方法	发明	ZL201910538137.5	2019-06-20	申请日起二十年	原始取得
320	芯片拼接方法	发明	ZL201910529990.0	2019-06-19	申请日起二十年	原始取得
321	锁存器	发明	ZL201910476094.2	2019-06-03	申请日起二十年	原始取得
322	半导体器件隔离侧墙厚度计算方法及其计算系统	发明	ZL201910476089.1	2019-06-03	申请日起二十年	原始取得
323	CMOS 图像传感器及其制造方法	发明	ZL201910452540.6	2019-05-28	申请日起二十年	原始取得
324	半导体器件的形成方法	发明	ZL201910450593.4	2019-05-28	申请日起二十年	原始取得
325	MOS_D 晶体管及其构成的 ESD 保护电路	发明	ZL201910432616.9	2019-05-23	申请日起二十年	原始取得
326	一种缺陷检测系统、检测方法及电子束扫描机台	发明	ZL201910386157.5	2019-05-09	申请日起二十年	原始取得
327	OPC 修正方法及 OPC 修正系统	发明	ZL201910385297.0	2019-05-09	申请日起二十年	原始取得
328	全局快门 CMOS 图像传感器	发明	ZL201910382534.8	2019-05-09	申请日起二十年	原始取得
329	基于 FinFET 结构的高速标准单元库版图设计方法	发明	ZL201910382478.8	2019-05-09	申请日起二十年	原始取得
330	一种分离栅闪存单元的半导体结构及其制造方法	发明	ZL201910362571.2	2019-04-30	申请日起二十年	原始取得
331	CMOS 图像传感器的形成方法	发明	ZL201910358958.0	2019-04-29	申请日起二十年	原始取得
332	一种自对准双层图形的形成方法	发明	ZL201910313973.3	2019-04-18	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
333	一种半导体结构及其制造方法	发明	ZL201910265516.1	2019-04-03	申请日起二十年	原始取得
334	一种防止 ONO 刻蚀造成衬底损伤的方法	发明	ZL201910244692.7	2019-03-28	申请日起二十年	原始取得
335	一种辅助对准方法及系统	发明	ZL201910234065.5	2019-03-26	申请日起二十年	原始取得
336	一种用于改善硅片翘曲度并提高套刻精度的方法	发明	ZL201910177307.1	2019-03-08	申请日起二十年	原始取得
337	一种侧墙结构的形成方法	发明	ZL201910173445.2	2019-03-07	申请日起二十年	原始取得
338	一种晶圆清洗干燥装置、方法及化学机械研磨机台	发明	ZL201910173003.8	2019-03-07	申请日起二十年	原始取得
339	掩膜版、闪存器件及其制造方法	发明	ZL201910172994.8	2019-03-07	申请日起二十年	原始取得
340	闪存器件及其制造方法	发明	ZL201910172992.9	2019-03-07	申请日起二十年	原始取得
341	一种形成随机存储器层的方法	发明	ZL201910157174.1	2019-03-01	申请日起二十年	原始取得
342	一种探针卡的针尖的智能检测及处理方法	发明	ZL201910157146.X	2019-03-01	申请日起二十年	原始取得
343	一种分析半导体晶圆的方法及装置	发明	ZL201811636763.X	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
344	NOR FLASH 器件结构及其制造方法	发明	ZL201811632627.3	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
345	晶圆的晶边缺陷的监控方法	发明	ZL201811632588.7	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
346	STI 的填充方法	发明	ZL201811632345.3	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
347	SOI 二极管	发明	ZL201811632266.2	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
348	晶圆制造中在线产品批次跑货状态的分析预测方法	发明	ZL201811630469.8	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
349	拼接产品的测试光罩及其组合方法	发明	ZL201811630468.3	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
350	分栅闪存的制造方法	发明	ZL201811630467.9	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
351	NOR 闪存及其制造方法	发明	ZL201811630391.X	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
352	分栅闪存的测试结构及其制造方法	发明	ZL201811630384.X	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
353	缺陷监控分析系统及方法	发明	ZL201811630264.X	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
354	台阶状 ONO 薄膜的刻蚀方法	发明	ZL201811607216.9	2018-12-27	申请日起二十年	原始取得
355	电子束扫描机台电子束孔径动态调整结构及测试方法	发明	ZL201811607200.8	2018-12-27	申请日起二十年	原始取得
356	一种自动扫描缺陷的方法	发明	ZL201811595214.2	2018-12-25	申请日起二十年	原始取得
357	晶圆刻蚀系统及晶圆刻蚀方法	发明	ZL201811580776.X	2018-12-24	申请日起二十年	原始取得
358	一种提高混合刻蚀工艺稳定性的方法	发明	ZL201811557616.3	2018-12-19	申请日起二十年	原始取得
359	一种提高刻蚀腔电流稳定性的方法	发明	ZL201811557608.9	2018-12-19	申请日起二十年	原始取得
360	分离栅 flash 器件的工艺方法	发明	ZL201811553752.5	2018-12-19	申请日起二十年	原始取得
361	去除侧壁 ONO 结构中阻挡氧化层残留的工艺方法	发明	ZL201811516115.0	2018-12-12	申请日起二十年	原始取得
362	晶体管电性测试结构及测试方法	发明	ZL201811477002.4	2018-12-05	申请日起二十年	原始取得
363	一种处理半导体晶圆的方法	发明	ZL201811471840.0	2018-12-04	申请日起二十年	原始取得
364	一种晶圆转速监控装置及监控方法	发明	ZL201811467391.2	2018-12-03	申请日起二十年	原始取得
365	气体注入装置及高温炉管	发明	ZL201811460120.4	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
366	源漏极离子注入方法及注入系统	发明	ZL201811460106.4	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
367	一种改善衬底缺陷处的图形刻蚀的方法	发明	ZL201811458598.3	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
368	SRAM 测试结构	发明	ZL201811458597.9	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
369	半导体器件的缺陷检测结构、装置及其检测方法	发明	ZL201811458596.4	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
370	半导体结构的制备方法	发明	ZL201811458583.7	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
371	一种双大马士革结构的形成方法	发明	ZL201811458561.0	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
372	一种 MOS 晶体管栅极小信号电容测试方法及系统	发明	ZL201811458548.5	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
373	电阻模型的建立方法	发明	ZL201811458546.6	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
374	酸槽式湿法刻蚀工艺	发明	ZL201811458540.9	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
375	一种自对准双层图形的形成方法	发明	ZL201811458523.5	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
376	一种 LOD 应力效应 SPICE 建模的方法	发明	ZL201811458514.6	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
377	改善自对准像素单元满阱容量的 CMOS 图像传感器	发明	ZL201811458508.0	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
378	晶圆缺陷扫描方法	发明	ZL201811458489.1	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
379	一种 MRC 冲突协同优化算法	发明	ZL201811458473.0	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
380	一种晶圆缺陷扫描方法	发明	ZL201811458460.3	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
381	一种 SONOS 存储结构及其制造方法	发明	ZL201811444528.2	2018-11-29	申请日起二十年	原始取得
382	一种刻蚀方法及半导体器件	发明	ZL201811432033.8	2018-11-28	申请日起二十年	原始取得
383	一种验证设计规则检查脚本的方法	发明	ZL201811408981.8	2018-11-23	申请日起二十年	原始取得
384	Interconnect 电容值 SPICE 建模方法	发明	ZL201811396797.6	2018-11-22	申请日起二十年	原始取得
385	半导体产品良率上限分析方法	发明	ZL201811396608.5	2018-11-22	申请日起二十年	原始取得
386	SONOS 器件的制造方法	发明	ZL201811396604.7	2018-11-22	申请日起二十年	原始取得
387	栅极结构的制造方法	发明	ZL201811396595.1	2018-11-22	申请日起二十年	原始取得
388	一种晶粒缺陷监控方法	发明	ZL201811369312.4	2018-11-16	申请日起二十年	原始取得
389	一种检测机台的派工方法	发明	ZL201811368312.2	2018-11-16	申请日起二十年	原始取得
390	一种离子注入的方法及设备	发明	ZL201811344422.5	2018-11-13	申请日起二十年	原始取得
391	一种缺陷抽检方法	发明	ZL201811340879.9	2018-11-12	申请日起二十年	原始取得
392	一种通过光阻膜厚监控涂胶显影机台	发明	ZL201811302702.X	2018-11-02	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	涂胶槽水平程度的方法					
393	一种优化通孔层连接性能的光学邻近修正方法	发明	ZL201811289318.0	2018-10-31	申请日起二十年	原始取得
394	闪存的制造方法	发明	ZL201811281931.8	2018-10-31	申请日起二十年	原始取得
395	一种优化势垒区像素离子注入改善串扰的方法	发明	ZL201811246105.X	2018-10-24	申请日起二十年	原始取得
396	改善分栅结构闪存多步多晶硅刻蚀损伤的工艺集成方法	发明	ZL201811217631.3	2018-10-18	申请日起二十年	原始取得
397	一种改善 SONOS 存储器之多晶硅薄膜沉积特性的方法	发明	ZL201811217621.X	2018-10-18	申请日起二十年	原始取得
398	闪存器件的制造方法	发明	ZL201811216570.9	2018-10-18	申请日起二十年	原始取得
399	一种膜质监控方法及装置	发明	ZL201811216561.X	2018-10-18	申请日起二十年	原始取得
400	一种光学临近修正前的预处理方法	发明	ZL201811204210.7	2018-10-16	申请日起二十年	原始取得
401	一种阈值可调式高压金属氧化物半导体器件及其制备方法	发明	ZL201811198257.7	2018-10-15	申请日起二十年	原始取得
402	一种样品去层次方法	发明	ZL201811198243.5	2018-10-15	申请日起二十年	原始取得
403	一种图形密度的分析方法	发明	ZL201811154697.2	2018-09-30	申请日起二十年	原始取得
404	闪存结构及其控制方法	发明	ZL201811134024.0	2018-09-27	申请日起二十年	原始取得
405	闪存结构及对应的编程、擦除和读取方法	发明	ZL201811132953.8	2018-09-27	申请日起二十年	原始取得
406	一种涂布机构以及在硅片上涂布 HMDS 的方法	发明	ZL201811064491.0	2018-09-12	申请日起二十年	原始取得
407	应用于高压电路防静电保护的无回滞效应硅控整流器	发明	ZL201811064488.9	2018-09-12	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
408	缺陷过滤系统及过滤方法和计算机存储介质	发明	ZL201811063793.6	2018-09-12	申请日起二十年	原始取得
409	一种刻蚀副产物智能自清洁方法	发明	ZL201811026563.2	2018-09-04	申请日起二十年	原始取得
410	一种形成金属扩散阻挡层的方法	发明	ZL201811015325.1	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
411	晶圆缺陷检测系统及检测方法和计算机存储介质	发明	ZL201811014892.5	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
412	一种锁存电路	发明	ZL201811014888.9	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
413	故障设备识别系统及识别方法和计算机存储介质	发明	ZL201811014880.2	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
414	一种冗余图形添加方法	发明	ZL201811014864.3	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
415	一种像素结构及其制造方法	发明	ZL201811013688.1	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
416	晶圆清洗装置	发明	ZL201811013483.3	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
417	一种多晶层光刻工艺热点查找方法	发明	ZL201811012246.5	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
418	一种校正及监测铜电镀中洗边位置的方法	发明	ZL201811012214.5	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
419	一种一体化刻蚀方法	发明	ZL201811011770.0	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
420	一种掩模版的制备方法	发明	ZL201811011755.6	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
421	控片及其制造方法和化学机械研磨缺陷的监测方法	发明	ZL201811011719.X	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
422	一种 CMOS 图像传感器的形成方法	发明	ZL201811011675.0	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
423	一种形成具有高深宽比图形的结构的方法	发明	ZL201810941652.3	2018-08-17	申请日起二十年	原始取得
424	改善高深宽比图形不一致和提高光刻胶形貌陡度的方法	发明	ZL201810927353.4	2018-08-15	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
425	去除光刻胶层的方法	发明	ZL201810898935.4	2018-08-08	申请日起二十年	原始取得
426	改善闪存单元擦除相关失效的工艺集成方法	发明	ZL201810840312.1	2018-07-27	申请日起二十年	原始取得
427	改善 N 型 SONOS 器件阈值电压均一性的方法	发明	ZL201810840290.9	2018-07-27	申请日起二十年	原始取得
428	基于 BSIM4 模型的 MOS 器件子电路温度模型及建模方法	发明	ZL201810840264.6	2018-07-27	申请日起二十年	原始取得
429	滤除图形匹配度误报错的方法	发明	ZL201810840252.3	2018-07-27	申请日起二十年	原始取得
430	一种 MOSFET 栅氧化层电容校准结构	发明	ZL201810800725.7	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
431	一种改善双重图形刻蚀芯模顶端圆角的工艺方法	发明	ZL201810800712.X	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
432	一种浅沟槽隔离结构的形成方法及浅沟槽隔离结构	发明	ZL201810800695.X	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
433	一种光刻工艺热点的检查方法	发明	ZL201810800585.3	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
434	一种应用于干法去胶工艺的匹配验证方法	发明	ZL201810800573.0	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
435	一种晶圆制程工艺参数的反馈方法	发明	ZL201810759253.5	2018-07-11	申请日起二十年	原始取得
436	一种半导体器件及其制造方法	发明	ZL201810714188.4	2018-06-29	申请日起二十年	原始取得
437	一种工艺控制方法	发明	ZL201810706079.8	2018-06-26	申请日起二十年	原始取得
438	检测晶圆工作台平坦度的方法	发明	ZL201810672956.4	2018-06-26	申请日起二十年	原始取得
439	快速热退火工艺能力的监控方法	发明	ZL201810672950.7	2018-06-26	申请日起二十年	原始取得
440	化学机械研磨设备工艺能力的监控方法	发明	ZL201810672949.4	2018-06-26	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
441	一种分裂栅结构下的浮栅隔离刻蚀工艺	发明	ZL201810632298.6	2018-06-19	申请日起二十年	原始取得
442	一种分裂栅结构下的侧墙栅极隔离刻蚀膜层工艺	发明	ZL201810632297.1	2018-06-19	申请日起二十年	原始取得
443	一种双大马士革结构的制作方法	发明	ZL201810604625.7	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
444	一种等离子体刻蚀的方法	发明	ZL201810604623.8	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
445	栅极区域的 OPC 验证方法	发明	ZL201810604622.3	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
446	一种存储单元模型的阈值电压调节方法和系统	发明	ZL201810604592.6	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
447	一种改善等离子体刻蚀工艺中首片效应的方法	发明	ZL201810604582.2	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
448	探针卡	发明	ZL201810604560.6	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
449	一种 SONOS 存储器及其制造方法	发明	ZL201810604556.X	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
450	一种划片区内的监控图形的排布方法	发明	ZL201810565129.5	2018-06-04	申请日起二十年	原始取得
451	金属离子监控方法	发明	ZL201810504049.9	2018-05-23	申请日起二十年	原始取得
452	一种应用于 SRAM 的可调节 WLUD 读写辅助电路	发明	ZL201810504047.X	2018-05-23	申请日起二十年	原始取得
453	一种化学气相淀积机台及处理机台报警的方法	发明	ZL201810503740.5	2018-05-23	申请日起二十年	原始取得
454	一种闪存单元结构的制备方法	发明	ZL201810428572.8	2018-05-07	申请日起二十年	原始取得
455	E-FUSE 存储阵列、E-FUSE 以及 E-FUSE 操作方法	发明	ZL201810388020.9	2018-04-26	申请日起二十年	原始取得
456	一种静电吸附盘的温度监控方法	发明	ZL201810387262.6	2018-04-26	申请日起二十年	原始取得
457	一种检测站的来料负荷控制方法	发明	ZL201810362521.X	2018-04-20	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
458	一种调试关键尺寸均匀性的方法	发明	ZL201810360659.6	2018-04-20	申请日起二十年	原始取得
459	一种晶圆的测试方法	发明	ZL201810355979.2	2018-04-19	申请日起二十年	原始取得
460	一种铜金属互连电迁移测试结构及其测试方法	发明	ZL201810316625.7	2018-04-10	申请日起二十年	原始取得
461	一种芯片测试装置、测试方法及测试板	发明	ZL201810298527.5	2018-04-03	申请日起二十年	原始取得
462	无回滞效应栅接地 NMOS 静电防护半导体器件及其实现方法	发明	ZL201810277913.6	2018-03-30	申请日起二十年	原始取得
463	一种改进型的多样品并行去封装方法	发明	ZL201810252902.2	2018-03-26	申请日起二十年	原始取得
464	获取晶圆晶背刮伤来源的方法	发明	ZL201810157691.4	2018-02-24	申请日起二十年	原始取得
465	芯片的测试方法	发明	ZL201810157468.X	2018-02-24	申请日起二十年	原始取得
466	一种检测晶圆上介质层孔道连通性的方法	发明	ZL201810153103.X	2018-02-11	申请日起二十年	原始取得
467	射频晶体管射频参数模型建立方法	发明	ZL201810114825.4	2018-02-06	申请日起二十年	原始取得
468	一种独立控温的用于可靠性测试的测试结构及其测试方法	发明	ZL201810096981.2	2018-01-31	申请日起二十年	原始取得
469	闪存的制造方法	发明	ZL201810084833.9	2018-01-29	申请日起二十年	原始取得
470	一种光刻胶回刻蚀工艺中改善晶圆表面颗粒缺陷的方法	发明	ZL201810069436.4	2018-01-24	申请日起二十年	原始取得
471	闪存	发明	ZL201810063032.4	2018-01-23	申请日起二十年	原始取得
472	闪存及其制造方法	发明	ZL201810063024.X	2018-01-23	申请日起二十年	原始取得
473	光刻胶去除方法	发明	ZL201810058404.4	2018-01-22	申请日起二十年	原始取得
474	闪存阵列的制作方法及闪存阵列	发明	ZL201711466172.8	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
475	一种电迁移加速测试方法	发明	ZL201711465933.8	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
476	无回滞效应硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201711464516.1	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
477	无回滞效应硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201711464508.7	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
478	一种闪烁噪声统计模型的建模方法及其提取方法	发明	ZL201711464504.9	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
479	OPC 建模中次分辨率辅助图形确定的方法	发明	ZL201711464502.X	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
480	适用于离子注入工艺套刻精度的评估方法	发明	ZL201711461652.5	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
481	一种带 SONOS 结构的晶体管及其制造方法	发明	ZL201711430506.6	2017-12-26	申请日起二十年	原始取得
482	改善 HTO 厚度稳定性的方法	发明	ZL201711419332.3	2017-12-25	申请日起二十年	原始取得
483	一种对插塞缺陷进行检测的方法	发明	ZL201711394241.9	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
484	一种版图重复单元匹配性检查方法及系统	发明	ZL201711394189.7	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
485	一种压控振荡器电路	发明	ZL201711394141.6	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
486	一种高可靠性读出电路	发明	ZL201711394120.4	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
487	去除斜边凸起的方法	发明	ZL201711394075.2	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
488	一种降低连接孔层程式运行时间的 OPC 修正方法	发明	ZL201711394054.0	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
489	一种 SPICE 集中模型的建模方法及系统	发明	ZL201711393123.6	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
490	一种电子束扫描程式参数自调整方法	发明	ZL201711393038.X	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
491	晶圆侧边去光阻方法	发明	ZL201711392379.5	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
492	一种 MOSFET 器件之全局工艺角模型的建模方法	发明	ZL201711392362.X	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
493	一种电感版图之辅助层及器件参数抽取的方法	发明	ZL201711392318.9	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
494	适用于随机存储器自动测试的高速电路结构及其测试方法	发明	ZL201711392308.5	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
495	SONOS 存储器的 ONO 刻蚀方法	发明	ZL201711392296.6	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
496	一种改善长寿命钽靶材后期使用的腔体套件结构	发明	ZL201711392270.1	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
497	具有侧墙型选择栅的非易失存储器及其制造方法	发明	ZL201711389221.2	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
498	一种检测多晶硅是否出现短路的检测方法	发明	ZL201711387149.X	2017-12-20	申请日起二十年	原始取得
499	一种通过增加热处理过程改善 CIS 白色像素点的方法	发明	ZL201711387099.5	2017-12-20	申请日起二十年	原始取得
500	一种带沟槽结构的双极型晶体管及其制作方法	发明	ZL201711374117.6	2017-12-19	申请日起二十年	原始取得
501	提高通孔层 OPC 精度的方法	发明	ZL201711345445.3	2017-12-15	申请日起二十年	原始取得
502	预调金属导线尺寸的方法	发明	ZL201711312299.4	2017-12-11	申请日起二十年	原始取得
503	优化不同透光率下浅槽隔离刻蚀形貌的方法	发明	ZL201711281769.5	2017-12-07	申请日起二十年	原始取得
504	改善金属层腐蚀缺陷方法	发明	ZL201711279353.X	2017-12-06	申请日起二十年	原始取得
505	监控 3D 栅极氧化层工艺的方法及结	发明	ZL201711244384.1	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	构					
506	金属互连结构及其制作方法	发明	ZL201711243083.7	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
507	避免控制栅形成中刻蚀返工导致无定型碳膜剥落的方法	发明	ZL201711242834.3	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
508	浅沟槽隔离的制造方法	发明	ZL201711241074.4	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
509	一种亮场缺陷检测设备自动优化光强条件的方法及系统	发明	ZL201711240724.3	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
510	一种金属连线恒温电迁移测试结构	发明	ZL201711240650.3	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
511	一种存储单元及其存储阵列结构、操作方法	发明	ZL201711240646.7	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
512	刻蚀腔体部件的检测方法	发明	ZL201711239742.X	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
513	提高注入机生产效率的方法	发明	ZL201711237469.7	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
514	改善闪存中高压器件栅极氧化层可靠性的工艺集成方法	发明	ZL201711237456.X	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
515	小样品的去层方法	发明	ZL201711234859.9	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
516	一种金属层光阻顶部缺失工艺热点的版图处理方法	发明	ZL201711227505.1	2017-11-29	申请日起二十年	原始取得
517	根据电路设计图形设置扫描阈值的方法	发明	ZL201711220974.0	2017-11-29	申请日起二十年	原始取得
518	一种自动监控产品跑货状况的方法	发明	ZL201711219188.9	2017-11-28	申请日起二十年	原始取得
519	一种基于光学临近效应修正减少栅极波动的方法	发明	ZL201711219183.6	2017-11-28	申请日起二十年	原始取得
520	一种形成不同深度接触孔的刻蚀方法	发明	ZL201711219182.1	2017-11-28	申请日起二十年	原始取得
521	单端转差分电路及其构成的缓冲器电	发明	ZL201711201528.5	2017-11-27	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	路和采样保持电路					
522	一种一键式激活数据收集项目的方法	发明	ZL201711192842.1	2017-11-24	申请日起二十年	原始取得
523	一种改善锗硅源漏极形貌的制备方法	发明	ZL201711191234.9	2017-11-24	申请日起二十年	原始取得
524	一种化学机械研磨垫磨损的检测装置及工作方法	发明	ZL201711189823.3	2017-11-24	申请日起二十年	原始取得
525	一种改善层间介质研磨工艺厚度稳定性的方法	发明	ZL201711189813.X	2017-11-24	申请日起二十年	原始取得
526	一种模拟内部版图图形的边缘冗余图形生成方法	发明	ZL201711183763.4	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
527	半导体器件的 SAB 工艺方法	发明	ZL201711178355.X	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
528	提高离子注入区的深宽比的制造方法	发明	ZL201711178339.0	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
529	槽式湿法清洗机台	发明	ZL201711178278.8	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
530	去除光刻胶显影后残留缺陷的方法	发明	ZL201711178203.X	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
531	一种监测离子注入设备性能的方法	发明	ZL201711177123.2	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
532	一种晶圆的重测方法	发明	ZL201711177120.9	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
533	一种用于尺寸缩减 NORFlash 单元工艺集成方法	发明	ZL201711176780.5	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
534	一种高可靠性三态输出电路	发明	ZL201711176777.3	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
535	一种改善一体化刻蚀聚集残留缺陷的方法	发明	ZL201711172098.9	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
536	SONOS 器件的形成方法	发明	ZL201711168493.X	2017-11-21	申请日起二十年	原始取得
537	一种精确控制浅沟槽隔离的整体形貌和性能的方法	发明	ZL201711167683.X	2017-11-21	申请日起二十年	原始取得
538	一种嵌入式闪存工艺集成方法	发明	ZL201711160947.9	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
539	一种具备故障诊断的系统级芯片生产方法	发明	ZL201711160758.1	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
540	一种建立全局调节模型进行优化快速热退火的方法	发明	ZL201711160733.1	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
541	一种改善 HCD 氮化硅沉积工艺过程缺陷状况的装置	发明	ZL201711160388.1	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
542	一种对芯片表面进行分区域对比扫描的检测方法及设备	发明	ZL201711160370.1	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
543	一种基于缺陷贡献度的缺陷检测机台自动派工系统和方法	发明	ZL201711159860.X	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
544	一种接触孔底部钨栓缺陷的检测结构及检测方法	发明	ZL201711140573.4	2017-11-16	申请日起二十年	原始取得
545	闪存的工艺集成结构和方法	发明	ZL201711138163.6	2017-11-16	申请日起二十年	原始取得
546	一种检测接触孔底部钨栓缺失缺陷的方法	发明	ZL201711132944.4	2017-11-15	申请日起二十年	原始取得
547	一种消除湿法刻蚀金属硅化物阻挡层底切缺陷的工艺方法	发明	ZL201711131180.7	2017-11-15	申请日起二十年	原始取得
548	PVD 设备的工艺腔的工艺调节结构和方法	发明	ZL201711127897.4	2017-11-15	申请日起二十年	原始取得
549	一种改善的套刻精度量测方法	发明	ZL201711125009.5	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
550	一种存储器件中形成控制栅的工艺流程方法	发明	ZL201711123938.2	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
551	有源区顶部圆滑度的模拟检测方法	发明	ZL201711121971.1	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
552	镍金属硅化物的 TEM 样品的制备方	发明	ZL201711121958.6	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	法					
553	闪存单元结构及其制造方法	发明	ZL201711121845.6	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
554	刻蚀腔体的聚合物清洁方法	发明	ZL201711121422.4	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
555	基于规则的 OPC 方法	发明	ZL201711112632.7	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
556	一种改善光刻填充材料平坦度的方法	发明	ZL201711106966.3	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
557	接触孔的金属连接结构及其制造方法	发明	ZL201711102829.2	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
558	光刻套刻精度量测准确性的评估方法	发明	ZL201711102811.2	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
559	用于化学机械研磨工艺模型建模的测试图形	发明	ZL201711102787.2	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
560	一种边缘保护圈结构、反应室和化学气相沉积设备	发明	ZL201711100107.3	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
561	一种提高离子注入层抗前层反射的 OPC 修正方法	发明	ZL201711100020.6	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
562	一种分布式存储区块访问电路	发明	ZL201711100003.2	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
563	一种改善闪存单元的工艺集成方法	发明	ZL201711099991.3	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
564	一种带误码消除功能的锁定指示器电路	发明	ZL201711099120.1	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
565	一种提高监控图形监控精度的方法	发明	ZL201711099108.0	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
566	一种省去 CLDD 光罩的 NorFlash 器件集成工艺方法	发明	ZL201711098208.1	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
567	OPC 修正方法	发明	ZL201711097082.6	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
568	刻蚀工艺方法	发明	ZL201711097030.9	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
569	一种高效的缺陷抽检方法及系统	发明	ZL201711092655.6	2017-11-08	申请日起二十年	原始取得
570	一种制备西格玛凹槽的方法	发明	ZL201711092654.1	2017-11-08	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
571	一种根据射频时数改善一体化刻蚀工艺面内均匀性的方法	发明	ZL201711091683.6	2017-11-08	申请日起二十年	原始取得
572	一种检测静电吸盘表面颗粒污染物的方法	发明	ZL201711091677.0	2017-11-08	申请日起二十年	原始取得
573	一种检测及校正晶圆与腔体载物台偏移的装置及方法	发明	ZL201711073025.4	2017-11-03	申请日起二十年	原始取得
574	一种闪存晶圆的制作方法	发明	ZL201711057785.6	2017-10-23	申请日起二十年	原始取得
575	一种减小 WPE 效应的标准单元库版图设计方法	发明	ZL201711050885.6	2017-10-31	申请日起二十年	原始取得
576	一种完善光刻模型数据对测试图形覆盖范围的方法	发明	ZL201710987039.0	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
577	浅沟槽隔离结构的形成方法	发明	ZL201710987035.2	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
578	重复性缺陷的筛选方法	发明	ZL201710987031.4	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
579	一种高性能输出驱动电路	发明	ZL201710986287.3	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
580	一种自适应闪存写入操作控制方法及电路	发明	ZL201710986267.6	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
581	一种多晶硅层桥接断路的解决方法	发明	ZL201710985194.9	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
582	一种套刻精度点检方法	发明	ZL201710985188.3	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
583	一种光刻辅助图形的设计方法	发明	ZL201710928912.9	2017-10-09	申请日起二十年	原始取得
584	一种校正全局金属层工艺热点的方法	发明	ZL201710924604.9	2017-09-30	申请日起二十年	原始取得
585	一种分裂栅的栅极形成方法	发明	ZL201710884971.0	2017-09-26	申请日起二十年	原始取得
586	源/漏的形成方法以及半导体器件的形成方法	发明	ZL201710882857.4	2017-09-26	申请日起二十年	原始取得
587	一种锗硅源漏极及其制备方法	发明	ZL201710882787.2	2017-09-26	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
588	一种光罩的校正方法	发明	ZL201710861813.3	2017-09-21	申请日起二十年	原始取得
589	一种温度的测量方法及电迁移的测试方法	发明	ZL201710822916.9	2017-09-13	申请日起二十年	原始取得
590	一种 MIP 平板电容结构及其形成方法	发明	ZL201710801609.2	2017-09-07	申请日起二十年	原始取得
591	一种针对产品量测区域缺陷监控的方法	发明	ZL201710797272.2	2017-09-06	申请日起二十年	原始取得
592	一种线宽量测和问题评估的方法	发明	ZL201710797215.4	2017-09-06	申请日起二十年	原始取得
593	一种离子注入机钨金属污染的监控方法	发明	ZL201710796722.6	2017-09-06	申请日起二十年	原始取得
594	一种套刻误差量测和问题评估的方法	发明	ZL201710796702.9	2017-09-06	申请日起二十年	原始取得
595	基于计算机辅助设计的晶圆激光标识工艺实现方法及系统	发明	ZL201710758627.7	2017-08-29	申请日起二十年	原始取得
596	适用于 TDDB 的原位侦测热点方法	发明	ZL201710757942.8	2017-08-29	申请日起二十年	原始取得
597	光刻工艺热点的整合方法	发明	ZL201710757929.2	2017-08-29	申请日起二十年	原始取得
598	一种晶圆检测方法	发明	ZL201710750267.6	2017-08-28	申请日起二十年	原始取得
599	一种新型硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710731685.0	2017-08-23	申请日起二十年	原始取得
600	一种新型硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710731223.9	2017-08-23	申请日起二十年	原始取得
601	一种改善浮栅极并联电容稳定性的方法	发明	ZL201710730505.7	2017-08-23	申请日起二十年	原始取得
602	一种多晶硅上接触孔粘结层异常缺陷检测方法	发明	ZL201710730497.6	2017-08-23	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
603	一种改善 CMOS 图像传感器刻蚀腔体金属污染的方法	发明	ZL201710702567.7	2017-08-16	申请日起二十年	原始取得
604	一种通孔的形成方法	发明	ZL201710702565.8	2017-08-16	申请日起二十年	原始取得
605	一种掩膜板微尘影响评估方法和系统	发明	ZL201710701067.1	2017-08-16	申请日起二十年	原始取得
606	一种光学临近修正工艺的预处理方法	发明	ZL201710670732.5	2017-08-08	申请日起二十年	原始取得
607	一种确定离子注入机注入角度偏差的方法	发明	ZL201710642794.5	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
608	一种降低存储器擦写功耗的电荷泵电路	发明	ZL201710642793.0	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
609	一种双时域动态变频测试方法	发明	ZL201710641641.9	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
610	一种新型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710640089.1	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
611	一种图形转角的 OPC 修正方法	发明	ZL201710636987.X	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
612	一种浅离子注入层的 OPC 修正方法	发明	ZL201710636973.8	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
613	一种自适应定义缺陷扫描方程式扫描区域的方法	发明	ZL201710613874.8	2017-07-25	申请日起二十年	原始取得
614	电阻模型及其修正方法	发明	ZL201710612356.4	2017-07-25	申请日起二十年	原始取得
615	一种用于闪存电路中的变容二极管结构及其制造方法	发明	ZL201710609969.2	2017-07-25	申请日起二十年	原始取得
616	一种基于改进的带隙基准结构的上电复位电路	发明	ZL201710567419.9	2017-07-12	申请日起二十年	原始取得
617	刻蚀管控系统及其管控方法和刻蚀机台	发明	ZL201710567416.5	2017-07-12	申请日起二十年	原始取得
618	一种用于聚焦离子束机台提取样品的	发明	ZL201710567411.2	2017-07-12	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	方法					
619	一种熔断器及其制造方法	发明	ZL201710561178.7	2017-07-11	申请日起二十年	原始取得
620	图像传感器的制备方法	发明	ZL201710494748.5	2017-06-26	申请日起二十年	原始取得
621	一种高能离子注入工艺中形成高深宽比隔离的方法	发明	ZL201710471715.9	2017-06-20	申请日起二十年	原始取得
622	一种模拟离子注入光阻穿透深度的模型及其建模方法	发明	ZL201710471713.X	2017-06-20	申请日起二十年	原始取得
623	静电释放装置及制造方法、聚焦离子束设备及使用方法	发明	ZL201710470999.X	2017-06-20	申请日起二十年	原始取得
624	提高套刻精度的方法	发明	ZL201710458343.6	2017-06-16	申请日起二十年	原始取得
625	一种检测晶圆表面氮化硅残留的方法	发明	ZL201710429161.6	2017-06-08	申请日起二十年	原始取得
626	一种新型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710420095.6	2017-06-06	申请日起二十年	原始取得
627	一种新型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710420086.7	2017-06-06	申请日起二十年	原始取得
628	一种电平转换与非电路	发明	ZL201710419522.9	2017-06-06	申请日起二十年	原始取得
629	一种减小 STI-CMP 过程中碟型凹陷的方法	发明	ZL201710401452.4	2017-05-31	申请日起二十年	原始取得
630	晶圆退火的热量补偿方法	发明	ZL201710401289.1	2017-05-31	申请日起二十年	原始取得
631	半导体芯片老化测试装置及方法	发明	ZL201710400323.3	2017-05-31	申请日起二十年	原始取得
632	一种晶圆颗粒检测系统及方法	发明	ZL201710399666.2	2017-05-31	申请日起二十年	原始取得
633	一种驱动力可配置的电荷泵电路	发明	ZL201710370115.3	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得
634	一种光刻胶供应装置	发明	ZL201710370114.9	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得
635	一种在氧化硅湿法刻蚀中降低硅损伤	发明	ZL201710370095.X	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	的方法					
636	一种器件建模中最优器件的自动选择方法及系统	发明	ZL201710368792.1	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得
637	一种通孔中光刻胶栓刻蚀量的自动调节方法	发明	ZL201710368784.7	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得
638	晶圆缺陷的检测方法	发明	ZL201710353548.8	2017-05-18	申请日起二十年	原始取得
639	一种金属互连结构的制备方法	发明	ZL201710329424.6	2017-05-11	申请日起二十年	原始取得
640	光学邻近校正前的图形预处理方法	发明	ZL201710318782.7	2017-05-08	申请日起二十年	原始取得
641	计算版图中线宽固定节距不同的线条的分布的方法	发明	ZL201710318781.2	2017-05-08	申请日起二十年	原始取得
642	一种采用电流编程的电子可编程熔丝电路结构	发明	ZL201710312461.6	2017-05-05	申请日起二十年	原始取得
643	一种通过预补值来快速建立光刻工艺条件的方法	发明	ZL201710276130.1	2017-04-25	申请日起二十年	原始取得
644	一种电荷捕获型非易失存储器及其制作方法	发明	ZL201710272690.X	2017-04-24	申请日起二十年	原始取得
645	一种降低闪存源端导通电阻的方法	发明	ZL201710272670.2	2017-04-24	申请日起二十年	原始取得
646	一种结合耐高压晶体管的电荷捕获型非易失存储器制作方法	发明	ZL201710272223.7	2017-04-24	申请日起二十年	原始取得
647	一种层间电容的控制方法及控制系统	发明	ZL201710229267.1	2017-04-10	申请日起二十年	原始取得
648	一种嵌入式存储器自适应工作参数调整方法	发明	ZL201710228681.0	2017-04-10	申请日起二十年	原始取得
649	图形光罩连接孔缺陷检查测试结构及方法	发明	ZL201710225567.2	2017-04-07	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
650	接触孔制作工艺缺陷的检查方法	发明	ZL201710225130.9	2017-04-07	申请日起二十年	原始取得
651	实现更小线宽的光刻工艺	发明	ZL201710190157.9	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
652	一种大尺寸拼接产品曝光方法	发明	ZL201710190123.X	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
653	一种钳位电压电路	发明	ZL201710189260.1	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
654	减缓晶圆边缘散焦的光刻方法	发明	ZL201710188876.7	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
655	套刻精度补正的优化方法及系统	发明	ZL201710187899.6	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
656	一种 EFUSE 烧写方法及烧写电路	发明	ZL201710187627.6	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
657	一种浪涌电流控制模块及其方法	发明	ZL201710187522.0	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
658	版图重复单元光学邻近效应修正一致性检查方法	发明	ZL201710170707.0	2017-03-21	申请日起二十年	原始取得
659	补偿由光刻镜头散射光导致曝光误差的方法	发明	ZL201710170252.2	2017-03-21	申请日起二十年	原始取得
660	一种上电复位电路	发明	ZL201710169793.3	2017-03-21	申请日起二十年	原始取得
661	一种监控 Ge 离子注入质量的方法	发明	ZL201710146467.0	2017-03-13	申请日起二十年	原始取得
662	一种时钟分布网络结构及其生成方法	发明	ZL201710146090.9	2017-03-13	申请日起二十年	原始取得
663	一种提高芯片同测数的方法	发明	ZL201710141184.7	2017-03-10	申请日起二十年	原始取得
664	一种增强型 CMOS 施密特电路	发明	ZL201710141051.X	2017-03-10	申请日起二十年	原始取得
665	一种光罩颗粒尺寸的评估方法	发明	ZL201710140908.6	2017-03-10	申请日起二十年	原始取得
666	一种提高 SONOS 器件读取电流的方法	发明	ZL201710140796.4	2017-03-10	申请日起二十年	原始取得
667	一种刻蚀方法	发明	ZL201710033545.6	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
668	图形光罩接触孔缺陷检测方法	发明	ZL201611089543.0	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
669	测试结构及测试方法	发明	ZL201611087779.0	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
670	一种基于频率比较的锁定指示器	发明	ZL201611086921.X	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
671	一种基于前层图形判别的离子注入层边界的光学临近修正方法	发明	ZL201611085965.0	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
672	WAT 机台报警引起的 lot 异常处理优化方法及系统	发明	ZL201611085624.3	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
673	一种半导体晶圆的测试结构	发明	ZL201611077582.9	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
674	一种降低热载流子劣化的电平转换电路	发明	ZL201611077581.4	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
675	一种改善高深宽比光刻胶形貌的结构和方法	发明	ZL201611077084.4	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
676	防止研磨头与研磨垫修整器相撞的装置、方法及研磨设备	发明	ZL201611076614.3	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
677	一种监控 CIS 像素单元相关电容的电路及方法	发明	ZL201611076611.X	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
678	一种用于优化晶圆边缘缺陷的晶圆传送方法	发明	ZL201611076590.1	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
679	一种电源箝位 ESD 保护电路结构	发明	ZL201611076587.X	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
680	一种优化低功耗产品漏电流的方法	发明	ZL201611076529.7	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
681	半导体器件的形成方法	发明	ZL201611075479.0	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
682	一种考虑版图环境的电阻模型提取方法及系统	发明	ZL201611061474.2	2016-11-25	申请日起二十年	原始取得
683	一种应用于 PLL 的高性能 VCO 电路	发明	ZL201611061473.8	2016-11-25	申请日起二十年	原始取得
684	一种电阻闪烁噪声模型的建立方法及系统	发明	ZL201611061346.8	2016-11-25	申请日起二十年	原始取得
685	一种炉管尾气处理管道	发明	ZL201611059866.5	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
686	一种通用版图临近效应表征模型及其提取方法	发明	ZL201611053506.4	2016-11-25	申请日起二十年	原始取得
687	一种电阻子电路噪声模型结构及其建模方法	发明	ZL201611048937.1	2016-11-23	申请日起二十年	原始取得
688	一种增强 OPC 处理精度的方法	发明	ZL201611047406.0	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
689	一种用于产生二维 OPC 测试图形的方法	发明	ZL201611042085.5	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
690	一种自校准可扩展性 SRAM 延时测试电路	发明	ZL201611041043.X	2016-11-23	申请日起二十年	原始取得
691	改善有源区点状腐蚀缺陷的方法	发明	ZL201611040507.5	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
692	芯片内部动作时间的检测系统及方法	发明	ZL201611040490.3	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
693	一种基于理想电阻的可熔断电阻验证系统及方法	发明	ZL201611037379.9	2016-11-23	申请日起二十年	原始取得
694	一种 WAT 阈值电压测试方法及系统	发明	ZL201611031129.4	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
695	一种改善非对称性静电吸盘刻蚀腔体边缘缺陷的方法	发明	ZL201611028534.0	2016-11-18	申请日起二十年	原始取得
696	一种多步骤干法刻蚀机台颗粒监测的方法	发明	ZL201611027701.X	2016-11-01	申请日起二十年	原始取得
697	一种 NISSIN 离子注入机台的自动化程式正确性管理方法及装置	发明	ZL201611018094.0	2016-11-18	申请日起二十年	原始取得
698	PMOS 器件及其集成工艺方法	发明	ZL201611017984.X	2016-11-17	申请日起二十年	原始取得
699	电迁移测试结构	发明	ZL201611010913.7	2016-11-17	申请日起二十年	原始取得
700	一种动态调整安全研磨时间限的方法	发明	ZL201610993680.0	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
701	一种上电复位电路	发明	ZL201610986873.3	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
702	一种可探知晶圆滑动的机械臂装置	发明	ZL201610986671.9	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
703	提高前照式 CMOS 图像传感器红光量子效率的方法及结构	发明	ZL201610985910.9	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
704	一种集成 5 伏器件和 SONOS 存储器的制造方法	发明	ZL201610985902.4	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
705	一种晶圆化学机械抛光保持环的清洗装置及清洗方法	发明	ZL201610985516.5	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
706	一种集成离子刻蚀划片槽和密封环的制造方法	发明	ZL201610985505.7	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
707	用于钨沉积前的接触孔表面的处理方法	发明	ZL201610985481.5	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
708	半导体器件及其制备方法	发明	ZL201610984921.5	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
709	消除前金属层内部缺陷导致的短路漏电的方法	发明	ZL201610984912.6	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
710	一种炉管的氮气冷却系统及晶圆和晶舟的冷却方法	发明	ZL201610983199.3	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
711	一种延长刻蚀腔体开腔保养时间间隔的保养方法	发明	ZL201610983032.7	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
712	一种快速收集阈值电压分布的方法	发明	ZL201610971021.7	2016-11-01	申请日起二十年	原始取得
713	一种化学机械研磨机台研磨压力补偿方法	发明	ZL201610957345.5	2016-10-27	申请日起二十年	原始取得
714	恒温电迁移测试中的电流加速因子评估方法	发明	ZL201610950150.8	2016-10-26	申请日起二十年	原始取得
715	用于封装级可靠性测试的静电防护电	发明	ZL201610949909.0	2016-10-26	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	路和测试安装方法					
716	一种基于 systemverilog 的 AHB 核随机验证方法	发明	ZL201610936104.2	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
717	药液槽承载晶圆的底座及提高槽式湿法刻蚀均匀性的方法	发明	ZL201610926005.6	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
718	一种嵌入式闪存及其电流比较读出电路	发明	ZL201610925994.7	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
719	一种晶圆边缘清洗装置及清洗方法	发明	ZL201610925966.5	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
720	一种优化晶圆环状缺陷的方法	发明	ZL201610924726.3	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
721	自校准式恒温电迁移测试中的金属活化能评估方法	发明	ZL201610924546.5	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
722	一种减少曝光焦距误差的方法	发明	ZL201610924503.7	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
723	一种 CIS 器件及优化后段光通道工艺来降低 CIS 暗电流的方法	发明	ZL201610924437.3	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
724	抗电磁干扰的晶振谐振回路电路	发明	ZL201610924231.0	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
725	一种用于无电容型 LDO 的补偿电路	发明	ZL201610901016.9	2016-10-17	申请日起二十年	原始取得
726	一种改善应力记忆工艺效果的方法	发明	ZL201610885707.4	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得
727	一种连接孔图形光罩缺点的检测方法	发明	ZL201610884418.2	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得
728	一种降低背照式 CMOS 图像传感器白像素的方法	发明	ZL201610884399.3	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得
729	一种剥离嵌入式闪存的逻辑及 SRAM 区中浮栅结构的方法	发明	ZL201610884377.7	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得
730	一种金属线层小尺寸冗余图形的添加和处理方法	发明	ZL201610884323.0	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
731	一种双向 ESD 器件及其制作方法	发明	ZL201610875594.X	2016-09-30	申请日起二十年	原始取得
732	一种用于缺陷检测机台的实时侦测光阻损伤的方法	发明	ZL201610857461.X	2016-09-27	申请日起二十年	原始取得
733	一种用作 ESD 保护的 GGNMOS 器件及其制作方法	发明	ZL201610854759.5	2016-09-27	申请日起二十年	原始取得
734	一种栅氧层的制备方法	发明	ZL201610854700.6	2016-09-27	申请日起二十年	原始取得
735	一种上电复位电路	发明	ZL201610852610.3	2016-09-26	申请日起二十年	原始取得
736	一种 ESD 器件及其制作方法	发明	ZL201610850755.X	2016-09-26	申请日起二十年	原始取得
737	降低化学机械抛光工艺热点检测漏报率的方法	发明	ZL201610828347.4	2016-09-18	申请日起二十年	原始取得
738	一种突破外观缺陷机台检测极限的方法	发明	ZL201610795422.1	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
739	适用于各类周期性测试算法的存储器内建自测试电路	发明	ZL201610795123.8	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
740	一种测试有源区顶部圆滑度的方法	发明	ZL201610790820.4	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
741	一种形成 MIS 结构的方法	发明	ZL201610790816.8	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
742	降低离子注入层光刻胶剥离风险的方法	发明	ZL201610790803.0	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
743	一种优化 CMOS 图像传感器晶圆边缘缺陷的方法	发明	ZL201610790785.6	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
744	提高良率提升缺陷监测效率的方法	发明	ZL201610790782.2	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
745	电化学镀铜洗边装置以及电化学镀铜洗边方法	发明	ZL201610790760.6	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
746	保形沉积的薄膜厚度预测模型建立及	发明	ZL201610777684.5	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	应用方法					
747	刻蚀设备以及用于去除晶背边缘薄膜的晶背边缘刻蚀方法	发明	ZL201610776793.5	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
748	一种监控侧墙刻蚀后残留的方法	发明	ZL201610770418.X	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
749	一种炉管的进气装置	发明	ZL201610770371.7	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
750	一种降低变容器最小电容的方法	发明	ZL201610766363.5	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
751	可制造性检测分析方法	发明	ZL201610766345.7	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
752	一种检测浅沟槽隔离区空洞缺陷的方法	发明	ZL201610704834.X	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
753	一种锗硅 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201610704833.5	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
754	一种非易失存储器结构及其制作方法	发明	ZL201610704806.8	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
755	改善有源区边界处的栅极拐角的方法	发明	ZL201610704771.8	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
756	一种嵌入式闪存的电荷泵控制电路结构	发明	ZL201610704743.6	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
757	一种在接触孔中制备薄膜的方法	发明	ZL201610704710.1	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
758	一种晶圆研磨头清洗装置及清洗方法	发明	ZL201610703066.6	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
759	一种适用于低电容密度电容测试结构的版图布局方法	发明	ZL201610703053.9	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
760	一种可调控制栅增加 ILD 填充窗口的工艺方法	发明	ZL201610703052.4	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
761	防止重掺杂的硅衬底边缘的离子析出的方法	发明	ZL201610703032.7	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
762	一种避免电子束扫描过程中产生电弧放电的缺陷检测方法	发明	ZL201610703019.1	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
763	半浮栅晶体管工艺方法	发明	ZL201610696009.X	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
764	改善 OPC 版图处理不一致的方法	发明	ZL201610695909.2	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
765	透射电子显微镜样品结染色的方法	发明	ZL201610694441.5	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
766	针对多晶硅氧化物栅极缺失的电子束扫描检测方法	发明	ZL201610694386.X	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
767	多产品共晶圆流片中的几何信息提取方法	发明	ZL201610694146.X	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
768	降低金属硬质掩模大马士革一体化刻蚀缺陷生长的方法	发明	ZL201610694050.3	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
769	制备透射电子显微镜样品的方法	发明	ZL201610692334.9	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
770	透射电子显微镜样品结染色的方法	发明	ZL201610692332.X	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
771	自加热电迁移测试结构以及晶圆级自加热电迁移测试方法	发明	ZL201610608746.X	2016-07-29	申请日起二十年	原始取得
772	离子注入设备及监控方法	发明	ZL201610608697.X	2016-07-29	申请日起二十年	原始取得
773	一种化学机械研磨模拟方法	发明	ZL201610606958.4	2016-07-28	申请日起二十年	原始取得
774	一种单位格点几何信息提取方法	发明	ZL201610606945.7	2016-07-28	申请日起二十年	原始取得
775	一种基于图形密度的工艺模型建模与修正方法	发明	ZL201610606942.3	2016-07-28	申请日起二十年	原始取得
776	SEN 离子注入机台的自动化程式正确性管理方法及装置	发明	ZL201610585587.6	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得
777	用于执行版图 OPC 处理的方法	发明	ZL201610585550.3	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得
778	具有双外延层结构的 CMOS 图像传感器及其制造方法	发明	ZL201610585056.7	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得
779	一种用于共源架构嵌入式闪存的字线	发明	ZL201610584970.X	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	驱动电路及其方法					
780	一种改善圆晶片内膜厚均匀性的方法	发明	ZL201610584924.X	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得
781	改善闪存阵列区垫氧层刻蚀过程中硅衬底完整性的方法	发明	ZL201610510527.8	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
782	一种降低 ESD 风险的版图处理方法	发明	ZL201610510504.7	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
783	一种离子注入工艺的精确控制方法	发明	ZL201610498922.9	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
784	一种快速降低热板温度的方法	发明	ZL201610498921.4	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
785	一种量测工序的智能抽样方法及系统	发明	ZL201610498899.3	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
786	调节衬底表面反射率的结构及方法、光刻方法	发明	ZL201610498878.1	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
787	一种离子注入层图形线宽尺寸的形成方法	发明	ZL201610498312.9	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
788	一种优化 OPC 验证的方法	发明	ZL201610421103.4	2016-06-14	申请日起二十年	原始取得
789	一种电化学镀铜洗边宽度的自动调节装置和自动调节方法	发明	ZL201610415928.5	2016-06-14	申请日起二十年	原始取得
790	用于 CMP 设备上的研磨垫安装夹具装置及使用方法	发明	ZL201610370175.0	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
791	一种光刻机的晶圆承载吸附压力优化方法	发明	ZL201610370135.6	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
792	一种曝光条件检测方法及系统	发明	ZL201610370132.2	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
793	一种自对准 STI 的制备方法	发明	ZL201610367958.3	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
794	一种铜研磨方法及系统	发明	ZL201610367935.2	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
795	一种提高 OPC 修正精度的方法	发明	ZL201610367932.9	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
796	改善闪存浅槽嵌壁工艺缺陷的双光刻	发明	ZL201610357144.1	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	处理方法					
797	防止有形貌晶圆表面刻蚀损伤的光刻刻蚀方法	发明	ZL201610357141.8	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
798	一种暗场缺陷检测设备自对准工艺窗口的校正方法	发明	ZL201610357127.8	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
799	局部曝光异常缺陷自动检测方法	发明	ZL201610356816.7	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
800	一种亮场扫描设备自动定义扫描区域的检测方法	发明	ZL201610355214.X	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
801	一种优化 CMOS 图像传感器晶圆边缘缺陷的方法	发明	ZL201610355204.6	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
802	一种金属层膜厚堆叠模型校准的方法及系统	发明	ZL201610355194.6	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
803	一种离子注入机的智能工艺互锁控制方法及系统	发明	ZL201610355192.7	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
804	一种靶材边缘之铝熔射层的检测方法	发明	ZL201610353584.X	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
805	函括格点边缘区域图形数据的版图特征参数提取方法	发明	ZL201610327932.6	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
806	超浅结退火方法	发明	ZL201610327931.1	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
807	一种平面 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201610327914.8	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
808	化学机械研磨工艺模型校准验证流程中薄膜厚度引入方法	发明	ZL201610327878.5	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
809	实现多晶硅栅极平坦化的方法	发明	ZL201610327876.6	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
810	版图设计中的权重线宽的提取方法	发明	ZL201610326227.4	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
811	基于掩模板规则限制优化光学临近修	发明	ZL201610326182.0	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	正结果的方法					
812	一种减少光刻胶中毒的方法	发明	ZL201610323439.7	2016-05-16	申请日起二十年	原始取得
813	用于预防半导体芯片版图的天线效应的方法	发明	ZL201610320945.0	2016-05-13	申请日起二十年	原始取得
814	一种离子注入层阴影效应分析结构的形成方法	发明	ZL201610319144.2	2016-05-16	申请日起二十年	原始取得
815	一种 3D 集成电路结构及其制造方法	发明	ZL201610319141.9	2016-05-16	申请日起二十年	原始取得
816	一种加速 WAT 测试的系统和方法	发明	ZL201610280121.5	2016-04-29	申请日起二十年	原始取得
817	离子注入层版图的光学修正方法	发明	ZL201610280103.7	2016-04-29	申请日起二十年	原始取得
818	一种使电荷泵输出电压具有多种温度系数的电路	发明	ZL201610250583.2	2016-04-21	申请日起二十年	原始取得
819	一种基于 MEEF 的 OPC 验证方法	发明	ZL201610250573.9	2016-04-21	申请日起二十年	原始取得
820	一种用于小电容失配检测及绝对值测量的电路及方法	发明	ZL201610250571.X	2016-04-21	申请日起二十年	原始取得
821	阻挡介质层的刻蚀方法	发明	ZL201610250432.7	2016-04-21	申请日起二十年	原始取得
822	MOS 管阈值电压分布的测量系统及测量方法	发明	ZL201610219022.6	2016-04-11	申请日起二十年	原始取得
823	一种通过改变 SAB 膜质降低 CIS 器件噪声的方法	发明	ZL201610218970.8	2016-04-11	申请日起二十年	原始取得
824	离子注入设备的冷却单元	发明	ZL201610212943.X	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
825	梯度压力模式改善膜厚均一性的方法	发明	ZL201610212828.2	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
826	测试金属线的电迁移结构	发明	ZL201610212826.3	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
827	一种平衡存储单元区填充与逻辑区栅氧完整性的工艺方法	发明	ZL201610212604.1	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
828	利用曝光辅助图形来减少基底反射影响的方法	发明	ZL201610212558.5	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
829	一种确定 OPC 模型焦平面的方法	发明	ZL201610212556.6	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
830	一种改善晶圆翘曲度的方法	发明	ZL201610186873.5	2016-03-29	申请日起二十年	原始取得
831	一种改善炉管晶舟支撑脚颗粒状况的装置及方法	发明	ZL201610185803.8	2016-03-29	申请日起二十年	原始取得
832	控制多晶硅栅极关键尺寸均匀性的方法	发明	ZL201610173911.3	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
833	高电流注入机台监控方法	发明	ZL201610173716.0	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
834	炉管、晶片冷却方法以及自动晶舟清洁方法	发明	ZL201610173685.9	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
835	自动晶圆校准方法	发明	ZL201610173682.5	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
836	一种消除闪光退火机台首十枚效应的方法	发明	ZL201610173408.8	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
837	阻挡 CMOS 图像传感器 HDP 浅沟槽填充过程中金属污染的方法	发明	ZL201610173365.3	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
838	针对版图设计数据改版的光刻工艺的友善性检查方法	发明	ZL201610173339.0	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
839	一种 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201610164426.X	2016-03-22	申请日起二十年	原始取得
840	一种 MOSFET BSIM4 子电路器件模型及其建模方法	发明	ZL201610163792.3	2016-03-22	申请日起二十年	原始取得
841	一种改善深亚微米级闪存器件耦合率的沟槽氧化物的刻蚀方法	发明	ZL201610163759.0	2016-03-22	申请日起二十年	原始取得
842	一种校正电子显微镜电子束与晶圆位	发明	ZL201610114691.7	2016-03-01	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	置偏差的方法					
843	一种解决 HDP PSG 制程厚度均一性持续跳高的方法	发明	ZL201610109837.9	2016-02-29	申请日起二十年	原始取得
844	降低 CMOS 图像传感器的无金属硅化物区域接触电阻的方法	发明	ZL201610107865.7	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
845	一种兼容不同规格之探针的探针卡	发明	ZL201610107841.1	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
846	改善静电吸附盘树脂保护环损伤的结构及方法	发明	ZL201610107752.7	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
847	改善闪存产品多晶硅表面缺陷检测灵敏度的方法及结构	发明	ZL201610107730.0	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
848	双结构接触孔同步刻蚀工艺	发明	ZL201610107729.8	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
849	一种提升经时击穿测试有效性的方法	发明	ZL201610107358.3	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
850	栅氧化层厚度实时监控方法	发明	ZL201610088975.3	2016-02-17	申请日起二十年	原始取得
851	一种用于槽型湿法设备的干燥装置及干燥方法	发明	ZL201610088128.7	2016-02-17	申请日起二十年	原始取得
852	一种验证快闪存储器隧穿氧化层可靠性的方法	发明	ZL201610088127.2	2016-02-17	申请日起二十年	原始取得
853	消除比较器延迟的振荡电路	发明	ZL201510724253.8	2015-10-29	申请日起二十年	原始取得
854	一种 CMOS 图像传感器的结构及其制备方法	发明	ZL201510719251.X	2015-10-29	申请日起二十年	原始取得
855	一种 H3PO4 槽小换酸的控制方法	发明	ZL201510719240.1	2015-10-29	申请日起二十年	原始取得
856	一种检测光刻机焦距偏移量的方法	发明	ZL201510719205.X	2015-10-29	申请日起二十年	原始取得
857	一种排除电性噪声干扰的方法	发明	ZL201510716961.7	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
858	一种改善低介电质膜厚稳定性的方法	发明	ZL201510716951.3	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
859	一种改善低介电质薄膜厚度稳定性的方法	发明	ZL201510716938.8	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
860	形成源漏区外延锗硅均匀轮廓的方法	发明	ZL201510716917.6	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
861	一种降低颗粒产生的方法	发明	ZL201510716894.9	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
862	一种针对多晶硅层光刻版图的工艺热点检查方法	发明	ZL201510715852.3	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
863	一种降低接触式图像传感器工作区金属污染的方法	发明	ZL201510708400.2	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
864	一种降低接触式图像传感器工作区金属污染的方法	发明	ZL201510708385.1	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
865	一种 MOS 可变电容的仿真模型建立方法和仿真方法	发明	ZL201510707912.7	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
866	嵌入式外延锗硅层的盖帽层的制作方法	发明	ZL201510707870.7	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
867	嵌入式外延锗硅层的盖帽层的制作方法	发明	ZL201510707673.5	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
868	研磨液供给及研磨垫整理装置、研磨机台	发明	ZL201510707376.0	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
869	一种研磨垫及其更换方法	发明	ZL201510703868.2	2015-10-26	申请日起二十年	原始取得
870	一种保持研磨机台研磨率平衡的方法	发明	ZL201510703181.9	2015-10-26	申请日起二十年	原始取得
871	用于化学机械研磨机台的固定环	发明	ZL201510683995.0	2015-10-20	申请日起二十年	原始取得
872	一种 TEM 芯片样品的标记方法	发明	ZL201510680560.0	2015-10-19	申请日起二十年	原始取得
873	一种 CIS 器件的制造方法	发明	ZL201510680467.X	2015-10-19	申请日起二十年	原始取得
874	MIM 电容器的测试结构和测试方法	发明	ZL201510680458.0	2015-10-19	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
875	抑制浅沟槽隔离结构深度负载效应的方法	发明	ZL201510663204.8	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
876	一种侦测锗硅残留的方法	发明	ZL201510663115.3	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
877	无深度负载效应的浅沟槽隔离结构的制备方法	发明	ZL201510663074.8	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
878	一种 SRAM 单元建模方法	发明	ZL201510663043.2	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
879	一种晶圆验收测试机台加压校准方法	发明	ZL201510662809.5	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
880	一种半导体器件电性测试方法	发明	ZL201510662806.1	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
881	对准精度测量的图形结构	发明	ZL201510662782.X	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
882	一种利用信息码识别的探针卡及方法	发明	ZL201510662503.X	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
883	一种避免浅沟槽隔离结构出现深度负载效应的方法	发明	ZL201510662464.3	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
884	一种 AL 刻蚀机台热量再利用的装置及方法	发明	ZL201510662415.X	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
885	离子注入阻挡层的制作方法	发明	ZL201510662096.2	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
886	一种存储器测试装置及一种存储器芯片测试方法	发明	ZL201510655029.8	2015-09-27	申请日起二十年	原始取得
887	一种消除比较器延迟和失配的振荡电路	发明	ZL201510626725.6	2015-09-28	申请日起二十年	原始取得
888	一种光刻套准补正的方法	发明	ZL201510626687.4	2015-09-28	申请日起二十年	原始取得
889	一种金属沟槽刻蚀方法	发明	ZL201510626669.6	2015-09-28	申请日起二十年	原始取得
890	一种偏置电压显性相关的失配模型及其提取方法	发明	ZL201510624152.3	2015-09-27	申请日起二十年	原始取得
891	U 形栅极的形成方法	发明	ZL201510624106.3	2015-09-27	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
892	一种通用失配模型及其提取方法	发明	ZL201510623395.5	2015-09-27	申请日起二十年	原始取得
893	一种降低 CMOS 图像传感器白像素的集成工艺	发明	ZL201510621256.9	2015-09-25	申请日起二十年	原始取得
894	通过多晶硅吸杂降低 CMOS 图像传感器白像素的方法	发明	ZL201510621245.0	2015-09-25	申请日起二十年	原始取得
895	通过 C 离子注入降低 CMOS 图像传感器白像素的方法	发明	ZL201510621209.4	2015-09-25	申请日起二十年	原始取得
896	通过 F 离子注入降低 CMOS 图像传感器暗电流的方法	发明	ZL201510621207.5	2015-09-25	申请日起二十年	原始取得
897	一种改善晶圆形变的曝光载片台	发明	ZL201510608938.6	2015-09-22	申请日起二十年	原始取得
898	一种漏电流的测试版图、检测结构及其检测方法	发明	ZL201510592962.5	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
899	一种改善晶圆边缘产品良率的方法	发明	ZL201510591788.2	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
900	一种栅极阵列图形的双重曝光制作方法	发明	ZL201510591374.X	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
901	一种光学邻近效应修正离焦模型的校准方法	发明	ZL201510591365.0	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
902	一种制作 Sigma 型锗硅沟槽的方法	发明	ZL201510591355.7	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
903	一种提高器件性能均一性的方法	发明	ZL201510591338.3	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
904	一种扫描程式运用阈值修正进行晶圆检测的方法	发明	ZL201510591333.0	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
905	一种防止 TEM 芯片样品破裂的方法	发明	ZL201510578320.X	2015-09-11	申请日起二十年	原始取得
906	用于 CMOS 器件离子注入光学修正的测试结构及方法	发明	ZL201510578319.7	2015-09-11	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
907	解决高能量下连续片晶圆孤立线宽下降的方法	发明	ZL201510578270.5	2015-09-11	申请日起二十年	原始取得
908	一种 SONOS 器件中 ONO 结构的制造方法	发明	ZL201510547787.8	2015-08-31	申请日起二十年	原始取得
909	一种晶圆边缘产品良率的改善方法	发明	ZL201510547779.3	2015-08-31	申请日起二十年	原始取得
910	常压炉管生长的薄膜厚度的控制方法	发明	ZL201510546241.0	2015-08-31	申请日起二十年	原始取得
911	高深宽比结构的光刻胶填充方法	发明	ZL201510546180.8	2015-08-31	申请日起二十年	原始取得
912	一种制备 TEM 芯片样品的方法	发明	ZL201510532705.2	2015-08-26	申请日起二十年	原始取得
913	电迁移测试结构及测试方法	发明	ZL201510532704.8	2015-08-26	申请日起二十年	原始取得
914	用于减少高浓度外延工艺中的位错缺陷的方法和系统	发明	ZL201510524163.4	2015-08-24	申请日起二十年	原始取得
915	一种互连寄生电阻电容校准结构	发明	ZL201510514462.X	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
916	CMOS 器件工艺中锗硅外延层的制备方法	发明	ZL201510514447.5	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
917	一种集成电路分析中透射电镜平面样品的制备方法	发明	ZL201510514446.0	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
918	一种双位 SONOS 存储器及其编译、擦除和读取方法	发明	ZL201510514435.2	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
919	一种 N 沟道非易失性闪存器件及其编译、擦除和读取方法	发明	ZL201510514392.8	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
920	一种栅氧化层缺陷的分析方法	发明	ZL201510514373.5	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
921	一种防止 I/O 电路不确定态的上电检测电路	发明	ZL201510514279.X	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
922	预估 MEEF 较大图形的方法及系统	发明	ZL201510497384.7	2015-08-13	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
923	多管路液体气化反应成膜设备气流控制方法	发明	ZL201510494546.1	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
924	一种∑型结构的半浮栅器件的制造方法	发明	ZL201510494525.X	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
925	光刻生产控制方法	发明	ZL201510493961.5	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
926	一种 TEM 样品制备方法	发明	ZL201510493945.6	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
927	一种引线键合去除的方法	发明	ZL201510493865.0	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
928	金属硬掩模一体化刻蚀中桥接位置的检测方法	发明	ZL201510489081.0	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
929	弯折探针及其治具	发明	ZL201510489059.6	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
930	栅极硬掩模层的去除方法	发明	ZL201510489041.6	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
931	一种避免光刻机镜头过热的方法	发明	ZL201510489028.0	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
932	抑制反短沟道效应的方法及 NMOS 器件制备方法	发明	ZL201510488879.3	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
933	一种基于多曝光程序的多硅片循环运动方法	发明	ZL201510488878.9	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
934	一种平面 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201510487953.X	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
935	超薄栅氧的制备方法	发明	ZL201510487665.4	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
936	一种引入套刻误差的光刻工艺规则检查方法	发明	ZL201510460417.0	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
937	一种自动放行 WAT PM 探针卡的系统及方法	发明	ZL201510460280.9	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
938	一种双浅沟槽隔离形成方法	发明	ZL201510460278.1	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
939	一种栅介质层的制备方法	发明	ZL201510460277.7	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
940	一种晶圆支撑件的清洗装置及清洗方法	发明	ZL201510460195.2	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
941	一种重复单元结构 TEM 样品的定位方法	发明	ZL201510460194.8	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
942	一种在线测试半导体器件衬底	发明	ZL201510459334.X	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
943	一种避免在形成金属硅化物工艺中接触孔尺寸偏移的方法	发明	ZL201510459314.2	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
944	一种集成电路芯片反向工程的定位方法	发明	ZL201510459284.5	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
945	栅极区域的光学临近修正验证方法	发明	ZL201510456589.0	2015-07-29	申请日起二十年	原始取得
946	离子注入层光刻胶膜厚的优化方法	发明	ZL201510456455.9	2015-07-29	申请日起二十年	原始取得
947	针对特定重复图形的光学临近效应修正方法	发明	ZL201510435966.2	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
948	一种同时形成一维和二维光刻胶图形的方法	发明	ZL201510435960.5	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
949	通过优化电荷释放步骤工艺条件改善球状缺陷的方法	发明	ZL201510435956.9	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
950	一种测试 SRAM 共享接触孔与多晶硅接触电阻的结构	发明	ZL201510435944.6	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
951	一种晶圆反应腔室及晶圆反应腔室之晶圆保护方法	发明	ZL201510435942.7	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
952	一种测试 SRAM 共享接触孔与有源区接触电阻的结构	发明	ZL201510435916.4	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
953	金属电迁移测试结构以及金属电迁移	发明	ZL201510435910.7	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	测试方法					
954	进出气装置、具有进出气装置之热处理机台及进出气方法	发明	ZL201510435906.0	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
955	形成不同深度沟槽的集成电路制造方法	发明	ZL201510435897.5	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
956	晶圆测试管理系统及方法	发明	ZL201510435476.2	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
957	一种同时形成一维和二维光刻胶图形的方法	发明	ZL201510435445.7	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
958	一种 SPC 策略自动更新方法及 SPC 自动策略系统	发明	ZL201510435372.1	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
959	一种半导体工艺生产线的派工方法及系统	发明	ZL201510435344.X	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
960	掩模板表面微尘去除装置及除尘方法	发明	ZL201510435342.0	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
961	一种节省光罩的 CMOS 阱形成方法	发明	ZL201510430138.X	2015-07-21	申请日起二十年	原始取得
962	一种双位无结闪存存储器及其编程、擦除和读取方法	发明	ZL201510422547.5	2015-07-17	申请日起二十年	原始取得
963	金属氧化物金属电容器制作方法	发明	ZL201510375658.5	2015-06-30	申请日起二十年	原始取得
964	针对晶圆晶边的化学气相沉积工艺腔及化学气相沉积方法	发明	ZL201510375630.1	2015-06-30	申请日起二十年	原始取得
965	刻蚀映射关系模型和控制浅槽隔离刻蚀关键尺寸的方法	发明	ZL201510369469.7	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
966	侧墙的形成方法	发明	ZL201510369468.2	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
967	改善磷硅玻璃中磷分布均匀性的方法	发明	ZL201510369420.1	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
968	双层套刻精度控制层次管理的方法、	发明	ZL201510369337.4	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	校准标记及测量系统					
969	一种镍硅化物的形成方法	发明	ZL201510369145.3	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
970	一种探针卡	发明	ZL201510367325.8	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
971	一种掩膜板及孤立孔寻址图形在测量中的应用方法	发明	ZL201510367319.2	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
972	一种制作镍硅化物的方法	发明	ZL201510367130.3	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
973	一种镍硅化物的优化方法	发明	ZL201510367108.9	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
974	一种镍硅化物的制作方法	发明	ZL201510367094.0	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
975	一种跨导恒定的差分对输入电路	发明	ZL201510309771.3	2015-06-08	申请日起二十年	原始取得
976	一种控制静电吸盘吸力的方法	发明	ZL201510277990.8	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
977	一种基于动态电压衬度分析的样品制备方法	发明	ZL201510277921.7	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
978	一种用于器件建模的标准单元选择方法	发明	ZL201510277904.3	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
979	一种金属硬质掩模一体化刻蚀通孔过刻蚀量的检测方法	发明	ZL201510277903.9	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
980	一种降低图像传感器暗电流的方法	发明	ZL201510277901.X	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
981	一种晶圆曝光顺序的优化方法	发明	ZL201510277863.8	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
982	探针针痕位置的检测系统及方法	发明	ZL201510277862.3	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
983	一种混合晶向无结 CMOS 结构	发明	ZL201510276547.9	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
984	光刻抗反射层的离线监控方法	发明	ZL201510272206.4	2015-05-25	申请日起二十年	原始取得
985	通过工艺集成优化减小半导体器件性能调试难度的方法	发明	ZL201510249105.5	2015-05-15	申请日起二十年	原始取得
986	一种改善不同晶片之间有源区关键尺	发明	ZL201510249102.1	2015-05-15	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	寸差异的方法					
987	一种提高芯片去层次时均匀度的方法	发明	ZL201510248913.X	2015-05-15	申请日起二十年	原始取得
988	减少聚合物产生的光刻化学品喷涂系统及控制方法	发明	ZL201510225370.X	2015-05-04	申请日起二十年	原始取得
989	一种离子注入机的剂量匹配方法	发明	ZL201510216741.8	2015-04-30	申请日起二十年	原始取得
990	一种刻蚀反应腔体的清洁方法	发明	ZL201510213483.8	2015-04-29	申请日起二十年	原始取得
991	一种嵌入式锗硅结构的制作方法	发明	ZL201510213373.1	2015-04-29	申请日起二十年	原始取得
992	一种监控光刻机台稳定性的方法及系统	发明	ZL201510199044.6	2015-04-23	申请日起二十年	原始取得
993	一种透射电镜样品的制备方法及定位方法	发明	ZL201510199043.1	2015-04-23	申请日起二十年	原始取得
994	一种铜互连的制备方法	发明	ZL201510198901.0	2015-04-22	申请日起二十年	原始取得
995	一种 SONOS 双栅闪存器件及其编译方法	发明	ZL201510198895.9	2015-04-22	申请日起二十年	原始取得
996	用于使用保形填充层改善器件表面均匀性的方法和系统	发明	ZL201510189718.4	2015-04-20	申请日起二十年	原始取得
997	等离子体刻蚀装置及提高硅钴镍刻蚀效率的方法	发明	ZL201510174002.7	2015-04-13	申请日起二十年	原始取得
998	一种 Flash 产品的 ONO 薄膜缺陷的失效分析方法	发明	ZL201510174001.2	2015-04-13	申请日起二十年	原始取得
999	降低多孔 low-k 材料的 k 值的互连工艺	发明	ZL201510173995.6	2015-04-13	申请日起二十年	原始取得
1000	钴阻挡层的形成方法和金属互连工艺	发明	ZL201510173198.8	2015-04-13	申请日起二十年	原始取得
1001	光刻对准标记结构及其制造方法	发明	ZL201510149621.0	2015-03-31	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1002	一种气体喷嘴	发明	ZL201510149062.3	2015-03-31	申请日起二十年	原始取得
1003	一种掩膜版装载盒	发明	ZL201510149035.6	2015-03-31	申请日起二十年	原始取得
1004	改善 ArF 光阻在硅片表面上的黏附性的方法	发明	ZL201510149034.1	2015-03-31	申请日起二十年	原始取得
1005	晶片刻蚀腔室的清洗方法	发明	ZL201510145288.6	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1006	集成目标图形优化与光学邻近修正的方法	发明	ZL201510144598.6	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1007	接触孔的形成方法	发明	ZL201510144276.1	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1008	一种解决光罩图形单元 ESD 现象的处理方法	发明	ZL201510144260.0	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1009	检测刻蚀负载效应的方法	发明	ZL201510144256.4	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1010	一种基于模型的离子析出缺陷改善方法	发明	ZL201510144225.9	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1011	一种晶圆边缘缺陷的检测方法	发明	ZL201510144223.X	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1012	根据集成电路制程能力指数自动调整抽检频率的量测方法	发明	ZL201510144222.5	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1013	一种 TEM 样品制备方法	发明	ZL201510144200.9	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1014	一种提高二维图形解析度的工艺方法	发明	ZL201510144159.5	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1015	栅氧层缺陷检测方法及器件漏电检测方法	发明	ZL201510144158.0	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1016	一种通过显微镜法实现纳米级套刻精度的方法	发明	ZL201510133717.8	2015-03-25	申请日起二十年	原始取得
1017	一种浮栅闪存器件及其编译方法	发明	ZL201510128242.3	2015-03-23	申请日起二十年	原始取得
1018	晶圆可接受性测试机台内部环境的监	发明	ZL201510128230.0	2015-03-23	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	测方法和监测装置					
1019	一种监控电子显微镜真空腔体洁净度的方法	发明	ZL201510126619.1	2015-03-20	申请日起二十年	原始取得
1020	一种检测接触孔过度刻蚀的方法	发明	ZL201510126618.7	2015-03-20	申请日起二十年	原始取得
1021	相邻两个同电位通孔的光学临近修正方法	发明	ZL201510126616.8	2015-03-20	申请日起二十年	原始取得
1022	一种侦测图形底部光刻胶残留的缺陷检测方法	发明	ZL201510126604.5	2015-03-20	申请日起二十年	原始取得
1023	具有用于嵌入锗材料的成形腔的半导体器件及其双沟槽制造工艺	发明	ZL201510079521.5	2015-02-13	申请日起二十年	原始取得
1024	具有用于嵌入锗材料的成形腔的半导体器件及其制造工艺	发明	ZL201510079513.0	2015-02-13	申请日起二十年	原始取得
1025	嵌入式 SiGe 外延测试块的设计	发明	ZL201510050661.X	2015-01-30	申请日起二十年	原始取得
1026	用于改善 SiGe 厚度的均匀性的方法和系统	发明	ZL201510035496.0	2015-01-23	申请日起二十年	原始取得
1027	一种 UV 处理机台工艺性能的日常检查方法	发明	ZL201410714988.8	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1028	一种接触孔刻蚀装置及刻蚀方法	发明	ZL201410714909.3	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1029	ONO 介质层的制备方法	发明	ZL201410714893.6	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1030	消除多晶硅刻蚀工艺中多晶硅残余的方法	发明	ZL201410714842.3	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1031	一种光刻工艺热点的自动修复方法	发明	ZL201410714799.0	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1032	一种改善金属硅化物的方法	发明	ZL201410714798.6	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1033	一种测定薄膜研磨速率的方法	发明	ZL201410710267.X	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1034	一种改善金属硅化物的方法	发明	ZL201410710161.X	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1035	一种离子注入机的预处理方法	发明	ZL201410710134.2	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1036	嵌入式碳化硅的制备方法	发明	ZL201410697561.1	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1037	改善 SiGe CMOS 工艺中 PMOS 器件的电学性能的方法	发明	ZL201410697473.1	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1038	一种采用存储器监测器件制程余量的方法	发明	ZL201410697305.2	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1039	嵌入式锗硅器件的制作方法	发明	ZL201410693124.2	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1040	一种 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201410692996.7	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1041	DC-DC 转换电路	发明	ZL201410692975.5	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1042	NMOS 器件的硅衬底表面的处理方法及 NMOS 器件的制作方法	发明	ZL201410664725.0	2014-11-19	申请日起二十年	原始取得
1043	改善浅沟槽隔离边缘 SiC 应力性能的方法	发明	ZL201410664592.7	2014-11-19	申请日起二十年	原始取得
1044	半导体器件的形成方法	发明	ZL201410664315.6	2014-11-19	申请日起二十年	原始取得
1045	晶圆净化装置、刻蚀机台及大马士革刻蚀方法	发明	ZL201410654598.6	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1046	一种闪存器件及其编程方法	发明	ZL201410654597.1	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1047	一种 SONOS 闪存器件的编译方法	发明	ZL201410654584.4	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1048	一种浮栅闪存器件及其编程方法	发明	ZL201410654582.5	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1049	一种 SONOS 闪存器件及其编译方法	发明	ZL201410654511.5	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1050	一种降低源极和漏极电阻的方法	发明	ZL201410654365.6	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1051	降低源极和漏极电阻的结构和方法	发明	ZL201410654361.8	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1052	一种静电吸盘性能的监测方法	发明	ZL201410652825.1	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1053	一种接触孔关键尺寸的控制方法	发明	ZL201410652823.2	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1054	根据特殊电路结构脱落缺陷确定可疑工艺步骤的方法	发明	ZL201410629236.1	2014-11-10	申请日起二十年	原始取得
1055	后段铜互连工艺中降低通孔间介质材料的 K 值的方法	发明	ZL201410625362.X	2014-11-07	申请日起二十年	原始取得
1056	改善浅沟槽隔离边缘 SiC 应力性能的方法	发明	ZL201410619982.2	2014-11-05	申请日起二十年	原始取得
1057	SiGe 源漏 MOS 器件制造方法	发明	ZL201410619373.7	2014-11-05	申请日起二十年	原始取得
1058	半导体器件的形成方法	发明	ZL201410618097.2	2014-11-05	申请日起二十年	原始取得
1059	一种浅沟槽隔离结构的制造方法	发明	ZL201410597402.4	2014-10-29	申请日起二十年	原始取得
1060	背面探测式光子辐射显微镜装置及测试方法	发明	ZL201410597388.8	2014-10-29	申请日起二十年	原始取得
1061	一种调节高压器件电性的多晶硅刻蚀方法	发明	ZL201410522341.5	2014-09-30	申请日起二十年	原始取得
1062	改善 HCD 氮化硅沉积工艺的应力缺陷的方法	发明	ZL201410520740.8	2014-09-30	申请日起二十年	原始取得
1063	浅沟槽隔离的制造方法	发明	ZL201410491604.0	2014-09-24	申请日起二十年	原始取得
1064	一种探针卡清针装置	发明	ZL201410491591.7	2014-09-24	申请日起二十年	原始取得
1065	铜互连的扩散阻挡层、半导体器件及其制造方法	发明	ZL201410487739.X	2014-09-23	申请日起二十年	原始取得
1066	一种用于制备等离子氮化栅极介质层的方法	发明	ZL201410443794.9	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得
1067	高深宽比沟槽刻蚀残留缺陷的检测方法	发明	ZL201410443792.X	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1068	改善亮场机台缺陷扫描精度的方法	发明	ZL201410443791.5	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得
1069	消息中间件的监控系统	发明	ZL201410443404.8	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得
1070	一种接触孔可靠性测试装置	发明	ZL201410443389.7	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得
1071	一种对图形结构刻蚀能力的检测方法	发明	ZL201410441474.X	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1072	一种用于缺陷分类的光学检测方法	发明	ZL201410441473.5	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1073	一种检测离子阱注入形貌对器件性能影响的方法	发明	ZL201410441471.6	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1074	一种清洗设备颗粒监控的方法	发明	ZL201410441448.7	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1075	预防机台偏移对产品造成机械刮伤的方法	发明	ZL201410441418.6	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1076	一种提高外延机台产能的装置与方法	发明	ZL201410440501.1	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1077	一种刻蚀装置与方法	发明	ZL201410440490.7	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1078	改善晶圆边缘缺陷的装置	发明	ZL201410440477.1	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1079	样品座	发明	ZL201410440457.4	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1080	一种检测图形尺寸对离子阱形貌影响的方法	发明	ZL201410440456.X	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1081	一种检测扫描机台的性能方法	发明	ZL201410440447.0	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1082	一种光罩图形缺陷检测系统及方法	发明	ZL201410440440.9	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1083	减少修正迭代次数的 OPC 方法	发明	ZL201410428712.3	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1084	n 沟道 SONOS 器件及其编译方法	发明	ZL201410428695.3	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1085	一种双接触孔刻蚀停止层的制作方法	发明	ZL201410428687.9	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1086	用于镍硅合金化工艺的阻挡层的制备方法	发明	ZL201410428597.X	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1087	改善激光退火热分布的方法	发明	ZL201410428585.7	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1088	一种光罩自动派工控制方法及控制系统	发明	ZL201410428244.X	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1089	n 沟道非易失性存储元件及其编译方法	发明	ZL201410427477.8	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1090	SONOS 闪存器件及其编译方法	发明	ZL201410427471.0	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1091	闪存器件的编程方法	发明	ZL201410427436.9	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1092	一种提高钴阻挡层沉积选择比的方法	发明	ZL201410427394.9	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1093	电子束缺陷扫描装置及方法	发明	ZL201410414994.1	2014-08-21	申请日起二十年	原始取得
1094	晶圆缺陷扫描方法	发明	ZL201410414597.4	2014-08-21	申请日起二十年	原始取得
1095	梯度式干法去胶方法	发明	ZL201410412283.0	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1096	静态存储器的检测设备及检测方法	发明	ZL201410411989.5	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1097	一种修复超低介质常数薄膜侧壁损伤的方法	发明	ZL201410411975.3	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1098	一种减少超低介质常数薄膜侧壁损伤的方法	发明	ZL201410411972.X	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1099	一种防止化学机械研磨时微观刮伤的研磨方法	发明	ZL201410411838.X	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1100	形成浅沟槽隔离结构的方法	发明	ZL201410410384.4	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1101	末端射程损伤的检测以及修复方法	发明	ZL201410403765.X	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1102	图形预处理方法以及测量图形密度的方法	发明	ZL201410403759.4	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1103	改善 PMOS 器件性能的离子注入方法	发明	ZL201410403757.5	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1104	用于多孔低介电常数材料的紫外光固	发明	ZL201410403729.3	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	化工艺方法					
1105	改善多孔低介电常数材料垂直均匀性的方法	发明	ZL201410403327.3	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1106	半导体制造过程的监控方法及半导体生产方法	发明	ZL201410390822.5	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1107	根据图形特征对自动聚焦光强进行补偿的缺陷检测方法	发明	ZL201410390806.6	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1108	湿法清洗工艺设备颗粒监控方法	发明	ZL201410390799.X	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1109	一种提高同测数的新型测试开发方法	发明	ZL201410390798.5	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1110	通过刻蚀不足缺陷检测多晶硅与连接孔对准度的方法	发明	ZL201410390797.0	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1111	一种浅沟槽隔离结构的制造方法	发明	ZL201410390784.3	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1112	通过栅氧的双氧化提高栅氧均匀性的方法	发明	ZL201410390774.X	2014-09-18	申请日起二十年	原始取得
1113	一种产品通孔刻蚀缺陷的检测方法	发明	ZL201410377465.9	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1114	半导体器件缺陷的光学检测方法	发明	ZL201410377459.3	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1115	晶圆缺陷监控方法	发明	ZL201410377374.5	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1116	静态存储器的在线失效分析方法及在线电子束检测设备	发明	ZL201410377359.0	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1117	量测群组设备及量测方法	发明	ZL201410377345.9	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1118	一种对缺陷进行选择性检测的方法	发明	ZL201410377341.0	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1119	一种具有凸面栅极结构的 B4-Flash	发明	ZL201410375182.0	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1120	一种有效验证探针卡异常的方法	发明	ZL201410374767.0	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1121	气体过滤方法	发明	ZL201410374698.3	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1122	一种具有凸面栅极结构的 B4-Flash	发明	ZL201410374646.6	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1123	一种无结晶体管	发明	ZL201410374634.3	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1124	用于制作嵌入式锗硅的方法	发明	ZL201410374256.9	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1125	曝光辅助图形的优化方法	发明	ZL201410371051.5	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1126	一种透射电镜样品的制备方法	发明	ZL201410370914.7	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1127	测试结构及其测试方法	发明	ZL201410369986.X	2014-07-30	申请日起二十年	原始取得
1128	浅沟槽隔离的工艺方法	发明	ZL201410359893.9	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1129	CMOS 中 P 型源漏离子注入对准度的监控结构及方法	发明	ZL201410357338.2	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1130	P 型轻掺杂离子注入对准度的监控结构及方法	发明	ZL201410357335.9	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1131	N 型轻掺杂离子注入对准度的监控结构及方法	发明	ZL201410357285.4	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1132	利用同型结监控 N 型源漏离子注入对准度的结构及方法	发明	ZL201410357283.5	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1133	恒温测试系统及温度监测方法	发明	ZL201410357245.X	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1134	一种通孔刻蚀不足的检测方法	发明	ZL201410357244.5	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1135	利用同型结监控 N 型轻掺杂离子注入对准度的结构及方法	发明	ZL201410357242.6	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1136	一种改善通孔刻蚀后晶圆表面微环境的方法	发明	ZL201410357201.7	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1137	浅沟槽隔离工艺	发明	ZL201410357183.2	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1138	CMOS 中 N 型源漏注入对准度的监控结构及方法	发明	ZL201410357182.8	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1139	利用同型结监控 P 型轻掺杂离子注入对准度的结构及方法	发明	ZL201410357174.3	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1140	负偏压温度不稳定性评估方法	发明	ZL201410357130.0	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1141	一种通孔刻蚀不足的检测方法	发明	ZL201410357129.8	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1142	形成浅沟槽隔离结构的方法	发明	ZL201410357127.9	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1143	一种消除连接孔刻蚀副产物凝结缺陷的晶圆净化设备	发明	ZL201410357115.6	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1144	炉管清洗工艺	发明	ZL201410356934.9	2014-07-24	申请日起二十年	原始取得
1145	监控图形晶片栅极氧化层表面的方法	发明	ZL201410356924.5	2014-07-24	申请日起二十年	原始取得
1146	监控图形晶片栅极氧化层表面的方法	发明	ZL201410356373.2	2014-07-24	申请日起二十年	原始取得
1147	减少自对准硅化镍尖峰缺陷和管道缺陷的方法	发明	ZL201410331759.8	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1148	半导体制造的多平行动态流程控制方法	发明	ZL201410331742.2	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1149	晶圆边缘非晶碳薄膜清除装置及方法	发明	ZL201410331729.7	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1150	测试结构的断路定位方法	发明	ZL201410331726.3	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1151	OPC 修正方法	发明	ZL201410331704.7	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1152	消除晶圆曝光失焦缺陷的吸盘及方法	发明	ZL201410321501.X	2014-07-08	申请日起二十年	原始取得
1153	半导体工艺方法以及半导体结构	发明	ZL201410315127.2	2014-07-03	申请日起二十年	原始取得
1154	并行测试系统及其测试方法	发明	ZL201410307559.9	2014-06-30	申请日起二十年	原始取得
1155	干氧扩散过程中氧在硅基片中扩散系数的确定方法	发明	ZL201410306975.7	2014-06-30	申请日起二十年	原始取得
1156	一种解决 TEOS 机台保养后颗粒跳高的方法	发明	ZL201410286826.9	2014-06-24	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1157	浸没式光刻工艺方法	发明	ZL201410276008.0	2014-06-19	申请日起二十年	原始取得
1158	掩膜板图形的形成方法和光刻及刻蚀方法	发明	ZL201410275987.8	2014-06-19	申请日起二十年	原始取得
1159	电击穿测试结构	发明	ZL201410274268.4	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1160	半导体器件的制备方法	发明	ZL201410273962.4	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1161	半导体生产约束管控方法	发明	ZL201410273947.X	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1162	SONOS B4-flash 存储器	发明	ZL201410273620.2	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1163	一种提高图形搜索准确率的方法	发明	ZL201410273618.5	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1164	一种晶圆横向水平对准的方法	发明	ZL201410273408.6	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1165	一种晶圆边缘找平的方法	发明	ZL201410273168.X	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1166	光刻机对准性能的检测方法	发明	ZL201410261079.3	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1167	一种在线确定光刻工艺窗口的方法	发明	ZL201410261076.X	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1168	铝刻蚀工艺用聚焦环、铝刻蚀工艺	发明	ZL201410260820.4	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1169	晶圆曝光布局的优化方法	发明	ZL201410260817.2	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1170	一种用于光刻胶厚度摆动曲线测试的硅片及制作方法	发明	ZL201410260816.8	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1171	离子注入层图形线宽尺寸的优化方法	发明	ZL201410260767.8	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1172	机台之机械手臂偏移的检测装置及其检测方法	发明	ZL201410258529.3	2014-06-11	申请日起二十年	原始取得
1173	小尺寸样品层次去除方法	发明	ZL201410254088.X	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1174	一种低功耗高稳定性的复位电路	发明	ZL201410254082.2	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1175	一种采用双侧墙工艺形成超低尺寸图形的方法	发明	ZL201410253948.8	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1176	SRAM 版图的生成方法	发明	ZL201410253555.7	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1177	利用氮注入改善锗硅选择性外延的侧墙淀积问题的方法	发明	ZL201410253551.9	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1178	PMOS 器件漏电测量方法	发明	ZL201410253237.0	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1179	一种采用双侧墙工艺形成超低尺寸图形的方法	发明	ZL201410253213.5	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1180	通孔链结构的失效分析方法	发明	ZL201410253207.X	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1181	半导体芯片失效分析的方法	发明	ZL201410253203.1	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1182	一种化学机械研磨后的清洗装置	发明	ZL201410228259.1	2014-05-27	申请日起二十年	原始取得
1183	铜互连大马士革工艺方法	发明	ZL201410217938.9	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1184	金属互连结构及其制造方法	发明	ZL201410217927.0	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1185	一次性可编程器件的制造方法	发明	ZL201410217798.5	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1186	侧墙结构、侧墙结构的制备方法、CMOS 器件	发明	ZL201410217721.8	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1187	辅助图形的设计方法、测试版图的制作方法、光刻方法	发明	ZL201410217697.8	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1188	一种优化离子注入区域形貌的方法	发明	ZL201410217696.3	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1189	锁存比较器	发明	ZL201410217637.6	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1190	一种内介电层的制备方法	发明	ZL201410217636.1	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1191	一种监控电子显微镜化学油污污染的方法	发明	ZL201410216685.3	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1192	应用晶边扫描预防线状分布缺陷发生的方法	发明	ZL201410216683.4	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1193	一种消除晶边颗粒残留的铝刻蚀前置工艺方法	发明	ZL201410215840.X	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1194	离子注入设备及离子注入方法	发明	ZL201410215837.8	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1195	一种改善晶圆尖峰退火均一性的校准方法	发明	ZL201410215824.0	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1196	单电容振荡器	发明	ZL201410215811.3	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1197	高粘度光刻胶的涂布方法、光刻方法	发明	ZL201410215788.8	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1198	一种探针卡探针的颗粒物清洁控制方法	发明	ZL201410215781.6	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1199	金属互连线拼接版图结构	发明	ZL201410193170.6	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1200	一种低介电常数薄膜的成膜方法	发明	ZL201410193144.3	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1201	一种形成低介电常数薄膜及其缓冲层的成膜方法	发明	ZL201410193143.9	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1202	氧化硅薄膜制备方法	发明	ZL201410192908.7	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1203	硅通孔绝缘层制备方法	发明	ZL201410192894.9	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1204	金属硬掩膜结构、制造方法及铜互连结构制造方法	发明	ZL201410192846.X	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1205	一种用于硅通孔形貌修正的 SiCoNi 蚀刻方法	发明	ZL201410192806.5	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1206	测试结构及其版图生成方法	发明	ZL201410182131.6	2014-04-30	申请日起二十年	原始取得
1207	一种传输晶体管结构	发明	ZL201410174842.9	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1208	一种浅沟槽氧化物空洞和浮栅极多晶硅凹点的消除方法	发明	ZL201410174759.1	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1209	一种有源区制备方法	发明	ZL201410174736.0	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1210	一种用于光阻喷嘴的清洗槽体结构及其应用	发明	ZL201410174612.2	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1211	一种栅极侧墙减薄工艺	发明	ZL201410174441.3	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1212	一个光罩内的单元芯片存在不同图像条件的缺陷扫描方法	发明	ZL201410173942.X	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1213	晶圆回收方法	发明	ZL201410164593.5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1214	一种半导体炉管的晶舟	发明	ZL201410164143.6	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1215	一种缺陷检测和观察设备的位置同步方法	发明	ZL201410164124.3	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1216	用于预防封装时测试结构短路的保护环和封装测试方法	发明	ZL201410164122.4	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1217	一种新的芯片测试结构	发明	ZL201410164090.8	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1218	一种消除有源区损伤的多晶硅刻蚀方法	发明	ZL201410164086.1	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1219	一种离子注入倾角的日常监控方法	发明	ZL201410164080.4	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1220	一种采用温度模型进行曲线拟合的方法	发明	ZL201410164079.1	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1221	一种快速退火装置的监控方法	发明	ZL201410164077.2	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1222	一种闪存的存储单元栅极制备方法	发明	ZL201410164074.9	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1223	一种形成浅沟槽隔离的方法	发明	ZL201410164057.5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1224	一种套刻精度测量的图像结构及其套刻精度测量方法	发明	ZL201410164035.9	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1225	一种管理设备状态转换关系的方法	发明	ZL201410163886.1	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1226	一种提高光刻工艺窗口的版图处理方法	发明	ZL201410163857.5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1227	一种研磨盘装置	发明	ZL201410163591.4	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1228	一种集成电路缺陷的分析方法	发明	ZL201410163560.9	2014-07-28	申请日起二十年	原始取得
1229	降低多晶硅栅极与活化区镍硅化物厚度比的方法	发明	ZL201410163504.5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1230	晶圆测试结果图标记修改方法	发明	ZL201410163495.X	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1231	电流检测电路及包括该电流检测电路的电流环控制电路	发明	ZL201410163453.6	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1232	一种降低在线 WAT 测试对铜互连可靠性影响的方法	发明	ZL201410163450.2	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1233	链式通孔结构样品处理方法及失效测试方法	发明	ZL201410163436.2	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1234	降低多晶硅栅极与活化区镍硅化物厚度比的方法	发明	ZL201410162899.7	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1235	改善器件负偏压温度不稳定性的方法	发明	ZL201410162847.X	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1236	用于监控炉管无氧氛围的监控片、制造方法及其监控方法	发明	ZL201410162818.3	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1237	降低手机时间管理模块漏电的工艺改进方法	发明	ZL201410162700.0	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1238	一种多晶硅上小尺寸图形结构的制备方法	发明	ZL201410161318.8	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1239	一种激光脉冲退火方法	发明	ZL201410161316.9	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1240	一种底部无负载的自对准双层图形的制作方法	发明	ZL201410161257.5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1241	一种监控离子注入机稳定性和均匀性的方法	发明	ZL201410161246.7	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1242	围栅型纳米线晶体管	发明	ZL201410145600.7	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1243	离子注入浓度的校准方法	发明	ZL201410141310.5	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1244	延长超低介电常数材料的工艺等待时间的方法	发明	ZL201410138998.1	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1245	一种改进接触孔线宽均一性的刻蚀方法	发明	ZL201410138996.2	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1246	闪存存储器	发明	ZL201410138977.X	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1247	浸润式光刻机浸润部件的自动清洗装置和清洗方法	发明	ZL201410127033.2	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1248	等离子体刻蚀装置的腔体清洗方法	发明	ZL201410127005.0	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1249	离线机台利用率计算系统及计算方法	发明	ZL201410126994.1	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1250	透射电镜样品的制备方法	发明	ZL201410126975.9	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1251	PMOS 制造工艺中减少 e-SiGe 晶格缺陷的方法	发明	ZL201410125554.4	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1252	用于清洗半导体晶圆的清洗槽	发明	ZL201410125553.X	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1253	一种添加冗余图形的方法	发明	ZL201410125546.X	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1254	原子力显微镜探针装置	发明	ZL201410118223.8	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1255	晶圆良率监测方法	发明	ZL201410118221.9	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1256	原子力显微镜探针装置	发明	ZL201410118215.3	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1257	一种半导体制造试验工艺流程的建立方法	发明	ZL201410118200.7	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1258	一种多晶硅层器件辅助图形的绘制方法	发明	ZL201410118199.8	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1259	一种双栅氧的制备方法	发明	ZL201410118197.9	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1260	一种智能探针卡针压控制系统及控制方法	发明	ZL201410118188.X	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1261	多晶硅残留监测结构	发明	ZL201410117788.4	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1262	PMOS 器件的制造方法	发明	ZL201410117766.8	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1263	一种与激光退火工艺问题相关的排除硅片质量因素的方法	发明	ZL201410117759.8	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1264	一种多通道管控工艺流程的设计方法	发明	ZL201410117735.2	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1265	一种智能化选择性目标尺寸调整方法	发明	ZL201410111322.3	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1266	用于 NDC 薄膜的离线监控方法	发明	ZL201410111309.8	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1267	一种 NAND 闪存器件及其制造方法	发明	ZL201410111308.3	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1268	探针卡识别芯片安装方法	发明	ZL201410111293.0	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1269	晶圆后段电容电性测试结构	发明	ZL201410111285.6	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1270	层间介质层性能的测试结构和测试方法	发明	ZL201410110743.4	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1271	双层栅介质层结构及其制备方法	发明	ZL201410110065.1	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1272	对准图形及晶圆	发明	ZL201410110062.8	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1273	P 型沟道闪存器件及其制造方法	发明	ZL201410110060.9	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1274	用于 WAT 测试的半导体结构	发明	ZL201410110056.2	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1275	监测方法	发明	ZL201410109846.9	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1276	离子注入层的光学临近效应修正方法	发明	ZL201410109835.0	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1277	监测氧化硅沉积工艺中硅损耗的方法	发明	ZL201410109834.6	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1278	减少互补式金氧半导体影像传感器白像素的方法	发明	ZL201410109814.9	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1279	一种优化浅槽隔离刻蚀线宽的方法	发明	ZL201410106820.9	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1280	一种浅沟槽填充方法	发明	ZL201410106819.6	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1281	一种监测低温离子注入的方法	发明	ZL201410106663.1	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1282	一种防止研磨垫刮伤晶圆的系统	发明	ZL201410106660.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1283	读取非易失性存储器电流的方法及获取电流分布状态的方法	发明	ZL201410106658.0	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1284	一种针对光刻版图接触孔热点的检查方法	发明	ZL201410106641.5	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1285	一种验证缺陷检测程序灵敏度的方法	发明	ZL201410106633.0	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1286	一种稳定 MIM 电容光刻线宽的方法	发明	ZL201410106627.5	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1287	一种提高栅氧化层质量的方法	发明	ZL201410106618.6	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1288	一种提高 B4-Flash 器件耐久性的方法	发明	ZL201410106616.7	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1289	一种用于氮掺杂碳化硅薄膜的离线监控方法	发明	ZL201410106607.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1290	采用电容衬度测试结构检测多晶硅底部桥连缺陷的方法	发明	ZL201410106602.5	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1291	一种测试样品的制备方法	发明	ZL201410106589.3	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1292	一种形成浅沟槽隔离的方法	发明	ZL201410106568.1	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1293	一种用于锁相环电路的锁定检测电路	发明	ZL201410106552.0	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1294	对没有重复分界的存储区域进行扫描的方法	发明	ZL201410106540.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1295	一种降低镍管道缺陷的方法	发明	ZL201410106537.6	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1296	控制栅极刻蚀方法	发明	ZL201410106533.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1297	一种降低源漏外延生长缺陷的方法	发明	ZL201410106521.5	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1298	一种金属电迁移结构	发明	ZL201410106505.6	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1299	一种减少 OPC 修正后验证误报错的方法	发明	ZL201410106502.2	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1300	探针卡	发明	ZL201410106479.7	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1301	一种优化等离子体均匀性的压力控制阀门及方法	发明	ZL201410106477.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1302	离子注入段问题机台的判定方法	发明	ZL201410060668.5	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1303	芯片分区采集最佳光线偏振信号的缺陷程式建立方法	发明	ZL201410060660.9	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1304	一种晶圆可接受测试方法	发明	ZL201410060659.6	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1305	具有毛刺抑制能力的电流舵型数模转换电路	发明	ZL201410060641.6	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1306	用于湿法刻蚀工艺的酸槽	发明	ZL201410060590.7	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1307	采用电容测试结构检测多晶硅栅极刻蚀缺陷的方法	发明	ZL201410060338.6	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1308	一种检测多晶硅残留的测试结构	发明	ZL201410060317.4	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1309	一种 WAT 测试的备份结构及备份方法	发明	ZL201410060309.X	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1310	采用小窗口图形测试结构检测多晶硅底部桥连缺陷的方法	发明	ZL201410060130.4	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1311	一种高压晶体管制备工艺	发明	ZL201410060105.6	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1312	一种晶圆可接受性测试的探针卡自动更换方法	发明	ZL201410059971.3	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1313	采用离子击穿检测多晶硅底部刻蚀不足缺陷的方法	发明	ZL201410059958.8	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1314	一种通用型针座及其使用方法	发明	ZL201410059942.7	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1315	制备嵌入式锗硅外延前的表面处理方法	发明	ZL201410042486.5	2014-01-29	申请日起二十年	原始取得
1316	用于激光退火机的监控方法	发明	ZL201410042474.2	2014-01-29	申请日起二十年	原始取得
1317	改善工艺窗口的光学临近修正方法	发明	ZL201410042455.X	2014-01-29	申请日起二十年	原始取得
1318	自动扩展缺陷图形库的方法	发明	ZL201410042444.1	2014-01-29	申请日起二十年	原始取得
1319	一种制备空气间隙铜互连结构的方法	发明	ZL201310637734.6	2013-12-02	申请日起二十年	原始取得
1320	一种利用高深宽比工艺的器件隔离方法	发明	ZL201310632125.1	2013-12-02	申请日起二十年	原始取得
1321	晶圆多次测试数据的整合方法	发明	ZL201310631845.6	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1322	多层薄膜层间粘附性能表征及其试样制备方法	发明	ZL201310631772.0	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1323	浮栅晶体管阵列及其制备方法	发明	ZL201310631488.3	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1324	电流舵数模转换器电流源阵列的版图结构	发明	ZL201310631462.9	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1325	通孔或接触孔的形成方法	发明	ZL201310631359.4	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1326	双大马士革结构的制造方法	发明	ZL201310631357.5	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1327	控制多晶硅栅极关键尺寸的方法	发明	ZL201310630338.0	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1328	离子注入角度监控方法	发明	ZL201310630276.3	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1329	干法工艺稳定性和匹配性的判断方法	发明	ZL201310630263.6	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1330	CMOS 器件栅氧化层的制造方法	发明	ZL201310630240.5	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1331	双大马士革结构的制造方法	发明	ZL201310630206.8	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1332	改善 HDP PSG 工艺的方法及金属沉积前的介电质层制造方法	发明	ZL201310625737.8	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1333	基于规则图形过滤的版图设计光刻工艺友善性检查方法	发明	ZL201310625726.X	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1334	CMOS 感光器件接触孔刻蚀方法及 CMOS 感光器件制造方法	发明	ZL201310625589.X	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1335	TEM 样品的制作方法及其 TEM 样品	发明	ZL201310625537.2	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1336	一种晶圆可接受性测试系统及方法	发明	ZL201310625206.9	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1337	一种铝衬垫制备方法	发明	ZL201310625197.3	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1338	栅极侧墙图形化的方法	发明	ZL201310616217.0	2013-11-26	申请日起二十年	原始取得
1339	一种 WAT 测试头的布置方法	发明	ZL201310612743.X	2013-11-26	申请日起二十年	原始取得
1340	一种低介电常数薄膜的紫外线处理方法	发明	ZL201310612730.2	2013-11-26	申请日起二十年	原始取得
1341	十字型探针卡	发明	ZL201310565733.5	2013-11-13	申请日起二十年	原始取得
1342	三维容错性自寻路径交叉开关矩阵设备	发明	ZL201310565679.4	2013-11-13	申请日起二十年	原始取得
1343	一种浅沟槽隔离结构的形成方法	发明	ZL201310565677.5	2013-11-13	申请日起二十年	原始取得
1344	一种炉管设备的组批派工系统和方法	发明	ZL201310554674.1	2013-11-08	申请日起二十年	原始取得
1345	DRC 文件的坐标数据对比方法	发明	ZL201310554644.0	2013-11-08	申请日起二十年	原始取得
1346	一种软启动电路及包括该软启动电路的 DC-DC 电路	发明	ZL201310554631.3	2013-11-08	申请日起二十年	原始取得
1347	开关装置及具有该开关装置的多通道耦合选择器	发明	ZL201310554295.2	2013-11-08	申请日起二十年	原始取得
1348	浅沟槽隔离结构制备方法	发明	ZL201310530767.0	2013-10-30	申请日起二十年	原始取得
1349	曝光机文件自动检查系统	发明	ZL201310506771.3	2013-10-23	申请日起二十年	原始取得
1350	SECS/GEM 消息交换设备和方法	发明	ZL201310505310.4	2013-10-23	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1351	一种形成多层复合式接触孔刻蚀阻挡层的方法	发明	ZL201310505137.8	2013-10-23	申请日起二十年	原始取得
1352	多种类硅化物掩膜层的形成方法	发明	ZL201310505099.6	2013-10-23	申请日起二十年	原始取得
1353	一种 CMOS 图像传感器有源像素的结构及其制造方法	发明	ZL201310495735.1	2013-10-21	申请日起二十年	原始取得
1354	减小负偏压温度不稳定性的 CMOS 器件制作方法	发明	ZL201310492053.5	2013-10-18	申请日起二十年	原始取得
1355	一种金属硬掩膜层及铜互连结构的制备方法	发明	ZL201310491799.4	2013-10-18	申请日起二十年	原始取得
1356	一种光刻胶填充式金属互连结构及其制造方法	发明	ZL201310491613.5	2013-10-18	申请日起二十年	原始取得
1357	嵌入式锗硅工艺中静态随机存储器及写入冗余度改善方法	发明	ZL201310491611.6	2013-10-18	申请日起二十年	原始取得
1358	一种用于非晶碳沉积工艺中的清洗方法	发明	ZL201310461217.8	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
1359	一种在芯片失效分析过程中去除层次的方法	发明	ZL201310460450.4	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
1360	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310449849.2	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1361	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432459.4	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1362	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432456.0	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1363	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432448.6	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1364	制作栅极线条的方法	发明	ZL201310432435.9	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1365	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432414.7	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1366	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方	发明	ZL201310432385.4	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	法					
1367	能简化极小线宽栅极线条的制作工艺的栅极线条制作方法	发明	ZL201310432087.5	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1368	一种可按照离子注入区域分类的电子束缺陷检测方法	发明	ZL201310432063.X	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1369	解决氮化硅和镍硅化物界面剥落问题的工艺方法	发明	ZL201310432018.4	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1370	提高源漏接触和氮化硅薄膜黏附力的方法	发明	ZL201310432014.6	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1371	一种金属硬掩膜层及铜互连结构的制备方法	发明	ZL201310380002.3	2013-08-27	申请日起二十年	原始取得
1372	应用于栅极线尾切割的双重图形成型方法	发明	ZL201310360830.0	2013-08-16	申请日起二十年	原始取得
1373	栅极 LELE 双重图形成型方法	发明	ZL201310360404.7	2013-08-16	申请日起二十年	原始取得
1374	基于 DARC 掩膜结构的栅极 LELE 双重图形成型方法	发明	ZL201310360385.8	2013-08-16	申请日起二十年	原始取得
1375	基于 DARC 掩膜结构的双重图形成型方法	发明	ZL201310360384.3	2013-08-16	申请日起二十年	原始取得
1376	双深度浅沟道隔离槽的刻蚀工艺	发明	ZL201310354785.8	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1377	多晶硅炉管生长厚度监测方法	发明	ZL201310354782.4	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1378	高压 ESD 器件版图结构以及包含该版图结构的芯片	发明	ZL201310354719.0	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1379	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354689.3	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1380	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354686.X	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1381	浅沟槽隔离工艺	发明	ZL201310354616.4	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1382	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354609.4	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1383	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354608.X	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1384	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354606.0	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1385	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354604.1	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1386	接触孔的刻蚀方法	发明	ZL201310354603.7	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1387	改善有源区损伤的方法	发明	ZL201310337067.X	2013-08-02	申请日起二十年	原始取得
1388	SRAM 失配晶体管检测方法	发明	ZL201310317737.1	2013-07-25	申请日起二十年	原始取得
1389	用于测试 MIM 电容的半导体结构	发明	ZL201310312455.2	2013-07-23	申请日起二十年	原始取得
1390	SONOS 器件中 ONO 结构的制造方法	发明	ZL201310302913.4	2013-07-18	申请日起二十年	原始取得
1391	高压 NPN 器件及其版图结构	发明	ZL201310286451.1	2013-07-09	申请日起二十年	原始取得
1392	检测通孔蚀刻不足和通孔缺失缺陷的方法	发明	ZL201310286389.6	2013-07-09	申请日起二十年	原始取得
1393	改善电容器件击穿电压的方法	发明	ZL201310265059.9	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1394	一种可按照工艺晶圆数量负载动态调整的缺陷抽检方法	发明	ZL201310264843.8	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1395	增强光刻工艺能力的装置及利用该装置进行的光刻工艺	发明	ZL201310264730.8	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1396	检测多晶硅栅极与接触孔对准度的方法	发明	ZL201310264726.1	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1397	双结构接触孔同步刻蚀工艺	发明	ZL201310264711.5	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1398	改善栅氧有源区缺陷的方法	发明	ZL201310264408.5	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1399	检测接触孔与多晶硅栅极对准度的方法	发明	ZL201310262927.8	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1400	抗反射涂层填充式超低介电常数之铜互连制造方法	发明	ZL201310262907.0	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1401	版图数据的处理方法	发明	ZL201310258304.3	2013-06-26	申请日起二十年	原始取得
1402	栅极的形成方法	发明	ZL201310258301.X	2013-06-26	申请日起二十年	原始取得
1403	测算接触孔与多晶硅栅极对准偏差值的方法	发明	ZL201310256841.4	2013-06-25	申请日起二十年	原始取得
1404	测算接触孔与多晶硅栅极对准偏差值的方法	发明	ZL201310256206.6	2013-06-25	申请日起二十年	原始取得
1405	保护浅沟槽隔离区的方法	发明	ZL201310253617.X	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1406	改善硅片背面金属污染的方法	发明	ZL201310253594.2	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1407	改善 GP CMOS 器件的电性参数均一性的方法	发明	ZL201310253193.7	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1408	一种多功能半导体样品夹具	发明	ZL201310253153.2	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1409	改善半导体器件电性参数的方法	发明	ZL201310253134.X	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1410	光学临近效应修正方法	发明	ZL201310229404.3	2013-06-08	申请日起二十年	原始取得
1411	改善半导体器件良率的方法	发明	ZL201310222267.0	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1412	一种制备铜种子层的方法	发明	ZL201310221366.7	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1413	改善 CMOS 图像传感器性能的方法	发明	ZL201310221336.6	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1414	一种快速高效的晶背缺陷识别方法	发明	ZL201310220498.8	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1415	flash 抗编程串扰的优化方法	发明	ZL201310220497.3	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1416	一种缺陷扫描结果控制制程机台的派工方法	发明	ZL201310220485.0	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1417	改善半导体器件负偏压温度不稳定性的方法	发明	ZL201310220483.1	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1418	∑形凹槽的制作方法	发明	ZL201310217267.1	2013-06-03	申请日起二十年	原始取得
1419	化学气相沉积室的清洁方法	发明	ZL201310213637.4	2013-05-31	申请日起二十年	原始取得
1420	一种提高叠对测量精度的方法	发明	ZL201310213617.7	2013-05-31	申请日起二十年	原始取得
1421	采用双极曝光方式的光刻装置、通光单元及光刻方法	发明	ZL201310211966.5	2013-05-31	申请日起二十年	原始取得
1422	具有环形透光光圈的光刻装置、通光单元及光刻方法	发明	ZL201310211954.2	2013-05-31	申请日起二十年	原始取得
1423	一种磷酸硅玻璃薄膜的等离子体化学气相沉积方法	发明	ZL201310196276.7	2013-05-23	申请日起二十年	原始取得
1424	降低冗余金属耦合电容的通孔优先双大马士革铜互连方法	发明	ZL201310196254.0	2013-05-23	申请日起二十年	原始取得
1425	光刻胶的处理方法以及半导体器件的制备方法	发明	ZL201310195621.5	2013-05-23	申请日起二十年	原始取得
1426	降低冗余金属耦合电容的通孔优先双大马士革铜互连方法	发明	ZL201310195572.5	2013-05-23	申请日起二十年	原始取得
1427	双栅氧器件的制造方法	发明	ZL201310177577.5	2013-05-14	申请日起二十年	原始取得
1428	膜厚量测机台中颗粒的监控方法及控片	发明	ZL201310166041.3	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1429	CMOS 带隙基准源电路	发明	ZL201310166026.9	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1430	监控制程稳定性的测试模块和方法	发明	ZL201310165992.9	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1431	CMOS 电荷泵电路	发明	ZL201310165971.7	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1432	TEM 样品的制备方法	发明	ZL201310165226.2	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1433	提高高压器件浅沟槽隔离性能的方法	发明	ZL201310165188.0	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1434	一种在 SiGe BiCMOS 工艺中寄生的 PNP 管及其制造方法	发明	ZL201310164260.8	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1435	一种双层浅沟槽隔离结构、制备方法及横向扩散 MOS 管	发明	ZL201310157307.8	2013-05-02	申请日起二十年	原始取得
1436	晶体管及其沟道长度的形成方法	发明	ZL201310157253.5	2013-05-02	申请日起二十年	原始取得
1437	一种控制晶圆温度的等离子体刻蚀腔室及其方法	发明	ZL201310157252.0	2013-05-02	申请日起二十年	原始取得
1438	∑形凹槽的制作方法	发明	ZL201310156183.1	2013-04-28	申请日起二十年	原始取得
1439	半导体芯片的版图图层设计方法及其掩膜板	发明	ZL201310153678.9	2013-04-28	申请日起二十年	原始取得
1440	半导体器件的制造方法	发明	ZL201310122105.X	2013-04-09	申请日起二十年	原始取得
1441	一种制备栅极氧化层的方法	发明	ZL201310120029.9	2013-04-08	申请日起二十年	原始取得
1442	浅沟槽隔离工艺	发明	ZL201310119905.6	2013-04-08	申请日起二十年	原始取得
1443	一种形成超浅结面的方法	发明	ZL201310119895.6	2013-04-08	申请日起二十年	原始取得
1444	一种栅氧化层的制备方法	发明	ZL201310085199.8	2013-03-15	申请日起二十年	原始取得
1445	金属沟槽的刻蚀方法	发明	ZL201310085181.8	2013-03-15	申请日起二十年	原始取得
1446	实现浅沟道隔离的工艺方法	发明	ZL201310085158.9	2013-03-15	申请日起二十年	原始取得
1447	金属硬质掩模结构的修复方法	发明	ZL201310084505.6	2013-03-15	申请日起二十年	原始取得
1448	一种 Σ 型硅沟槽的制造方法	发明	ZL201310082117.4	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1449	TEM 样品的制备方法	发明	ZL201310082083.9	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1450	掩膜版的自动化管理系统及方法	发明	ZL201310082060.8	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1451	检测研磨工艺负载效应的方法	发明	ZL201310082029.4	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1452	一种形成硅化物阻挡层的方法	发明	ZL201310081989.9	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1453	一种 U 型沟槽的制造方法	发明	ZL201310081961.5	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1454	一种二氧化硅金属阻挡层的淀积方法	发明	ZL201310081930.X	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1455	一组应用于双大马士革金属互连工艺的光掩模	发明	ZL201310081912.1	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1456	提高 PMOS 栅氧负偏压温度不稳定性的方法	发明	ZL201310081898.5	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1457	去除 BPSG 薄膜中散射状颗粒的方法	发明	ZL201310081872.0	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1458	涂布装置及其涂布方法	发明	ZL201310062544.6	2013-02-27	申请日起二十年	原始取得
1459	实现浅沟槽隔离的工艺方法	发明	ZL201310062525.3	2013-02-27	申请日起二十年	原始取得
1460	互连电迁移的测试结构	发明	ZL201310062231.0	2013-02-27	申请日起二十年	原始取得
1461	一种氧化反应炉及利用该反应炉进行氧化反应的方法	发明	ZL201310055077.4	2013-02-20	申请日起二十年	原始取得
1462	一种侦测硅片平坦度的装置及方法	发明	ZL201210501282.4	2012-11-30	申请日起二十年	原始取得
1463	优化浅槽隔离刻蚀工艺的方法	发明	ZL201210501020.8	2012-11-29	申请日起二十年	原始取得
1464	浅沟槽隔离之边角圆化的方法	发明	ZL201210496571.X	2012-11-28	申请日起二十年	原始取得
1465	铜金属覆盖层的制备方法	发明	ZL201210496254.8	2012-11-28	申请日起二十年	原始取得
1466	湿法刻蚀装置及其刻蚀方法	发明	ZL201210496197.3	2012-11-28	申请日起二十年	原始取得
1467	一种研磨垫及利用该研磨垫进行研磨时的损耗检测方法	发明	ZL201210493978.7	2012-11-28	申请日起二十年	原始取得
1468	铜金属覆盖层的制备方法	发明	ZL201210451889.6	2012-11-12	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1469	双应力薄膜的制造方法以及半导体器件	发明	ZL201210451699.4	2012-11-12	申请日起二十年	原始取得
1470	接触孔的制作方法	发明	ZL201210451655.1	2012-11-12	申请日起二十年	原始取得
1471	接触孔的制作方法	发明	ZL201210451318.2	2012-11-12	申请日起二十年	原始取得
1472	一种 B4-flash 器件及其制作方法	发明	ZL201210432508.X	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1473	一种监控设备运行状态的系统及方法	发明	ZL201210432475.9	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1474	一种铜互联线的制作工艺	发明	ZL201210432401.5	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1475	一种磁阻存储器的环状存储单元的制作方法	发明	ZL201210432398.7	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1476	一种检测半导体圆形接触孔圆度的方法	发明	ZL201210432250.3	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1477	一种介电常数可调整的金属互连层及其制作方法	发明	ZL201210432249.0	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1478	铜金属覆盖层的制备方法	发明	ZL201210389028.X	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1479	检测光刻机对图形模糊成像控制能力的方法	发明	ZL201210389026.0	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1480	机台传送部件自清洗方法以及机台传送部件	发明	ZL201210388933.3	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1481	通孔优先铜互连制作方法	发明	ZL201210388834.5	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1482	多晶硅栅极刻蚀方法	发明	ZL201210388740.8	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1483	一种提高 MOM 电容密度的方法	发明	ZL201210380938.1	2012-10-09	申请日起二十年	原始取得
1484	提高 MOM 电容密度的方法	发明	ZL201210380920.1	2012-10-09	申请日起二十年	原始取得
1485	一种形成双深度隔离沟槽的方法	发明	ZL201210375753.1	2012-10-08	申请日起二十年	原始取得
1486	一种简化存储器中字线介电质膜刻蚀	发明	ZL201210375725.X	2012-10-08	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	成型工艺的方法					
1487	炉管挡片结构制造方法	发明	ZL201210352952.0	2012-09-19	申请日起二十年	原始取得
1488	一种增大 MOM 电容密度的制造工艺方法	发明	ZL201210345797.X	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1489	一种形成磁阻存储器环状存储单元的方法	发明	ZL201210343578.8	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1490	一种具有多孔结构的双大马士革结构	发明	ZL201210343547.2	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1491	一种对 40/45 纳米工艺金属硬光罩结构的缺陷解决方案	发明	ZL201210343527.5	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1492	改善掺杂与非掺杂多晶硅栅极刻蚀形貌差异的方法	发明	ZL201210343505.9	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1493	一种对 40/45 纳米工艺金属硬光罩结构的缺陷解决方案	发明	ZL201210343463.9	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1494	一种带有空气间隙的大马士革工艺	发明	ZL201210341832.0	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1495	一种提高 Cu CMP 效率的方法	发明	ZL201210341662.6	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1496	一种制备顶层金属互联工艺刻蚀中间停止层的方法	发明	ZL201210341630.6	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1497	双大马士革结构中底部抗反射涂层的刻蚀方法	发明	ZL201210335545.9	2012-09-11	申请日起二十年	原始取得
1498	提高 MOM 电容密度的方法	发明	ZL201210335529.X	2012-09-11	申请日起二十年	原始取得
1499	一种铜互联线的制作工艺	发明	ZL201210333872.0	2012-09-11	申请日起二十年	原始取得
1500	一种双位 NROM 存储器及提高其电子注入效率的方法和结构	发明	ZL201210333706.0	2012-09-11	申请日起二十年	原始取得
1501	提高通孔图形性能表现的方法	发明	ZL201210293369.7	2012-08-16	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1502	改善刻蚀形貌并提升可靠性的铜互连制备方法	发明	ZL201210292646.2	2012-08-16	申请日起二十年	原始取得
1503	半导体器件的制造方法	发明	ZL201210292632.0	2012-08-16	申请日起二十年	原始取得
1504	改善可靠性的铜互连层制备方法及半导体器件	发明	ZL201210292621.2	2012-08-16	申请日起二十年	原始取得
1505	通孔优先铜互连制作方法	发明	ZL201210264541.6	2012-07-27	申请日起二十年	原始取得
1506	一种消除侧墙宽度负载效应的工艺	发明	ZL201210259241.9	2012-07-25	申请日起二十年	原始取得
1507	一种有效判定铜扩散阻挡层阻挡能力的方法	发明	ZL201210259216.0	2012-07-25	申请日起二十年	原始取得
1508	一种形成无负载效应大尺寸沟槽的方法	发明	ZL201210259010.8	2012-07-25	申请日起二十年	原始取得
1509	CMOS 图像传感器及其制作方法	发明	ZL201210229018.X	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1510	一种具有低操作电压的 NROM 结构器件	发明	ZL201210228272.8	2012-07-04	申请日起二十年	原始取得
1511	一种利用非对称分层势垒提高 SONNS 结构器件可靠性的方法	发明	ZL201210225804.2	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1512	一种浅沟槽隔离工艺研磨装置及其使用方法	发明	ZL201210225801.9	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1513	一种去除晶圆上 SiGe 薄膜的方法	发明	ZL201210225796.1	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1514	一种具有低操作电压的 SONOS 结构器件	发明	ZL201210225786.8	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1515	测算半导体器件井区注入离子横向扩散能力的方法	发明	ZL201210225784.9	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1516	超低介电材料的化学机械抛光方法	发明	ZL201210220362.2	2012-06-28	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1517	NMOS 器件制作方法	发明	ZL201210209049.9	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1518	NMOS 器件制作方法	发明	ZL201210209048.4	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1519	金属硬掩膜层制备方法以及半导体制造方法	发明	ZL201210208994.7	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1520	NMOS 器件制作方法	发明	ZL201210208991.3	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1521	使用应力记忆技术的半导体器件制造方法	发明	ZL201210208961.2	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1522	双应力氮化硅蚀刻阻挡层形成方法和半导体器件制造方法	发明	ZL201210208909.7	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1523	使用应力记忆技术的半导体器件制造方法	发明	ZL201210208906.3	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1524	一种形成厚度均匀二氧化硅侧墙的方法	发明	ZL201210204506.5	2012-06-20	申请日起二十年	原始取得
1525	一种检测接触孔和多晶硅栅极对准度的方法	发明	ZL201210204463.0	2012-06-20	申请日起二十年	原始取得
1526	一种具有低编译电压捕获电荷的 BE-SONOS 结构器件及形成方法	发明	ZL201210204452.2	2012-06-20	申请日起二十年	原始取得
1527	一种短沟道围栅结构 MOSFET 的阈值电压解析模型	发明	ZL201210204444.8	2012-06-20	申请日起二十年	原始取得
1528	SONOS 栅极结构及其制备方法、以及半导体器件	发明	ZL201210170390.8	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1529	提高载流子迁移率的 PMOS 器件的制作方法及器件结构	发明	ZL201210170354.1	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1530	一次性可编程器件以及集成电路	发明	ZL201210169827.6	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1531	利用应力技术提高 SONOS 结构器件编译速度的方法	发明	ZL201210169810.0	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1532	提高载流子迁移率的 CMOS 器件的制作方法及器件结构	发明	ZL201210169809.8	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1533	一次性可编程器件以及集成电路	发明	ZL201210169500.9	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1534	降低 N 型掺杂和非掺杂多晶硅栅极刻蚀后形貌差异的方法	发明	ZL201210163138.4	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1535	一种具有低操作电压的 BE-SONOS 结构器件及形成方法	发明	ZL201210158901.4	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1536	一种形成双应力层氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201210158843.5	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1537	一种形成半导体通孔的方法	发明	ZL201210158835.0	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1538	一种形成双应力刻蚀阻挡层的方法	发明	ZL201210158828.0	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1539	一种形成双应力刻蚀阻挡层的方法	发明	ZL201210158826.1	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1540	一种用于 45 纳米及以下技术节点的金属前介质集成工艺	发明	ZL201210136032.5	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1541	一种离子注入阻挡层的制作方法	发明	ZL201210136017.0	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1542	一种提高金属-绝缘体-金属电容器可靠性的方法及其工艺结构	发明	ZL201210136004.3	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1543	一种提高金属-绝缘体-金属电容器介电质质量的方法	发明	ZL201210135983.0	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1544	一种用于 45 纳米及以下技术节点的金属前介质集成工艺	发明	ZL201210135982.6	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1545	基于 SOI 的后栅型积累模式 Si-NWFET 制备方法	发明	ZL201210135272.3	2012-05-03	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1546	SOI 上双层隔离混合晶向后栅型反型模式 SiNWFET 的制备方法	发明	ZL201210133935.8	2012-05-03	申请日起二十年	原始取得
1547	多层金属-氧化硅-金属电容器的制作方法	发明	ZL201210116158.6	2012-04-20	申请日起二十年	原始取得
1548	一种形成双应力层氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201210114142.1	2012-04-17	申请日起二十年	原始取得
1549	一种形成双应力层氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201210114141.7	2012-04-17	申请日起二十年	原始取得
1550	连接孔的形成方法	发明	ZL201210114135.1	2012-04-17	申请日起二十年	原始取得
1551	一种形成双应力层氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201210113716.3	2012-04-17	申请日起二十年	原始取得
1552	多层金属-多层绝缘体-金属电容器的制作方法	发明	ZL201210109591.7	2012-04-16	申请日起二十年	原始取得
1553	一种成型无定形碳牺牲栅极的基体的制备方法	发明	ZL201210109584.7	2012-04-16	申请日起二十年	原始取得
1554	一种无定形碳牺牲栅极结构的浅结和侧墙的制备方法	发明	ZL201210109582.8	2012-04-16	申请日起二十年	原始取得
1555	一种防止磷硅酸盐玻璃或硼磷硅酸盐玻璃薄膜吸水的方法	发明	ZL201210100763.4	2012-04-09	申请日起二十年	原始取得
1556	一种制备无定形碳牺牲栅极结构的浅结和侧墙的方法	发明	ZL201210098261.2	2012-04-06	申请日起二十年	原始取得
1557	一种埋入式可编程闪存器件及其控制方法	发明	ZL201210098232.6	2012-04-06	申请日起二十年	原始取得
1558	提高静态随机存储器写入冗余度的方法	发明	ZL201210093940.0	2012-03-31	申请日起二十年	原始取得
1559	基于体硅的纵向堆叠式后栅型 SiNWFET 制备方法	发明	ZL201210093913.3	2012-03-31	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1560	金属-多层绝缘体-金属电容器及其制造方法、集成电路	发明	ZL201210081402.X	2012-03-23	申请日起二十年	原始取得
1561	金属-多层绝缘体-金属电容器及其制造方法、集成电路	发明	ZL201210081401.5	2012-03-23	申请日起二十年	原始取得
1562	一种表征多层栅极中多晶硅电阻的方法	发明	ZL201210077724.7	2012-03-22	申请日起二十年	原始取得
1563	一种形成双应力刻蚀阻挡层及前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064639.7	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1564	一种形成前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064629.3	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1565	一种形成前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064628.9	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1566	一种形成前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064615.1	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1567	一种形成前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064614.7	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1568	双层隔离纵向堆叠式半导体纳米线 MOSFET	发明	ZL201210050780.1	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1569	一种用于铜互连冗余金属图形的插入算法	发明	ZL201210049162.5	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1570	一种超低介电常数薄膜生长中形成渐进二氧化硅层的方法	发明	ZL201210047381.X	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1571	一种利用应变硅技术提高 SONOS 的擦写速度的方法	发明	ZL201210047380.5	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1572	一种增加浅沟槽隔离压应力提高 NMOS 电子迁移率的方法	发明	ZL201210047378.8	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1573	一种用于栅极侧墙的二氧化硅薄膜的沉积方法	发明	ZL201210046161.5	2012-02-27	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1574	一种宽频带锁相环频率综合器电路	发明	ZL201210016167.8	2012-01-18	申请日起二十年	原始取得
1575	一种栅极图形尺寸收缩方法	发明	ZL201210014989.2	2012-01-18	申请日起二十年	原始取得
1576	SONOS 结构制造方法以及 SONOS 结构	发明	ZL201210009215.0	2012-01-12	申请日起二十年	原始取得
1577	双位氮化硅只读存储器制造方法及双位氮化硅只读存储器	发明	ZL201210009093.5	2012-01-12	申请日起二十年	原始取得
1578	改善高密度等离子体化学气相淀积的磷硅玻璃形貌的方法	发明	ZL201210009089.9	2012-01-12	申请日起二十年	原始取得
1579	一种形成高阶电常数 K 和 T 型金属栅极的形成方法	发明	ZL201110393469.2	2011-12-02	申请日起二十年	原始取得
1580	用于等离子体刻蚀的先进工艺控制方法	发明	ZL201110392794.7	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1581	一种相位移焦距检测光罩及制造方法及检测焦距差的方法	发明	ZL201110392792.8	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1582	一种低介电常数阻挡层工艺中的预处理的监控方法及装置	发明	ZL201110392783.9	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1583	一种金属-氧化物-金属电容的制作方法	发明	ZL201110392608.X	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1584	金属-氧化物-金属电容的制作方法	发明	ZL201110392607.5	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1585	一种多层金属-氧化物-金属电容的制作方法	发明	ZL201110391743.2	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1586	一种多层金属-氧化硅-金属电容的制作方法	发明	ZL201110391732.4	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1587	用于等离子体刻蚀结构的光学探测方	发明	ZL201110391728.8	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	法及计算机辅助系统					
1588	一种光刻机曝光方法	发明	ZL201110391163.3	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1589	CMOS 半导体器件及其制造方法	发明	ZL201110389208.3	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1590	可降低方块电阻的铜互连结构的制造方法	发明	ZL201110388945.1	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1591	应力记忆作用的半导体器件及其制造方法	发明	ZL201110388942.8	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1592	PMOS 源漏区离子注入方法及相应的器件制造方法	发明	ZL201110388784.6	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1593	可降低方块电阻的铜互连结构的制造方法	发明	ZL201110388783.1	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1594	一种形成厚金属的单大马士革方法	发明	ZL201110388371.8	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1595	一种双镶嵌结构的形成方法	发明	ZL201110386916.1	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1596	一种提高金属绝缘层金属电容层多次光刻重复性的方法	发明	ZL201110386908.7	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1597	一种降低铜互连方块电阻的单大马士革方法	发明	ZL201110386892.X	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1598	一种形成高介电常数 K 和 T 型金属栅极的形成方法	发明	ZL201110386890.0	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1599	具有部分冗余通孔的集成电路制作方法及集成电路	发明	ZL201110386297.6	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1600	具有部分冗余通孔的集成电路制作方法及集成电路	发明	ZL201110386296.1	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1601	具有部分冗余通孔的集成电路制作方	发明	ZL201110386112.1	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	法及集成电路					
1602	扫描电子显微镜的检测方法	发明	ZL201110386090.9	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1603	一种降低铜互连方块电阻的全光阻双大马士革方法	发明	ZL201110385563.3	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1604	一种利用上掩膜实现铜互连的方法	发明	ZL201110384049.8	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1605	一种半导体制程中的偏移管理的良率提升系统	发明	ZL201110384048.3	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1606	一种利用上掩膜实现高性能铜互连的方法	发明	ZL201110384046.4	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1607	一种半导体制程中的设备监控方法	发明	ZL201110384000.2	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1608	钨生长控制设备及方法	发明	ZL201110379861.1	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1609	提高空穴迁移率的方法以及半导体器件制造方法	发明	ZL201110379854.1	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1610	通孔刻蚀方法、集成电路制造方法和集成电路	发明	ZL201110379853.7	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1611	铜填充硅通孔的制作方法	发明	ZL201110379852.2	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1612	具有空气侧墙的 CMOS 制作方法	发明	ZL201110379535.0	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1613	光刻机投影物镜温度均衡装置及均衡方法	发明	ZL201110374963.4	2011-11-22	申请日起二十年	原始取得
1614	提高浮体效应存储单元写入速度的方法及半导体器件	发明	ZL201110366206.2	2011-11-17	申请日起二十年	原始取得
1615	提高浮体效应存储单元写入速度的方法及半导体器件	发明	ZL201110366188.8	2011-11-17	申请日起二十年	原始取得
1616	接触孔刻蚀方法、集成电路制造方法	发明	ZL201110366186.9	2011-11-17	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	以及集成电路					
1617	一种多层金属-氮化硅-金属电容的制造方法	发明	ZL201110361155.4	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1618	一种金属-氮化硅-金属电容的制造方法	发明	ZL201110361154.X	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1619	一种多层金属-氮化硅-金属电容及其制作方法	发明	ZL201110361149.9	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1620	一种导电聚合物凝胶填充硅通孔的方法	发明	ZL201110359862.X	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1621	一种利用上掩膜实现高性能铜互连的方法	发明	ZL201110359760.8	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1622	一种存储器单元的制备方法	发明	ZL201110349900.3	2011-11-08	申请日起二十年	原始取得
1623	用 DPN 氮氧化硅作为 SONOS 存储介质层的 ONO 结构及其制备方法	发明	ZL201110349894.1	2011-11-08	申请日起二十年	原始取得
1624	形成绝缘体上碳硅-锗硅异质结 1T--DRAM 结构的方法及形成结构	发明	ZL201110349874.4	2011-11-08	申请日起二十年	原始取得
1625	一种低应力金属硬掩膜层的制备方法	发明	ZL201110347738.1	2011-11-07	申请日起二十年	原始取得
1626	提高浮体效应存储单元写入速度的方法	发明	ZL201110341117.2	2011-11-02	申请日起二十年	原始取得
1627	一种形成浅沟槽隔离的方法	发明	ZL201110341116.8	2011-11-02	申请日起二十年	原始取得
1628	半导体器件制作方法	发明	ZL201110335363.7	2011-10-29	申请日起二十年	原始取得
1629	硅纳米线器件的制作方法	发明	ZL201110328162.4	2011-10-25	申请日起二十年	原始取得
1630	保留部分无定形碳层的方法	发明	ZL201110328160.5	2011-10-25	申请日起二十年	原始取得
1631	高速电流模式逻辑到互补金属氧化物	发明	ZL201110322330.9	2011-10-21	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	半导体信号转换电路					
1632	一种形成侧墙的方法及由该方法形成存储单元	发明	ZL201110322309.9	2011-10-21	申请日起二十年	原始取得
1633	基于埋层 N 型阱的异质结 1T-DRAM 结构及其形成方法	发明	ZL201110314347.X	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1634	提高写入速度的浮体动态随机存储器单元及其制作方法	发明	ZL201110314346.5	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1635	提高写入速度的浮体动态随机存储器单元及其制作方法	发明	ZL201110314344.6	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1636	基于埋层 N 型阱的异质结 1T-DRAM 结构及其制备方法	发明	ZL201110314331.9	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1637	一种提高写入速度的浮体动态随机存储器单元的制作方法	发明	ZL201110314327.2	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1638	基于埋层 N 型阱的异质结 1T-DRAM 结构及其制备方法	发明	ZL201110314325.3	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1639	超低介电常数薄膜铜互连的制作方法	发明	ZL201110310575.X	2011-10-13	申请日起二十年	原始取得
1640	一种金属-氧化物-金属电容及其制作方法	发明	ZL201110308004.2	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1641	一种高性能金属-氧化物-金属电容及其制作方法	发明	ZL201110308002.3	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1642	一种金属-氧化物-金属电容	发明	ZL201110307989.7	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1643	一种金属-氧化物-金属电容及其制作方法	发明	ZL201110307984.4	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1644	一种降低化学机械抛光后微粒缺陷的	发明	ZL201110307983.X	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	方法					
1645	一种金属-氧化物-金属电容的制作方法	发明	ZL201110307976.X	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1646	铜互连结构的制作方法	发明	ZL201110301126.9	2011-09-28	申请日起二十年	原始取得
1647	一种降低双大马士革氮化硅工艺颗粒的处理方法	发明	ZL201110299091.X	2011-09-29	申请日起二十年	原始取得
1648	一种避免双刻蚀阻挡层引起的接触孔不通的方法	发明	ZL201110298921.7	2011-09-29	申请日起二十年	原始取得
1649	一种提高浅沟隔离多次曝光稳定性的方法	发明	ZL201110285100.X	2011-09-23	申请日起二十年	原始取得
1650	超低介电常数薄膜铜互连的制作方法	发明	ZL201110274496.8	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1651	具有金属前介质填充结构的半导体器件及其制备方法	发明	ZL201110274490.0	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1652	金属铜大马士革互联结构的制造方法	发明	ZL201110274227.1	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1653	一种大马士革的集成方法	发明	ZL201110272665.4	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1654	预防物理气相沉积溅射工艺过程中金属靶材被击穿的方法	发明	ZL201110272663.5	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1655	一种改进的硬质掩膜与多孔低介电常数值材料的集成方法	发明	ZL201110266463.9	2011-09-09	申请日起二十年	原始取得
1656	制备具有多厚度硅化物掩模层的半导体器件的方法	发明	ZL201110266445.0	2011-09-09	申请日起二十年	原始取得
1657	一种单一厚度栅氧化层实现多级工作电压的 CMOS 器件的制备方法	发明	ZL201110265327.8	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1658	一种提高浮体动态随机存储器单元性	发明	ZL201110265311.7	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	能的栅刻蚀方法					
1659	一种根据不同衬底进行光学临近修正的方法	发明	ZL201110265304.7	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1660	一种解决高磷浓度 PSG 薄膜表面雾状颗粒的工艺方法	发明	ZL201110265302.8	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1661	一种增加两次图形曝光工艺窗口的方法	发明	ZL201110265283.9	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1662	一种用于提高半导体器件性能的硅化物掩模刻蚀方法	发明	ZL201110265270.1	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1663	一种降低碳辅助注入工艺流程中多晶硅栅电阻的方法	发明	ZL201110265267.X	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1664	一种利用侧向边墙技术提高 STI 凹陷区特性的方法	发明	ZL201110265265.0	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1665	提高浮体动态随机存储单元写入速度的方法	发明	ZL201110265239.8	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1666	一种金属—绝缘层—金属电容结构的制造工艺	发明	ZL201110265234.5	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1667	一种减小半导体器件热载流子注入损伤的方法	发明	ZL201110265219.0	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1668	绝缘体上硅硅片及浮体动态随机存储器单元的制造方法	发明	ZL201110256001.9	2011-08-31	申请日起二十年	原始取得
1669	绝缘体上硅硅片及浮体动态随机存储器单元的制造方法	发明	ZL201110256000.4	2011-08-31	申请日起二十年	原始取得
1670	一种新的硅化物和金属前介质集成工	发明	ZL201110250281.2	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	艺及该形成的结构					
1671	一种新型的双 bit 线 SONOS 单元结构及其制作方法	发明	ZL201110250278.0	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1672	一种提高浮体动态随机存储器单元性能的栅氧预清洗方法	发明	ZL201110250276.1	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1673	一种 STI 结构 CMP 方法以及 STI 结构制作方法	发明	ZL201110250266.8	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1674	一种 CMP 机台内置清洗结构及方法	发明	ZL201110250265.3	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1675	一种简化侧墙定义的两次图形曝光工艺的方法	发明	ZL201110235262.2	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1676	一种实现两种不同绝缘层厚度电容的集成方法	发明	ZL201110235259.0	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1677	一种减小半导体器件热载流子注入损伤的方法	发明	ZL201110235255.2	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1678	一种提高浮体动态随机存储器单元写入速度的注入方法及结构	发明	ZL201110235254.8	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1679	一种后栅极两晶体管 DRAM 的制造方法	发明	ZL201110235244.4	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1680	改进双重通孔刻蚀停止层交叠区通孔刻蚀的方法	发明	ZL201110235240.6	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1681	一种源漏区超浅结的改进方法	发明	ZL201110235237.4	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1682	改进双重通孔刻蚀停止层交叠区域通孔刻蚀的方法	发明	ZL201110235219.6	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1683	后栅极两晶体管零电容动态随机存储	发明	ZL201110232271.6	2011-08-15	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	器的制备方法					
1684	增强应力记忆技术效果的方法	发明	ZL201110232262.7	2011-08-15	申请日起二十年	原始取得
1685	一种有助于消除倒 U 形镍硅化物的器件结构及其制备工艺	发明	ZL201110222302.X	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1686	一种改善 PMOS 器件载流子迁移率的方法	发明	ZL201110222150.3	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1687	一种改善 NMOS 器件载流子迁移率的方法	发明	ZL201110222138.2	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1688	一种利用 P 型离子注入形成双深度隔离沟道的方法	发明	ZL201110222125.5	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1689	改进双重通孔刻蚀停止层交叠区通孔刻蚀的方法及其器件	发明	ZL201110222089.2	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1690	一种不同多晶硅栅电极厚度的集成工艺	发明	ZL201110206448.5	2011-07-22	申请日起二十年	原始取得
1691	一种提高光刻胶与金属/金属化合物表面之间粘附力的方法	发明	ZL201110206446.6	2011-07-22	申请日起二十年	原始取得
1692	无金属阻挡层的铜后道互连工艺	发明	ZL201110194242.5	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1693	用于高、低压器件的多晶硅栅电极集成工艺	发明	ZL201110194223.2	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1694	一种铜后道互连工艺	发明	ZL201110194154.5	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1695	一种优化的多晶栅极氧化硅硬质掩膜去除方法	发明	ZL201110194153.0	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1696	MOS 电容器的结构的制作方法	发明	ZL201110194151.1	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1697	一种提高半导体器件中 MIM 电容密	发明	ZL201110194148.X	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	度的方法及其器件					
1698	一种增加半导体器件中 MIM 电容密度的方法及其结构	发明	ZL201110194118.9	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1699	抑制 GIDL 效应的后栅极工艺半导体器件及其制备方法	发明	ZL201110163853.3	2011-06-17	申请日起二十年	原始取得
1700	一种双晶体管零电容动态 RAM 的制备方法	发明	ZL201110163852.9	2011-06-17	申请日起二十年	原始取得
1701	一种抑制漏极感应势垒降低效应的后栅极工艺 CMOS 器件及其制备方法	发明	ZL201110160322.9	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1702	一种抑制漏极感应势垒降低效应的 CMOS 器件及其制备方法	发明	ZL201110160321.4	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1703	一种提高 MIM 器件电容均匀性的方法	发明	ZL201110160311.0	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1704	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容制造工艺及结构	发明	ZL201110160309.3	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1705	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容制造工艺及结构	发明	ZL201110160305.5	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1706	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容结构及制造工艺	发明	ZL201110160301.7	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1707	设置顶部刻蚀阻挡层以增加接触孔刻蚀制程窗口的方法	发明	ZL201110160287.0	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1708	一种双大马士革工艺中通孔填充的方法	发明	ZL201110150744.8	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1709	改善双应力氮化硅薄膜集成的工艺及	发明	ZL201110150725.5	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	其中的结构					
1710	一种用于双刻蚀阻挡层技术的应变硅工艺制作方法	发明	ZL201110150724.0	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1711	一种增强氮化硅薄膜张应力的方法	发明	ZL201110150722.1	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1712	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容制造工艺及结构	发明	ZL201110150721.7	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1713	消除栅极凹形缺陷的方法	发明	ZL201110150717.0	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1714	一种提高铜互连可靠性的表面处理方法	发明	ZL201110150700.5	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1715	一种 MIM（金属-绝缘层-金属）电容制作方法	发明	ZL201110150697.7	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1716	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容结构及制造工艺	发明	ZL201110138154.3	2011-05-26	申请日起二十年	原始取得
1717	一种形成 MIM 电容器结构的方法及 MIM 电容器	发明	ZL201110138130.8	2011-05-26	申请日起二十年	原始取得
1718	一种针对氟基等离子体刻蚀后的氮化钛薄膜的处理方法	发明	ZL201110138127.6	2011-05-26	申请日起二十年	原始取得
1719	一种利用铜大马士革工艺制造双层金属-绝缘层-金属电容的方法	发明	ZL201110138065.9	2011-05-26	申请日起二十年	原始取得
1720	离子注入调整隔离氧化物应力的浅沟槽隔离结构制备方法	发明	ZL201110133619.6	2011-05-23	申请日起二十年	原始取得
1721	用于提高半导体器件性能的在浅沟槽上形成接触孔的方法	发明	ZL201110123709.7	2011-05-13	申请日起二十年	原始取得
1722	一种具有自对准空洞层的 SON 互补	发明	ZL201110123708.2	2011-05-13	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	型金属氧化物半导体制备方法					
1723	一种提高 MIM 电容密度的结构及其制作工艺	发明	ZL201110123645.0	2011-05-13	申请日起二十年	原始取得
1724	一种 CMOS 侧墙结构及其制备方法	发明	ZL201110123643.1	2011-07-27	申请日起二十年	原始取得
1725	一种 MIM 电容的改进结构及其制造工艺	发明	ZL201110123642.7	2011-05-13	申请日起二十年	原始取得
1726	在浅沟槽上形成接触孔以提高半导体器件性能的方法	发明	ZL201110110384.9	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1727	提高半导体器件中空穴迁移率的方法	发明	ZL201110110382.X	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1728	一种提高 PMOS 器件中空穴迁移率的多晶硅栅附加样本填充方法	发明	ZL201110110369.4	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1729	一种增强应力记忆效应的栅多晶硅刻蚀方法	发明	ZL201110110368.X	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1730	一种制造高拉应力氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201110110367.5	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1731	一种用于表征低介电常数介质材料损伤的检测方法	发明	ZL201110110175.4	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1732	集成电路钝化层及其制造方法	发明	ZL201110110174.X	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1733	一种用于双刻蚀阻挡层技术的应变硅工艺集成方法	发明	ZL201110099265.8	2011-04-20	申请日起二十年	原始取得
1734	改进晶体管载流子迁移率的半导体器件及方法	发明	ZL201110078473.X	2011-03-30	申请日起二十年	原始取得
1735	一种减小半导体器件中交叠电容的方法	发明	ZL201110078449.6	2011-03-30	申请日起二十年	原始取得
1736	**非挥发性存储器的读参考电流自动调**	**发明**	**ZL202010831332.X**	**2020-08-18**	**申请日起二十年**	**原始取得**

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	节电路					
1737	PMOS 管触发双向硅控整流器	发明	ZL202111151124.6	2021-09-29	申请日起二十年	原始取得
1738	CMOS 图像传感器转移管垂直栅极深度检测方法	发明	ZL202010831333.4	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
1739	一种失效定位方法及电子设备	发明	ZL202310176980.X	2023-02-24	申请日起二十年	原始取得
1740	一种通过 STI 刻蚀工艺改善 HDP 填充缺陷的方法	发明	ZL202011252721.3	2020-11-11	申请日起二十年	原始取得
1741	一种用于带走工艺腔室内残污的工艺方法	发明	ZL202210420937.9	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
1742	高压器件的制造方法	发明	ZL202210761842.3	2022-06-29	申请日起二十年	原始取得
1743	静电消除装置及晶圆表面静电的消除方法	发明	ZL202211343831.X	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
1744	取卡装置	发明	ZL202210287643.3	2022-03-22	申请日起二十年	原始取得
1745	晶圆校准方法	发明	ZL202210629214.X	2022-05-30	申请日起二十年	原始取得
1746	一种涡轮分子泵用定子防尘组件	发明	ZL202211058220.0	2022-08-31	申请日起二十年	原始取得
1747	NMOS 管触发双向硅控整流器	发明	ZL202111153440.7	2021-09-29	申请日起二十年	原始取得
1748	一种 NOR 闪存的制备方法	发明	ZL202111681229.2	2021-12-28	申请日起二十年	原始取得
1749	一种增强特殊分布缺陷检测的方法	发明	ZL202111433602.2	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
1750	样品载体保存装置	发明	ZL202210743865.1	2022-06-27	申请日起二十年	原始取得
1751	去除等离子体反应腔体内的刻蚀残留物的方法	发明	ZL202410693041.7	2024-05-30	申请日起二十年	原始取得
1752	晶圆缺陷检测方法	发明	ZL202211129030.3	2022-09-16	申请日起二十年	原始取得
1753	CMOS 图像传感器的形成方法	发明	ZL202211192978.3	2022-09-28	申请日起二十年	原始取得
1754	调节器件电学参数的方法	发明	ZL202211343837.7	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1755	目标基准结构的选择及基于其制备半导体结构的方法	发明	ZL202211128817.8	2022-09-16	申请日起二十年	原始取得
1756	产品版图的评估系统及评估方法	发明	ZL202211053139.3	2022-08-29	申请日起二十年	原始取得
1757	一种闪存器件及其制备方法	发明	ZL202210906188.0	2022-07-29	申请日起二十年	原始取得
1758	CMOS 图像传感器及其制造方法	发明	ZL202310465646.6	2023-04-26	申请日起二十年	原始取得
1759	全局快门 CMOS 图像传感器及其制造方法	发明	ZL202010832325.1	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
1760	SRAM 及其版图设计方法	发明	ZL202111437296.X	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
1761	半导体制程量测数据的预测方法	发明	ZL202210419129.0	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
1762	一种晶圆失效原因的诊断方法	发明	ZL202310345544.0	2023-03-31	申请日起二十年	原始取得
1763	监测晶圆杂质的方法	发明	ZL202111656770.8	2021-12-30	申请日起二十年	原始取得
1764	MOS 晶体管	发明	ZL202111626376.X	2021-12-28	申请日起二十年	原始取得
1765	WAT 测试装置的检测方法及系统	发明	ZL202210602433.9	2022-05-30	申请日起二十年	原始取得
1766	透射电子显微镜样品的制备方法	发明	ZL202310341087.8	2023-03-31	申请日起二十年	原始取得
1767	一种接触层 OPC 方法	发明	ZL202310487630.5	2023-04-28	申请日起二十年	原始取得
1768	基于承载台的套刻精度修正方法	发明	ZL202310580502.5	2023-05-22	申请日起二十年	原始取得
1769	一种集成电路版图可制造性的分析方法	发明	ZL202111437319.7	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
1770	一种晶圆生产线智能获取派工 WPH 的控制系统和方法	发明	ZL202210108131.6	2022-01-28	申请日起二十年	原始取得
1771	PMOS 管触发双向硅控整流器	发明	ZL202111151126.5	2021-09-29	申请日起二十年	原始取得
1736	一种干泵信号接头及 CVD 成膜设备信号接头	实用新型	ZL202421830222.1	2024-07-30	申请日起十年	原始取得
1737	定位装置以及蚀刻机	实用新型	ZL202421524674.7	2024-06-28	申请日起十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1738	线圈支架、射频匹配电路组件以及半导体制造设备	实用新型	ZL202421520067.3	2024-06-28	申请日起十年	原始取得
1739	具有位置偏移检测装置的离子注入机	实用新型	ZL202421520050.8	2024-06-28	申请日起十年	原始取得
1740	等离子刻蚀装置	实用新型	ZL202420910871.6	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1741	石英管固定结构及反应腔体	实用新型	ZL202420908366.8	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1742	立式炉管装置	实用新型	ZL202420907843.9	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1743	具有除湿装置的前开式晶圆盒	实用新型	ZL202420907810.4	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1744	用于气化装置的进出口管路及具有其的气化设备	实用新型	ZL202420590490.4	2024-03-26	申请日起十年	原始取得
1745	喷嘴支撑臂位置偏移检测装置及旋涂单元和涂胶设备	实用新型	ZL202420590463.7	2024-03-26	申请日起十年	原始取得
1746	用于掩膜版存储柜的喷气组件	实用新型	ZL202420392586.X	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1747	固定装置及具有其的炉管机台	实用新型	ZL202420390531.5	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1748	一种干燥槽顶针	实用新型	ZL202420389435.9	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1749	涂料装置以及光刻设备	实用新型	ZL202420385391.2	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1750	用于牵引天车的连接杆结构	实用新型	ZL202420344486.X	2024-02-23	申请日起十年	原始取得
1751	隔振装置以及光刻设备	实用新型	ZL202420344063.8	2024-02-23	申请日起十年	原始取得
1752	防降温保护装置	实用新型	ZL202420232425.4	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1753	货物载入台以及测试机台	实用新型	ZL202420232052.0	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1754	天车维修系统	实用新型	ZL202420232021.5	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1755	检漏装置	实用新型	ZL202420231968.4	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1756	燃烧式除害设备	实用新型	ZL202420231058.6	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1757	辅助上油装置以及测试机台	实用新型	ZL202420143421.9	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1758	一种烘烤排气管清洗装置	实用新型	ZL202420141150.3	2024-01-19	申请日起十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1759	晶圆刻蚀均匀度提升装置	实用新型	ZL202420141145.2	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1760	连接组件以及半导体制造设备	实用新型	ZL202420141126.X	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1761	清针砂纸粘贴辅助装置	实用新型	ZL202322019571.7	2023-07-28	申请日起十年	原始取得
1762	一种信号线和背氦流量控制器的防干扰结构	实用新型	ZL202321351972.6	2023-05-30	申请日起十年	原始取得
1763	安装辅助支架	实用新型	ZL202321349596.7	2023-05-30	申请日起十年	原始取得
1764	一种阳极装置及电镀设备	实用新型	ZL202321349565.1	2023-05-30	申请日起十年	原始取得
1765	一种支撑架及收纳装置	实用新型	ZL202321251352.5	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1766	一种手动取片机械爪	实用新型	ZL202321251340.2	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1767	一种冷却水管路连接装置	实用新型	ZL202321251328.1	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1768	接头保护装置和液压快速接头	实用新型	ZL202321247559.5	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1769	清洁治具及刻蚀机	实用新型	ZL202321247527.5	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1770	研磨保护装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202321246644.X	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1771	漏液检测报警装置及刻蚀机	实用新型	ZL202321246628.0	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1772	校准治具及量测系统	实用新型	ZL202321246619.1	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1773	工艺腔清洁装置	实用新型	ZL202320982876.5	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1774	一种快速热处理半导体加工机台及半导体加工系统	实用新型	ZL202320982859.1	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1775	气柜部件清洗保护结构及半导体设备	实用新型	ZL202320982844.5	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1776	一种对石英腔体进行降温的装置	实用新型	ZL202320982818.2	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1777	适用于紫外线灯照射台的吸尘装置	实用新型	ZL202320982746.1	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1778	晶圆清洗装置	实用新型	ZL202320704865.0	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1779	清洗装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202320698685.6	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1780	一种真空吸附式取放装置	实用新型	ZL202320696516.9	2023-03-31	申请日起十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1781	一种用于晶圆存储盒的承载装置	实用新型	ZL202320695689.9	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1782	检测设备、工艺腔室及离子注入机	实用新型	ZL202320680210.4	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1783	一种晶圆存储盒的防坠落装置	实用新型	ZL202320680205.3	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1784	倾角传感器的保护结构及倾角传感器	实用新型	ZL202320351401.6	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1785	卡盘销组件及晶圆清洗设备	实用新型	ZL202320348444.9	2023-02-28	申请日起十年	原始取得
1786	晶圆级半自动探针台	实用新型	ZL202320347595.2	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1787	一种输送链的承载装置	实用新型	ZL202320347565.1	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1788	一种半导体设备及反应气体供应装置	实用新型	ZL202320347548.8	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1789	沉积环装置、静电卡盘装置及高温铝腔	实用新型	ZL202320345982.2	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1790	一种石英窗保温装置、等离子体反应设备及半导体加工机台	实用新型	ZL202320345925.4	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1791	臭氧分解装置及其保护结构	实用新型	ZL202320339205.7	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1792	一种防脱治具和静电吸盘	实用新型	ZL202320339162.2	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1793	电容防护装置	实用新型	ZL202320328598.1	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1794	一种真空管收集粉尘装置及真空吸附系统	实用新型	ZL202320328408.6	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1795	防光罩盒底盘掉落装置及光罩检测设备	实用新型	ZL202320328390.X	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1796	光罩传送台防尘装置	实用新型	ZL202320320779.X	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1797	起膜顶针的移动装置	实用新型	ZL202320320743.1	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1798	基座装置、溅射腔体及物理气相沉积设备	实用新型	ZL202320320717.9	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1799	光刻机温控用储液装置	实用新型	ZL202320171574.X	2023-01-30	申请日起十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1800	一种更换上部电极的治具	实用新型	ZL202320171532.6	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1801	阀门切换检测装置	实用新型	ZL202320163729.5	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1802	芯片测试板除霜装置	实用新型	ZL202320163714.9	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1803	一种高度测量治具和涂胶显影机	实用新型	ZL202320152873.9	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1804	铜电极组装装置及电化学电镀设备	实用新型	ZL202222915186.6	2022-10-31	申请日起十年	原始取得
1805	晶圆传送位置检测装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202222877144.8	2022-10-31	申请日起十年	原始取得
1806	管路装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202222876868.0	2022-10-31	申请日起十年	原始取得
1807	一种晶圆前开式传送盒的运输装置	实用新型	ZL202222623922.0	2022-09-30	申请日起十年	原始取得
1808	漏气检测装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202222614300.1	2022-09-30	申请日起十年	原始取得
1809	一种半导体设备电气柜的温度监控装置	实用新型	ZL202222601790.1	2022-09-29	申请日起十年	原始取得
1810	老化板及芯片老化测试系统	实用新型	ZL202222598976.6	2022-09-29	申请日起十年	原始取得
1811	一种光刻机的光罩传送手臂	实用新型	ZL202222598910.7	2022-09-29	申请日起十年	原始取得
1812	一种晶圆工作台用偏差矫正机构	实用新型	ZL202222596169.0	2022-09-29	申请日起十年	原始取得
1813	贯穿装置	实用新型	ZL202222304331.7	2022-08-31	申请日起十年	原始取得
1814	一种探针卡清洁纸辅助夹具	实用新型	ZL202222121460.2	2022-08-12	申请日起十年	原始取得
1815	清洗装置	实用新型	ZL202222110611.4	2022-08-11	申请日起十年	原始取得
1816	一种排气装置及尾气处理系统	实用新型	ZL202221984746.7	2022-07-29	申请日起十年	原始取得
1817	一种药液桶推车	实用新型	ZL202221982328.4	2022-07-29	申请日起十年	原始取得
1818	量测机台照明开关监控系统	实用新型	ZL202220927550.8	2022-04-20	申请日起十年	原始取得
1819	等离子刻蚀机台	实用新型	ZL202220924713.7	2022-04-20	申请日起十年	原始取得
1820	一种粉尘收集装置	实用新型	ZL202220923322.3	2022-04-20	申请日起十年	原始取得
1821	一种基座及半导体设备	实用新型	ZL202220421787.9	2022-02-28	申请日起十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1822	一种推车柜	实用新型	ZL202220348470.7	2022-02-21	申请日起十年	原始取得
1823	机械臂模块	实用新型	ZL202220260638.9	2022-02-07	申请日起十年	原始取得
1824	一种臭氧分解装置	实用新型	ZL202220252166.2	2022-01-28	申请日起十年	原始取得
1825	一种紫外线照射装置	实用新型	ZL202220250842.2	2022-01-27	申请日起十年	原始取得
1826	一种温控装置的加液口盖帽及温控装置的排气系统	实用新型	ZL202220238947.6	2022-01-28	申请日起十年	原始取得
1827	一种清洗装置	实用新型	ZL202220229831.6	2022-01-27	申请日起十年	原始取得
1828	清洗装置	实用新型	ZL202220228704.4	2022-01-27	申请日起十年	原始取得
1829	一种晶圆检测装置及半导体设备	实用新型	ZL202123436186.X	2021-12-30	申请日起十年	原始取得
1830	一种反应装置及半导体设备	实用新型	ZL202123348685.3	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1831	干法刻蚀机台的设备前端模块的颗粒堆积物清理检测系统	实用新型	ZL202123348572.3	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1832	一种校准装置及真空传送装置	实用新型	ZL202123348110.1	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1833	一种排湿装置、送风管和空调机	实用新型	ZL202123348080.4	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1834	一种研磨机台的冷却装置及研磨机台	实用新型	ZL202123347985.X	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1835	一种清洗设备	实用新型	ZL202123346972.0	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1836	一种清洗槽及具有其的清洗机台	实用新型	ZL202123341787.2	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1837	一种干式真空泵及半导体设备	实用新型	ZL202122963402.X	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1838	一种显影设备	实用新型	ZL202122961152.6	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1839	一种光刻机的载片台平坦度的检测系统及光刻机	实用新型	ZL202122953910.X	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1840	一种过热报警装置	实用新型	ZL202122953908.2	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1841	一种排风结构及除胶机	实用新型	ZL202122953885.5	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1842	一种 DRIE 机台的等离子体约束环用	实用新型	ZL202122945564.0	2021-11-29	申请日起十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	定位锁定结构					
1843	一种热电偶及半导体设备	实用新型	ZL202122638508.2	2021-10-29	申请日起十年	原始取得
1844	一种监测特气的装置及半导体设备	实用新型	ZL202122388633.2	2021-09-29	申请日起十年	原始取得
1845	一种加热器水平调节装置	实用新型	ZL202122377375.8	2021-09-29	申请日起十年	原始取得
1846	一种改造后的 LPCVD 反应室	实用新型	ZL202122065570.7	2021-08-30	申请日起十年	原始取得
1847	一种 LPCVD 晶舟旋转装置	实用新型	ZL202122065555.2	2021-08-30	申请日起十年	原始取得
1848	一种用于 LPCVD 模块的底座及其 LPCVD 模块	实用新型	ZL202122063121.9	2021-08-30	申请日起十年	原始取得
1849	一种光刻胶去除机台的晶圆传送手臂的清洁及干燥机构	实用新型	ZL202121585532.8	2021-07-13	申请日起十年	原始取得
1850	一种用于校正遮光板位置精度的监控光罩	实用新型	ZL202121584306.8	2021-07-13	申请日起十年	原始取得
1851	一种用于管道法兰拆装的工具	实用新型	ZL202120651747.9	2021-03-30	申请日起十年	原始取得
1852	一种间隙测量仪、反应腔及半导体设备	实用新型	ZL202120536419.4	2021-03-15	申请日起十年	原始取得
1853	晶圆清洗装置	实用新型	ZL202120412470.4	2021-02-24	申请日起十年	原始取得
1854	一种气体吹扫管路、反应腔及半导体设备	实用新型	ZL202120249404.X	2021-01-28	申请日起十年	原始取得
1855	预热激光光源冷却系统	实用新型	ZL202023245543.X	2020-12-29	申请日起十年	原始取得
1856	掩模板清洁装置	实用新型	ZL202023242011.0	2020-12-29	申请日起十年	原始取得
1857	炉管设备中的晶舟运动机构	实用新型	ZL202023180549.3	2020-12-25	申请日起十年	原始取得
1858	半导体冷却装置及半导体机台	实用新型	ZL202023036249.8	2020-12-16	申请日起十年	原始取得
1859	半导体传送装置	实用新型	ZL202023020628.8	2020-12-16	申请日起十年	原始取得
1860	接口阀及化学气相沉积设备	实用新型	ZL202022479572.6	2020-10-30	申请日起十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1861	显影液供应系统	实用新型	ZL202020671981.3	2020-04-27	申请日起十年	原始取得
1862	一种排气取样装置及湿法清洗机	实用新型	ZL202020328502.8	2020-03-16	申请日起十年	原始取得
1863	气体管路分流装置及干法刻蚀机	实用新型	ZL201922088521.8	2019-11-27	申请日起十年	原始取得
1864	一种腔体结构	实用新型	ZL201922081130.3	2019-11-27	申请日起十年	原始取得
1865	紫外光固化装置	实用新型	ZL201921603197.2	2019-09-24	申请日起十年	原始取得
1866	电极保护装置	实用新型	ZL201921576498.0	2019-09-20	申请日起十年	原始取得
1867	一种遮光结构和涂胶显影机	实用新型	ZL201921189178.X	2019-07-25	申请日起十年	原始取得
1868	预对准装置及晶圆处理系统	实用新型	ZL201920784669.2	2019-05-28	申请日起十年	原始取得
1869	一种光罩盒锁定/解锁装置及相应的光刻机	实用新型	ZL201920613386.1	2019-04-29	申请日起十年	原始取得
1870	一种改善白色像素点的隔离结构	实用新型	ZL201920391846.0	2019-03-26	申请日起十年	原始取得
1871	一种化学药液混合装置及湿法刻蚀装置	实用新型	ZL201920391750.4	2019-03-26	申请日起十年	原始取得
1872	一种改善 HCD 炉管硅片间均匀性差异的装置	实用新型	ZL201821904812.9	2018-11-19	申请日起十年	原始取得
1873	一种用于监控尼康光刻机底部镜头雾化散光程度的掩膜板	实用新型	ZL201821903870.X	2018-11-19	申请日起十年	原始取得
1874	一种用于研磨装置的新型研磨头	实用新型	ZL201821675862.4	2018-10-16	申请日起十年	原始取得
1875	电镀洗边结构	实用新型	ZL201820975644.6	2018-06-25	申请日起十年	原始取得
1876	用于刻蚀设备的新型陶瓷环	实用新型	ZL201820760179.4	2018-05-22	申请日起十年	原始取得
1877	化学气相沉淀机台中静电吸盘的拆装夹具	实用新型	ZL201721797367.6	2017-12-21	申请日起十年	原始取得
1878	一种高电流离子注入机末端测流器	实用新型	ZL201721682661.2	2017-12-06	申请日起十年	原始取得
1879	一种用于改善白像素的 CMOS 图像	实用新型	ZL201721592960.7	2017-11-24	申请日起十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
	传感器					
1880	一种改善 low-k 薄膜均一性的装置	实用新型	ZL201721252681.6	2017-09-27	申请日起十年	原始取得
1881	一种改善氮化硅薄膜膜厚均一性的炉管石英外管	实用新型	ZL201721251982.7	2017-09-27	申请日起十年	原始取得
1882	一种加热装置及化学气相沉积设备	实用新型	ZL201720969251.X	2017-08-04	申请日起十年	原始取得
1883	一种超声波修整盘及化学机械研磨机	实用新型	ZL201720948244.1	2017-08-01	申请日起十年	原始取得
1884	一种组合式溅射靶材及磁控溅射装置	实用新型	ZL201720931858.9	2017-07-28	申请日起十年	原始取得
1885	一种侦测电镀洗边异常的装置	实用新型	ZL201621209504.5	2016-11-09	申请日起十年	原始取得
1886	一种铜电镀机台腔体	实用新型	ZL201621151042.6	2016-10-24	申请日起十年	原始取得
1887	套准精度量测图形结构	实用新型	ZL201620809339.0	2016-07-29	申请日起十年	原始取得
1888	一种用于机台 RF 电感线圈的防电弧击伤装置	实用新型	ZL201620807709.7	2016-07-28	申请日起十年	原始取得
1889	一种化学气相成膜机台	实用新型	ZL201620283550.3	2016-04-07	申请日起十年	原始取得
1890	一种化学气相沉积工艺设备	实用新型	ZL201520861935.9	2015-10-30	申请日起十年	原始取得
1891	一种改善晶圆边缘缺陷的装置	实用新型	ZL201520857832.5	2015-10-29	申请日起十年	原始取得
1892	高密度等离子体机台顶端喷嘴与气体集流器的连接结构	实用新型	ZL201520856143.2	2015-10-29	申请日起十年	原始取得
1893	一种氧化炉晶舟	实用新型	ZL201520839960.7	2015-10-27	申请日起十年	原始取得
1894	一种探针台	实用新型	ZL201520828827.1	2015-10-23	申请日起十年	原始取得
1895	一种恒转矩控制系统	实用新型	ZL201520794773.1	2015-10-14	申请日起十年	原始取得
1896	一种探针卡	实用新型	ZL201520793943.4	2015-10-14	申请日起十年	原始取得
1897	一种机械手臂	实用新型	ZL201520739022.X	2015-09-22	申请日起十年	原始取得
1898	**一种干泵信号接头及 CVD 成膜设备信号接头**	**实用新型**	**ZL202421830222.1**	**2024-07-30**	**申请日起十年**	**原始取得**

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1899	定位装置以及蚀刻机	实用新型	ZL202421524674.7	2024-06-28	申请日起十年	原始取得
1900	线圈支架、射频匹配电路组件以及半导体制造设备	实用新型	ZL202421520067.3	2024-06-28	申请日起十年	原始取得
1901	具有位置偏移检测装置的离子注入机	实用新型	ZL202421520050.8	2024-06-28	申请日起十年	原始取得
1902	等离子刻蚀装置	实用新型	ZL202420910871.6	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1903	石英管固定结构及反应腔体	实用新型	ZL202420908366.8	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1904	立式炉管装置	实用新型	ZL202420907843.9	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1905	具有除湿装置的前开式晶圆盒	实用新型	ZL202420907810.4	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1906	用于气化装置的进出口管路及具有其的气化设备	实用新型	ZL202420590490.4	2024-03-26	申请日起十年	原始取得
1907	喷嘴支撑臂位置偏移检测装置及旋涂单元和涂胶设备	实用新型	ZL202420590463.7	2024-03-26	申请日起十年	原始取得
1908	用于掩膜版存储柜的喷气组件	实用新型	ZL202420392586.X	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1909	固定装置及具有其的炉管机台	实用新型	ZL202420390531.5	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1910	一种干燥槽顶针	实用新型	ZL202420389435.9	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1911	涂料装置以及光刻设备	实用新型	ZL202420385391.2	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1912	用于牵引天车的连接杆结构	实用新型	ZL202420344486.X	2024-02-23	申请日起十年	原始取得
1913	隔振装置以及光刻设备	实用新型	ZL202420344063.8	2024-02-23	申请日起十年	原始取得
1914	防降温保护装置	实用新型	ZL202420232425.4	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1915	货物载入台以及测试机台	实用新型	ZL202420232052.0	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1916	天车维修系统	实用新型	ZL202420232021.5	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1917	检漏装置	实用新型	ZL202420231968.4	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1918	燃烧式除害设备	实用新型	ZL202420231058.6	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1919	辅助上油装置以及测试机台	实用新型	ZL202420143421.9	2024-01-19	申请日起十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1920	一种烘烤排气管清洗装置	实用新型	ZL202420141150.3	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1921	晶圆刻蚀均匀度提升装置	实用新型	ZL202420141145.2	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1922	连接组件以及半导体制造设备	实用新型	ZL202420141126.X	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1923	清针砂纸粘贴辅助装置	实用新型	ZL202322019571.7	2023-07-28	申请日起十年	原始取得
1924	一种信号线和背氦流量控制器的防干扰结构	实用新型	ZL202321351972.6	2023-05-30	申请日起十年	原始取得
1925	安装辅助支架	实用新型	ZL202321349596.7	2023-05-30	申请日起十年	原始取得
1926	一种阳极装置及电镀设备	实用新型	ZL202321349565.1	2023-05-30	申请日起十年	原始取得
1927	一种支撑架及收纳装置	实用新型	ZL202321251352.5	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1928	一种手动取片机械爪	实用新型	ZL202321251340.2	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1929	一种冷却水管路连接装置	实用新型	ZL202321251328.1	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1930	接头保护装置和液压快速接头	实用新型	ZL202321247559.5	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1931	清洁治具及刻蚀机	实用新型	ZL202321247527.5	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1932	研磨保护装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202321246644.X	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1933	漏液检测报警装置及刻蚀机	实用新型	ZL202321246628.0	2023-05-22	申请日起十年	原始取得

表 2：标的公司拥有的主要境外已授权专利

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
1	Stack capacitor, a flash memory device and a manufacturing method thereof	发明	美国	US17/872,534	2022-7-25	申请日起二十年	原始取得
2	Stack capacitor, a flash memory device and a manufacturing method thereof	发明	美国	US17/213,885	2021-3-26	申请日起二十年	原始取得
3	One-time programmable memory and an operation method thereof	发明	美国	US17/206,631	2021-3-19	申请日起二十年	原始取得
4	Method for improving HDP filling defects through STI etching process	发明	美国	US17/142,623	2021-1-6	申请日起二十年	原始取得
5	Self-aligned two-time forming method capable of preventing sidewalls from being deformed	发明	美国	US17/142,500	2021-1-6	申请日起二十年	原始取得
6	Programmable memory	发明	美国	US16/952,262	2020-11-19	申请日起二十年	原始取得
7	Reading reference current automatic regulation circuit of non-volatile memory	发明	美国	US16/951,018	2020-11-18	申请日起二十年	原始取得
8	Method of sub resolution assist feature	发明	美国	US16/702,492	2019-12-3	申请日起二十年	原始取得
9	Flash with shallow trench in channel region and method for manufacturing the same	发明	美国	US16/854,129	2020-4-21	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
10	Semiconductor structure of split gate flash memory cell and method for manufacturing the same	发明	美国	US16/861,967	2020-4-29	申请日起二十年	原始取得
11	1.5T SONOS memory structure and manufacturing method	发明	美国	US16/826,554	2020-3-23	申请日起二十年	原始取得
12	Method of making resistive structure of RRAM	发明	美国	US16/850,993	2020-4-16	申请日起二十年	原始取得
13	LDO circuit device and overcurrent protection circuit thereof	发明	美国	US16/800,614	2020-2-25	申请日起二十年	华力集转让
14	Oscillator	发明	美国	US16/815,379	2020-3-11	申请日起二十年	原始取得
15	Erase-write cycling method of a flash device	发明	美国	US16/830,740	2020-3-26	申请日起二十年	原始取得
16	Power Supply Powering-On Structure	发明	美国	US16/822,757	2020-3-18	申请日起二十年	原始取得
17	Voltage-controlled oscillator circuit and phase-locked loop circuit	发明	美国	US16/789,550	2020-2-13	申请日起二十年	原始取得
18	50%-duty-cycle consecutive integer frequency divider and phase-locked loop circuit	发明	美国	US16/857,617	2020-4-24	申请日起二十年	原始取得
19	Classification method for automatically identifying wafer spatial pattern distribution	发明	美国	US16/690,470	2019-11-21	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
20	Nonvolatile memory device having a memory-transistor gate-electrode provided with a charge-trapping gate-dielectric layer and two sidewall select-transistor gate-electrodes	发明	美国	US16/666,418	2019-10-29	申请日起二十年	原始取得
21	Global shutter CMOS image sensor having photosensitive doped region with inhomogeneous potentials	发明	美国	US16/692,832	2019-11-22	申请日起二十年	原始取得
22	Method and apparatus for analyzing semiconductor wafer	发明	美国	US16/681,843	2019-11-13	申请日起二十年	原始取得
23	Etching method and a semiconductor device	发明	美国	US16/680,512	2019-11-12	申请日起二十年	原始取得
24	Method for detecting ultra-small defect on wafer surface	发明	美国	US16/691,180	2019-11-21	申请日起二十年	原始取得
25	Semiconductor device and manufacturing method therefor	发明	美国	US16/384,966	2019-4-16	申请日起二十年	原始取得
26	Semiconductor structure and method of manufacturing the same	发明	美国	US16/681,830	2019-11-13	申请日起二十年	原始取得
27	Method of ion implantation and an apparatus for the same	发明	美国	US16/566,876	2019-9-11	申请日起二十年	原始取得
28	Electrostatic protection circuit and a semiconductor structure	发明	美国	US16/566,875	2019-9-11	申请日起二十年	华力集转让

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
29	Methods and systems for reducing dislocation defects in high concentration epitaxy processes	发明	美国	US16/409,876	2019-5-13	申请日起二十年	原始取得
30	Method of manufacturing a bipolar transistor with trench structure	发明	美国	US16/427,356	2019-5-31	申请日起二十年	原始取得
31	Method for measuring interface state density	发明	美国	US13/656,701	2012-10-20	申请日起二十年	原始取得
32	Structure for critical dimension and overlay measurement	发明	美国	US13/667,363	2012-11-2	申请日起二十年	原始取得
33	Method of forming Cu interconnects	发明	美国	US13/667,492	2012-11-2	申请日起二十年	原始取得
34	CML to CMOS conversion circuit	发明	美国	US13/656,700	2012-10-20	申请日起二十年	原始取得
35	Method for producing silicon nanowire devices	发明	美国	US13/659,907	2012-10-24	申请日起二十年	原始取得
36	Temperature balancing device of projection objective of lithography machine and method thereof	发明	美国	US13/682,069	2012-11-20	申请日起二十年	原始取得
37	Method for depositing phosphosilicate glass	发明	美国	US13/728,743	2012-12-27	申请日起二十年	原始取得
38	Method for monitoring alignment between contact holes and polycrystalline silicon gate	发明	美国	US13/731,294	2012-12-31	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
39	Integration flow for LDD and spacer fabrication on a sacrificial amorphous carbon gate structure	发明	美国	US13/716,990	2012-12-17	申请日起二十年	原始取得
40	Method for etching polysilicon gate	发明	美国	US13/730,532	2012-12-28	申请日起二十年	原始取得
41	Method for improving write margins of SRAM cells	发明	美国	US13/721,071	2012-12-20	申请日起二十年	原始取得
42	Method of manufacturing a tungsten plug	发明	美国	US13/706,576	2012-12-6	申请日起二十年	原始取得
43	Dummy wafer structure and method of forming the same	发明	美国	US13/730,576	2012-12-28	申请日起二十年	原始取得
44	Method of forming contact hole	发明	美国	US13/730,486	2012-12-28	申请日起二十年	原始取得
45	Phase shift focus monitor reticle, manufacturing method thereof and method for monitoring focus difference	发明	美国	US13/688,407	2012-11-29	申请日起二十年	原始取得
46	Fabrication method for improving surface planarity after tungsten chemical mechanical polishing	发明	美国	US13/730,103	2012-12-28	申请日起二十年	原始取得
47	Method and structure to improve the erasing speed operation of SONOS memory device having a graded silicon nitride layer	发明	美国	US13/721,078	2012-12-20	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
48	Method of forming connection holes	发明	美国	US13/721,070	2012-12-20	申请日起二十年	原始取得
49	Method for reducing morphological difference between N-doped and undoped polysilicon gates after etching	发明	美国	US13/721,073	2012-12-20	申请日起二十年	原始取得
50	Measurement of lateral diffusion of implanted ions in doped well region of semiconductor devices	发明	美国	US13/721,082	2012-12-20	申请日起二十年	原始取得
51	Method of dual-depth STI formation	发明	美国	US13/728,190	2012-12-27	申请日起二十年	原始取得
52	Method of improving PMOS performance in a contact etch stop layer process	发明	美国	US13/730,169	2012-12-28	申请日起二十年	原始取得
53	Method to manufacture trench-first copper interconnection	发明	美国	US13/726,532	2012-12-24	申请日起二十年	原始取得
54	Algorithm of Cu interconnect dummy inserting	发明	美国	US13/731,128	2012-12-31	申请日起二十年	原始取得
55	Method of depositing the metal barrier layer comprising silicon dioxide	发明	美国	US14/069,570	2013-11-1	申请日起二十年	原始取得
56	Semiconductor structure with means for testing metal-insulator-metal capacitors	发明	美国	US14/040,741	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
57	Test module device and a test method for monitoring the stability of processes	发明	美国	US14/080,534	2013-11-14	申请日起二十年	原始取得
58	Method of manufacturing semiconductor device	发明	美国	US14/103,496	2013-12-11	申请日起二十年	原始取得
59	Layout pattern modification method	发明	美国	US14/105,689	2013-12-13	申请日起二十年	原始取得
60	Optical proximity correction method based on hybrid simulation model	发明	美国	US14/086,222	2013-11-21	申请日起二十年	原始取得
61	Method of detecting and measuring contact alignment shift relative to gate structures in a semicondcutor device	发明	美国	US14/040,730	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
62	Method of detecting transistors mismatch in a SRAM cell	发明	美国	US14/040,733	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
63	Method of reducing contamination in CVD chamber	发明	美国	US14/040,739	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
64	Method of manufacturing dual gate oxide devices	发明	美国	US14/040,737	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
65	Method of detecting the circular uniformity of the semiconductor circular contact holes	发明	美国	US14/053,750	2013-10-15	申请日起二十年	原始取得
66	Forming method of an annular storage unit of a magneto-resistive memory	发明	美国	US14/063,398	2013-10-25	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
67	Method of manufacturing the trench of U-shape	发明	美国	US14/070,060	2013-11-1	申请日起二十年	原始取得
68	Method of forming the gate with the LELE double pattern	发明	美国	US14/085,380	2013-11-20	申请日起二十年	原始取得
69	CMOS charge pump circuit	发明	美国	US14/091,337	2013-11-26	申请日起二十年	原始取得
70	Apparatus for detecting the flatness of wafer and the method thereof	发明	美国	US14/092,056	2013-11-27	申请日起二十年	原始取得
71	Method of inspecting misalignment of polysilicon gate	发明	美国	US14/142,584	2013-12-27	申请日起二十年	原始取得
72	Methods and systems for using oxidation layers to improve device surface uniformity	发明	美国	US14/590,011	2015-1-6	申请日起二十年	原始取得
73	Embedded SiGe epitaxy test pad	发明	美国	US15/937,881	2018-3-28	申请日起二十年	原始取得
74	Embedded SiGe epitaxy test pad	发明	美国	US14/691,516	2015-4-20	申请日起二十年	原始取得
75	Semiconductor devices with shaped cavities for embedding germanium material and manufacturing processes thereof	发明	美国	US14/691,508	2015-4-20	申请日起二十年	原始取得
76	Methods and Systems for Improved Uniformity of SiGe Thickness	发明	美国	US14/691,520	2015-4-20	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
77	Shaped cavity for SiGe filling material	发明	美国	US14/706,986	2015-5-8	申请日起二十年	原始取得
78	Methods and systems for using conformal filling layers to improve device surface uniformity	发明	美国	US14/720,829	2015-5-24	申请日起二十年	原始取得
79	Method for forming cobalt barrier layer and metal interconnection process	发明	美国	US14/753,311	2015-6-29	申请日起二十年	原始取得
80	Floating gate flash memory device and compilation method thereof	发明	美国	US14/753,220	2015-6-29	申请日起二十年	原始取得
81	Methods and systems for reducing dislocation defects in high concentration epitaxy processes	发明	美国	US14/879,057	2015-10-8	申请日起二十年	原始取得
82	Method of fabricating semiconductor device and semiconductor device fabricated thereby	发明	美国	US15/235,235	2016-8-12	申请日起二十年	原始取得
83	Method for establishing mapping relation in STI etch and controlling critical dimension of STI	发明	美国	US15/083,292	2016-3-29	申请日起二十年	原始取得
84	Method of planarizing polysilicon gate	发明	美国	US15/235,172	2016-8-12	申请日起二十年	原始取得
85	Method of preparing a plan-view transmission electron microscope sample used in an integrated circuit analysis	发明	美国	US15/241,284	2016-8-19	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
86	Structure for interconnect parasitic extraction	发明	美国	US15/241,108	2016-8-19	申请日起二十年	原始取得
87	System, method and test layout for detecting leakage current	发明	美国	US15/260,361	2016-9-9	申请日起二十年	原始取得
88	Simulation method of CMP process	发明	美国	US15/283,286	2016-9-30	申请日起二十年	原始取得
89	Method for forming shallow trenches of the dual active regions	发明	美国	US15/283,271	2016-9-30	申请日起二十年	原始取得
90	Photoresist bottle capable of improving poor coating coverage	发明	美国	US15/333,105	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
91	High pressure low thermal budge high-k post annealing process	发明	美国	US16/057,829	2018-8-8	申请日起二十年	原始取得
92	SiGe source/drain structure	发明	美国	US16/112,640	2018-8-24	申请日起二十年	原始取得
93	Method of sub resolution assist feature	发明	美国	US15/822,230	2017-11-27	申请日起二十年	原始取得
94	Hotspot correction method	发明	美国	US15/826,705	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
95	SiGe source/drain structure and preparation method thereof	发明	美国	US15/390,528	2016-12-25	申请日起二十年	原始取得
96	Method for forming high aspect ratio patterning structure	发明	美国	US15/385,884	2016-12-21	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
97	Method for quickly establishing lithography process condition by a pre-compensation value	发明	美国	US15/800,043	2017-10-31	申请日起二十年	原始取得
98	Method of etching a shallow trench	发明	美国	US15/389,414	2016-12-22	申请日起二十年	原始取得
99	Structure and generation method of clock distribution network	发明	美国	US15/659,577	2017-7-25	申请日起二十年	原始取得
100	Method and system for MOM capacitance value control	发明	美国	US15/826,726	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
101	Optimization method and system for overlay error compensation	发明	美国	US15/800,071	2017-11-1	申请日起二十年	原始取得
102	OPC method for a pattern corner	发明	美国	US15/800,088	2017-11-1	申请日起二十年	原始取得
103	OPC method for a shallow ion implanting layer	发明	美国	US15/800,081	2017-11-1	申请日起二十年	原始取得
104	Manufacturing method of a flash wafer	发明	美国	US15/822,226	2017-11-27	申请日起二十年	原始取得
105	High pressure low thermal budge high-k post annealing process	发明	美国	US15/429,194	2017-2-10	申请日起二十年	原始取得
106	Device and method for inrush current control	发明	美国	US15/638,383	2017-6-30	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
107	Transistor with SONOS structure having barrier wall over adjacent portions of the select transistor well and memory transistor well	发明	美国	US15/944,802	2018-4-4	申请日起二十年	原始取得
108	Bipolar transistor with trench structure	发明	美国	US15/944,801	2018-4-4	申请日起二十年	原始取得
109	Pixel structure and manufacturing method therefor	发明	美国	US16/203,628	2018-11-29	申请日起二十年	原始取得
110	Pattern density analysis method	发明	美国	US16/203,624	2018-11-29	申请日起二十年	原始取得
111	Silicon-controlled rectifier structure and manufacturing method thereof	发明	美国	US16/192,818	2018-11-16	申请日起二十年	原始取得
112	Manufacturing method of a high performance metal-oxide-metal	发明	美国	US13/339,593	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
113	Method for reducing a minimum line width in a spacer-defined double patterning process	发明	美国	US13/339,559	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
114	Treatment method for reducing particles in dual damascene silicon nitride process	发明	美国	US13/339,400	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
115	Method of making optical proximity correction to original gate photomask pattern based on different substrate areas	发明	美国	US13/339,411	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
116	Method for improving capacitance uniformity in a MIM device	发明	美国	US13/339,406	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
117	Method for decreasing polysilicon gate resistance in a carbon co-implantation process	发明	美国	US13/339,417	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
118	Global shutter CMOS image sensor and method for making the same	发明	美国	US18/063808	2022-12-9	申请日起二十年	原始取得
119	Method for locating open circuit failure point of test structure	发明	美国	US17/896336	2022-8-26	申请日起二十年	原始取得
120	Semiconductor structure and the manufacturing method thereof	发明	美国	US17/723305	2022-4-18	申请日起二十年	原始取得
121	Semiconductor structure of split gate flash memory cell	发明	美国	US17/409146	2021-8-23	申请日起二十年	原始取得
122	Method for manufacturing shallow trench isolations	发明	美国	US17/493229	2021-10-4	申请日起二十年	原始取得
123	Method for detecting flare degree of lens of exposure machine	发明	美国	US17/492786	2021-10-4	申请日起二十年	原始取得
124	Semiconductor device and method for manufacturing the same	发明	美国	US17/389182	2021-7-29	申请日起二十年	原始取得
125	Semiconductor device and manufacturing method thereof	发明	美国	US17/388842	2021-7-29	申请日起二十年	原始取得
126	Voltage controlled oscillator structure and phase-locked loop	发明	美国	US17/327294	2021-5-21	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
127	Silicon controlled rectifier and method for making the same	发明	美国	US17/240862	2021-4-26	申请日起二十年	原始取得
128	No-snapback silicon controlled rectifier and method for making the same	发明	美国	US17/217644	2021-3-30	申请日起二十年	原始取得
129	Silicon controlled rectifier and method for making the same	发明	美国	US17/217517	2021-3-30	申请日起二十年	原始取得
130	Manufacturing method for a semiconductor device	发明	美国	US17/244620	2021-4-29	申请日起二十年	原始取得
131	Silicon controlled rectifier and method for making the same	发明	美国	US17/234,633	2021-4-19	申请日起二十年	原始取得
132	Method for forming doped epitaxial layer of contact image sensor	发明	美国	US17/142431	2021-1-6	申请日起二十年	原始取得
133	Global shutter CMOS image sensor and method for making the same	发明	美国	US16/951606	2020-11-18	申请日起二十年	原始取得
134	Semiconductor structure and the manufacturing method thereof	发明	美国	US16/855803	2020-4-22	申请日起二十年	原始取得
135	Preventive maintenance method for chamber of metal etching machine	发明	美国	US17/958,548	2022-10-3	申请日起二十年	原始取得
136	Method for manufacturing deep trench isolation grid structure	发明	美国	US17/385,430	2021-7-26	申请日起二十年	原始取得
137	SONOS memory and method for making the same	发明	美国	US17/352,451	2021-6-21	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
138	Layout structure of eFuse unit	发明	美国	US16/952,288	2020-11-19	申请日起二十年	原始取得
139	Power-on-reset circuit	发明	美国	US18/231,851	2025-1-28	申请日起二十年	原始取得
140	Method for Preparing Pixel Cell of CMOS Image Sensor	发明	美国	US17/890,376	2022-8-18	申请日起二十年	原始取得
141	Method for Measuring Stitching Overlay Accuracy of Image Sensor Stitching Manufacturing	发明	美国	US17/893,425	2022-8-23	申请日起二十年	原始取得
142	Image Stitching Method for Stitching Product	发明	美国	US17/895,279	2022-8-25	申请日起二十年	原始取得
143	Method for Automatically Detecting Wafer Backside Brightfield Image Anomaly	发明	美国	US17/941,222	2022-9-9	申请日起二十年	原始取得
144	Method for purge clean of low pressure furnace	发明	美国	US18/305,983	2023-4-24	申请日起二十年	原始取得
145	Super Flash and Method for Manufacturing Same	发明	美国	US18/139,530	2023-4-26	申请日起二十年	原始取得
146	System for Truning Off Power Consumption of Auxiliary Startup Circuit	发明	美国	US18/368,775	2023-9-15	申请日起二十年	原始取得

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
147	One time programmable memory cell	发明	美国	US18/368,691	2023-09-15	申请日起二十年	原始取得
148	Method for manufacturing photomask and photomask	发明	美国	US17/893,387	2022-08-23	申请日起二十年	原始取得

表 3：标的公司拥有的主要集成电路布图设计专有权

序号	布图设计名称	布图设计登记号	专有权人	申请日期	登记日期
1	HL55LPPOR06S1V1P0	BS.165515805	华力微	2016-08-29	2016-10-11
2	HL55LPPOR12D1V1P0	BS.165515813	华力微	2016-08-29	2016-10-12
3	HL55LPAD12S025D1V1	BS.165515791	华力微	2016-08-29	2016-10-12
4	AD12S025D1V1_DAC	BS.165515783	华力微	2016-08-29	2016-10-11
5	HL55LPBGR12D1V1P0 TOP_B	BS.165515775	华力微	2016-08-29	2016-10-12
6	HL55LPVR100D1V1P0	BS.165515767	华力微	2016-08-29	2016-10-11
7	HL55LPBGR12D1V1P0 TOP_A	BS.165515759	华力微	2016-08-29	2016-10-12
8	HL55LPPLL1500S1V1P0_A	BS.165515732	华力微	2016-08-29	2016-10-12
9	HL55LPPLL1500D1V1P0	BS.165515740	华力微	2016-08-29	2016-10-11
10	HL55LPLD0100D1V1P0	BS.165515724	华力微	2016-08-29	2016-10-11